

PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

P. Lorenzini

Polytech'Nice Sophia

Dept. Électronique

Objectifs du cours

- Comprendre l'intérêt des semi-conducteurs dans la fabrication des composants électroniques
- Maîtriser des mécanismes de transports électroniques et des phénomènes physiques régissant le fonctionnement des composants discrets de l'électronique.
- Maitriser le fonctionnement DC et AC de la jonction PN

Plan du cours (18 h – 2 contrôles min)

1. Structure cristalline et cristallographie
2. Diffraction d'une onde par un cristal
3. mécanique quantique / ondulatoire : l'équation de Schrödinger
4. Les électrons quasi libres : le modèle de Sommerfeld
5. Les électrons dans une structure périodique : le modèle de Bloch – Brillouin
6. Courant dans les solides : cas particulier des semi-conducteurs
mécanique statistique : la fonction de Fermi Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann
7. Semi-conducteur à l'équilibre
8. Dopage des semi-conducteurs
9. Semi-conducteur hors équilibre: courant dans les semi-conducteurs
Jonction PN

Références bibliographiques

- C. Kittel, « physique de l'état solide », dunod université, 5° ed., 1983
- H. Mathieu, « Physique des semiconducteurs et des composants électroniques », dunod, 5° ed., 2004
- J. Singh, « semiconductors devices: an introduction », Mc.Graw Hill, 1994
- D.A.Neamen, « semiconductor physics and devices: basic principles », Mc.Graw Hill, 2003
- Cours de Physique des semiconducteurs, Pr. Rouzeyre, Université de Montpellier II, 1985
- McMurry and Fay, « Chemistry », Prentice Hall; 4th edition (April 7, 2003) (les figures du chapitre 1 proviennent majoritairement de cet ouvrage)

CHAPITRE 1

Liaison cristalline et cristallographie

structure cristalline et cristallographie

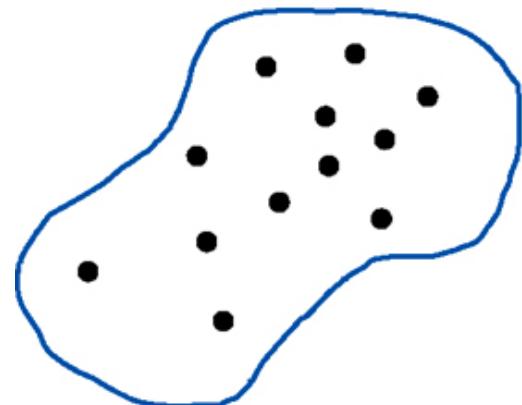
- États cristallin et amorphe
- Liaisons cristallines
- Géométrie des cristaux
- Diffraction cristalline - Réseau réciproque

États cristallin et amorphe

- amorphe \Leftrightarrow verre
- cristalin \Leftrightarrow quartz, SiO_2
- Distinction:
 - Au niveau macroscopique:
 - Si on élève la température du verre, on observe un passage progressif de l'état solide à l'état de liquide sans palier.
 - Pour un cristal, on observe un palier de température dû à une coexistence (changement) de phase.
 - Au niveau microscopique:
 - Amorphe : répartition aléatoire des atomes
 - Cristalin : répartition périodique dans l'espace des atomes.

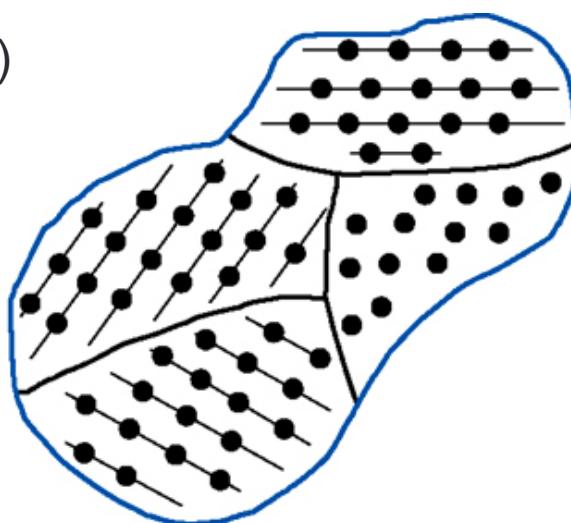
États cristallin et amorphe

(D'après Neamen)



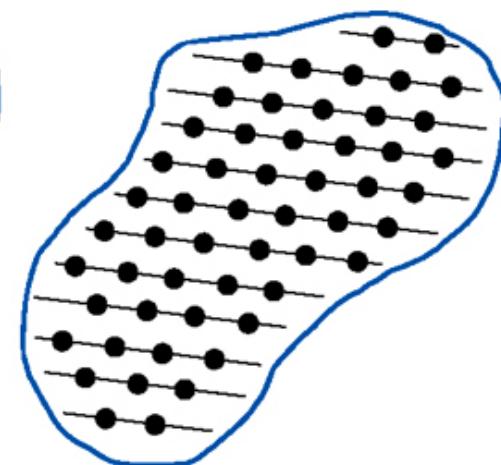
(a)

*Amorphe
(pas d'ordre)*



(b)

*Polycristallin
(ordre à courte portée)*



(c)

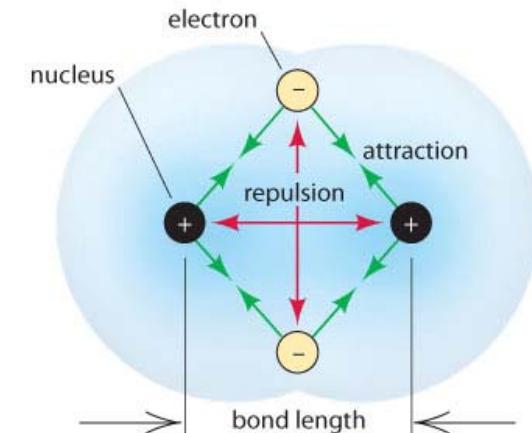
*Cristallin
(ordre à longue portée)*

La liaison cristalline

- Quelles sont les forces qui permettent aux atomes de se lier entre eux et de former telles ou telles structures?

$$\text{Le but : } U_{cristal} - U_{libre} < 0$$

- Plusieurs paramètres/effets à prendre en compte:
 - Garder les ions chargés positivement éloignés les uns des autres
 - Garder les électrons chargés négativement éloignés les uns des autres
 - Garder les électrons proches des ions
 - Minimiser l'énergie cinétique des électrons en les répartissant

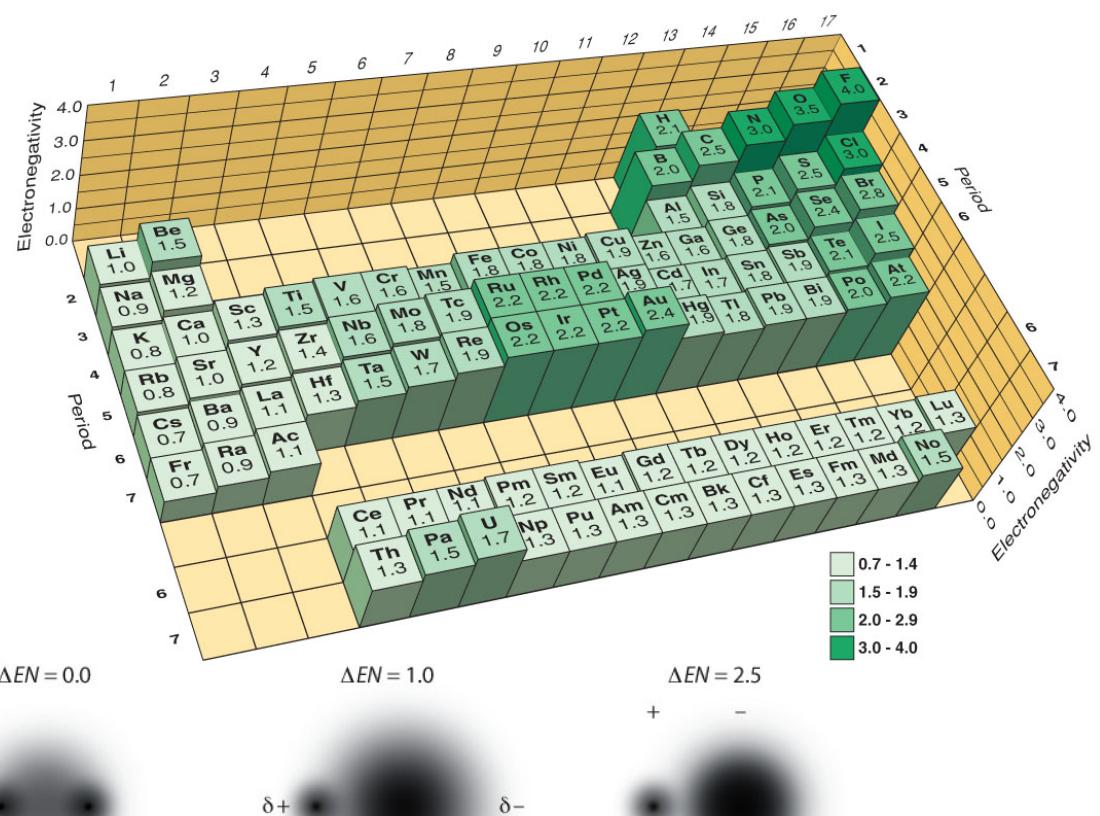


Electronégativité

- **Electronegativité:** c'est la capacité d'un atome à attirer les électrons mis en commun dans une liaison chimique.

La différence d'électronégativité ΔEN entre deux atomes liés peut être nulle, faible ou grande.

- $\Delta EN \sim 0$: les électrons sont également répartis
- $\Delta EN \sim 1$: les électrons sont plus proches de l'atome le plus électronégatif.
- ΔEN est élevée, les électrons sont peu partagés (pas mis en commun)



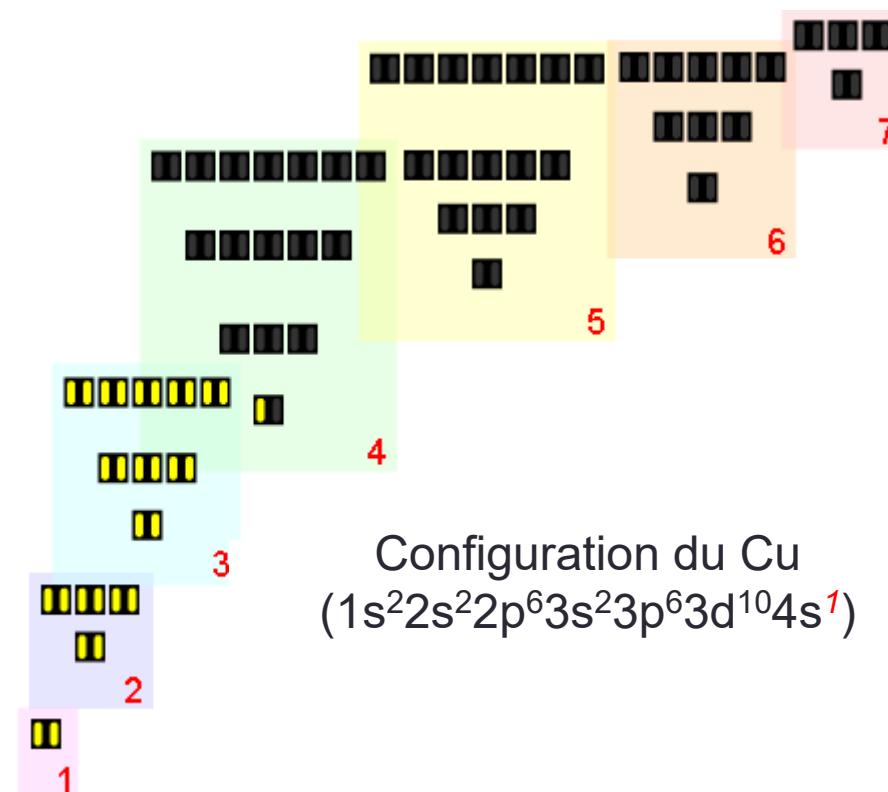
La liaison cristalline

- 4 principaux types:
 - Liaison métallique
 - Liaison covalente
 - Liaison ionique
 - Liaison de Van der Waals (gaz rares) ou liaison moléculaire
- Un point commun:
 - Les atomes essayent d'avoir leur dernière couche électronique vide ou complète !

La liaison métallique

- La majorité des éléments chimiques ont un comportement métallique plus ou moins marqué.
- Construite à partir d'éléments ayant peu d'électrons de valence /à leur période ou niveau d'énergie
- Exemple:
 - Sodium (Na) $\Leftrightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
 - Cuivre (Cu) $\Leftrightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

La liaison métallique : le cuivre



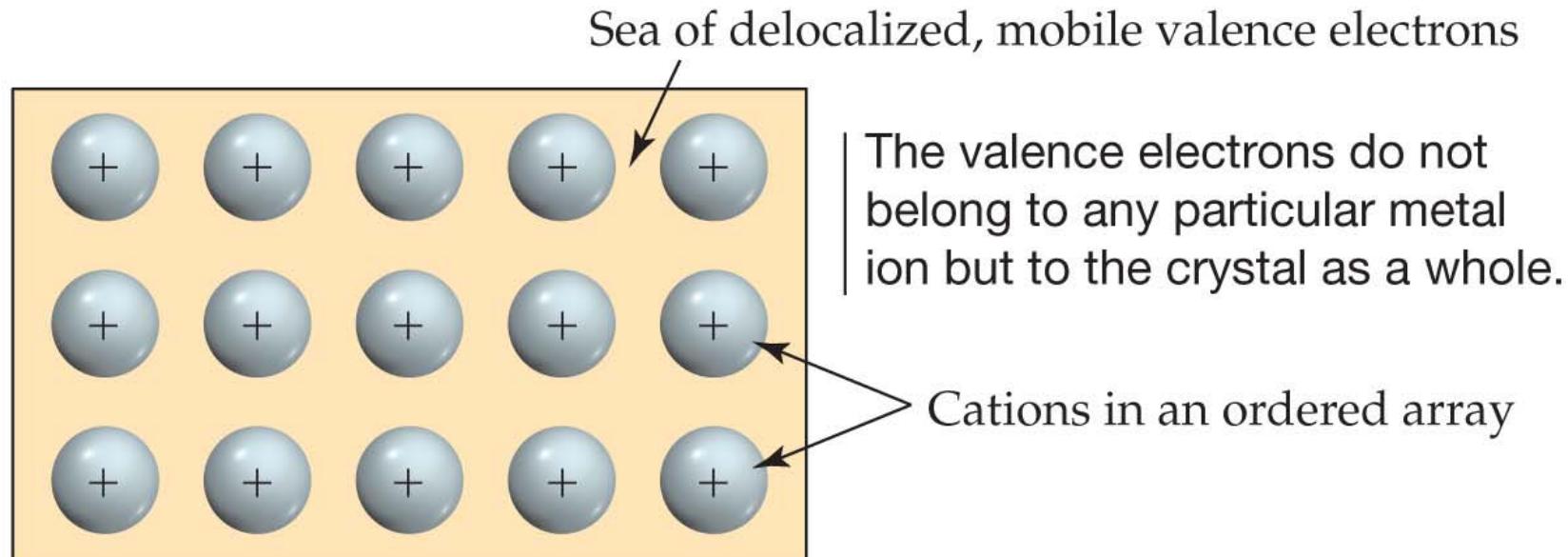
La liaison métallique

- Les électrons périphériques sont très peu liés à l'atome
- L'atome « libère » facilement ce(ces) électron(s)
- Les noyaux constituent alors un ensemble de charges positives ⇔ ions positifs à couche externe saturée
- La cohésion est assurée par le nuage électronique chargé négativement
- Force de cohésion ⇔ attraction Coulombienne
- Liaisons « plutôt » faibles ⇔ matériaux moins durs et fusion à basse Température

1	2	Melting Points of Metals (°C)												13
Li	Be													Al
180.5	128.7													
Na	Mg													
97.794	650	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		660.32	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga		
63.38	842	1541	1668	1910	1907	1246	1538	1495	1455	1084.6	419.53	29.77		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In		
39.30	777	1522	1854.7	2477	2623	2157	2334	1964	1554.8	9612.2	321.1	156.6		
Cs	Ba				W		Os		Pt	Au	Hg			
28.44	727				3422		3033		1768.2	1064.2	-38.83			

Metallic bond

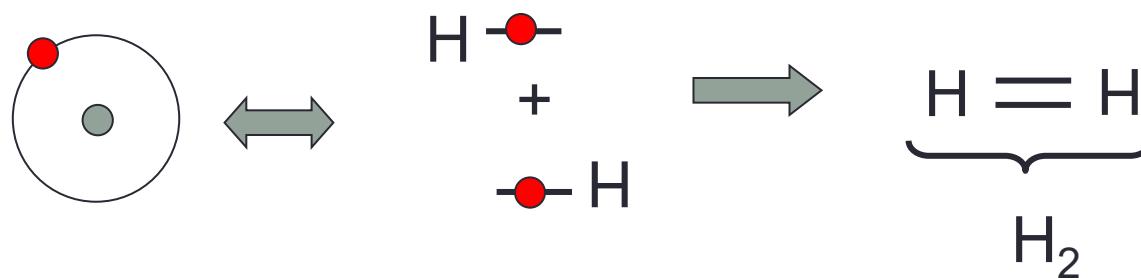
Electron-Sea Model: A metal crystal is viewed as a three-dimensional array of metal cations immersed in a sea of delocalized electrons that are free to move throughout the crystal.



La liaison covalente

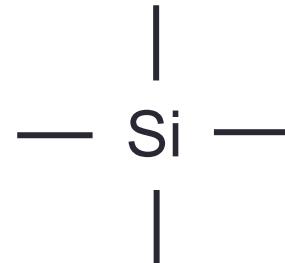
- Les cristaux appartiennent à la colonne IV du tableau périodique
- Liaison du même type que la liaison hydrogène
- L'Hydrogène:
 - 1 électron périphérique
 - Pour compléter sa couche, il accepterait « bien » un deuxième électron
 - Un deuxième atome d'H va permettre de mettre en commun leur électron périphérique
 - On obtient la molécule H_2

3A	4A	5A	6A	7A	He
5 B $2s^2 2p$	6 C $2s^2 2p^2$	7 N $2s^2 2p^3$			
13 Al $3s^2 3p$	14 Si $3s^2 3p^2$	15 P $3s^2 3p^3$			
31 Ga $4s^2 4s^2 4p$	32 Ge $4s^2 4p^2$	33 As $4s^2 4p^3$			
49 In $5s^2 5s^2 5p$	50 Sn $5s^2 5p^2$	51 Sb $5s^2 5p^3$			
81 Tl $6s^2 6s^2 6p$	82 Pb $6s^2 6p^2$	83 Bi $6s^2 6p^3$			
114 Unknown	114 Unknown	114 Unknown			

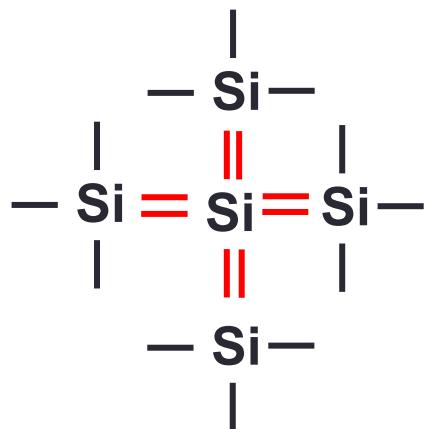


La liaison covalente

- Exemple : le Silicium
 - 4 électrons de valence



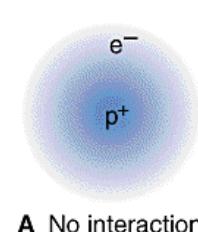
- Il « manque » 4 électrons de valence pour compléter sa couche externe
- Il suffit de « rapprocher » 4 autres Silicium



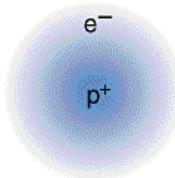
À la différence de H_2 , une fois les liaisons saturées, les 4 autres Si ont encore des liaisons « pendantes » ⇔ ce processus peut continuer ⇔ on forme alors un cristal.

La liaison covalente

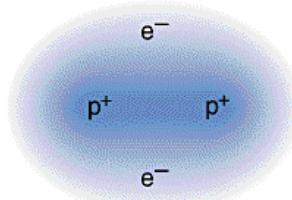
- Énergie plus faible si les électrons se « baladent » autour des 2 noyaux
- On peut obtenir le même type de résultats avec des composés II-VI ou encore III-V.(voir la suite)



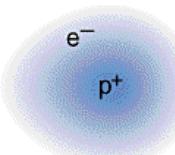
A No interaction



B Attraction begins



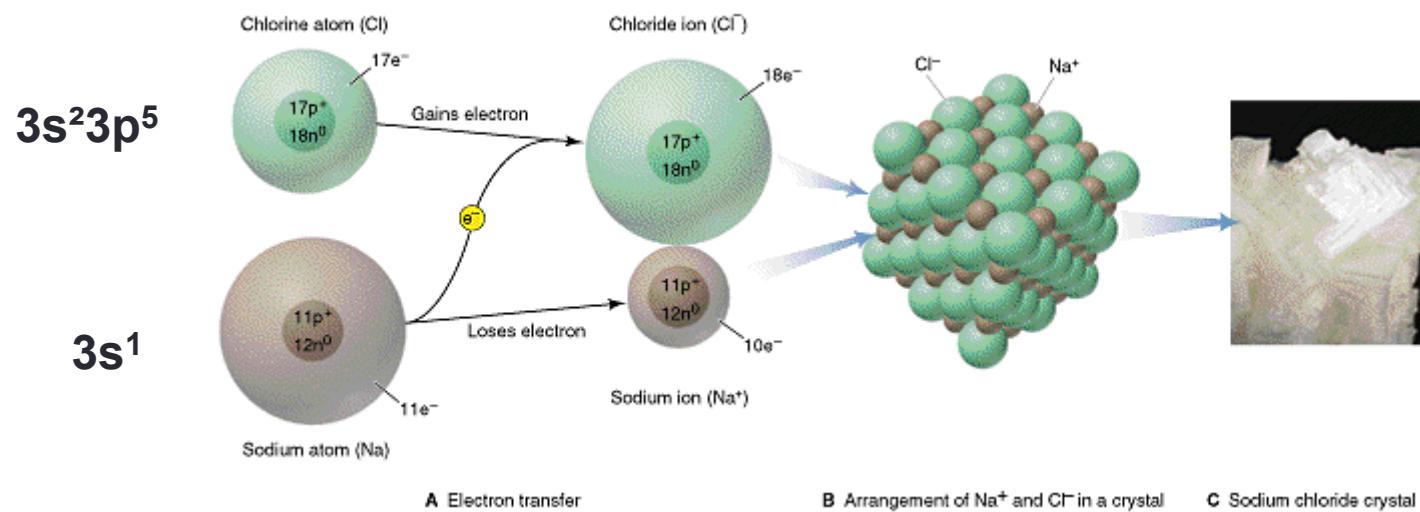
C Covalent bond



D Combination of forces

Liaison ionique

- Association d'un élément chimique fortement électronégatif ($7e^-$) et d'un élément fortement électropositif ($1e^-$): ex NaCl
- L'électronégatif accepte un e^- et devient un ion négatif (Cl^-), l'électropositif cède son e^- et devient un ion positif (Na^+)



(D'après McMurry and Fay)

Liaison ionique

- La force de cohésion est due à l'attraction Coulombienne des deux ions \Leftrightarrow liaison ionique
- En fait, liaison « identique » à la liaison covalente sauf que les atomes sont très différents (pas la même colonne)
- La frontière covalente/ionique n'est pas brutale: dépend de la nature électronique des éléments associés
 - Col I – VII \Leftrightarrow essentiellement ionique
 - Col II-VI \Leftrightarrow 80% ionique 20% covalente (CdTe)
 - Col III-V \Leftrightarrow 60% ionique 40% covalente (GaAs, GaP, InP)
 - Col IV-IV \Leftrightarrow essentiellement covalente (Si, Ge)

Liaison ionique

- L'électron libéré par le métal Alcalin (Na) est piégé par l'Halogène (Cl)
- Aucun électron libéré dans le réseau
- En général les cristaux ioniques sont **isolants**
- Liaison entre atomes très forte \Leftrightarrow cristaux très durs

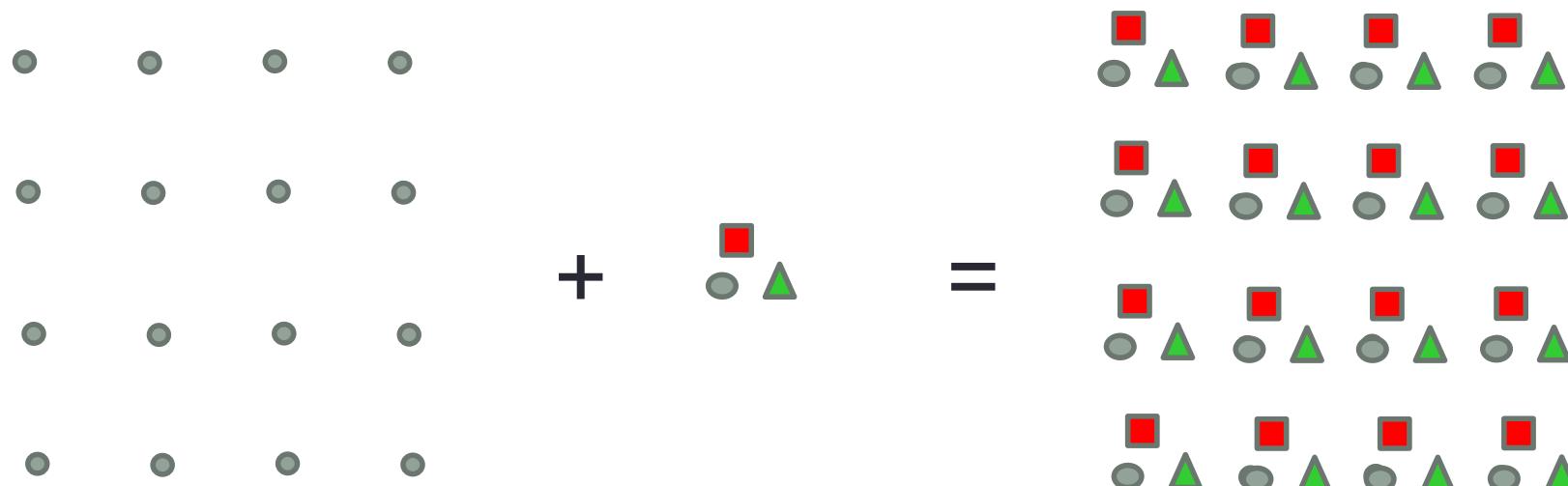
Liaison de type Van der Waals

- Ceux sont les cristaux les plus simples
- La distribution électronique = atome libre
- Couches électroniques déjà saturées (col. VIII)
- Les atomes s'empilent de façon la plus dense possible
- Énergie de liaison très faible (qq % de l'énergie d'ionisation de l'atome) \Leftrightarrow cristaux fondent à basse température
- Responsable de la cohésion des molécules

Géométrie des cristaux

- Un cristal est constitué par la répétition périodique d'un **motif** cristallin: c'est la base du réseau.
 - pour le Silicium, Ge base : 1 seul atome
 - Pour le GaAs base : 2 atomes
 - Pour un crist. moléculaire base : Protéine $10^4\text{-}10^5$ at.
- On décrit la structure périodique par un réseau: **le réseau cristallin**
- À 2 Dim: Réticule (net) \Leftrightarrow réseau plan
- À 3 Dim: Réseau (Lattice) \Leftrightarrow réseau 3D

Géométrie des cristaux



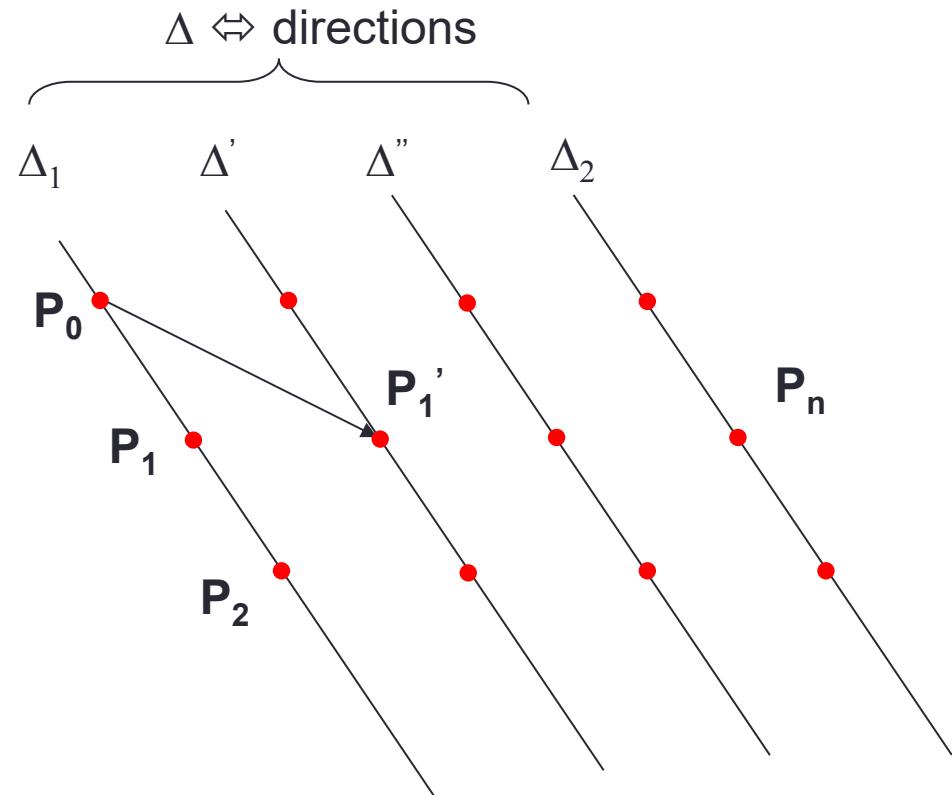
Lattice
(réseau)

Basis (base):
a building block of atoms

Crystal structure
(structure cristalline)

Géométrie des cristaux

- Postulat de Bravais: il existe dans le cristal un ensemble de points P_n qui ont exactement le même environnement microscopique que P_0 (le pt origine) ie que le paysage atomique vu de P_n est le même qu'en P_0 en grandeur **et** en direction. Cet ensemble de points est un ensemble de points congruents ou sommet du réseau
- Réseau de Bravais: c'est un échantillon de réseau qui montre toutes les translations du réseau. Il y en a 14 différents



Repérage des plans cristallins

- Repérage des plans cristallins: les nœuds du réseau peuvent être regroupés sur des ensembles de plans // et équidistants: **les plans réticulaires** (dans notre cas, les plans qui contiennent les atomes du réseau)
- Méthode :

$$\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \frac{1}{x_3}$$

- coordonnées des intersections des plans avec les directions cristallines
 - x_1 (distance / origine = $x_1.a$) en unité de a
 - x_2 (distance / origine = $x_2.b$) en unité de b
 - x_3 (distance / origine = $x_3.c$) en unité de c

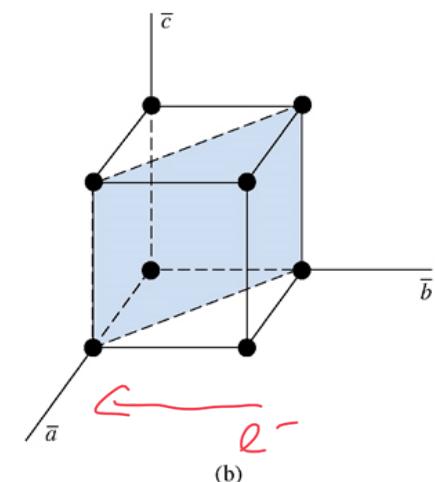
- Prendre les inverses
- Prendre les plus petits entiers dans le même rapport
- Exemple:

- $x_1=4, x_2=1, x_3=2$
- $\frac{1}{4}, 1, \frac{1}{2}$
- $1,4,2$

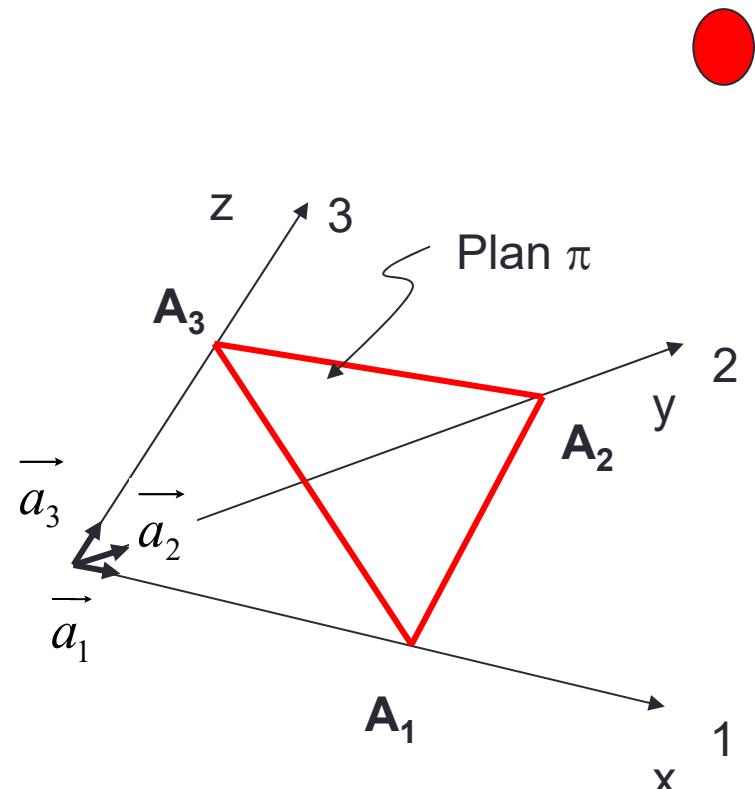
$$(h,k,l) = (1,4,2)$$

- Nota : si un des indices est négatif, on ajoute une barre sur le dessus \bar{h}

- h,k,l constituent **les indices de Miller**



Plan cristallin d'indices (h,k,l)



- $A_1, A_2, A_3 : 3$ nœuds \Leftrightarrow plan réticulaire π d'indices (hkl).

$$\overline{OA_i} = p_i \overline{a_i}$$

Valeurs de $p_1=?$, $p_2=?$, $p_3=?$

- Équation d'un plan:

$$Ax + By + Cz = 1$$

- Soit encore:

$$h \frac{x}{a_1} + k \frac{y}{a_2} + l \frac{z}{a_3} = 1$$

En utilisant les indices de Miller, on arrive (coord. numériques) à : $hx + ky + lz = N$
. Si $N=2$, le plan π est le 2° plan d'indices (h,k,l) après l'origine

Plan cristallin d'indices (h,k,l)

- Un plan réticulaire (hkl) est défini par une équation:

$$hu + kv + lw = s$$

numéro de plan

u,v,w entiers quelconques
h,k,l entiers premiers entre eux
u,v,w coordonnées numériques des nœuds

- Coordonnées vraies $x = u|\vec{a}|$ donc $u = \frac{x}{a}$

$$h\frac{x}{a} + k\frac{y}{b} + l\frac{z}{c} = s$$

平行晶面序号.

- Ce polynome peut prendre toutes les valeurs entières successives <0,>0 et 0, ie $s < 0, > 0$ et 0
 - $s=0 \Leftrightarrow$ plan passant par l'origine
 - $s=N \Leftrightarrow$ plan coupant x en ?, y en ?, z en ?
 - Exemple : plan qui coupe x en $3a$, y en $2b$, z en $2c \Leftrightarrow$ equation du plan?

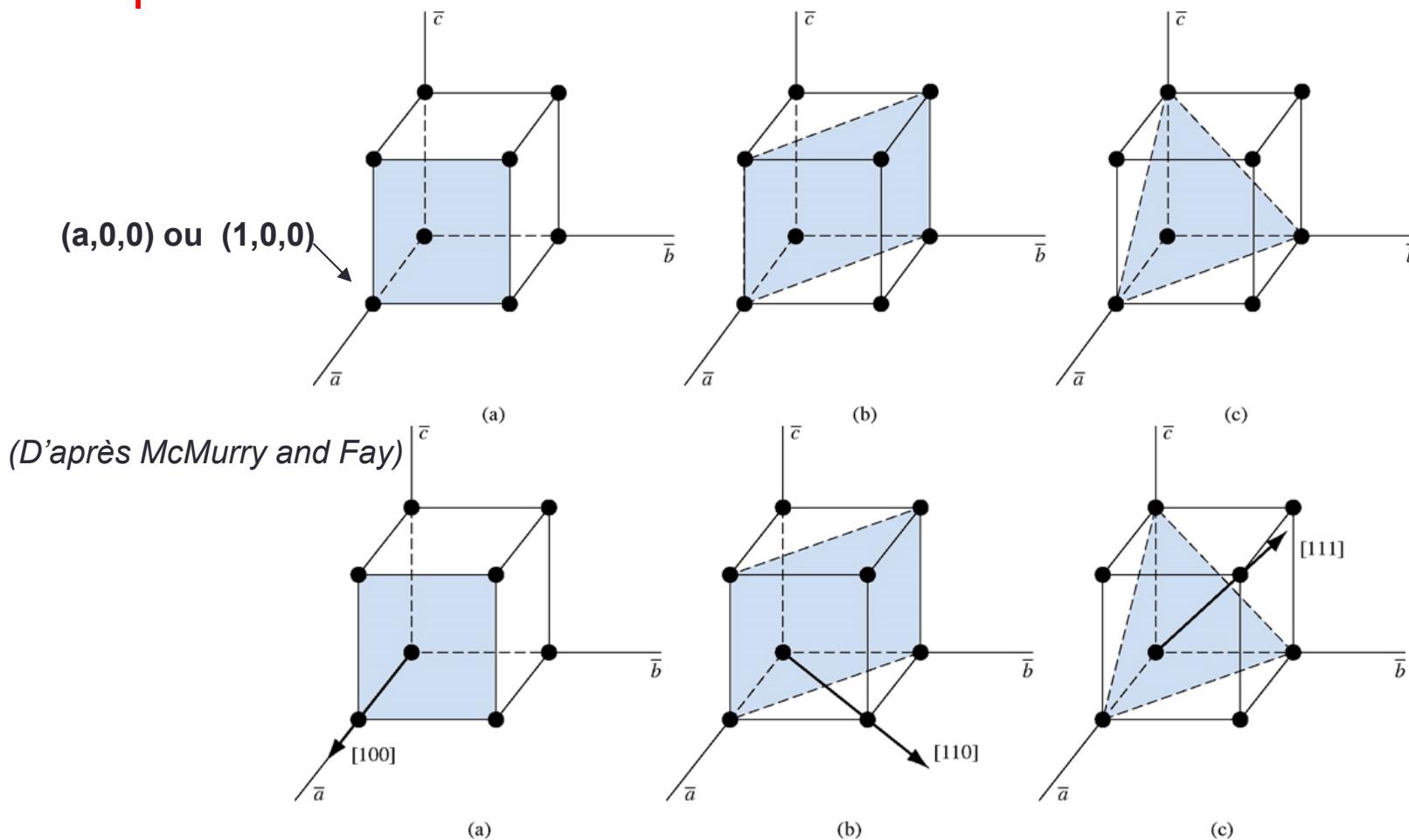
Directions cristallines

晶向

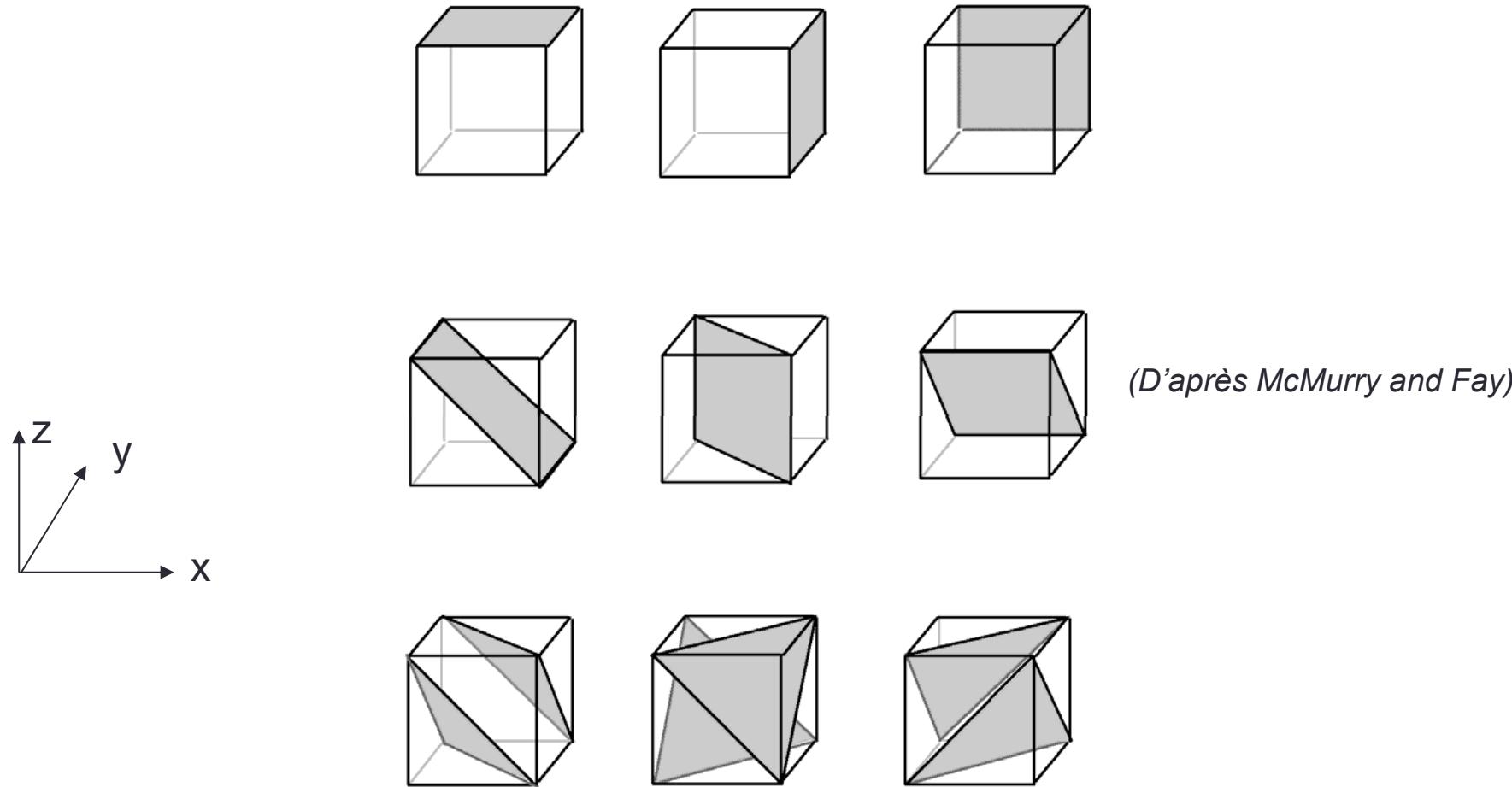
- Toute droite passant par 2 nœuds du réseau définit une **direction cristalline**. On peut la repérer par trois indices h,k,l plus petits entiers ayant même rapport entre eux que les composantes d'un vecteur colinéaire à la droite.
- Notation: $[h,k,l]$
- Cas particulier: une direction $[h,k,l]$ est orthogonale au plan de même indices (h,k,l) ou encore $[h,k,l]$ est le vecteur axial du plan (h,k,l) .

Indices de Miller (suite)

- Permet de définir des **directions cristallines** et l'orientation de **plans cristallins**:

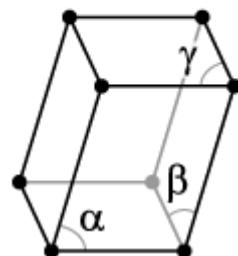


Exemples de plans dans un cristal cubique.



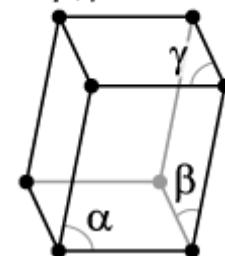
Les différentes structures cristallines

$\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$



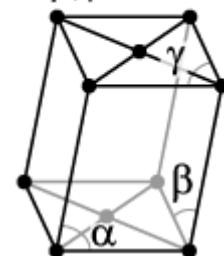
Triclinique

$\alpha \neq 90^\circ$
 $\beta, \gamma = 90^\circ$



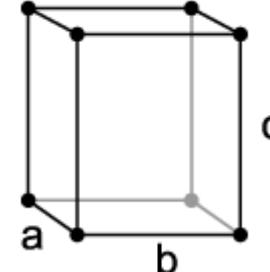
Monoclinique

$\alpha \neq 90^\circ$
 $\beta, \gamma = 90^\circ$



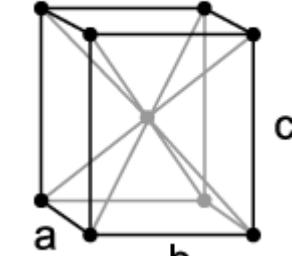
Monoclinique
centré

$a \neq b \neq c$



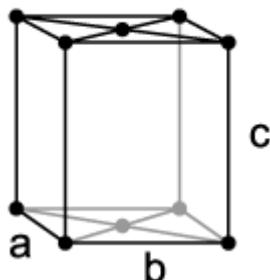
Orthorhombique

$a \neq b \neq c$



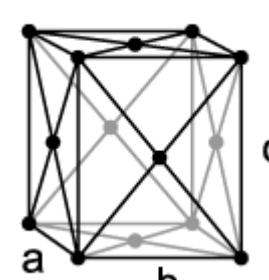
Orthorhombique
centré

$a \neq b \neq c$



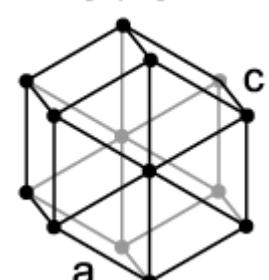
Orthorhombique
base centrée

$a \neq b \neq c$



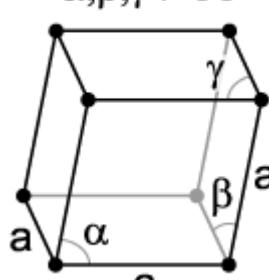
Orthorhombique
faces centrées

$a \neq c$



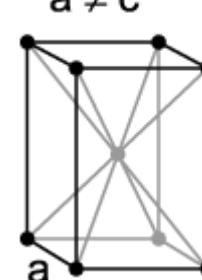
Hexagonal

$\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$



Rhomboédrique

$a \neq c$



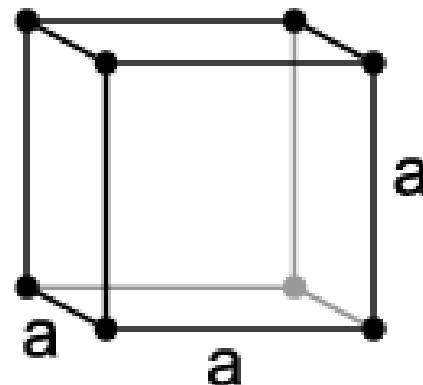
Tétragonal

$a \neq c$
↑
Tétragonal
centré

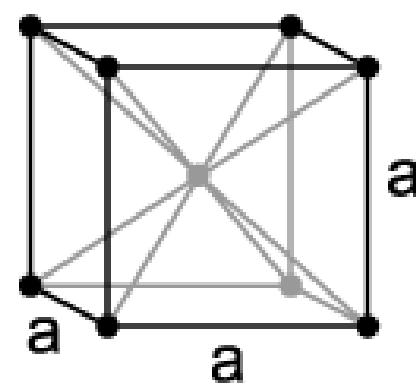
↑

↑

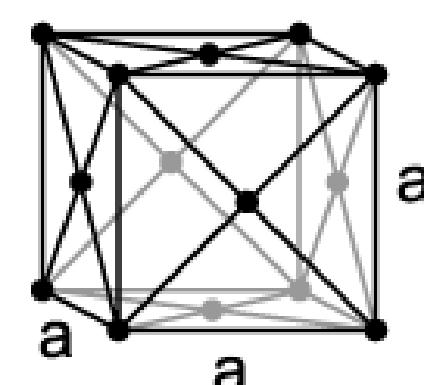
Les différentes structures cristallines



**Cubique simple
(cs)**



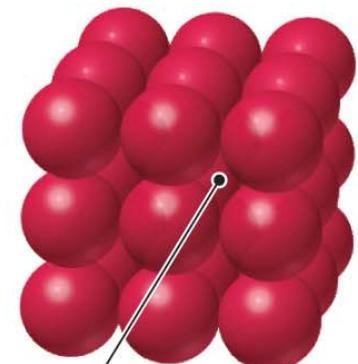
**Cubique centré
(cc)**



**Cubique faces centrées
(cfc)**

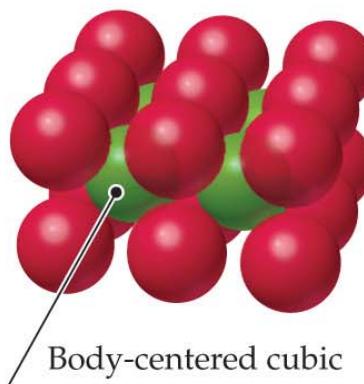
Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille

(a) In simple cubic packing, all **layers are identical** and all atoms are lined up in stacks and rows.

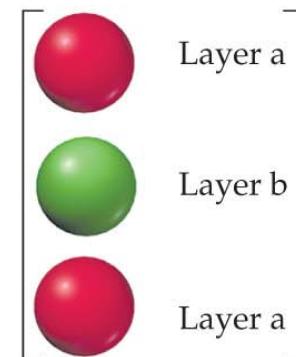


Simple cubic
Coordination number 6:
Each sphere is touched by six neighbors, four in the same layer, one directly above, and one directly below.

(b) In body-centered cubic packing, the spheres in **layer a** are separated slightly and the spheres in **layer b** are offset so that they fit into the depressions between atoms in layer a. The third layer is a repeat of the first.

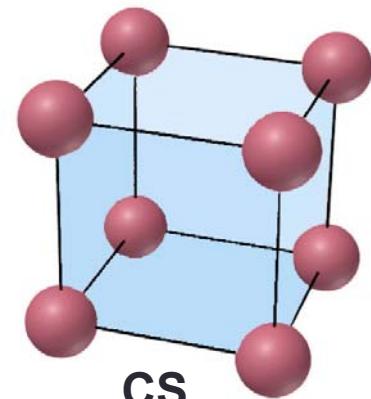


Body-centered cubic
Coordination number 8:
Each sphere is touched by eight neighbors, four in the layer below, and four in the layer above.

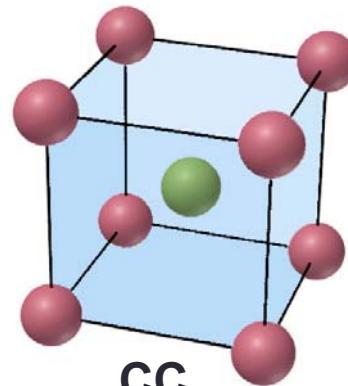


(D'après McMurry and Fay)

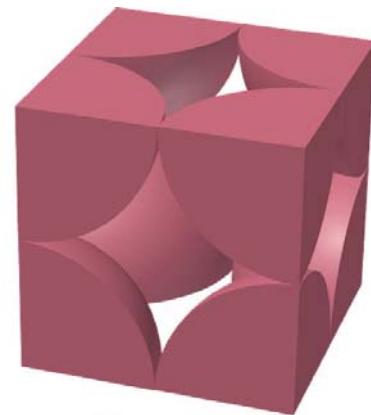
Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille



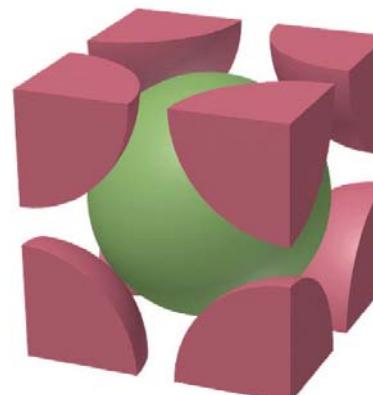
CS



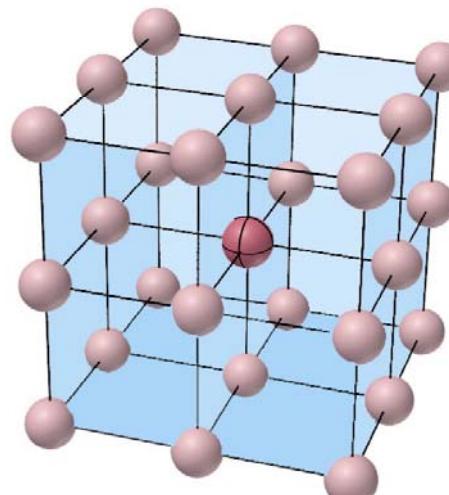
CC



(a)



(b)



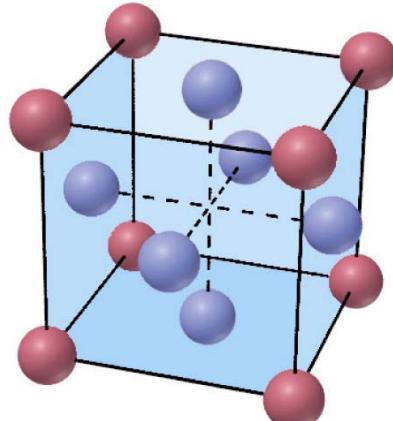
(c)

1 atome (nœud)
par maille

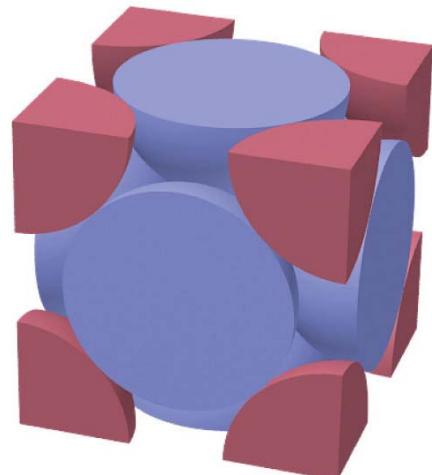
2 atomes (nœuds)
par maille

(D'après McMurry and Fay)

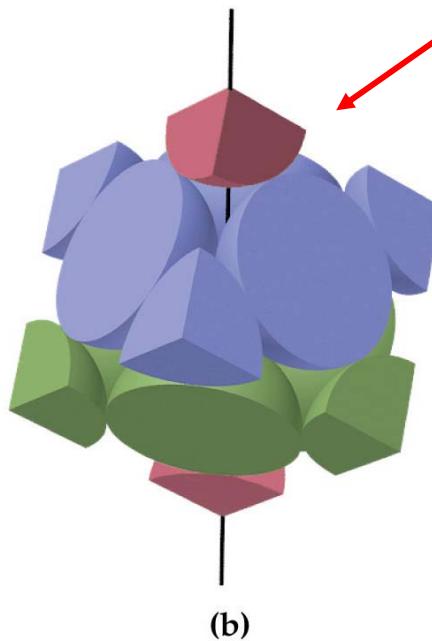
Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille



CFC



4 atomes (nœuds)
par maille

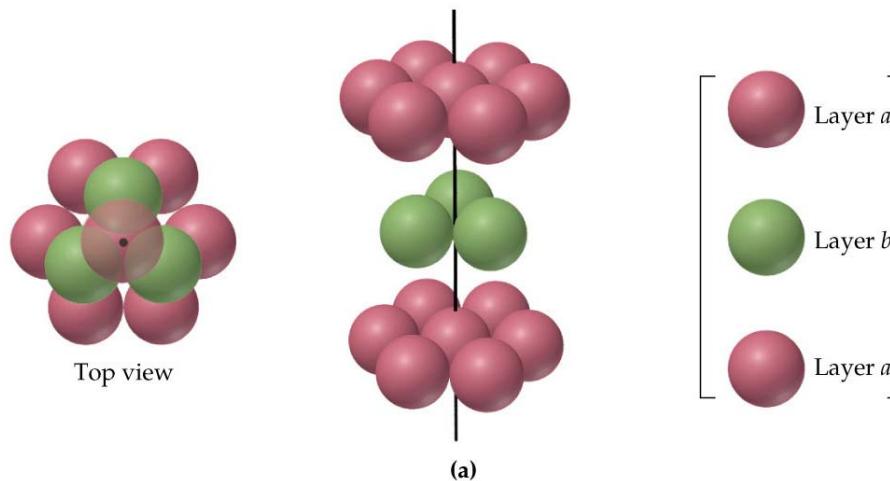


(D'après McMurry and Fay)

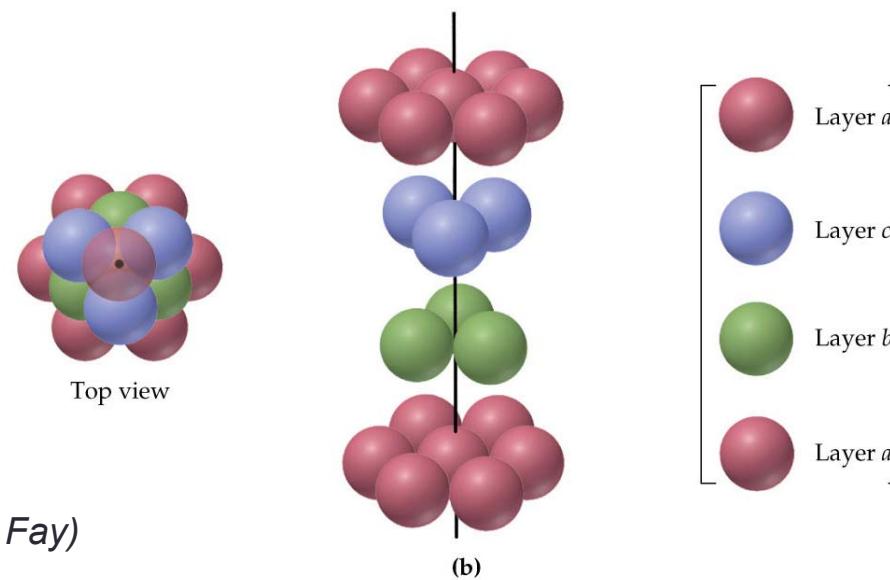
(b)

Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille

Structure Hexagonale



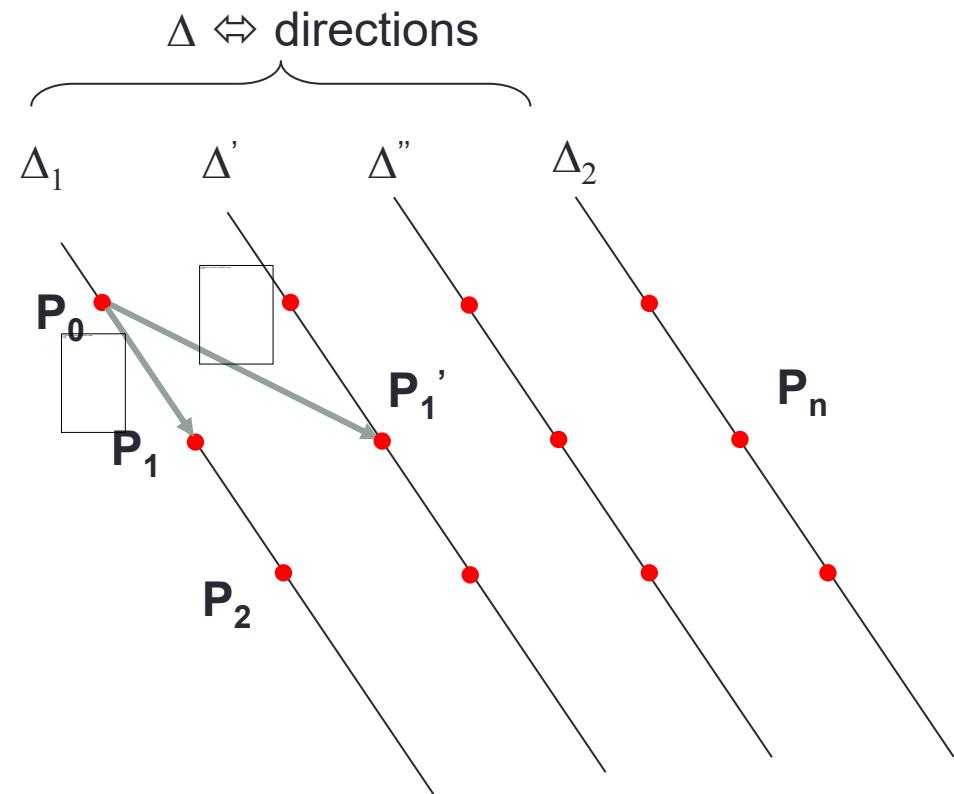
Structure Cubique Faces Centrées



(D'après McMurry and Fay)

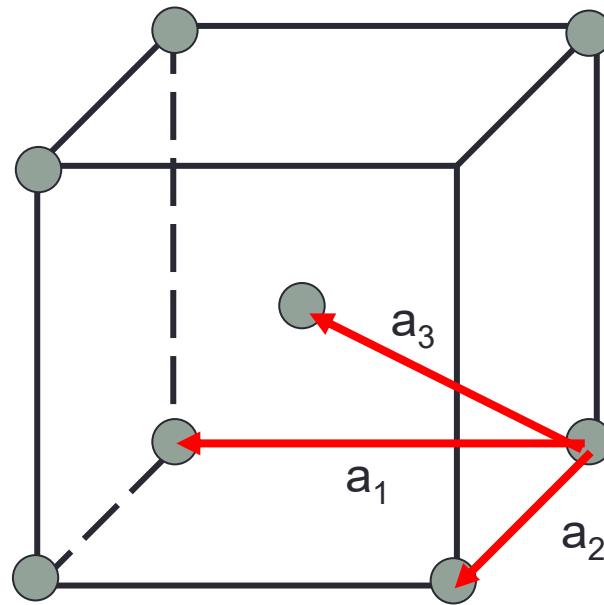
Choix des vecteurs primitifs

- Pas unique
- Méthode:
 - a_1 doit être la période la plus courte du réseau
 - a_2 doit être la période la plus courte du réseau non // à a_1
 - a_3 doit être la période la plus courte du réseau non coplanaire avec a_1 et a_2



*On obtient alors une **cellule primitive***

Le Cubique centré (cc)

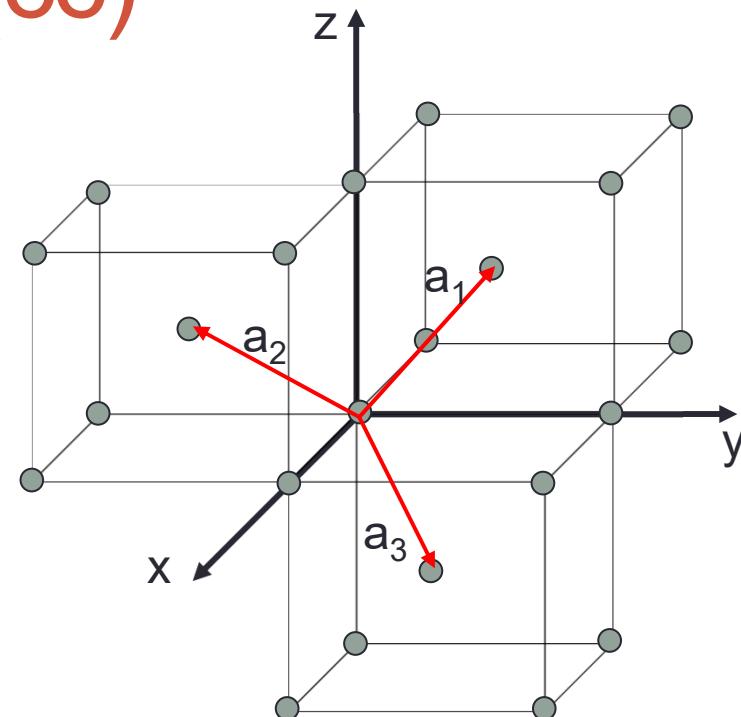


$$\vec{a}_1 = a\vec{x}$$

$$\vec{a}_2 = a\vec{y}$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$$

初歩： 体積 $\sqrt{\text{體積}} \ll$



Ou:

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{x} - \vec{y} + \vec{z})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{x} + \vec{y} - \vec{z})$$

$$V = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

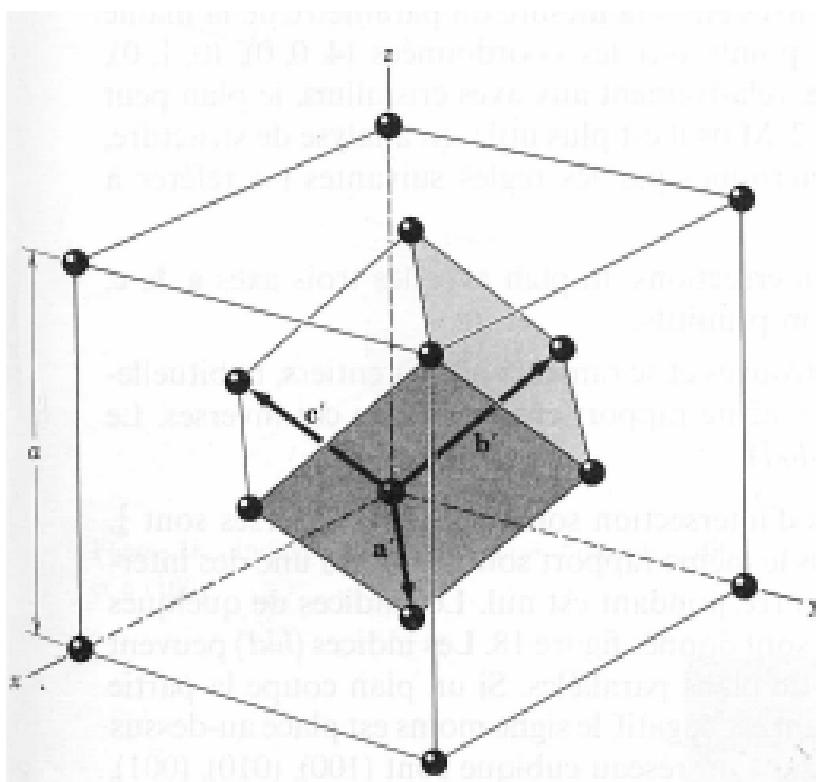


Figure 15 Maille élémentaire rhomboédrique d'un cristal cubique à faces centrées. Les vecteurs de translation fondamentaux a' , b' , c' relient un sommet aux centres des faces. Ces vecteurs sont

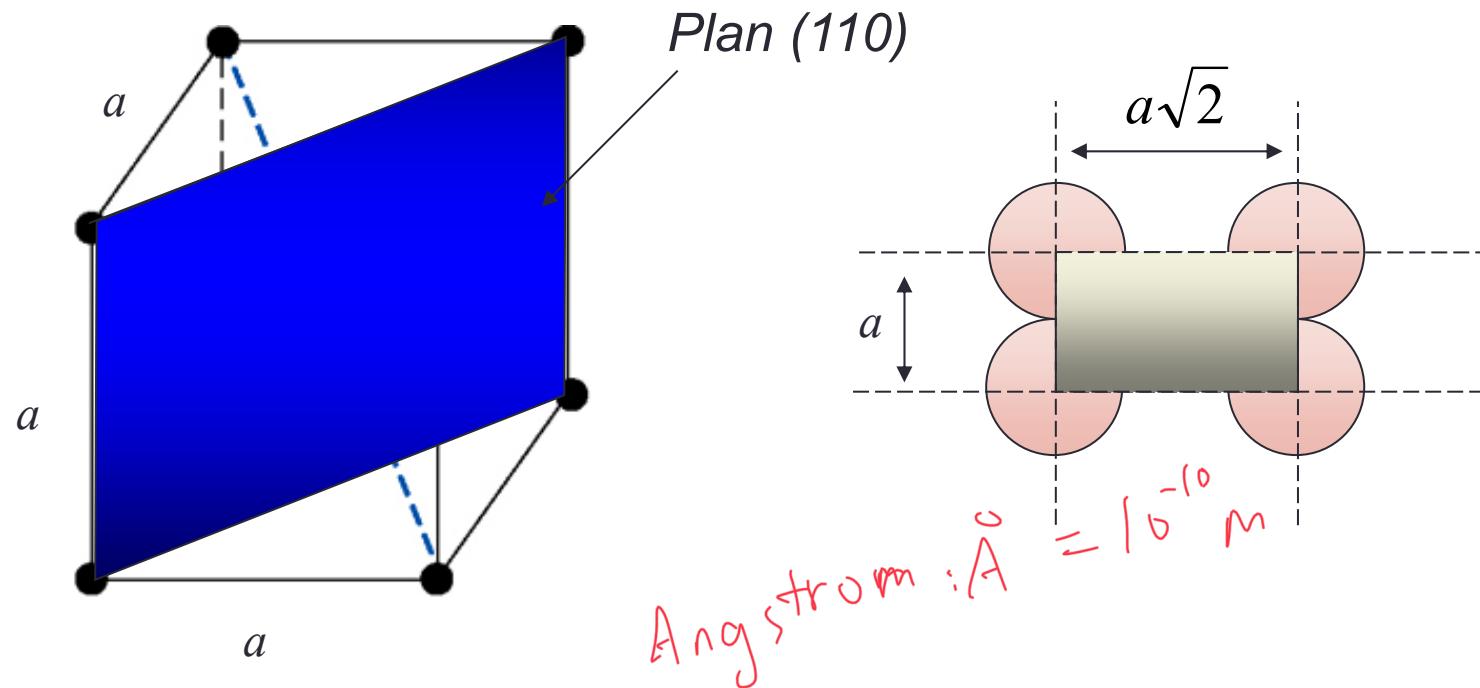
$$a' = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y}); \quad b' = \frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z});$$

$$c' = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{z}).$$

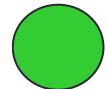
Ils sont séparés par des angles de 60° .

D'après C. Kittel, Dunod, 5^eed.

Densité surfacique d'atomes

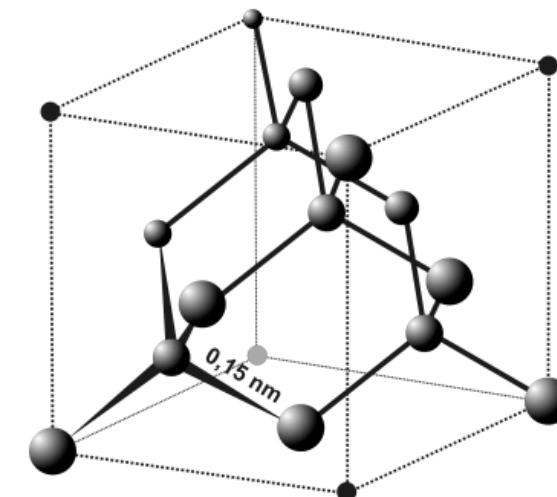
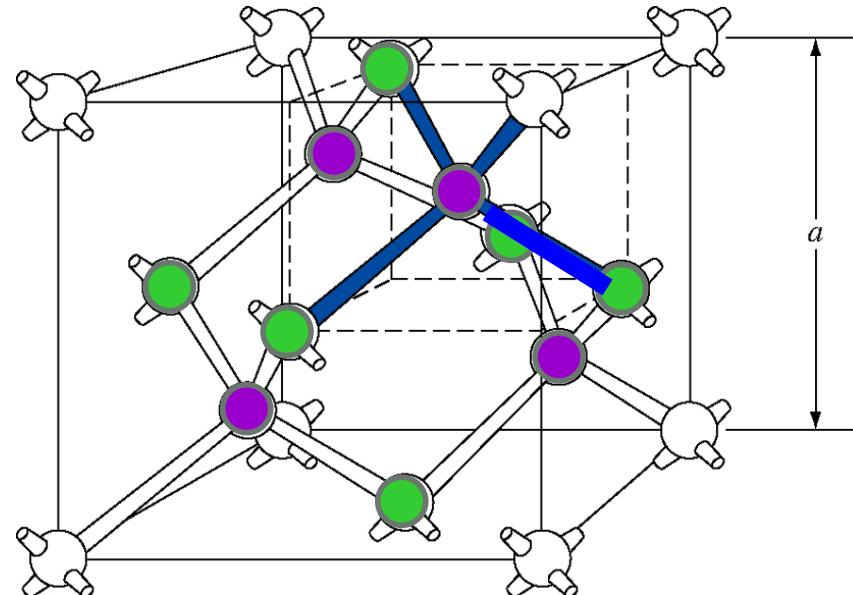


$$\text{densité surfacique} = \frac{1 + 4 \times 1/4}{a \times a\sqrt{2}} = \frac{2}{(5 \times 10^{-8} \text{ cm})^2 \times \sqrt{2}} = 5.66 \times 10^{14} \text{ at.cm}^{-2}$$

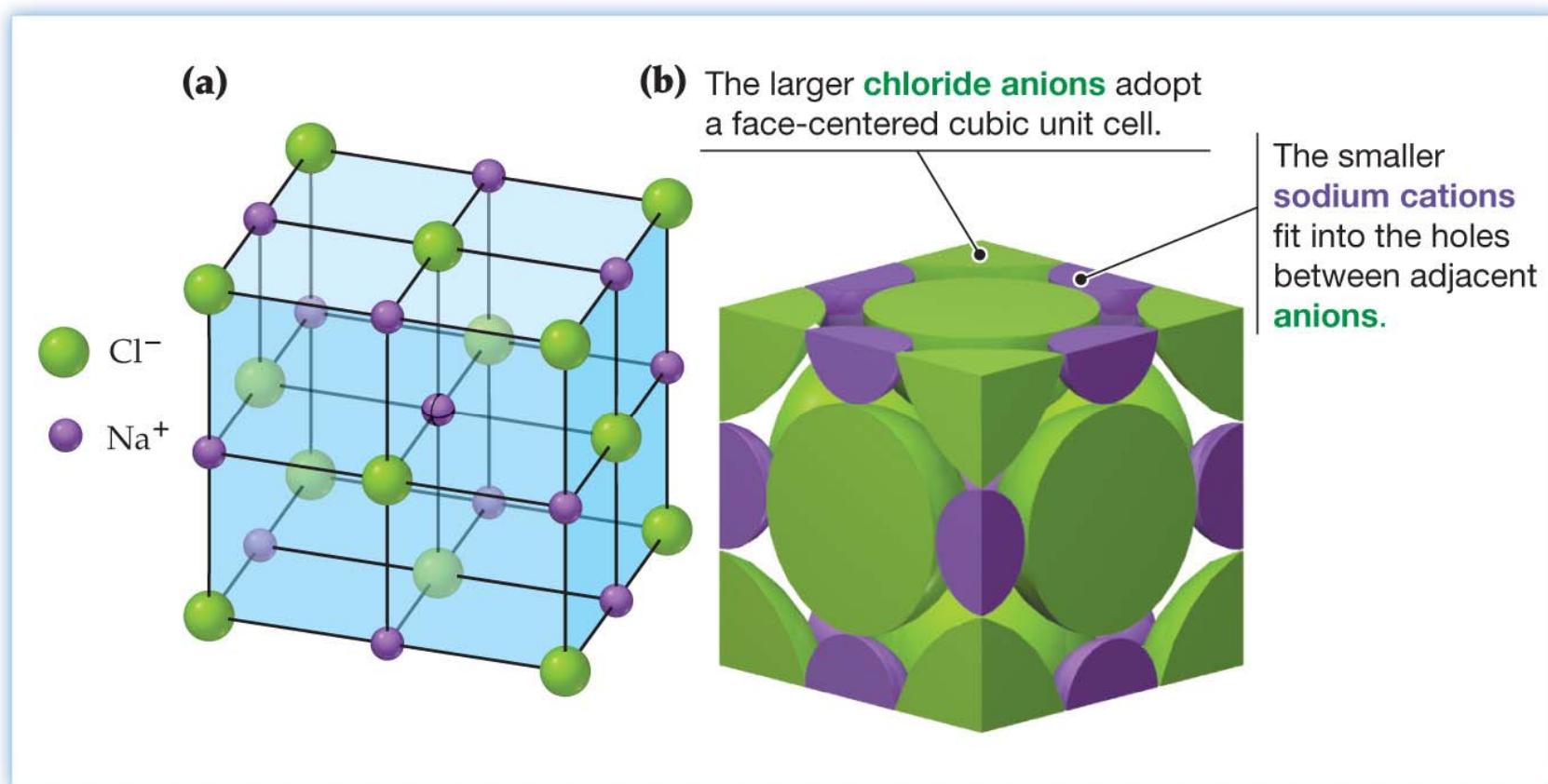


Le silicium et sa structure « Diamant ».

- Structure cubique CFC
- Deux atomes dans la base
- Identique à 2 CFC décalés de $\frac{1}{4}$ de diagonale
- Chaque atome a 4 atomes comme plus proches voisins (liaison tétragonale)



Structure NaCl

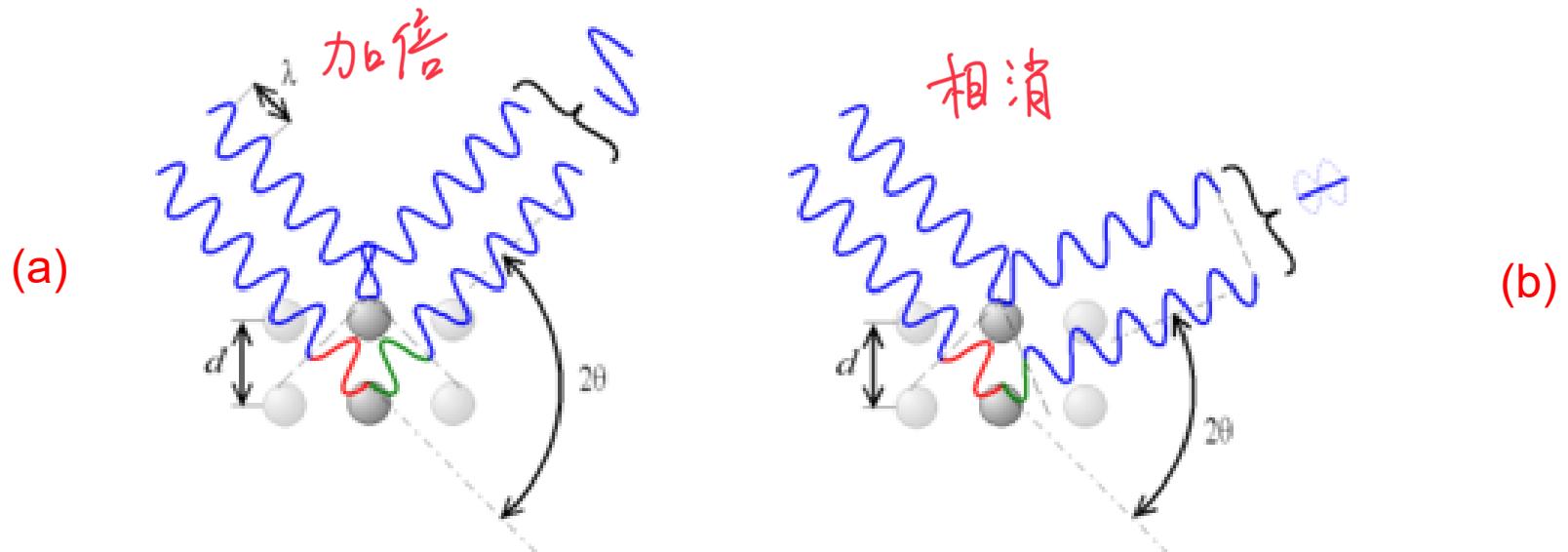


Rôle physique des plans réticulaires

- Interférences entre les **ondes diffusées**:
 • Destructives \Leftrightarrow pas de propagation (b)
 • Constructives \Leftrightarrow on les « voit » (a)



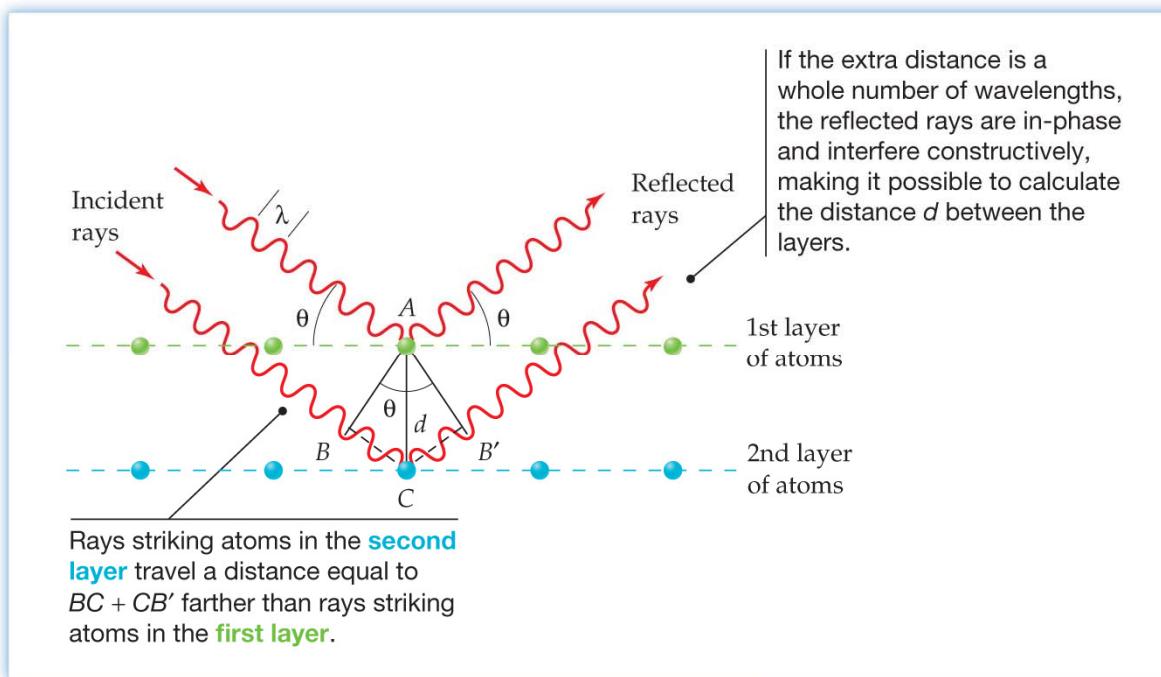
Condition de diffraction de Bragg



Rôle physique des plans réticulaires

行射

- **Diffraction**: Occurs when electromagnetic radiation is scattered by an object containing regularly spaced lines (such as a diffraction grating) or points (such as the atoms in a crystal)



Rôle physique des plans réticulaires

Bragg 定律判据.

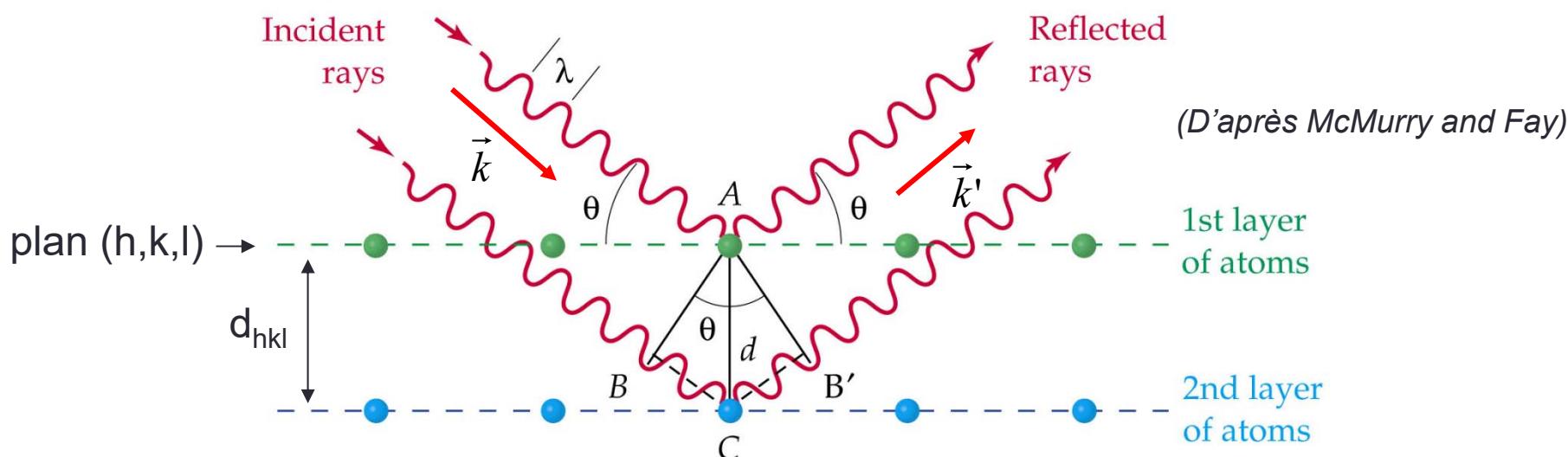
初等方法

- Détermination de la loi de Bragg: méthode élémentaire.

ddm: 位程差

- On considère les plans cristallins comme des miroirs
- On calcule la différence de marche (ddm) entre les deux rayons
- Interférence constructive $\Leftrightarrow ddm = n\lambda$

干涉相长



$$ddm = 2d_{hkl} \sin \theta$$

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

$$d_{hkl} = \frac{n\lambda}{2 \sin \theta}$$

CHAPITRE 3

Mécanique ondulatoire :
l'équation de *Schrödinger*

La fin de la mécanique classique?

- La matière:

- Position
- Vitesse (quantité de mouvement)

$$\vec{P} = m \times \vec{v}$$



- Loi de Newton

$$\sum \vec{f} = m \vec{a}$$



Six variables permettent de définir parfaitement l'état de chaque corpuscule

- La lumière:

- Composante champ électrique
- Composante champ magnétique



- Équations de Maxwell



On ne peut séparer la radiation en corpuscules maintenus localisés dans l'espace – processus d'interférence et diffraction

La fin de la mécanique classique?

- Au début du 20° siècle:

- Théorie corpusculaire de la matière:

- « marche » même à l'échelle microscopique
 - Complexité du pb à cette échelle \Leftrightarrow mécanique statistique

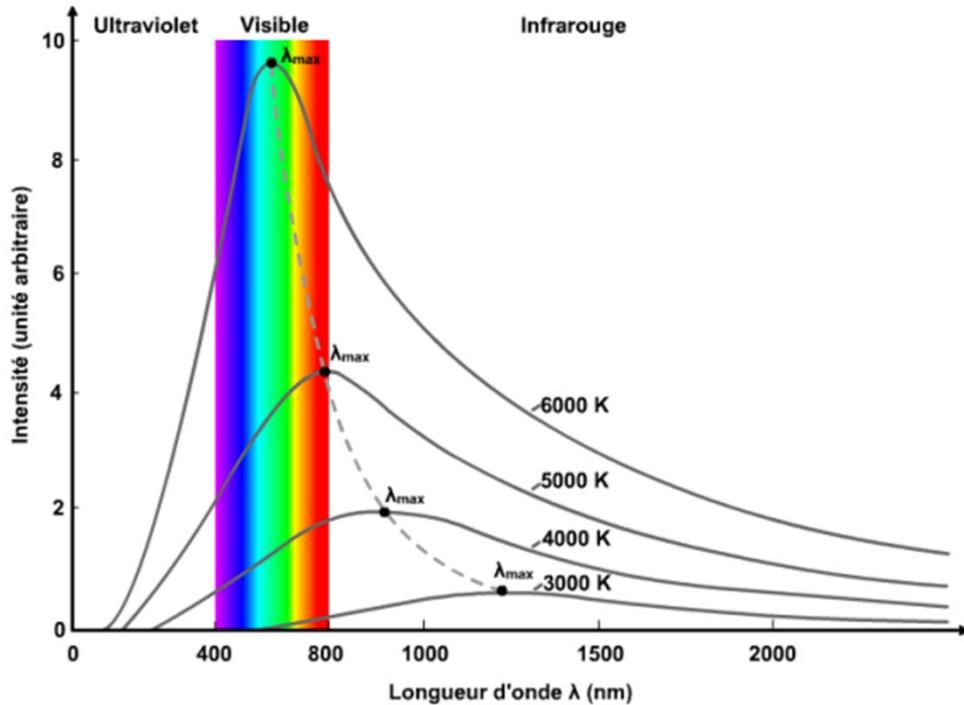
波辯証.

- Théorie ondulatoire de la lumière:

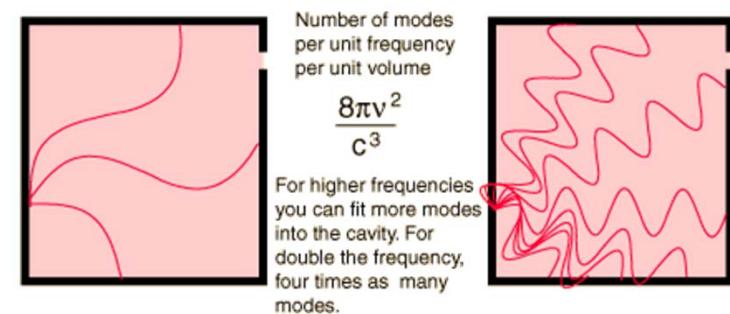
- Acceptée depuis Fresnel
 - Tous les phénomènes connus de la lumière interprétés
 - Équations de Maxwell + ondes radio (Hertz) \Leftrightarrow synthèse optique et électricité

La fin de la mécanique classique?

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
 - Rayonnement du corps noir



Corps noir: objet qui absorbe toute radiation qu'il reçoit

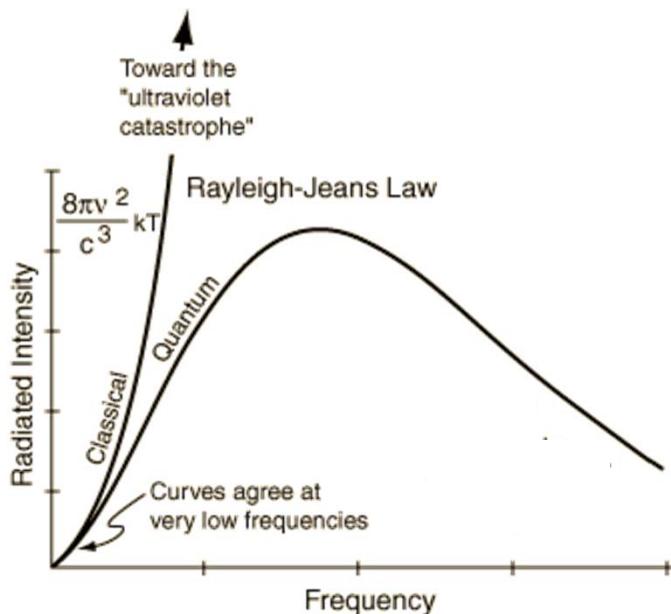


À l'intérieur de la cavité, le champ électromagnétique est équivalent à un ensemble d'oscillateurs harmoniques indépendants. Leur énergie moyenne (**en supposant que l'énergie peut varier de manière continue**) est donnée par :

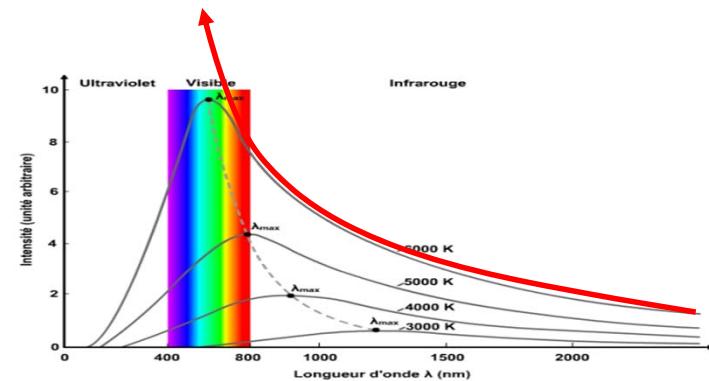
$$\bar{E} = \frac{\int_0^\infty E e^{-E/kT} dE}{\int_0^\infty e^{-E/kT} dE} = kT$$

La fin de la mécanique classique?

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
 - Rayonnement du corps noir



Corps noir: objet qui absorbe toute radiation qu'il reçoit



À l'intérieur de la cavité, le champ électromagnétique est équivalent à un ensemble d'oscillateurs harmoniques indépendants. Leur énergie moyenne (**en supposant que l'énergie peut varier de manière continue**) est donnée par :

$$\bar{E} = \frac{\int_0^\infty E e^{-E/kT} dE}{\int_0^\infty e^{-E/kT} dE} = kT$$

La fin de la mécanique classique?

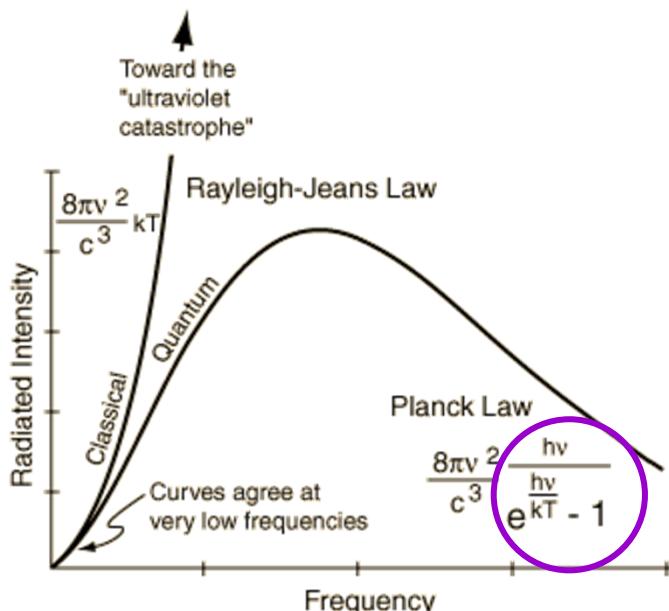
- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
 - Rayonnement du corps noir

M. Planck : Il postule que les échanges d'énergie entre la matière et les radiations ne se font pas de manière continue mais par des quantités indivisibles et discrète: *quanta* d'énergie. Il montre que la relation entre Energie et Fréquence est donnée par:

$$E_n = n \cdot h\nu$$

M. Planck : lie l'énergie et la fréquence \Leftrightarrow modes autorisés de plus en plus difficile à peupler. Dans l'enceinte (le corps noir), les atomes de la paroi jouent le rôle d'oscillateurs de fréquence ν dont l'énergie de l'atome est donnée par

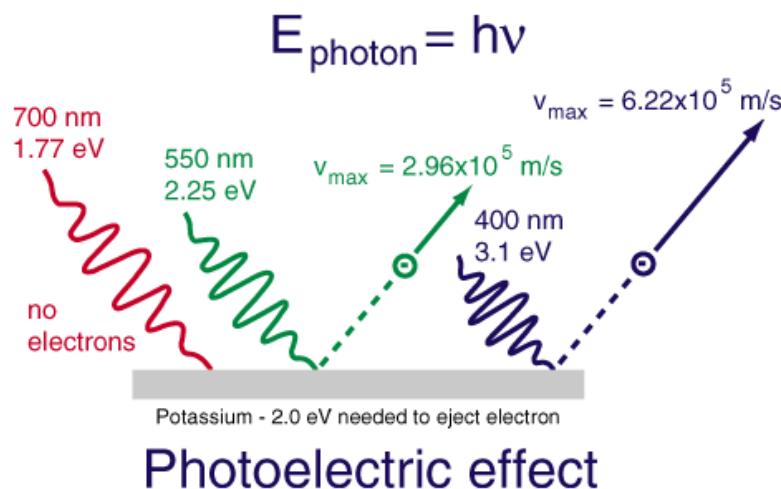
$E_n = n \cdot h\nu$. **Il en résulte que l'énergie moyenne par mode est l'énergie quantifiée fois la probabilité que ce mode soit occupé**



$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} E_n e^{-E/kT}}{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-E/kT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

La fin de la mécanique classique?

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
 - Effet photo électrique

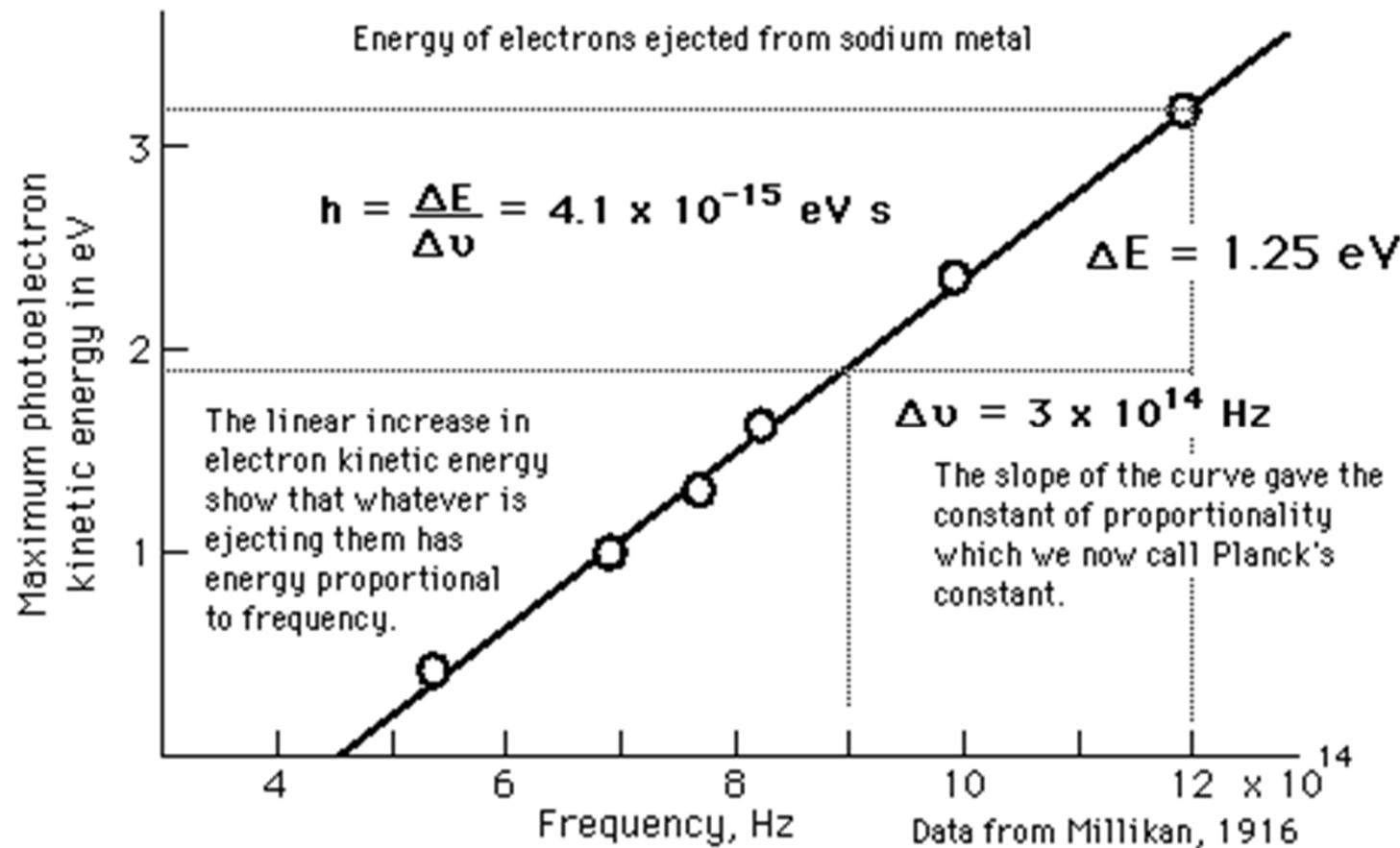


The remarkable aspects of the photoelectric effect when it was first observed were:

1. The electrons were emitted immediately - no time lag!
2. Increasing the intensity of the light increased the number of photoelectrons, but not their maximum kinetic energy!
3. Red light will not cause the ejection of electrons, no matter what the intensity!
4. A weak violet light will eject only a few electrons, but their maximum kinetic energies are greater than those for intense light of longer wavelengths!

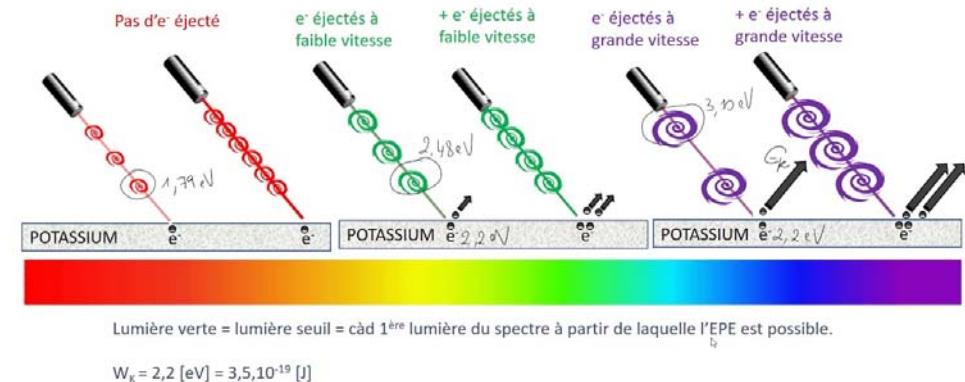
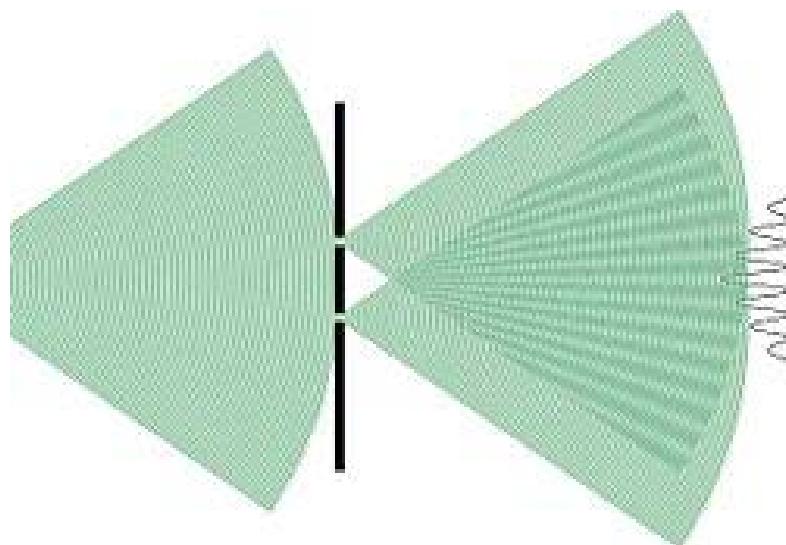
A. Einstein : quantification de l'énergie de la lumière (photon) $\Leftrightarrow E = nh\nu$, la lumière comme grain de lumière \Leftrightarrow aspect corpusculaire !!

La fin de la mécanique classique?

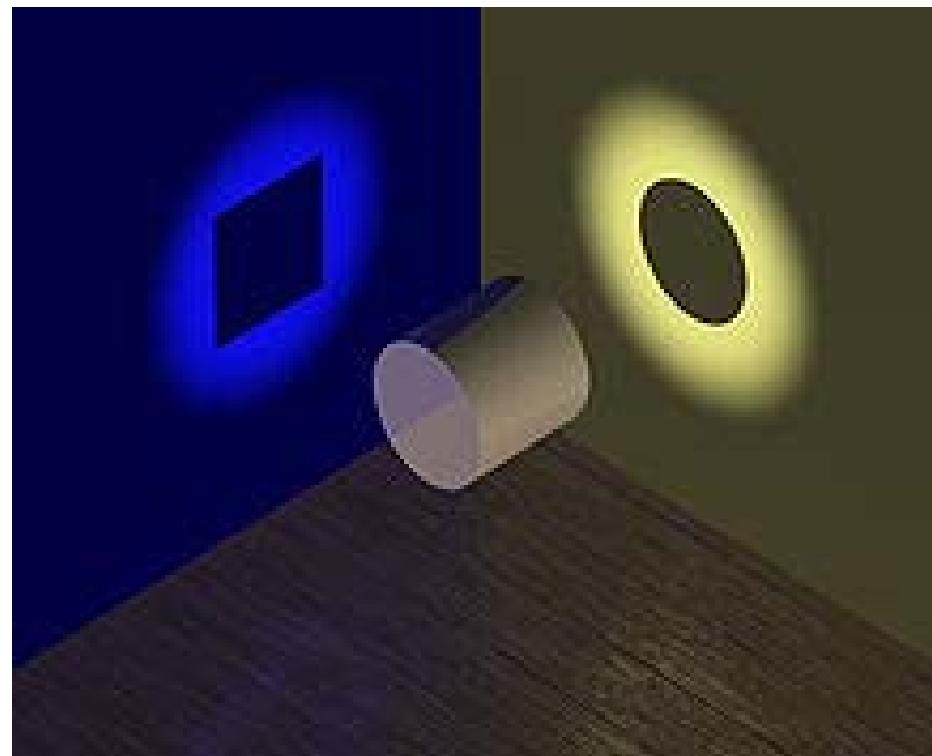


La fin de la mécanique classique?

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
 - Dualité onde – particule: la nature corpusculaire (effet photoélectrique) de la lumière est acquise , mais la nature ondulatoire est également admise (fentes de Young) !
 - La lumière est composée d'un quantum, une particule quantique qui ne peut être décrite que par les lois d'une mécanique nouvelle: *la mécanique ondulatoire est née.*
 - Suivant l'expérience considérée, la nature ondulatoire de la lumière doit être retenue (propagation de la lumière), dans d'autres c'est l'aspect corpusculaire (interaction lumière – matière).



Dualité: métaphore du cylindre



La fin de la mécanique classique?

$$e^- \rightarrow m_{e^-} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
 - Louis de Broglie: introduction des *ondes de matières*. (1924)
 - Hypothèse: la dualité onde – corpuscule est une propriété générale d'objets *microscopiques* et la matière, comme la lumière, présente à la fois un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire.
 - Hypothèse confirmée par la *diffraction des électrons* quelques années plus tard (1927).

RECHERCHES SUR LA THÉORIE
DES QUANTA

Par M. Louis de BROGLIE

Annales de Physique — 10^e Série — Tome III — Janvier-Février 1925

ondes de matières \Leftrightarrow longueur d'onde de de Broglie :

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

Dualité onde corpuscule

DUALITÉ ONDE-PARTICULE

Toutes les animations et explications sur
www.toutestquantique.fr

La mécanique ondulatoire

- L'équation de Erwin Schrödinger:

Second Series

December, 1926

Vol. 28, No. 6

THE
PHYSICAL REVIEW

AN UNDULATORY THEORY OF THE MECHANICS
OF ATOMS AND MOLECULES

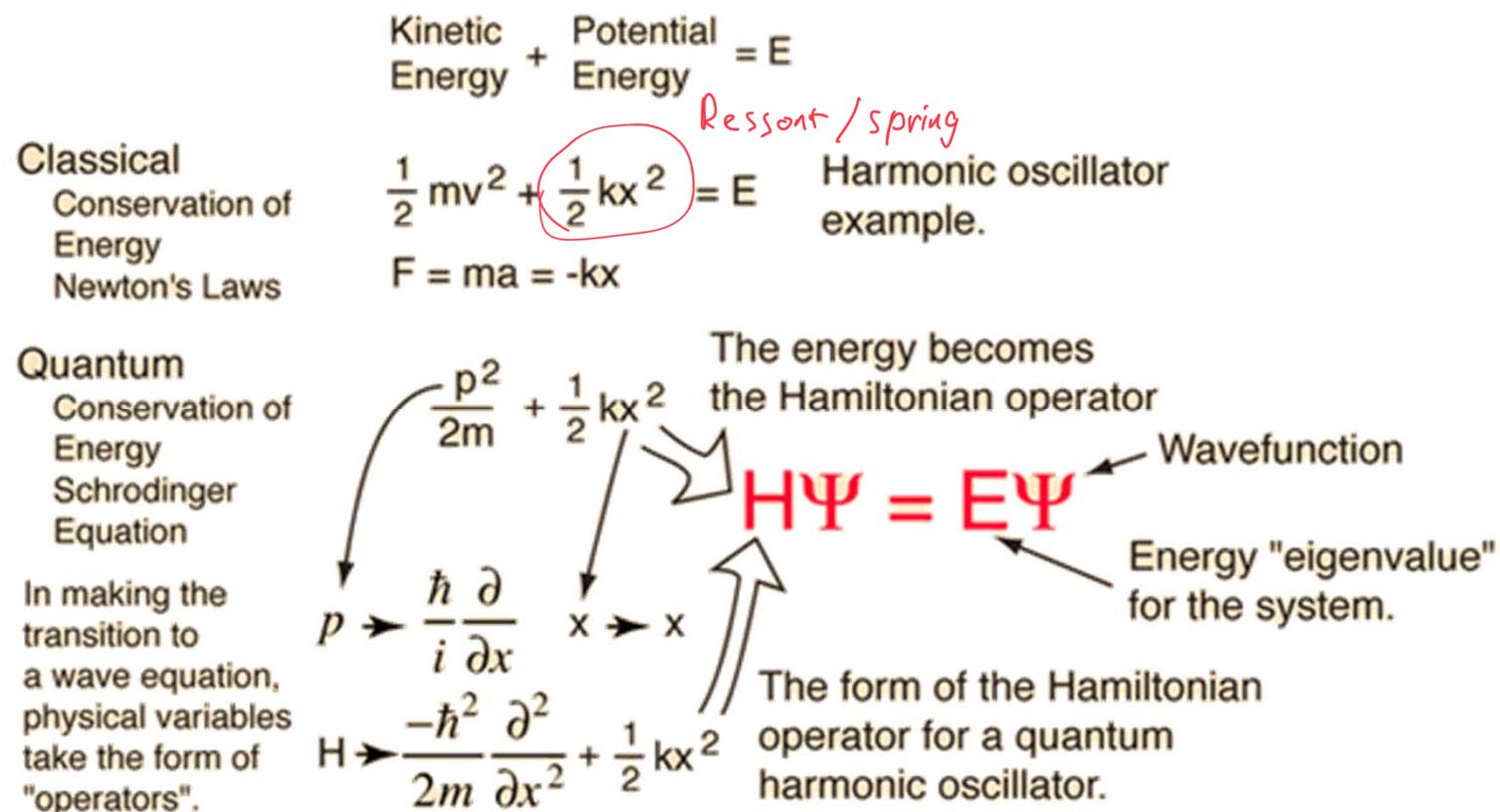
BY E. SCHRÖDINGER

1. The theory which is reported in the following pages is based on the very interesting and fundamental researches of L. de Broglie¹ on what he called “phase-waves” (“ondes de phase”) and thought to be associated with the motion of material points, especially with the motion of an electron or proton. The point of view taken here, which was first

La mécanique ondulatoire

- L'équation de Schrödinger:

I'équation de Schrödinger joue le rôle des lois de Newton et de la conservation de l'énergie de la mécanique classique. C'est une équation d'onde en termes de fonction d'onde qui va prédire analytiquement la probabilité qu'un évènement se produise.



$$p = \frac{h}{\lambda} \text{ et } E = E_0 e^{-i(kx - \omega t)}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow p = \hbar k$$

$$\frac{dE}{dx} = -ikE \Leftrightarrow k \Rightarrow -\frac{1}{i} \frac{d}{dx}$$

$$p \Rightarrow -\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} = i\hbar \frac{d}{dx}$$

$$p^2 = p \cdot p = i\hbar \frac{d}{dx} \left(i\hbar \frac{d}{dx} \right) = -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2}$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2 = H \rightarrow \text{Hamiltonien du système}$$

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Rightarrow H\Psi(x, t) = E\Psi(x, t)$$

$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$ Laplacian

(kinetic energy 繁忙)

$$H\Psi = E\Psi$$

$$\hat{p} = -i\hbar \nabla$$

La mécanique ondulatoire

- L'équation de Schrödinger:

Le mouvement d'une particule est décrit par une fonction d'onde $\Psi(r,t)$ dont le carré représente la probabilité de présence (Born) en un point r . Les fonctions $\Psi(r,t)$ obéissent à l'équation de Schrödinger:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(r,t) + V(r,t) \Psi(r,t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(r,t)}{\partial t}$$

Laplacien
 \hbar^2
Énergie potentiel
 $i\hbar$
 $\frac{\hbar}{2\pi}$
constante de Planck réduite

$$H\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad \leftarrow \text{Postulat de l'évolution temporelle}$$

- $\Psi(r,t)$ est la fonction d'onde (peut être une quantité complexe)
- $V(r)$ est l'énergie potentielle (le potentiel par abus de langage) auquel est soumis la particule 与时间无关的势函数.
- m est la masse de la particule

- L'équation de Schrödinger:

- tient compte à la fois de la notion de quanta (Planck) et de la dualité onde – matière (de Broglie)

波动力学

La mécanique ondulatoire

- Un cas particulier qui nous intéresse dans ce cours concerne *les régimes stationnaires* où le potentiel $V=V(r)$ auquel est soumis la particule est indépendant du temps.
- La méthode de résolution de cette équation consiste à chercher des solutions *en séparant les variables temps et espace*. On suppose que la fonction d'onde $\Psi(r,t)$ peut s'écrire:

$$\Psi(r,t) = \varphi(r)\chi(t)$$

- $\varphi(r)$ est une fonction de la position uniquement
- $\chi(t)$ est une fonction du temps uniquement
- En injectant cette forme de solution dans l'équation de Schrödinger, on obtient (*on passe à une dimension*):

$$\text{方程} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\varphi(x)} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + V(x) = i\hbar \frac{1}{\chi(t)} \frac{\partial \chi(t)}{\partial t}$$

x temp

L'équation de Schrödinger:

$$\text{粒子の運動量} E = -\frac{\hbar^2}{2m} \underbrace{\frac{1}{\varphi(x)} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2}}_{g(x)} + V(x) = i\hbar \underbrace{\frac{1}{\chi(t)} \frac{\partial \chi(t)}{\partial t}}_{f(t)}$$

- La relation ci dessus où une équation du temps est égale à une équation de l'espace, entraîne que ces deux équations sont des constantes. On voit d'autre part que l'équation aux dimensions de la fonction dépendante du temps est $[f(t)] = [\text{Énergie}]$. Il vient alors:

$$i\hbar \frac{1}{\chi(t)} \frac{\partial \chi(t)}{\partial t} = E \quad \rightarrow \quad \chi(t) = A e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$$

- Avec E , l'énergie de la particule, qui s'écrit :

通常 $A = 1$
 $\chi(t) = A e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$
 ↓ pulsation
 $E = \hbar \omega$
 $\nu = \omega$: 頻率

L'équation de Schrödinger:

- L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{1}{\varphi(x)} \cdot \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + V(x) = E \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

$|\psi(x,t)|^2$ 概率密度 avec :

$= |\varphi(x)|^2$ 与时间无关.

说明粒子坐标无法精确确定

↑ 矛盾

$$\psi(x,t) = \varphi(x) \exp\left(\frac{-iE}{\hbar}t\right)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2 dx = 1$$

$$\varphi = A e^{-ikx}$$

- Conditions aux limites:

- Continuité de la fonction d'onde
- Continuité de la dérivée première

If $\varphi(x_0) = \infty$
说明在 x_0 处位置 不确定

两个条件 { 波函数连续
一阶导连续

L'équation de Schrödinger:



- A ce stade, il est important de distinguer la notion 行波 *d'état ondulatoire* (onde plane) et combinaison *d'états ondulatoires* (paquet d'ondes). *Somme*

不同下值或不同动量的波叠加形成波包

Onde plane / paquet d'ondes

- Onde plane:

$$\psi(x,t) = \underbrace{Ae^{ikx}}_{\varphi(x)} \underbrace{e^{-i\omega t}}_{\chi(t)}$$

- Paquet d'ondes:

$$\varphi(x,t) = \int_{k_0 - \Delta k/2}^{k_0 + \Delta k/2} A e^{ikx} e^{-i\omega t} dk$$

- Nous allons montrer que *seul un paquet d'onde* peut être une représentation correcte d'une particule.

Onde plane / paquet d'ondes

- Supposons qu'une particule se déplace dans un potentiel constant $V(x) = V_0 = \text{cte}$. La force à laquelle elle est soumise est donnée par $F = -\nabla V_0 = 0$, c'est à dire que son mouvement est uniforme et donc son énergie E constante. On va maintenant :
particule libre
- Chercher des solutions simples de l'E.S
- Regarder si ces solutions simples correspondent aux domaines physiques
- Si tel n'est pas le cas, on essaiera une combinaison linéaire des solutions simples car l'E.S est linéaire en φ .

行波 / 波包

Onde plane / paquet d'ondes

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + V_0 \varphi(x) = E \varphi(x)$$

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} \varphi(x) = 0, \quad E - V_0 > 0$$

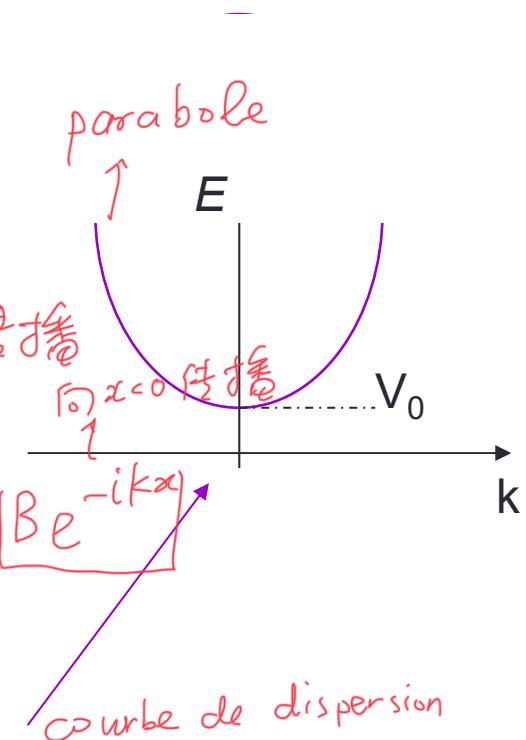
$$k^2$$

伊波单向传播

Une solution simple de $\varphi(x)$ peut être : $\varphi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$

avec $k = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}}$ soit encore $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0$

波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$



La question est "Peut-on se représenter une particule par cette fonction ?". Il suffit de calculer la probabilité de présence dans l'espace (ou ici à 1 Dim) de cette particule pour répondre à cette question.

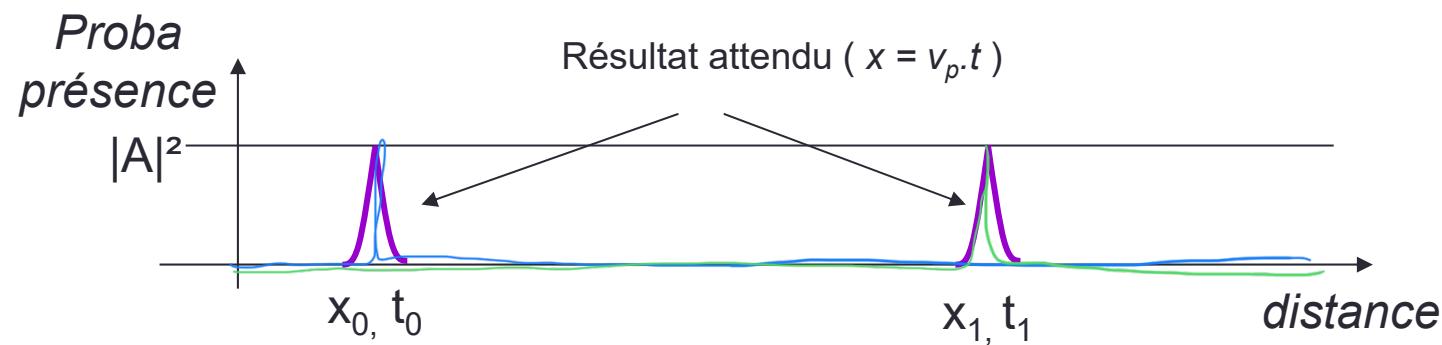
Onde plane / paquet d'ondes

- Onde plane:

具有确定的动量

粒子在空间

内出现概率相等. $|\psi(x, t)|^2 = (\psi(x, t)\psi^*(x, t))^2 = |A|^2 = \text{cste}$



- cette probabilité de présence $|A|^2$ est indépendante de x et du temps, ce qui est loin d'être « raisonnable » d'un point de vue physique

Onde plane / paquet d'ondes

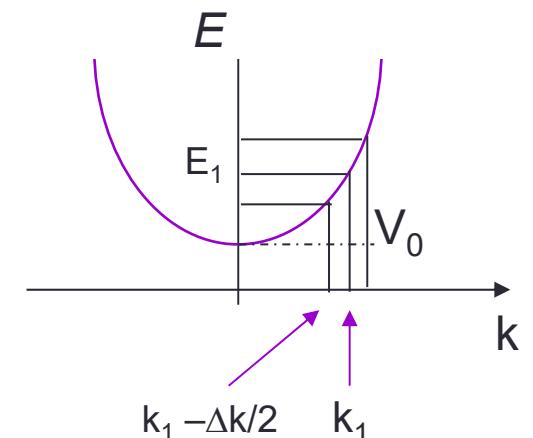
- On va donc essayer une C.L d'ondes planes centrées sur k_1 c'est à dire un paquet d'ondes depuis $k_1 - \Delta k/2$ et $k_1 + \Delta k/2$. La fonction d'onde s'écrit alors:

$$\Psi(x, t) = \int_{k_1 - \Delta k/2}^{k_1 + \Delta k/2} A e^{ikx} e^{-i\omega t} dk$$

- Prenons $A = \text{cste}$ (hyp simplificatrice)
 - à $t=0$:

$$\Psi(x, 0) = \int_{k_1 - \Delta k/2}^{k_1 + \Delta k/2} A e^{ik_1 x} e^{i(k-k_1)x} dk = A e^{ik_1 x} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i(k-k_1)x} d(k - k_1)$$

$$\begin{aligned} \Psi(x, 0) &= A e^{ik_1 x} \cdot \frac{1}{ix} \left[e^{i(k-k_1)x} \right]_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} = A e^{ik_1 x} \Delta k \frac{\sin(\frac{\Delta k x}{2})}{\frac{\Delta k}{2} x} \\ &= B \frac{\sin \alpha}{x} \end{aligned}$$

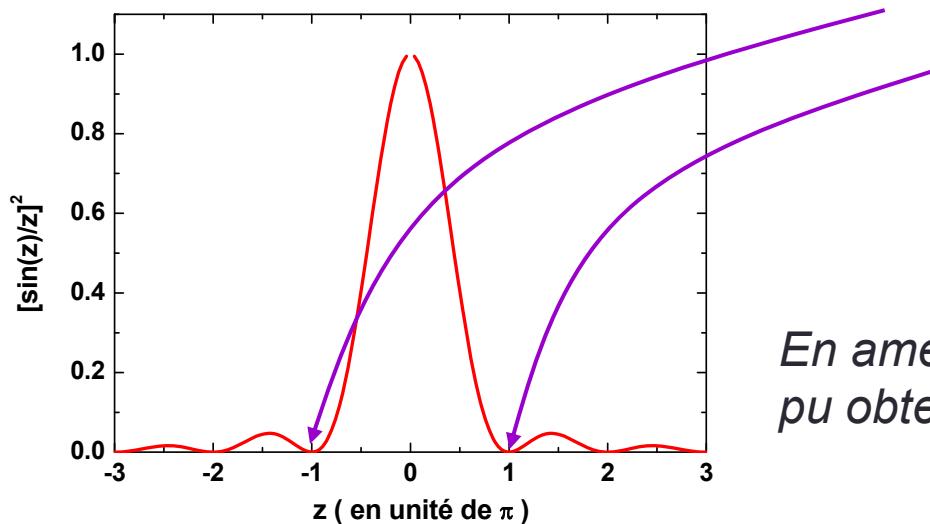


Onde plane / paquet d'ondes

- On calcule à nouveau la probabilité de présence en un point x :

$$|\Psi(x,0)|^2 = A^2 \Delta k^2 \frac{\sin^2 z}{z^2} \text{ avec } z = \frac{\Delta k \times x}{2}$$

$\Delta k \rightarrow \Delta E$.



$$x_1 = \pm \frac{2\pi}{\Delta k} \Rightarrow \Delta x = 2x_1 \approx \frac{4\pi}{\Delta k}$$

$$\Leftrightarrow \Delta x \times \Delta k \approx 4\pi$$

*En améliorant la loi d'Amplitude on aurait pu obtenir la relation d'**Heisenberg**:*

$$\Delta x \times \Delta k \approx 2\pi$$

Onde plane / paquet d'ondes

- On se place maintenant à $t=t_1$:

$$\Psi(x, t_1) = \int_{k_1 - \Delta k/2}^{k_1 + \Delta k/2} A e^{-i\omega_k t_1} e^{ikx} dk = A e^{ik_1 x} e^{-i\omega_1 t_1} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i(k-k_1)x} e^{i(\omega_k - \omega_1)t_1} d(k - k_1)$$

$$DL: \omega_k = \omega_1 + \left(\frac{d\omega_k}{dk} \right)_{k_1} (k - k_1) + \dots$$

$$\Psi(x, t_1) = A e^{ik_1 x} e^{-i\omega_1 t_1} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i(k-k_1)x} e^{i(k-k_1) \left(\frac{d\omega_k}{dk} \right)_{k_1} t_1} d(k - k_1)$$

posons $x' = x - \left(\frac{d\omega_k}{dk} \right)_{k_1} t_1 \Rightarrow \Psi(x, t_1) = A e^{ik_1 x} e^{-i\omega_1 t_1} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i(k-k_1)x'} d(k - k_1)$

$$\Psi(x, t_1) = A e^{ik_1 x} e^{-i\omega_1 t_1} \times \frac{e^{\frac{\Delta k}{2}x'} - e^{-\frac{\Delta k}{2}x'}}{ix'} = B \Delta k \frac{\sin \frac{\Delta k}{2}x'}{\frac{\Delta k}{2}x'} \text{ avec } \frac{\Delta k}{2}x' = \frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t_1$$

Onde plane / paquet d'ondes

- On obtient alors le même résultat qu'à $t=0$ mais pour $x'=0$, ie

$$x = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_1} t_1$$



→ La vitesse de la particule = v_g = *vitesse de groupe* qui est calculée au centre du paquet d'onde:

$$v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_1}$$

Vitesse de phase/ vitesse de groupe

- Dans le cas **d'une onde plane**, la vitesse considérée est la vitesse de propagation de plans en phase ou vitesse de phase:

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} \quad (k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v_\varphi T} = \frac{\omega}{v_\varphi})$$

d'après de Broglie ($p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hk}{2\pi} = \hbar k$)

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{E/\hbar}{p/\hbar} = \frac{E}{p} = \frac{E}{\hbar k} \quad \text{or} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0$$

$$\Rightarrow v_\varphi = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

- Raisonnons sur **le paquet d'ondes**:

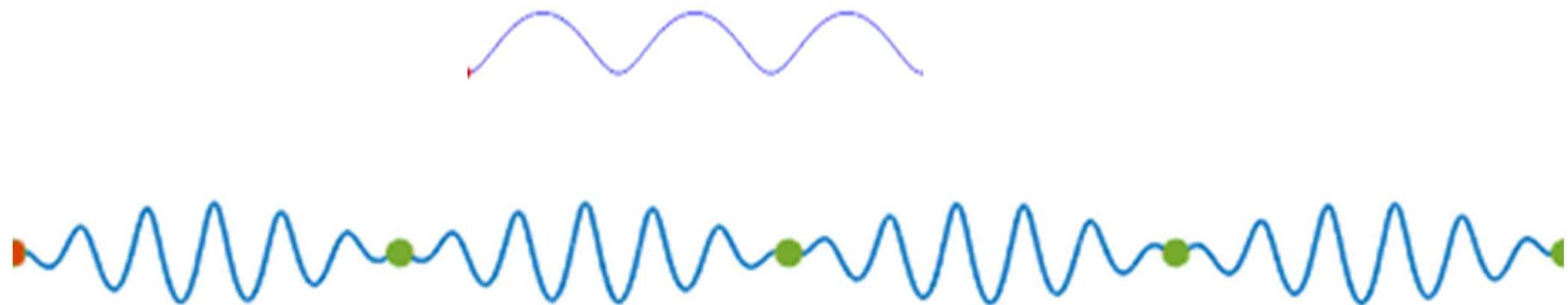
$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0$$

$$\left(\frac{dE}{dk} \right)_{k_1} = \hbar \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_1} = \frac{\hbar^2 k_1}{m} \Rightarrow v_g = \frac{p_1}{m}$$

$$\Rightarrow \text{on obtient bien } v_g = \frac{p}{m}$$

Intervient alors que $V_0 = \text{cste!}$
 \Leftrightarrow aucune intervention sur le mvt de la particule; absurde car $v_\varphi = p/m$

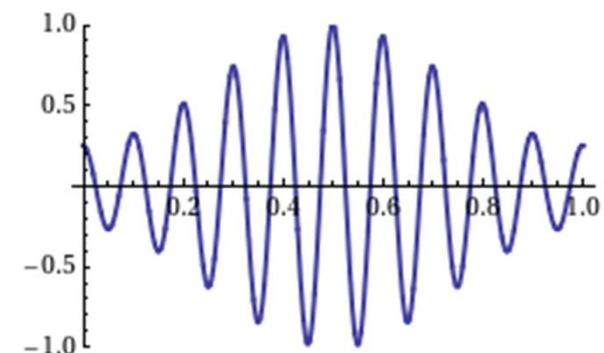
Vitesse de phase/ Vitesse de groupe



Vitesses de phase et de groupe d'une superposition de deux ondes monochromatiques. **Le point rouge** avance à la **vitesse de phase**, et les **points verts** à la **vitesse de groupe**. Dans cet exemple, la vitesse de phase vaut le double de la vitesse de groupe.

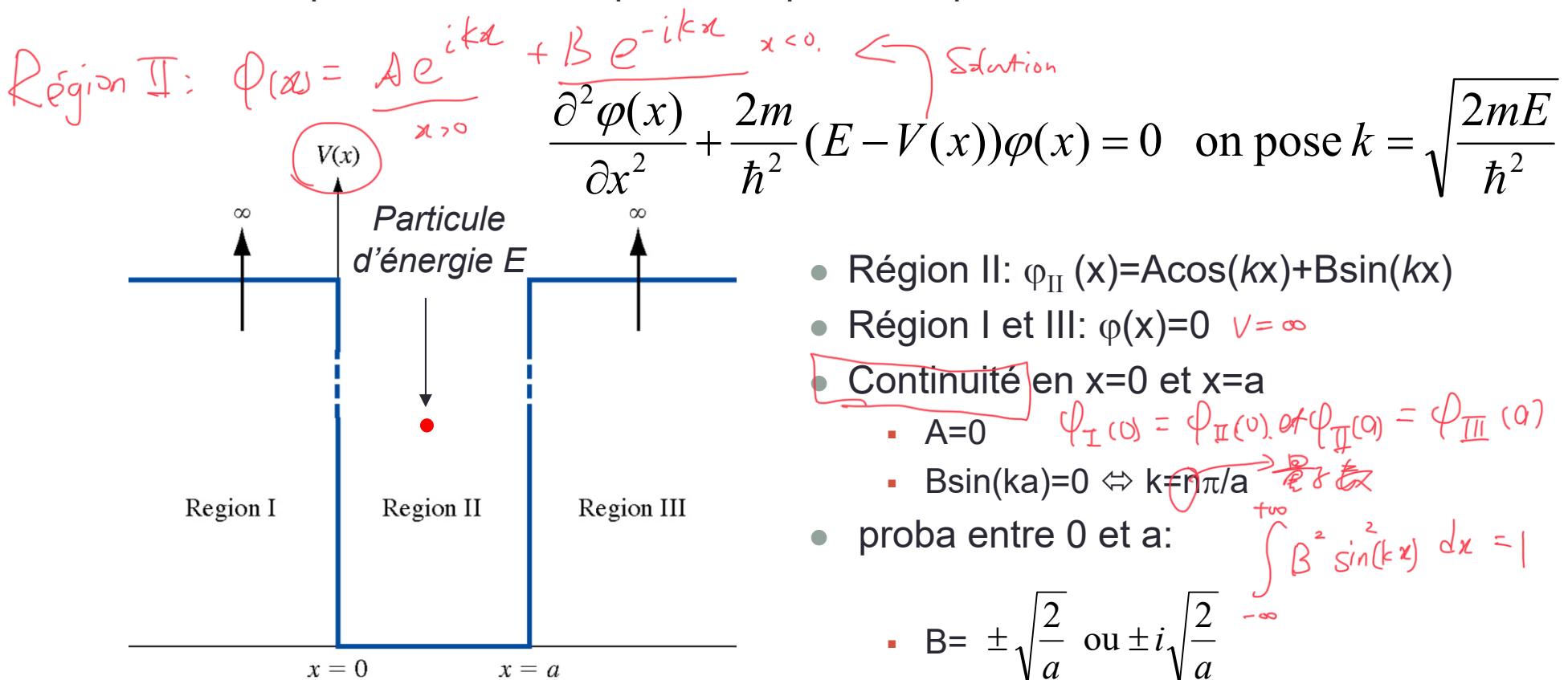
Un exemple dans lequel la vitesse de groupe et la vitesse de phase sont de signes opposés : l'enveloppe du paquet (donc la vitesse de groupe) se dirige vers la droite, alors que la phase (donc la vitesse de phase) se dirige vers la gauche.

<https://fr.wikipedia.org/>



Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

- Le puits de largeur a et de potentiel infini:
- « représente » l'exemple classique d'une particule liée.



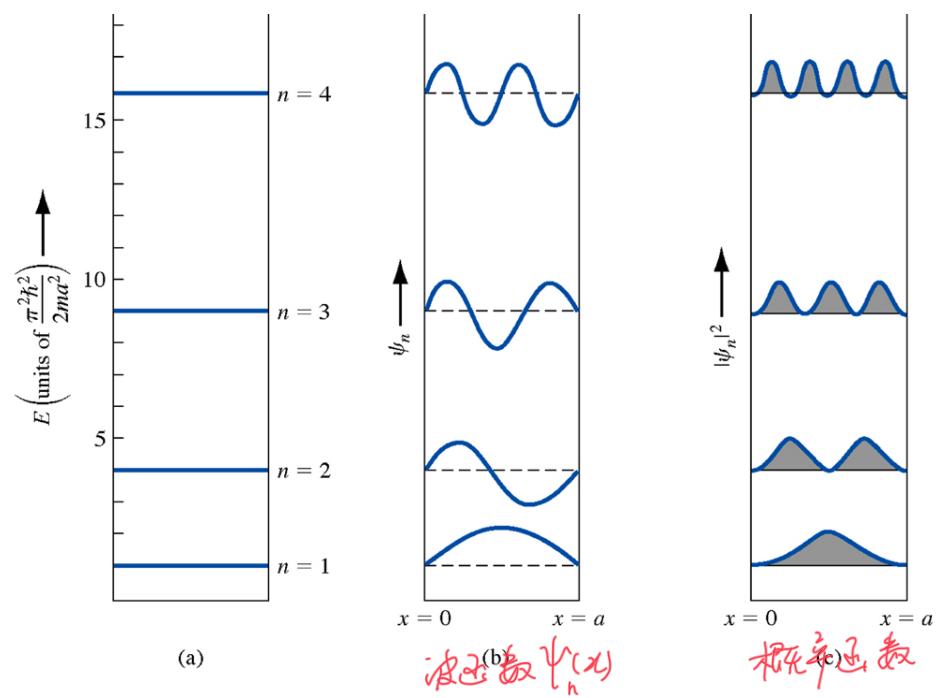
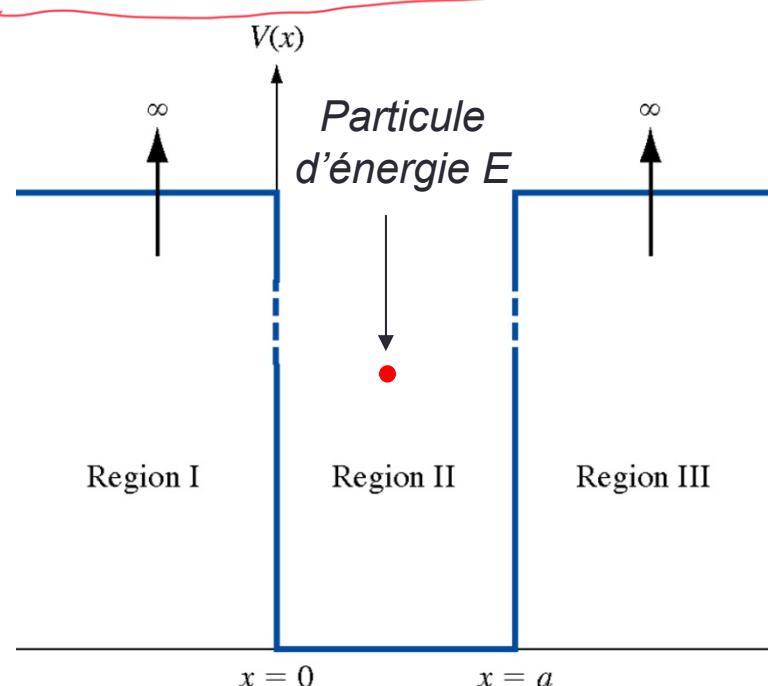
Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

驻波
↑ 代表束缚态粒子，电子处于无限深势阱中

- *Le puits de largeur a et de potentiel infini:*

$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ avec $n = 1, 2, 3, \dots$ $E = E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$ avec $n = 1, 2, 3, \dots$

Quantifiée



Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

- La marche de potentiel:
- Région I:

$$\frac{\partial^2 \phi_1(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \phi_1(x) = 0$$

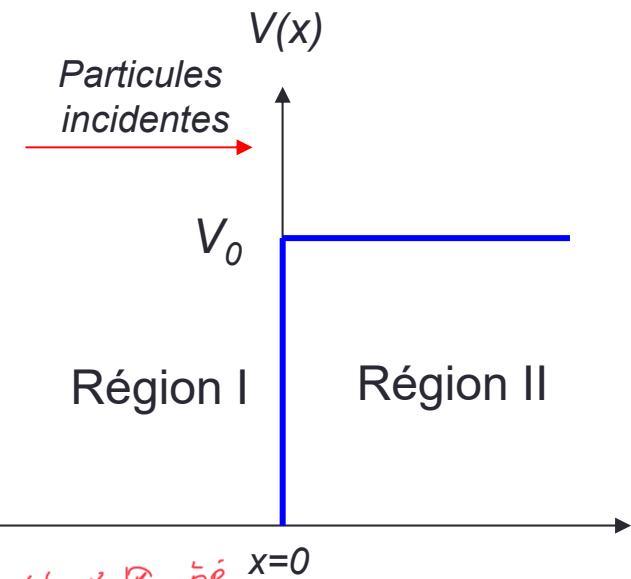
$(x \leq 0)$

$\Rightarrow \phi_1(x) = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}$ avec $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

波動方程

解:

+x方向
反射波
-x方向
反身波



$\Phi_{I(0)} = \Phi_{II(0)}$

\Downarrow

$\frac{\partial^2 \phi_2(x)}{\partial x^2} - \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) \phi_2(x) = 0$ $(x > 0)$

$\frac{\partial \phi_{II}(x)}{\partial x} = \frac{\partial \phi_{II}(x)}{\partial x} \Big|_{x=0}$ $\Rightarrow \phi_2(x) = A_2 e^{\rho x} + B_2 e^{-\rho x}$ avec $\rho = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$

$A_1 + B_1 = B_2$

$i k_1 A_1 - i k_1 B_1 = -k_2 B_2$

$\Phi_{II}(x) \neq 0 \Leftrightarrow V_0 \neq \infty$

物理量: m^{-1} $[\frac{1}{P}] = m$

若 $A_2 \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \Phi_2(x) = \infty$ 表明在 $x \rightarrow \infty$ 处位置不确定, 不可能.

Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

- La marche de potentiel:

- $A_2 = 0$ (divergence)

- Calcul du coefficient de réflexion:

Flux de particules réfléchies ($\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$)

$$R = \frac{v_r}{v_i} \frac{B_1 B_1^*}{A_1 A_1^*} = \frac{v_r}{v_i} \left| \frac{B_1}{A_1} \right|^2$$

$v_{\text{reflection}}$ 速度
 v_{in}

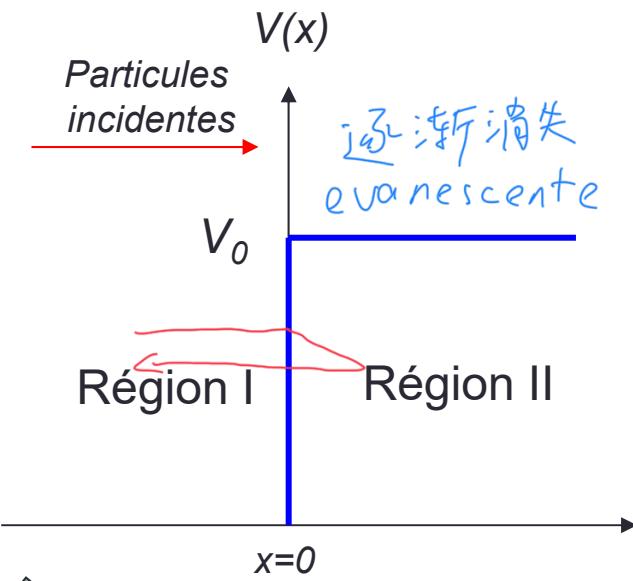
反射系数 R : 反射流与入射流比值.

- dans la région I, $V=0 \Leftrightarrow$ l'énergie est l'énergie cinétique

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)} = \frac{mv}{\hbar} \rightarrow v_i = v_r = \frac{\hbar}{m} k$$



$\varphi_2(x) \neq 0 \Leftrightarrow$ la particule (à la différence de la méca classique) peut s'y trouver
粒子全部反射, 不会穿过也不会被势垒吸收.



$$R = 1$$

Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

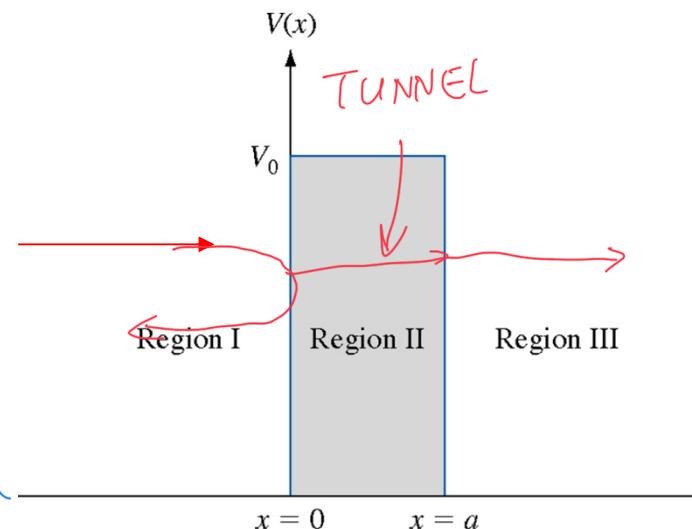
- La barrière de potentiel ($E < V_0$):

$$\varphi_1(x) = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx} \quad \text{avec } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\varphi_2(x) = A_2 e^{\rho x} + B_2 e^{-\rho x} \quad \text{avec } \rho = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)}$$

$$\varphi_3(x) = A_3 e^{ikx} + \cancel{X_3} e^{-ikx} \quad \text{pas de réflexion}$$

effet tunnel



- Facteur de transmission:

$$T = \frac{v_t}{v_i} \frac{A_3 A_3^*}{A_1 A_1^*} = \frac{A_3 A_3^*}{A_1 A_1^*} = \frac{4E(V_0 - E)}{4E(V_0 - E) + V_0^2 \sinh^2 \left[\sqrt{2m(V_0 - E)a/\hbar} \right]} \neq 0$$

Comparer a et $\frac{1}{\rho}$

C'est l'effet tunnel (T~78% avec 1 électron, $E=V_0/2=1\text{eV}$ et $a=1\text{\AA}$)

$a \gg \frac{1}{\rho}$ 没有穿透

CHAPITRE 4

Les électrons libres :
le modèle de *Sommerfeld*

Électron libre

- Électron libre \Leftrightarrow potentiel (énergie) est nul partout $\Leftrightarrow V(x)=0$:

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \varphi(x) = 0$$

- Solution de cette équation différentielle peut se mettre sous la forme:

$$\varphi(x) = A \exp\left[\frac{i\sqrt{2mE}}{\hbar} x\right] + B \exp\left[-\frac{i\sqrt{2mE}}{\hbar} x\right]$$

- Soit:

$$\psi(x, t) = \varphi(x) \exp(-i \frac{E}{\hbar} t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar} (x\sqrt{2mE} - Et)\right] + B \exp\left[-\frac{i}{\hbar} (x\sqrt{2mE} + Et)\right]$$

Électron libre

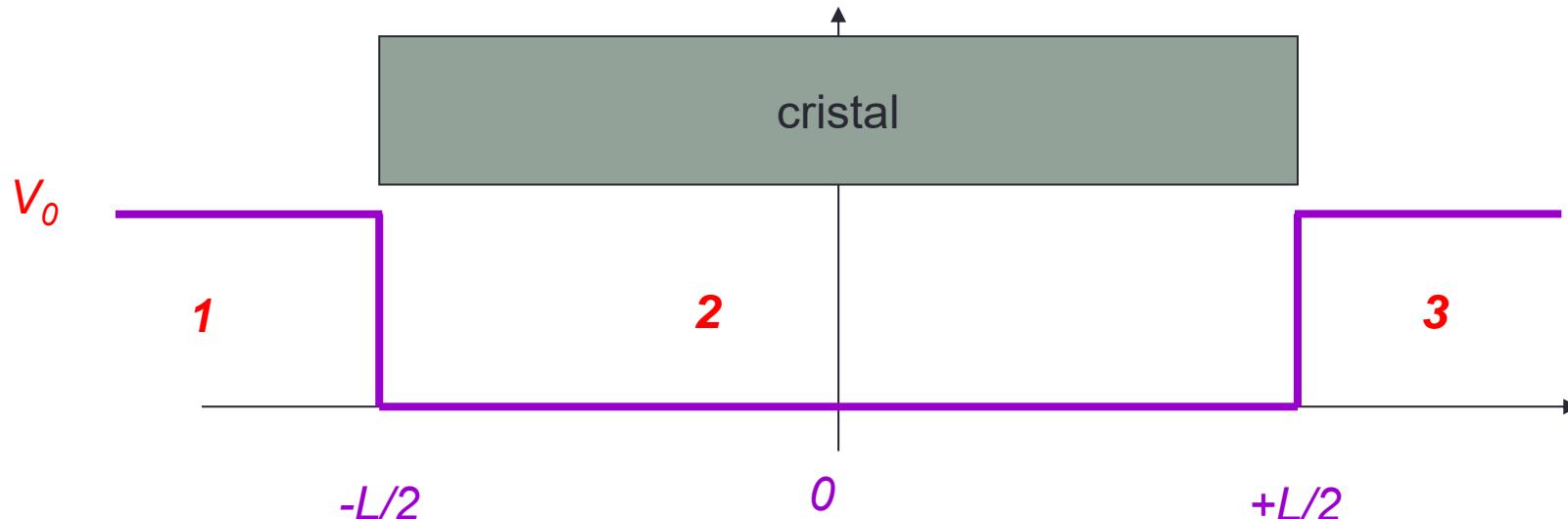
$$\psi(x,t) = \varphi(x) \exp(-i \frac{E}{\hbar} t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(x\sqrt{2mE} - Et)\right] + B \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(x\sqrt{2mE} + Et)\right]$$



- Onde *propagative* \Leftrightarrow une particule dans le vide peut être représentée par une onde : c'est normal, on est parti de l'éq. de Schrödinger !
- Supposons (simplicité!) que $B=0 \Leftrightarrow$ onde se propageant uniquement vers les $x>0$:
 - *Vecteur d'onde:* $k = 2\pi/\lambda$
 - *Longueur d'onde:* $\lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{2mE}}$
 - *Énergie:* $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ $E(k)$ c'est une parabole
 - *Probabilité de présence:* cste $= AA^*$ \Leftrightarrow en accord avec Heisenberg (k défini $\Rightarrow x$ indéfini) \Leftrightarrow réalité physique : Paquet d'ondes

Potentiel de Sommerfeld

- A. Sommerfeld considère 1 cristal unidirectionnel (1D) de longueur L
- Les électrons sont liés au cristal par les forces d'attraction Coulombienne.
- Les électrons sont piégés \Leftrightarrow ils ne peuvent sortir
被束缚.



Potentiel de Sommerfeld

- *Simplification*: on se rapproche de la réalité en considérant que la fonction d'onde associée à l'électron s'annule aux limites ($\pm L/2$) \Leftrightarrow les électrons ne peuvent s'échapper du cristal
- *Démarche*:
 - On cherche des solutions de l'E.S
 - On ne garde que celles qui satisfont les conditions de continuités
 - On forme un paquet d'ondes avec les conditions aux limites pour représenter l'électron.

Potentiel de Sommerfeld

- Solution en région 2 (idem électron libre):*

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \varphi(x) = 0 \quad \varphi(x) = A e^{ikx}$$

- Conditions aux limites:*

- Réelles: s'annulent en $\pm L/2$

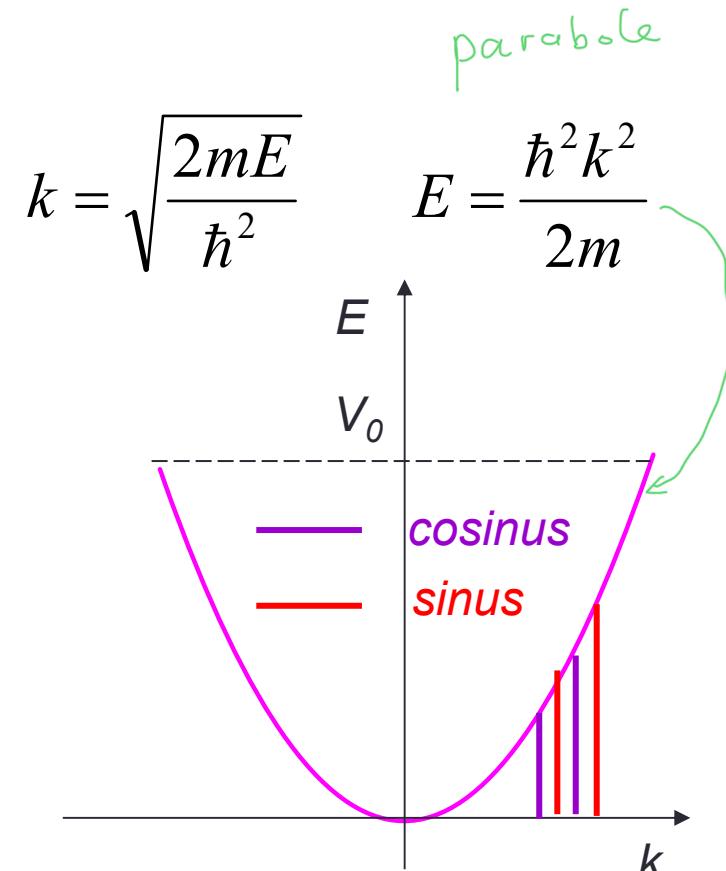
$$\begin{array}{c} \frac{Ae^{ikx} + cc}{2} \\ \Downarrow \\ A \cos(kx) \end{array} \qquad \begin{array}{c} \frac{Ae^{ikx} - cc}{2} \\ \Downarrow \\ A \sin(kx) \end{array}$$

- Solutions en cosinus

$$\cos k \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow k = (2p+1) \frac{\pi}{L} \Rightarrow \Delta k = \frac{2\pi}{L}$$

- Solutions en sinus

$$\sin k \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow k = p \frac{2\pi}{L} \Rightarrow \Delta k = \frac{2\pi}{L}$$



Le vecteur d'onde est quantifié
 \Leftrightarrow l'énergie l'est également

Potentiel de Sommerfeld

- *Conditions cycliques de Born von Karmann:*
 - L'idée est de considérer qu'à l'échelle de la longueur d'onde électronique, la dimension du cristal est infinie \Leftrightarrow on assimile le cristal unidimensionnel de longueur L à un cercle de périmètre L : on « oublie » les conditions aux limites?
 - La situation en x et en $x+L$ est identique:

$$\left. \begin{aligned} e^{ikx} &= e^{ik(x+L)} \\ e^{ikL} &= 1 \Rightarrow kL = p \times 2\pi \\ \Rightarrow k &= p \frac{2\pi}{L} \end{aligned} \right\}$$

Même résultat: il y a encore quantification de k donc de E

Modèle de Sommerfeld

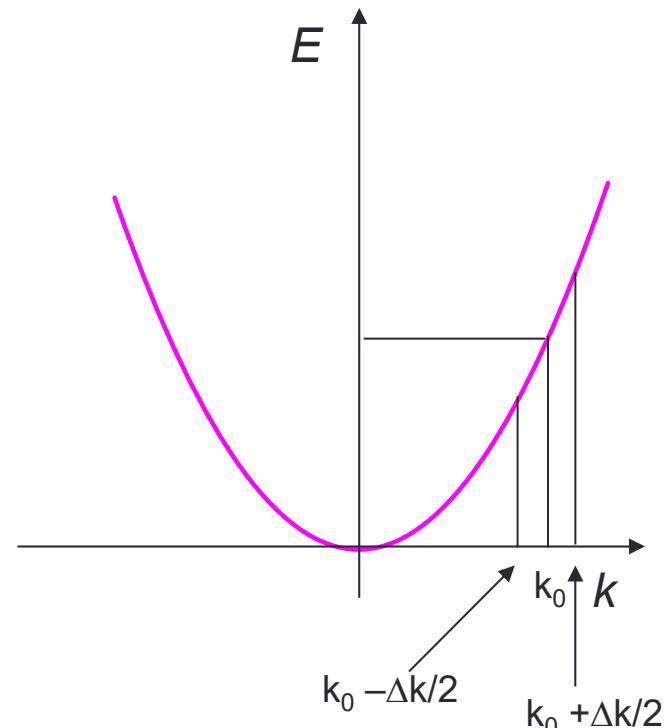
- L'électron de Sommerfeld:
 - Soit l'électron en k_0 : L est de l'ordre de 10^8Å (1 cm) \Leftrightarrow on admet que le paquet d'onde de largeur Δk , constitue un pseudo continuum car:

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{10^8} \approx 10^{-7} \text{ A}^{-1}$$

- *Vitesse de l'électron*:

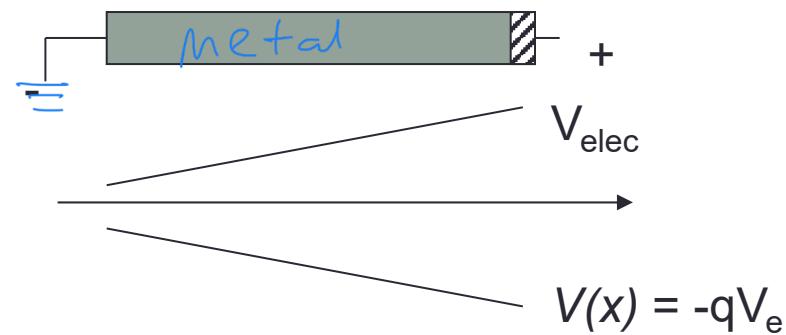
$$v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} \quad \text{avec } E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\Rightarrow v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}$$



Modèle de Sommerfeld

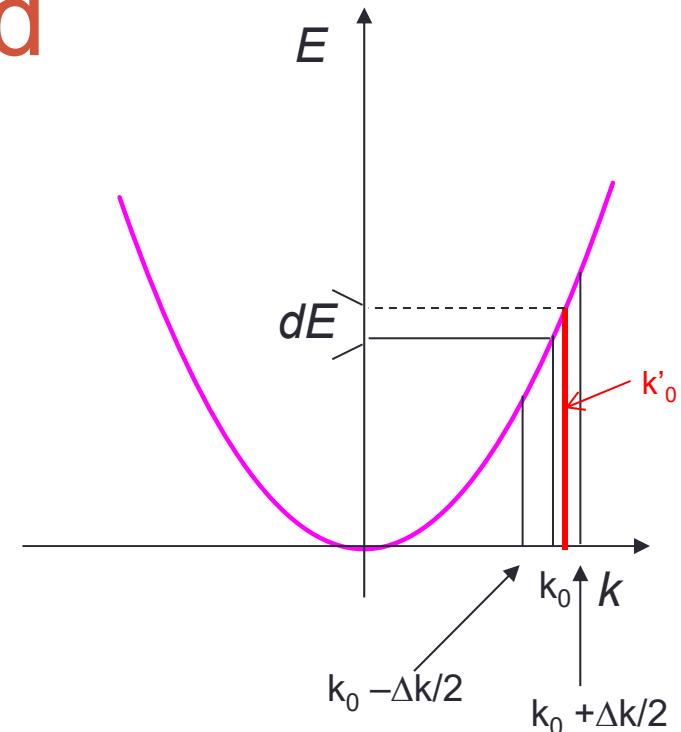
- L'électron de Sommerfeld:
 - *Accélération de l'électron:*



L'état (électron) acquiert de l'énergie

$$\Leftrightarrow \text{Entre } t \text{ et } t+dt \Rightarrow dE = F \cdot v_g \cdot dt$$

\Leftrightarrow Si E change, k change \Leftrightarrow la valeur centrale de k_0 a changé (k'_0 -).



$$dE = F \times v_g \times dt = F \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k_0} dt = dE$$

$$\Rightarrow F = \hbar \frac{dk_0}{dt} = \frac{dp_0}{dt}$$

Modèle de Sommerfeld

- L'électron de Sommerfeld:
 - *Accélération de l'électron:*

$$\frac{F}{m} = \frac{dv_g}{dt} = \gamma \quad \text{ici} \quad \vec{F} = -\underbrace{\overrightarrow{\text{grad}}V_0}_{(=0, V_0=\text{cste})} + \underbrace{F_{ext}}_{-qE_{elec}}$$

$$m \frac{dv_g}{dt} = -qE_{elec} \quad \text{et} \quad v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k_0}$$

$$\frac{dv_g}{dt} = \frac{dv_g}{dk} \frac{dk}{dt} = \gamma$$

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0} \times \frac{dk}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0} \times F = \frac{F}{m}$$

$$F = \hbar \frac{dk_0}{dt}$$

Si on appelle:

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0} \quad \text{car} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0$$



$$\frac{dv_g}{dt} = \gamma = \frac{F}{m} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0}$$

$f'(x)$ Pente

$f''(x)$ concavité

Modèle de Sommerfeld

$$\frac{dv_g}{dt} = \gamma = \frac{F}{m} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0}$$

- Nota: la relation $F=m\gamma$ est toujours vraie. La masse ainsi calculée n'est la masse de la particule que si $V=V_0=\text{cste}$, ie que les forces résultantes sont égales aux forces extérieures. Pour un potentiel $V(x)$ non constant, la relation est identique à condition de remplacer la masse par ***une masse efficace*** (ou effective m^*) qui traduira une réponse (inertie) différente de la particule (voir plus loin!).

Théorie ondulatoire appliquée aux atomes: l'atome de Bohr – Sommerfeld

- Atome à un électron (Hydrogène):
 - Noyau « lourd », chargé positivement (proton)
 - Il est ~ fixe
 - Électron « léger », chargé négativement
 - Attraction coulombienne entre proton et électron:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

- e : charge de l'électron
- ϵ_0 : permittivité du vide



Équation de Schrödinger à 3 dimensions

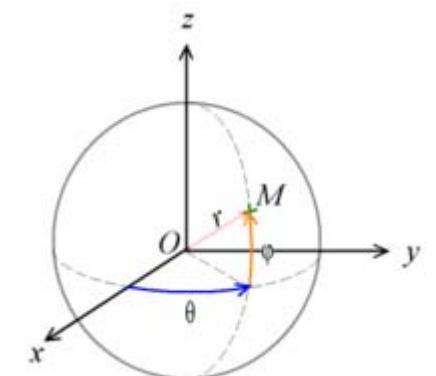
L'atome de Bohr - Sommerfeld

- *Équation de Schrödinger à 3 dimensions (C. sphériques)*

$$\nabla^2 \varphi(r, \theta, \phi) + \frac{2m_0}{\hbar^2} (E - V(r)) \varphi(r, \theta, \phi) = 0$$

- *Soit:*

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} + \\ \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{2m_0}{\hbar^2} (E - V(r)) \varphi = 0 \end{aligned}$$



L'atome de Bohr - Sommerfeld

- On applique la technique de séparation des variables:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\phi)$$

- On obtient:

$$\frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + r^2 \sin^2 \theta \frac{2m_0}{\hbar^2} (E - V) = 0$$

Fonction de ϕ
uniquement

- On pose

$$\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = -m^2 \longrightarrow \Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \text{ avec } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

L'atome de Bohr - Sommerfeld

- Si on poursuit la résolution (*hors de propos pour ce cours*) pour les 2 autres fonctions, on introduit en plus de m deux autres constantes l et n : on appelle ces entiers les nombres quantiques:
 - $n = 1, 2, 3, \dots \Leftrightarrow nb\;quantique\;principal$
 - $l = n-1, n-2, \dots, 0 \Leftrightarrow nb\;quantique\;azimutal$
 - $|m|=l, l-1, \dots, 0 \Leftrightarrow nb\;quantique\;magnétique$
- **Résultat majeur:**
 - On retrouve les énergies quantifiées de l'atome d'hydrogène

$$E_n = -\frac{m_0 e^4}{(4\pi\epsilon_0 \hbar^2)^2 2n^2} = -\frac{R_y}{n^2} = -\frac{13,6}{n^2} eV$$

<http://scienceworld.wolfram.com/physics/HydrogenAtom.html>

L'atome de Bohr - Sommerfeld

- L'énergie est quantifiée et la distance proton – électron est donnée par le rayon de Bohr a_0

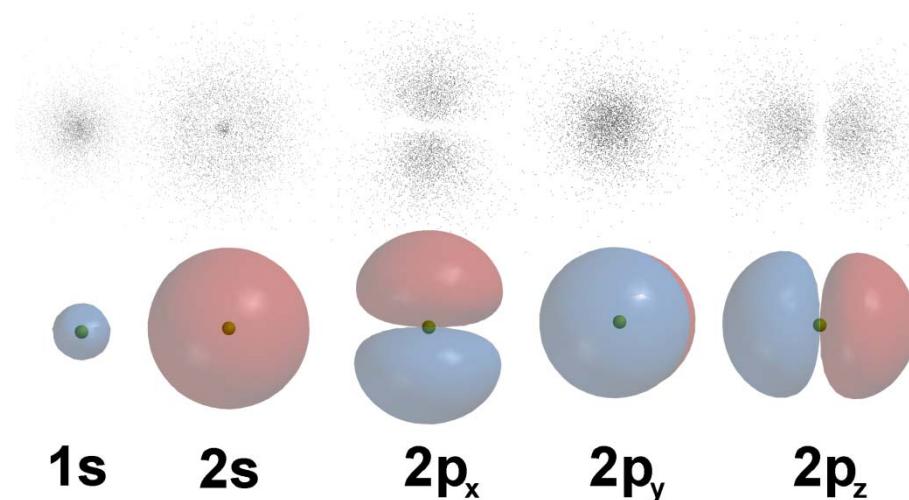
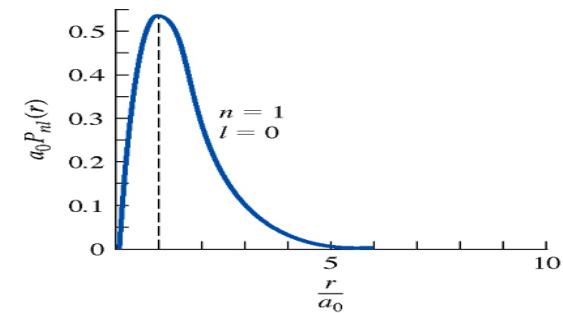
$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2} = 0,529 \text{ \AA}^0 \text{ pour l'Hydrogène}$$

- *Terminologie courante:*

- État s $l=0$
- État p $l=1$
- État d $l=2$

- *États électriques:*

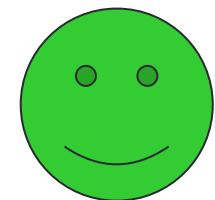
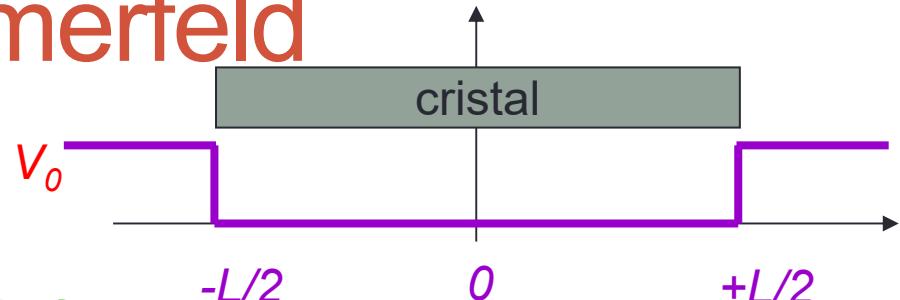
- 1s 2s 2p 3s 3p 3d ...



Le modèle de Sommerfeld

- Bilan:

- Compréhension de la chaleur spécifique
- Loi d'Ohm (on verra plus loin)
- ...
- Ne permet pas d'expliquer la différence entre un conducteur (métal), un semiconducteur et un isolant



電導率

$$\frac{\sigma_{métal}}{\sigma_{isolant}} \approx 10^{32} !!!$$



Il doit y avoir « quelque part » dans le modèle une approximation grossière !

CHAPITRE 6

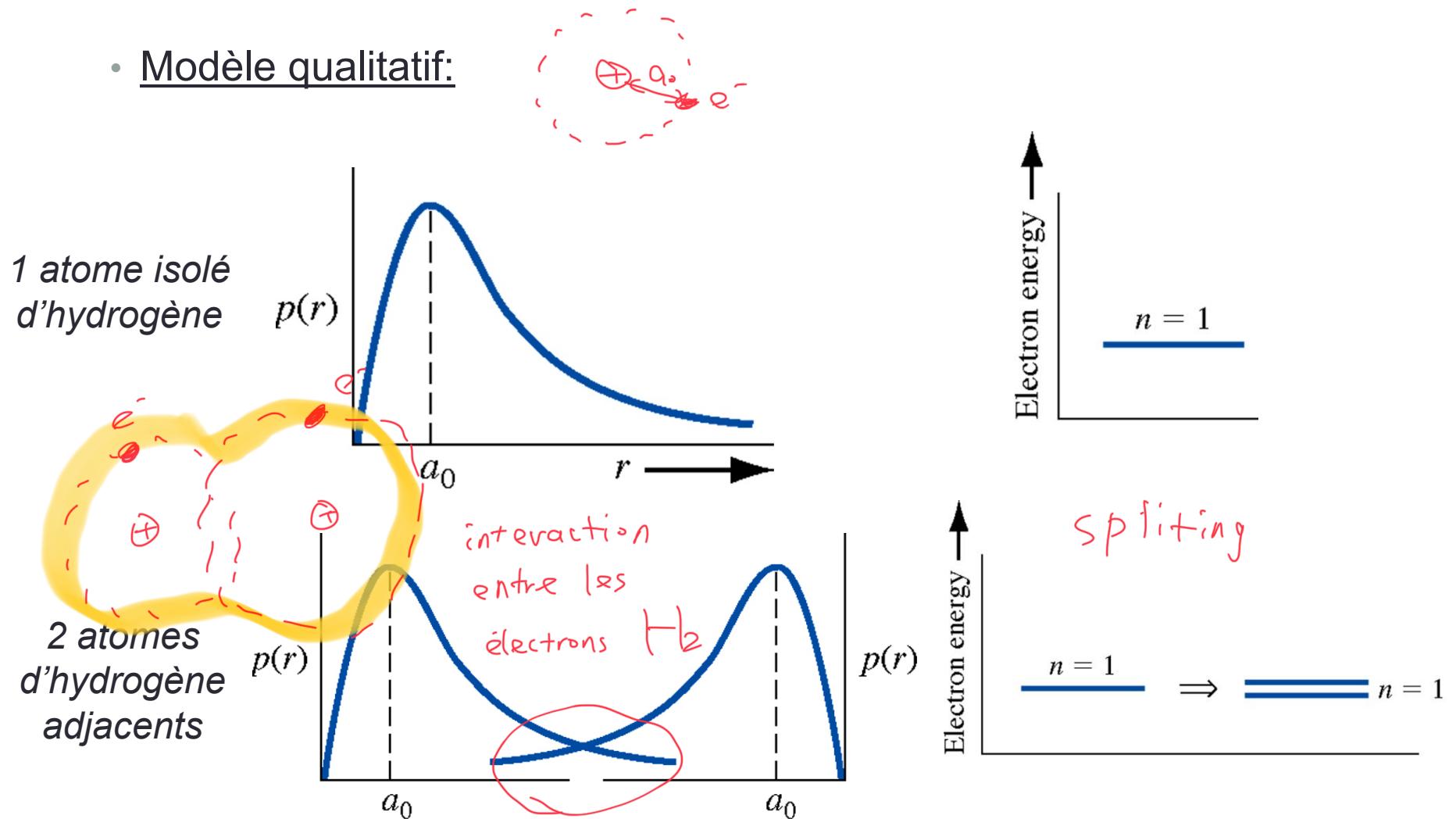
Les électrons dans une structure périodique :
le modèle de Bloch - Brillouin

plan

- Formation des bandes d'énergie
- Introduction de la périodicité du cristal
- Le pseudo vecteur d'onde
- Ondes de Bloch
- Modèle de Kronig-Penney
- Diagramme d'énergie dans l'espace des k

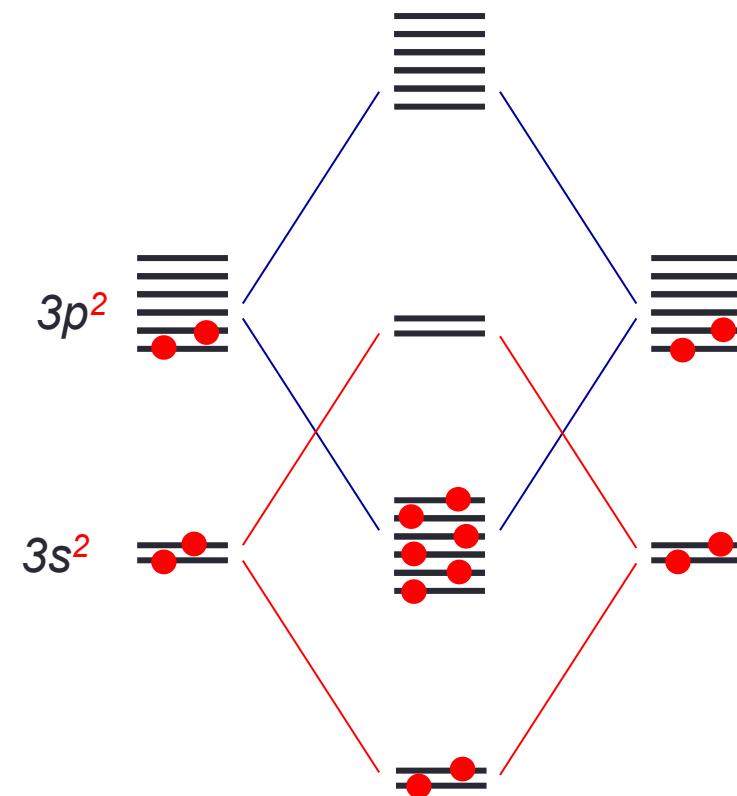
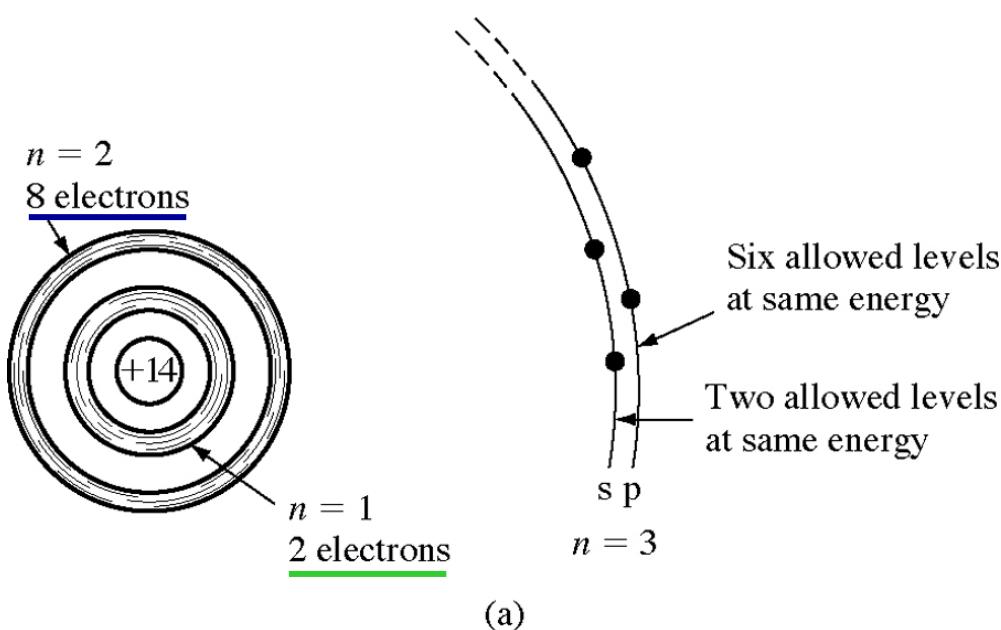
Formation des bandes d'énergie

- Modèle qualitatif:

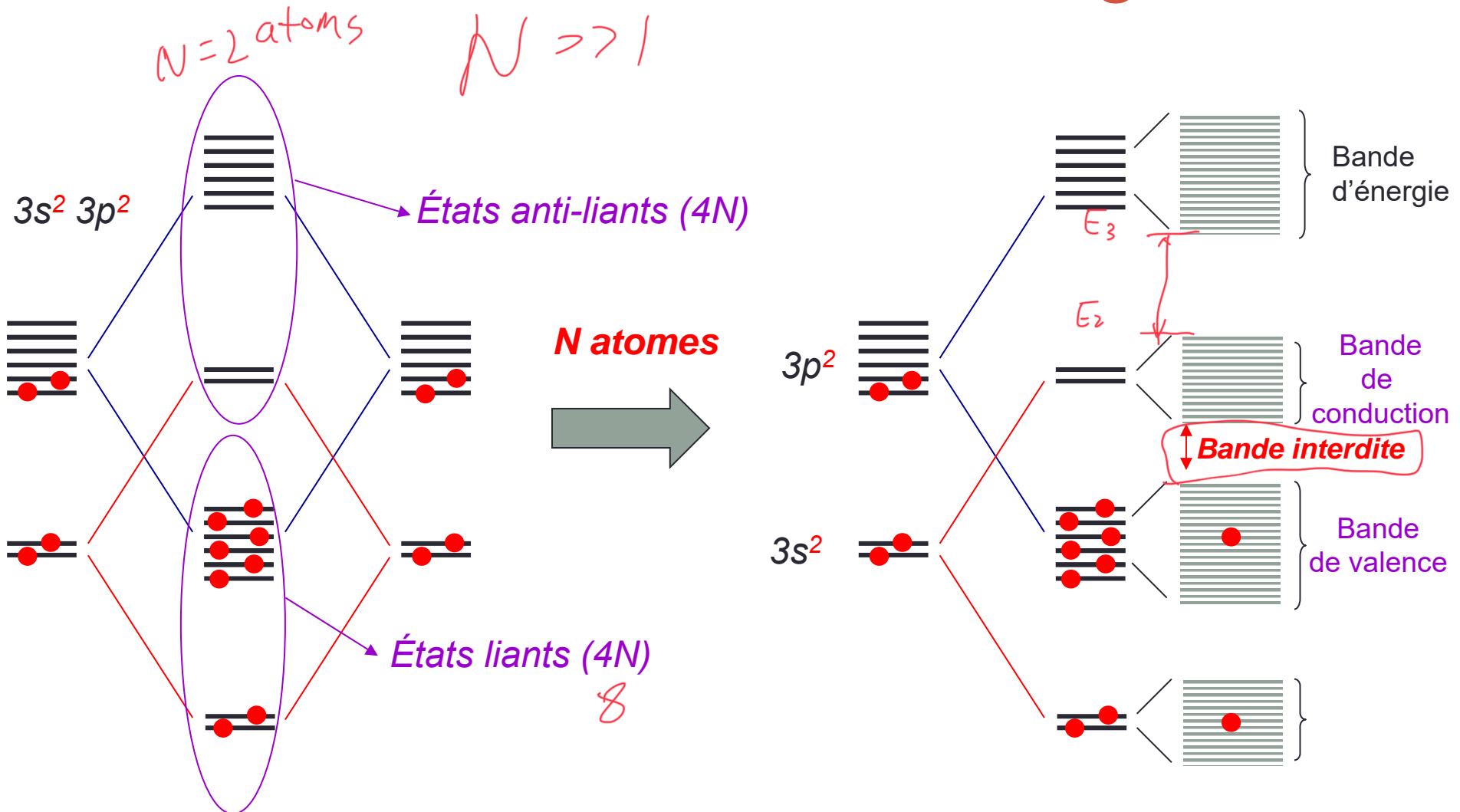


Formation des bandes d'énergie

- Modèle qualitatif pour le *Silicium*:
 - Structure électronique (14 électrons)
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

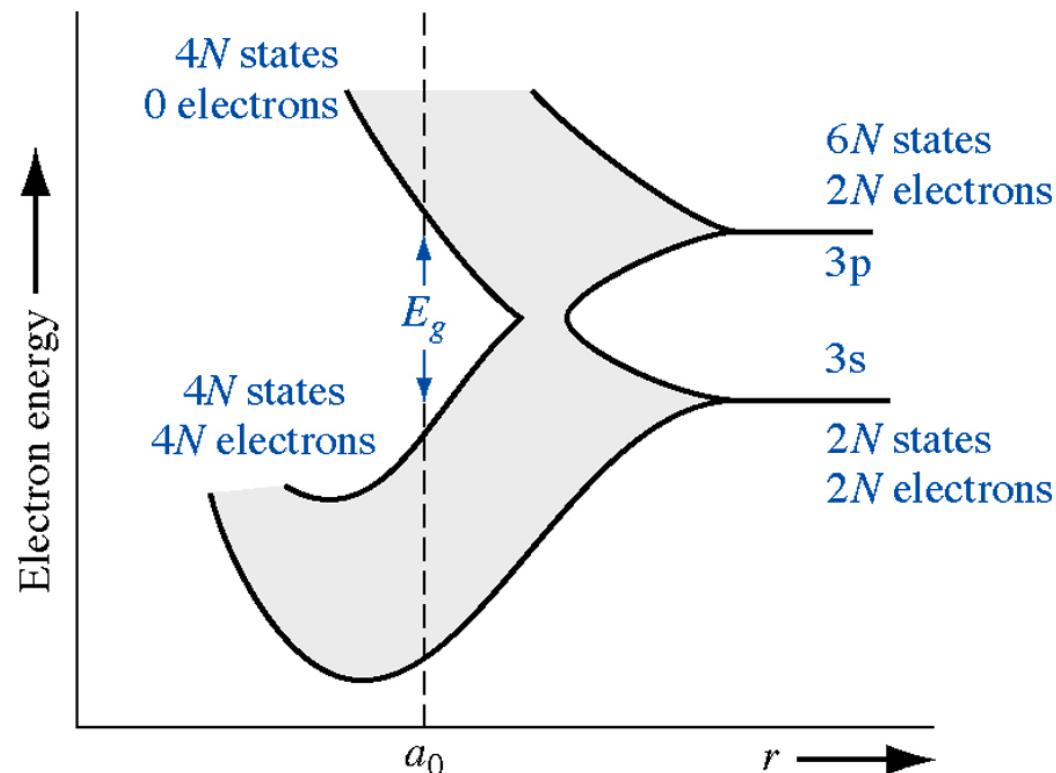


Formation des bandes d'énergie



Formation des bandes d'énergie

- La largeur de la bande interdite dépend (entre autre) de la distance inter atomique a_0

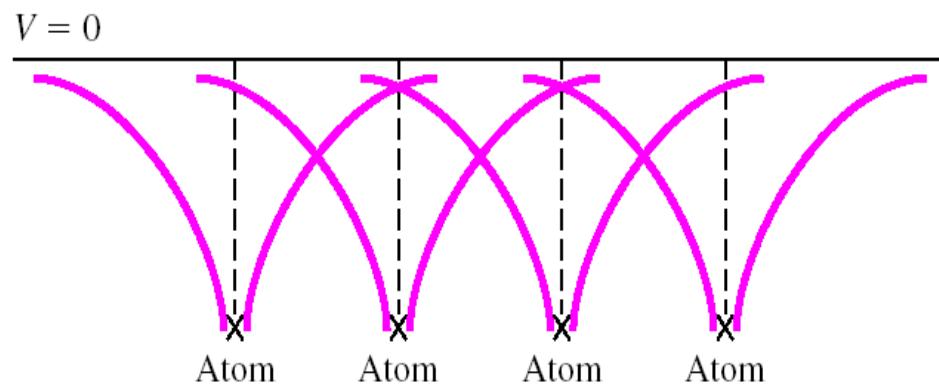
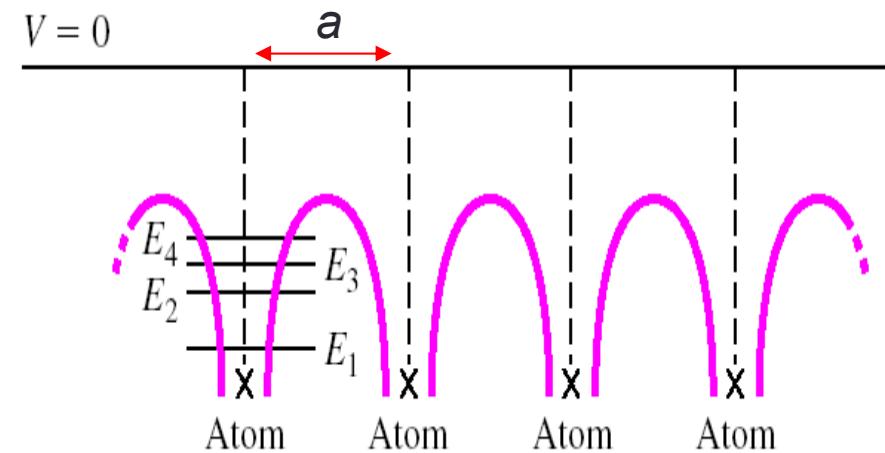
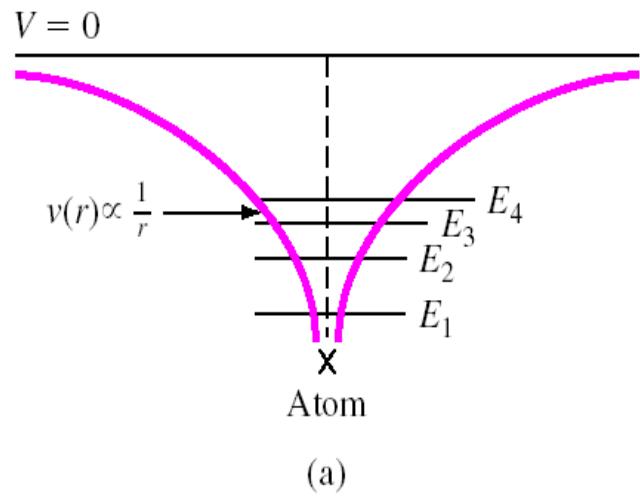


Formation des bandes d'énergie

- *Modèle « théorique » faisant appel à la mécanique quantique et l'éq. de Schrödinger.*
- *Que doit on rajouter par rapport au modèle de Sommerfeld pour arriver à comprendre la notion de bandes d'énergie permises et interdites?*

Le potentiel cristallin dans lequel se « balade » l'électron n'est pas constant !

Formation des bandes d'énergie



(d'après Neaman)

Le potentiel cristallin est périodique, de période a (celle du réseau!).

$$V(x) = V(x + a)$$

Modèle de Bloch Brillouin

- Conditions cycliques de BVK: (permet d'ignorer ce qui se passe en bout de l'échantillon de longueur L)

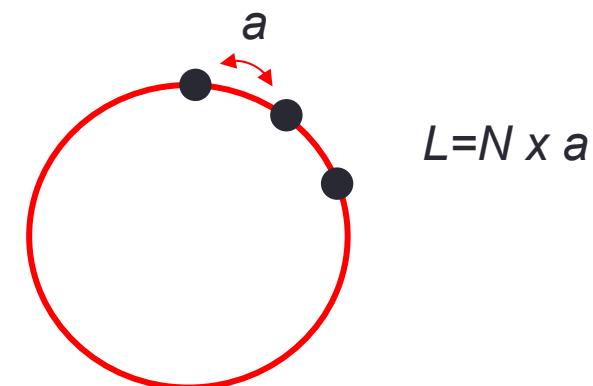
- Nb d'atomes ?
 - À 1D:

$$N = \frac{1}{a} \approx 10^7 \text{ cm}^{-1}$$

- À 3 D:

$$N = \frac{1^3}{a^3} \approx 10^{21} \text{ cm}^{-3}$$

$a = 10 \text{ \AA}$



$$V(x + L) = V(x)$$

$$\psi(x + L) \equiv \psi(x)$$

Le cristal étant périodique de période a , les propriétés du cristal sont les mêmes en x et $x+a$. Il en est de même pour la fonction d'onde, donc pour la probabilité de présence de l'électron.

Modèle de Bloch Brillouin

$$dP(x) = |\psi(x)|^2 \quad (1) \text{ } P \text{ en } x$$

solution

$$dP(x+a) = |\psi(x+a)|^2 \quad (2) \text{ } P \text{ en } (x+a)$$

$$(1) \equiv (2) \Rightarrow \psi(x)\psi^*(x) = \psi(x+a)\psi^*(x+a)$$

- Les deux fonctions d'onde ne peuvent être séparées que par un facteur de phase:

$$\psi(x+a) = e^{i\theta}\psi(x), \quad \psi(x+2a) = e^{i2\theta}\psi(x), \dots$$

$$\Rightarrow \psi(x+Na) = e^{iN\theta}\psi(x) = \psi(x)$$

$$\Rightarrow e^{iN\theta} = 1 \Leftrightarrow N\theta = p2\pi \Rightarrow \theta = p\frac{2\pi}{N} = p\frac{2\pi a}{Na} = p\frac{2\pi}{L}a$$

$$Na = L$$

Modèle de Bloch Brillouin

- Modification d'écriture: introduction du pseudo vecteur d'onde K .
 - Si on pose $K = p \frac{2\pi}{L}$, alors on peut écrire:
$$\psi(x + a) = e^{iKa} \psi(x)$$
 - K n'est pas un vecteur d'onde; il ne traduit que le déphasage entre 2 ondes de matière qui représentent la particule.
 - K est quantifié. Il prend N valeurs consécutives distantes de $\frac{2\pi}{L}$ et prend les mêmes valeurs à $\frac{2\pi}{a}$ près.

Modèle de Bloch Brillouin

- Onde de Bloch:

$$\psi(x+a) = e^{iKa} \psi(x) = e^{iK(a+x)} e^{-iKx} \psi(x)$$

posons $u(x) = e^{-iKx} \psi(x) \Leftrightarrow \psi(x) = u(x)e^{iKx}$

et

$$\begin{aligned} u(x) &= e^{-iKx} \psi(x) = e^{-iK(x+a)} e^{iKa} \psi(x) = e^{-iK(x+a)} \psi(x+a) \\ \Rightarrow u(x) &= u(x+a) \end{aligned}$$

- *Les fonctions d'onde stationnaire d'un électron dans un potentiel périodique sont des fonctions de Bloch de la forme (à 1D):*

$$\psi(x) = u(x)e^{iKx} \quad \forall x \text{ avec } u(x) = u(x+a)$$

Modèle de Bloch Brillouin

- Différence onde plane / onde de Bloch:
 - Onde plane:

$$\phi(x) = A e^{ikx} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ et } \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} x = kx$$

- Onde de Bloch:

$$\phi(x) = u(x) e^{iKx} \quad K = p \frac{2\pi}{L} \text{ et } \varphi = Kx + \underbrace{\arg(u(x))}_{inconnu}$$

Modèle de Bloch Brillouin

- La fonction d'onde de Bloch doit être injectée dans l'équation de Schrödinger \Leftrightarrow la résolution impose de connaître $u(x)$!

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} (u(x)e^{ikx}) + V_0 \times u(x)e^{ikx} = E \times u(x)e^{ikx}$$

- Pour résoudre le problème il faut connaître parfaitement la forme du potentiel cristallin (pas trivial!). Un modèle simplifié devrait nous permettre d'avoir une idée de la structure de bandes d'énergie

Modèle de Kronig et Penney

R.D. Kronig and W.G. Penney, "Quantum Mechanics of Electrons in Crystal Lattices",
Proceedings of the Royal Society London **130**, 499 (1931)

Introduction.—Through the work of Bloch our understanding of the behaviour of electrons in crystal lattices has been much advanced. The principal idea of Bloch's theory is the assumption that the interaction of a given electron with the other particles of the lattice may be replaced in first approximation by a periodic field of potential. With this model an interpretation of the specific heat,* the electrical and thermal conductivity,† the magnetic susceptibility,‡ the Hall effect,§ and the optical properties|| of metals could be obtained. The advantages and limitations inherent in the assumption of Bloch will be much the same as those encountered when replacing the interaction of the electrons in an atom by a suitable central shielding of the nuclear field, as in the work of Thomas and Hartree.

* Bloch, 'Z. Physik,' vol. 52, p. 555 (1928).

† Bloch, 'Z. Physik,' vol. 52, p. 555 (1928), vol. 53, p. 216 (1929), and vol. 59, p. 208 (1930); Peierls, 'Ann. Physik,' vol. 4, p. 121 (1930), and vol. 5, p. 244 (1930).

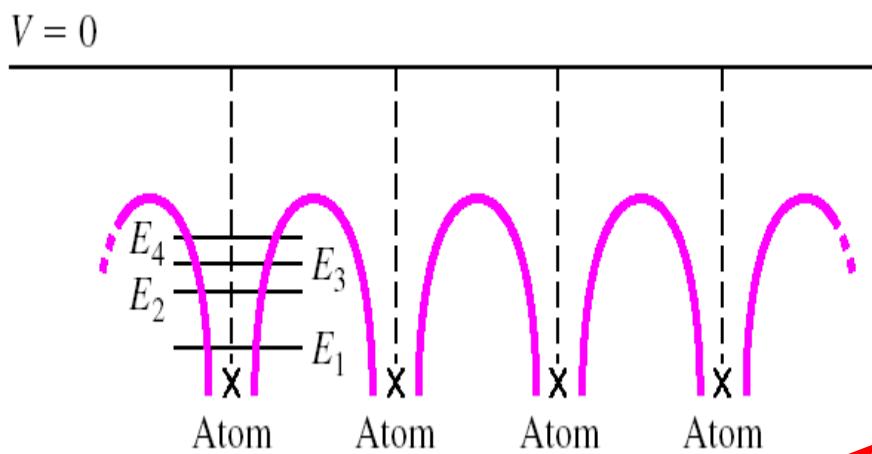
‡ Bloch, 'Z. Physik,' vol. 53, p. 216 (1929).

§ Peierls, 'Z. Physik,' vol. 53, p. 255 (1929).

|| Kronig, 'Proc. Roy. Soc.,' A, vol. 124, p. 409 (1929).

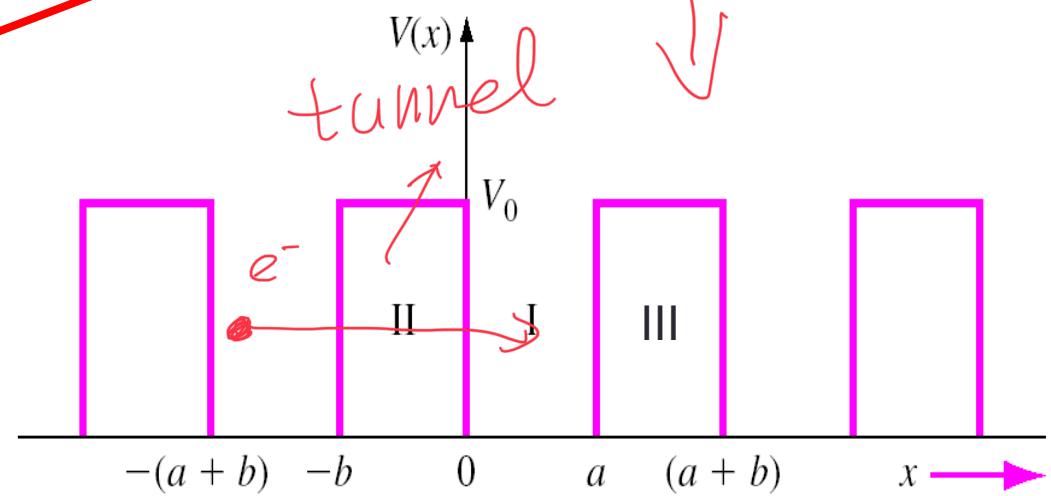
Modèle de Kronig et Penney

- On approxime le potentiel périodique cristallin par un potentiel périodique en crêneaux.



- Zone I : $0 < x < a$ $V(x) = 0$
- Zone II : $-b < x < 0$

période = $a+b$.



Modèle de Kronig et Penney

- Potentiel périodique \Leftrightarrow Ondes de Bloch
- Les fonctions (et leurs dérivées) ne diffèrent que d'un facteur de phase dans les régions II et III :

$$\phi_{III}(x) = e^{iK(a+b)} \phi_{II}(x - (a + b))$$

+ : \leftarrow
 - : \rightarrow

$$\phi_{III}(a) = \phi_{II}(a - a - b) e^{iK(a+b)} = \phi_{II}(-b) e^{\frac{+}{-} iK(a+b)}$$

- Électrons liés au cristal $\Leftrightarrow E < V_0$
- Potentiel $V(x)$ fini partout \Leftrightarrow la fonction d'onde et sa dérivée première doivent être continues partout.

Modèle de Kronig et Penney

- Résolution de l'équation de Schrödinger:

- Région I (dans le puits):

$$\phi_I(x) = A e^{i\beta x} + B e^{-i\beta x} , \quad \beta = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

- Région II (dans la barrière):

$$\phi_{II}(x) = C e^{\alpha x} + D e^{-\alpha x} , \quad \alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$$

- Région III (dans la barrière):

$$\phi_{III}(x) = E e^{i\beta x} + F e^{-i\beta x} , \quad \beta = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

- Continuité de la fonction d'onde et sa dérivée première en a et en 0 :
attention au déphasage !

Modèle de Kronig et Penney

- On obtient un système de 4 équations (2 par la continuité de la fonction d'onde et 2 par la dérivée première) à 4 inconnues (A,B, C et D)
- Solutions non triviales ($A=B=C=D=0$) ^{simple} ssi le déterminant du système est nul.
- On obtient (laborieux mais faisable!!)

$$\text{det} = 0 \rightarrow \cos k(a+b) = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta} \sin(\beta a) \sinh(\alpha b) + \cos(\beta a) \cosh(\alpha b)$$

Rappel !! : k est le pseudo vecteur d'onde !!

Modèle de Kronig et Penney

- Que fait on de cette équation?

$$\cos k(a+b) = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha\beta} \sin(\beta a) \sinh(\alpha b) + \cos(\beta a) \cosh(\alpha b)$$

- Résolution numérique ou graphique de façon à obtenir une relation entre E , V_0 et k le pseudo vecteur d'onde.
- De façon à se rapprocher de la réalité et rendre plus « visible » la résolution graphique, on fait tendre la barrière de potentiel vers des Dirac ($b \rightarrow 0$ et $V_0 \rightarrow \infty$), mais avec $bV_0 = \text{cste finie}$:

$$P \frac{\sin \beta a}{\beta a} + \cos \beta a = \cos ka \quad \text{avec } P = \frac{m V_0 b a}{\hbar^2}$$

Modèle de Kronig et Penney

- Diagramme $E(k)$

$$P \frac{\sin \beta a}{\beta a} + \cos \beta a = f(\beta a) = \cos(ka)$$

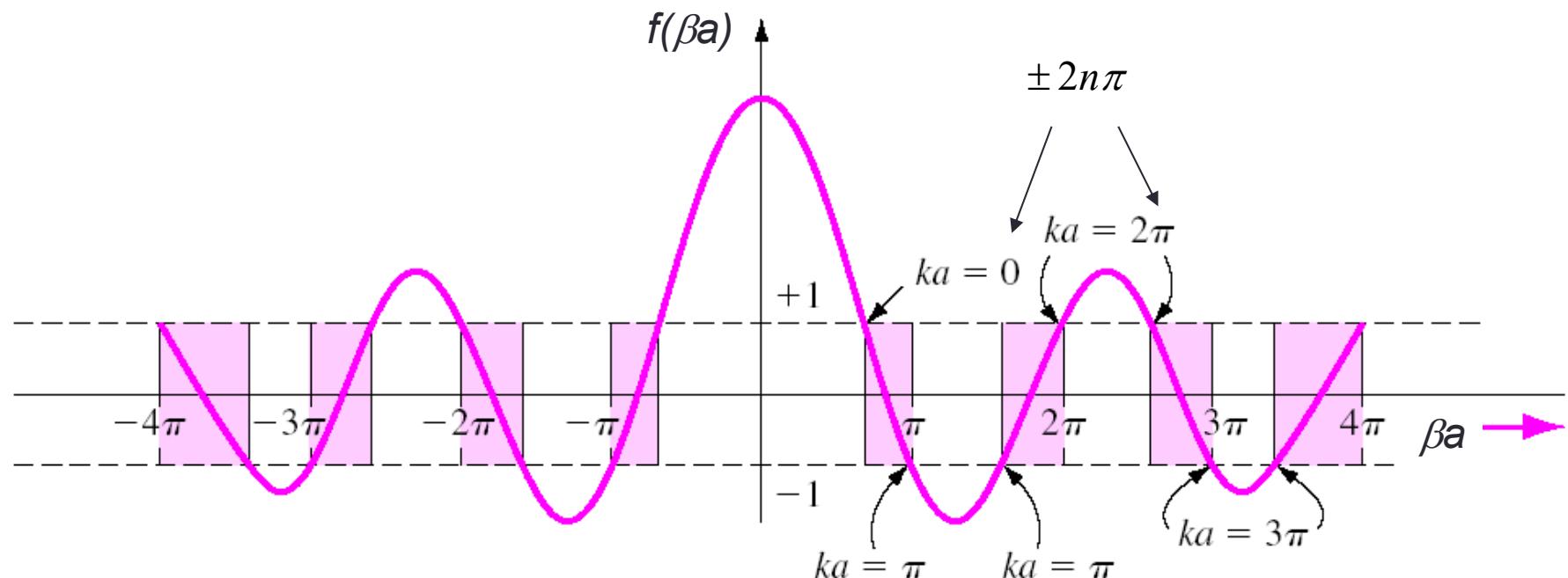
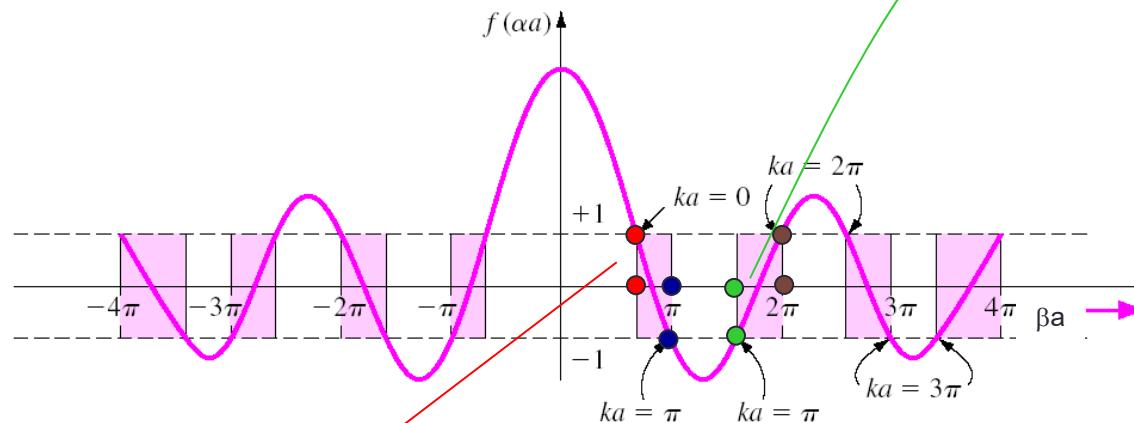


Diagramme $E(k)$



$$\beta = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \Leftrightarrow E = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2m}$$

- $ka=0 \Leftrightarrow$

$$1 = P \frac{\sin \beta a}{\beta a} + \cos \beta a$$

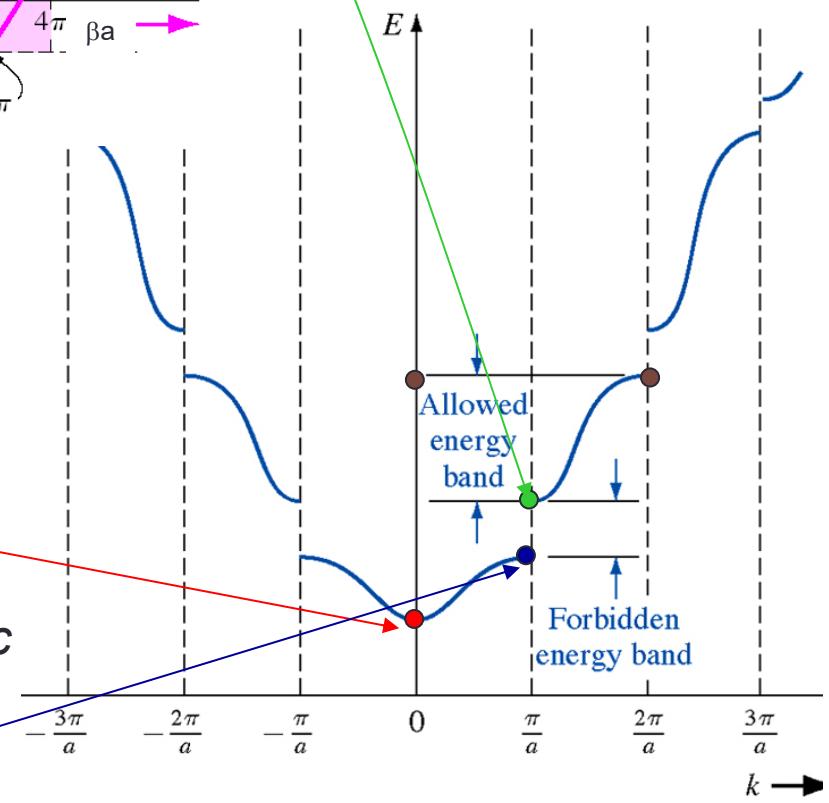
On en déduit une valeur de β donc de l'énergie E_1 .

-

- $ka=\pi \Leftrightarrow \beta a=\pi$

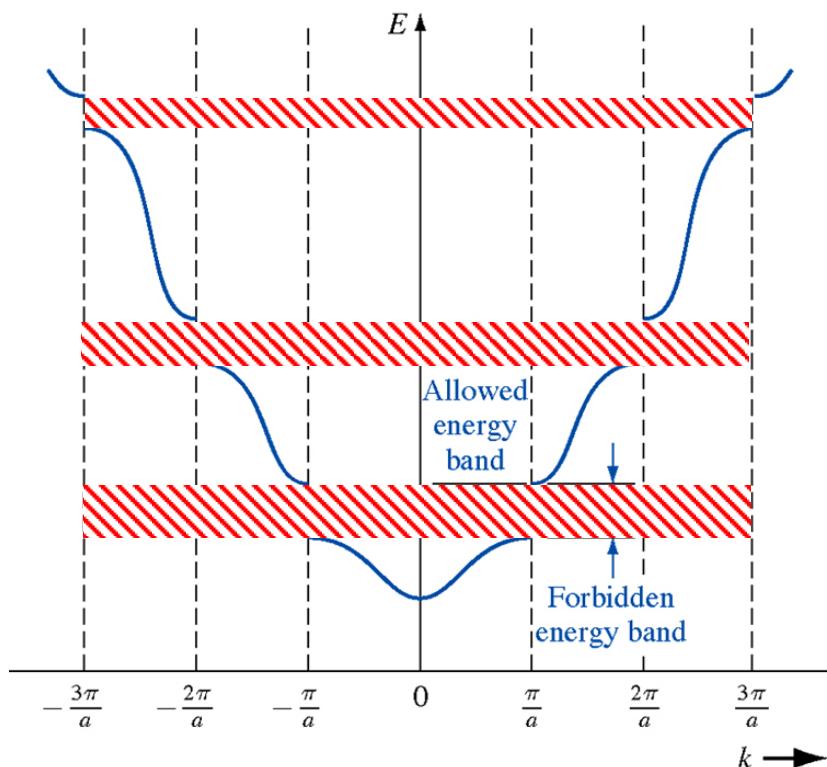
On en déduit une valeur de $\beta=\pi/a$ donc de l'énergie E_2 .

$$\sqrt{\frac{2mE_2}{\hbar^2}} = \frac{\pi}{a}$$



Bandes d'énergie

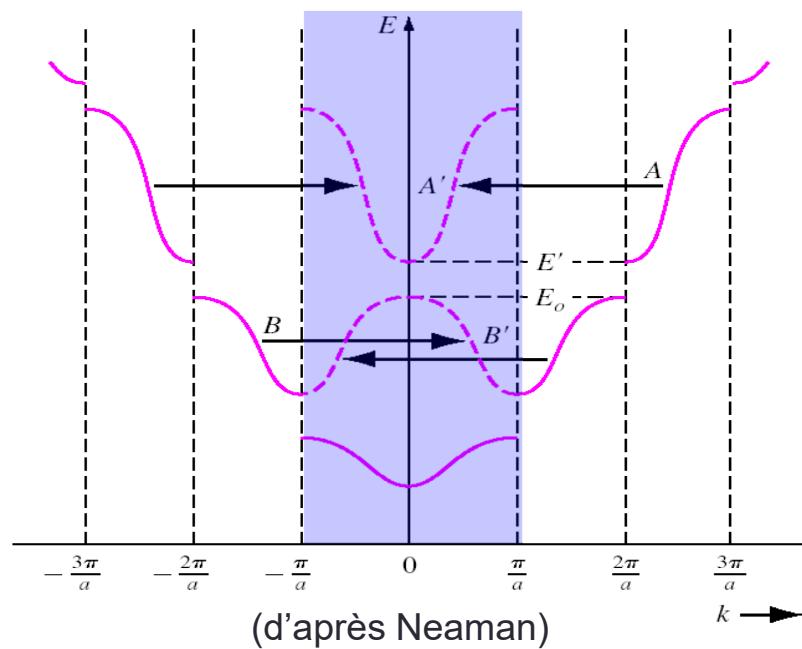
- Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique induit l'apparition de bandes d'énergie séparées les unes des autres par des bandes d'énergie interdite (rouge).



- Les électrons se « placent » sur les bandes d'énergies permises
- Il n'est pas nécessaire de tracer le diagramme sur tout le domaine de variation de k :
 - Périodicité en $2n\pi$

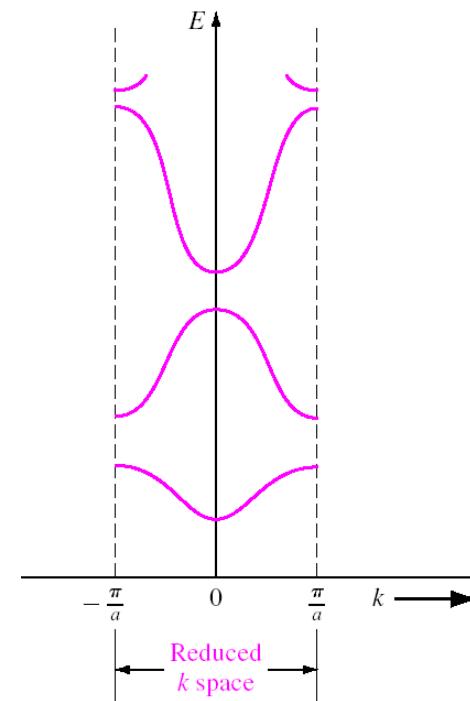
$$\cos ka = \cos(ka + 2n\pi) = \cos(ka - 2n\pi)$$

Schéma de zone réduite



Attention !!!!

$$k = p \frac{2\pi}{L}$$

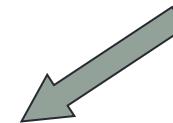
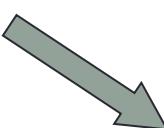


Notion de Gap (bande interdite) direct : ils se produisent alternativement en milieu de zone en $k=0$ et en bord de zone en $k=\pm\pi/a$. Chacun de ces gaps est dit direct en k car la discontinuité d'énergie se fait sans changer la valeur de k .

Limites d'énergie permise

- $\cos(ka) = \pm 1 \Leftrightarrow ka = n\pi \Leftrightarrow$
- on pose $P = \beta a \tan(\varphi)$

$$P \frac{\sin \beta a}{\beta a} + \cos \beta a = \pm 1$$



$$\cos(\beta a - \varphi) = \pm \cos \varphi$$

$$\cos(\beta a - \varphi) = + \cos \varphi$$

$$\bullet \beta a = 2n\pi : \quad \underline{E_{1n}} = \frac{h^2 n^2}{2ma^2}$$

$$\bullet \beta a = 2n\pi + 2\varphi : \quad \underline{E_{2n}} = \frac{h^2}{2ma^2} \left(n + \frac{\varphi}{\pi}\right)^2$$

$$\cos(\beta a - \varphi) = - \cos \varphi$$

$$\bullet \beta a = (2n+1)\pi : \quad \underline{E_{3n}} = \frac{h^2}{2ma^2} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$\bullet \beta a = (2n+1)\pi + 2\varphi : \quad \underline{E_{4n}} = \frac{h^2}{2ma^2} \left(n + \frac{1}{2} + \frac{\varphi}{\pi}\right)^2$$



Limite supérieure



Limite inférieure

$E(k)$ au voisinage d'un extremum

- Étude de la fonction: $\left. \frac{dE}{dk} \right|_{0, \pm \frac{\pi}{a}}$?
- On n'a pas de relation directe entre E et k !

$$\frac{dE}{dk} = \frac{dE/d\beta}{d\beta/dk} \quad ??? \quad \text{mais} \quad P \frac{\sin \beta a}{\beta a} + \cos \beta a = \cos ka$$

OK !

$$\frac{d[\cos ka]}{d\beta} = \frac{d[\cos ka]}{dk} \frac{dk}{d\beta} = \frac{d[P \frac{\sin \beta a}{\beta a} + \cos \beta a]}{d\beta}$$

→ On montre (voir TD!) qu'en centre de zone et en bord de zone,

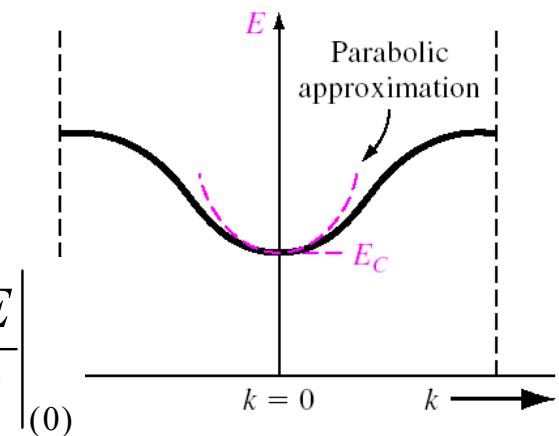
$$\left. \frac{dE}{dk} \right|_{0, \pm \frac{\pi}{a}} = 0$$

Masse effective de densité d'états

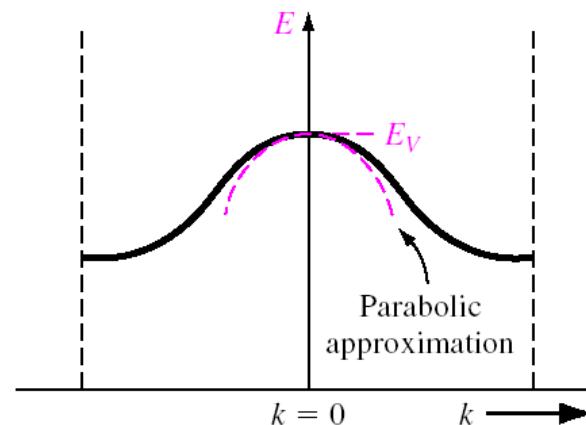
- Au voisinage d'un extremum: (DL à l'ordre 2)

$$E_k = E(0) + \underbrace{\frac{dE}{dk} \Big|_{k=0}}_{=0} (k - 0) + \frac{1}{2!} \frac{d^2 E}{dk^2} \Big|_{k=0} (k - 0)^2$$

$$E_k = E_{(0)} + \frac{1}{2} \frac{d^2 E}{dk^2} \Big|_{k=0} k^2 = E_{(0)} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} \text{ avec } \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} \Big|_{(0)}$$



Dans un certain intervalle autour des extrema de bandes, on a le droit de confondre la vraie courbe par une parabole: c'est l'approximation de la masse effective



Masse effective de densité d'états

- La masse effective est un paramètre qui relie les résultats de la mécanique quantique aux équations de la mécanique classique (Newton).
- Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique modifie son inertie \Leftrightarrow masse effective:

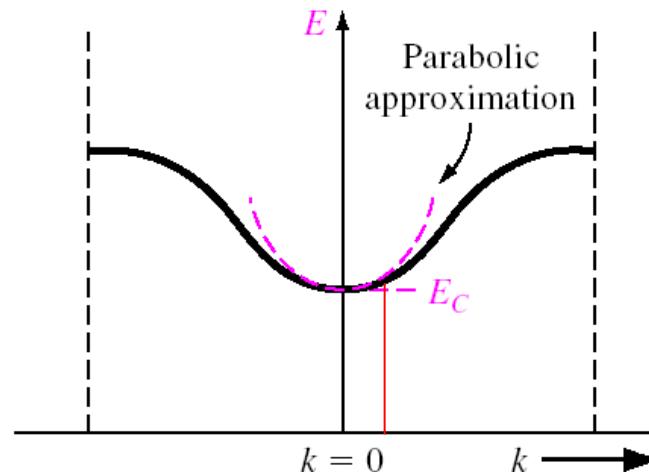
$$\frac{dv_g}{dt} = \gamma = \frac{F}{m^*} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0}$$

Signe de la masse effective

- Bas de bande:

$$E_k = E_{(0)} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_1^*}$$

- $E_k > E_{(0)} = E_{\text{minimum}}$

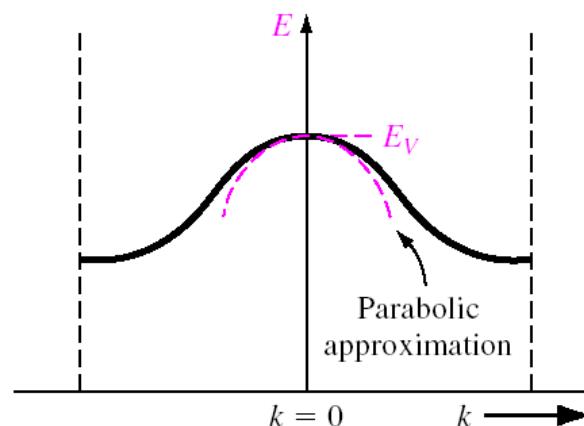


1° Règle: la masse efficace en bas de bande est un coefficient positif

- Sommet de bande:

$$E_k = E_{\text{Max}} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_2^*}$$

2° Règle: la masse efficace en sommet de bande est un coefficient négatif

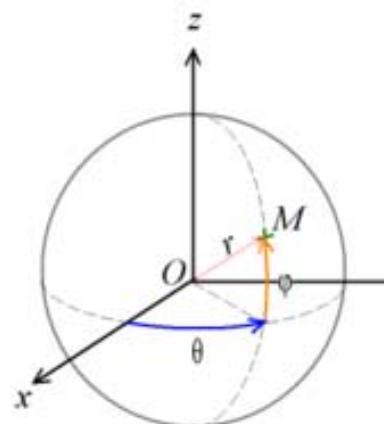


Densité d'états (approx. m^*)

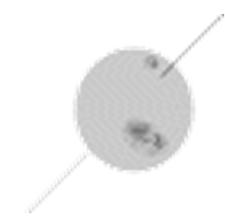
- le courant \Leftrightarrow déplacement de charges
- Nécessité de dénombrer le nombre de charge dans les bandes (conduction ou valence)
- Ce nombre est fonction du nombre d'états énergétiques ou états quantiques disponibles
- Attention: le principe d'exclusion de Pauli

Densité d'états (approx. m*)

- Avant de poursuivre:
 - Introduction de la notion de spin de l'électron:



$$\varphi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\phi)$$



- En plus des trois nombres quantiques (principal, azimuthal et magnétique), l'électron possède une propriété supplémentaire qui se traduit par un moment angulaire intrinsèque quantifié ($\pm \frac{1}{2}$) auquel on attribue un **quatrième** nb quantique de spin, s , indépendant des 3 autres.
- **Principe d'exclusion de Pauli** (dans les solides): on ne peut trouver deux électrons dans le solide ayant le même état d'énergie (mêmes nombres quantiques).

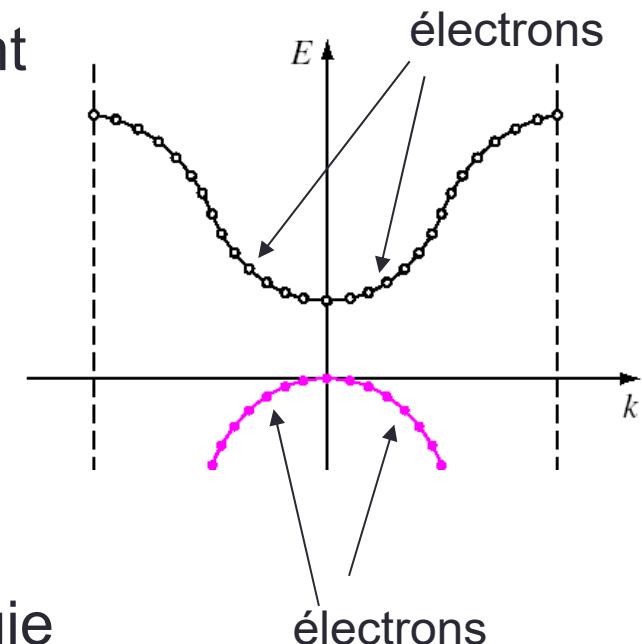
Densité d'états (approx. m^*)

- Cristal unidimensionnel de longueur L:
- Les états permis pour les électrons sont discrets séparés de $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$
- Autour du minimum ici, on approxime $E(k)$ par:

$$E = E_{\min} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

- La densité d'états est le nombre de modes (états, places) par unité d'énergie et de longueur ($L=1!$):

$$g_{1D}(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{\sqrt{2m^*}}{\pi\hbar} (E - E_{\min})^{-1/2} \quad J^{-1} m^{-1}$$



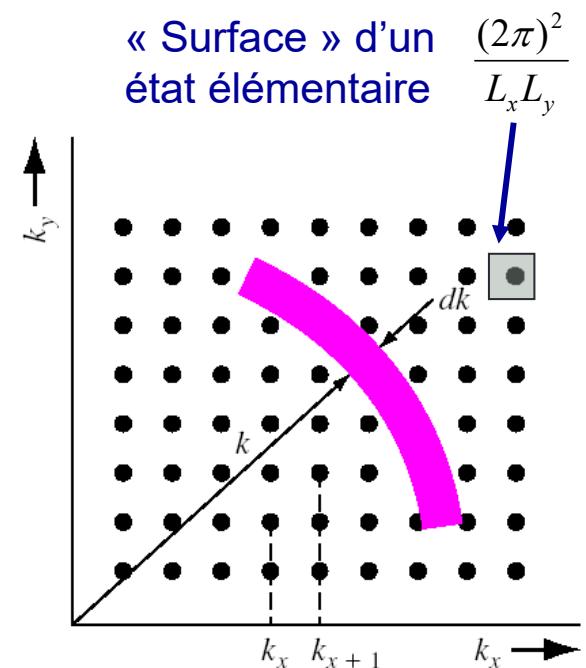
Densité d'états (approx. m^*)

- Cristal 2D de longueur L_x et L_y :
- Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
- L'énergie en bord de bande est toujours approximée par:

$$E = E_{\min} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

- La densité est alors donnée par:

$$g_{2D}(E) = \frac{dN}{dE} = L_x L_y \frac{m^*}{\pi \hbar^2} J^{-1} \quad \text{ou} \quad \frac{m^*}{\pi \hbar^2} J^{-1} m^{-2}$$



} *Indépendant de l'énergie !*

Densité d'états (approx. m^*)

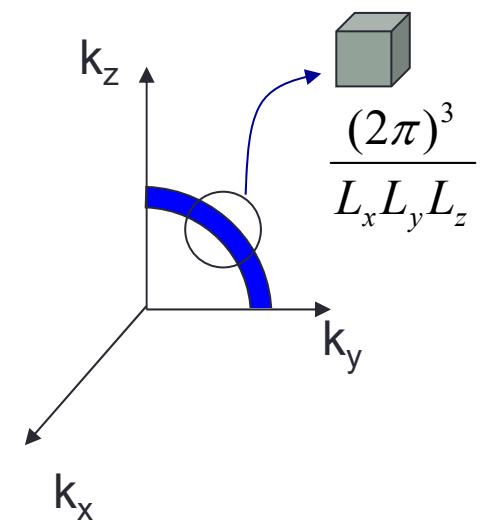
- Cristal 3D de longueur L_x L_y et L_z :
- Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
- L'énergie en bord de bande est toujours approximée par:

$$E_{\vec{k}} = E_{\min} + \frac{\hbar^2}{2m^*} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = E_{\min} + \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m^*}$$

- La densité est alors donnée ($L_x L_y L_z = 1$ ie par unité de volume):

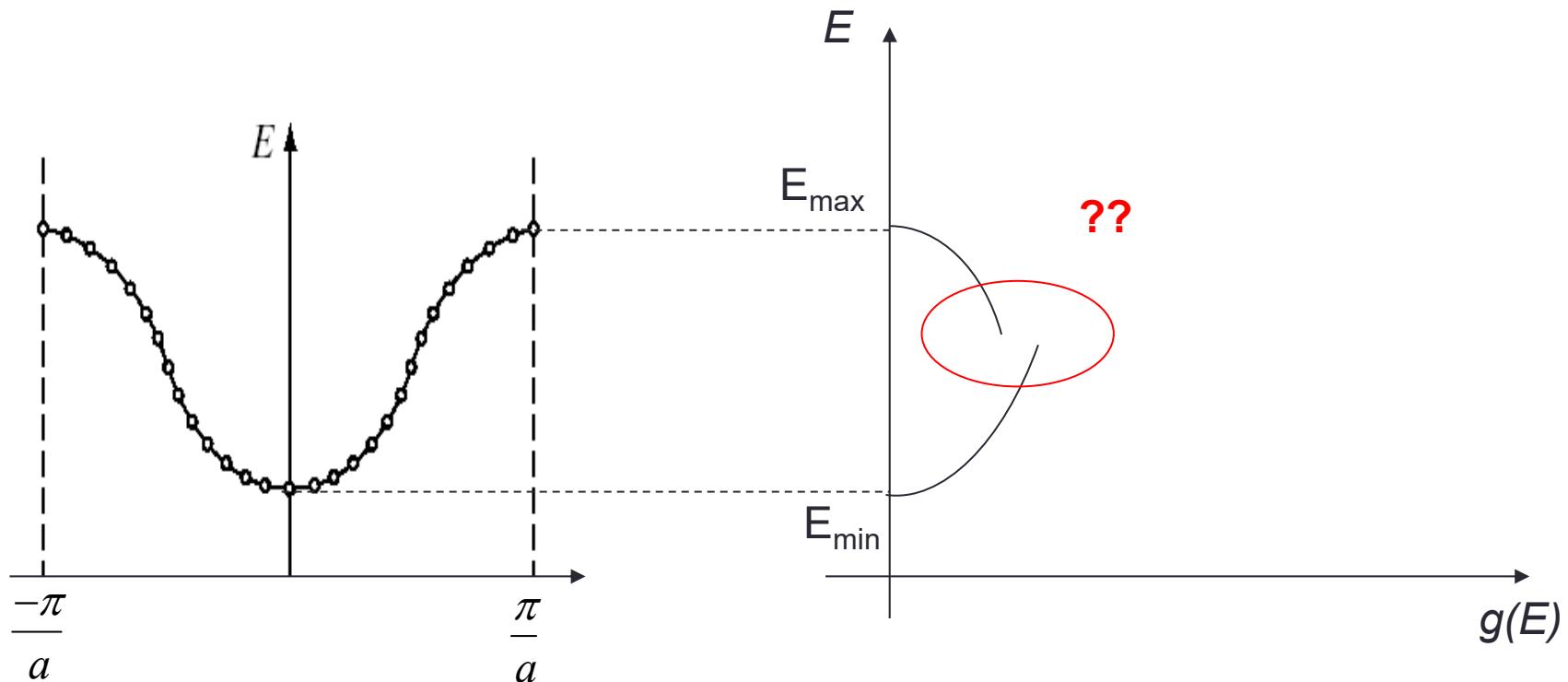
$$g_{3D}(E) = \frac{dN}{dE} = 4\pi \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (E - E_{\min})^{1/2} J^{-1} m^{-3}$$

———— = ————— $(E_{\max} - E)^{1/2}$



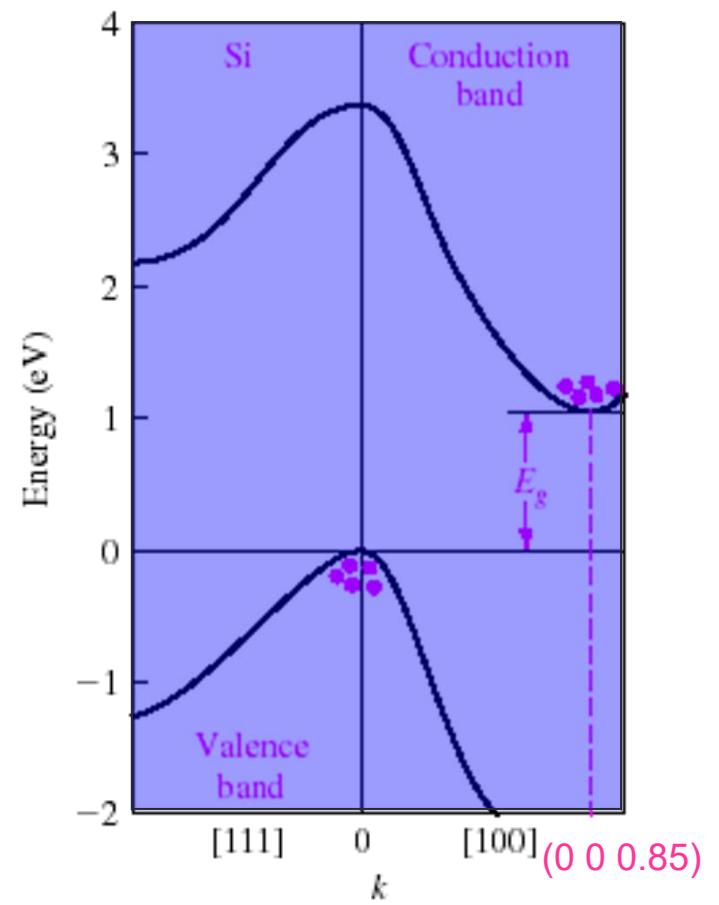
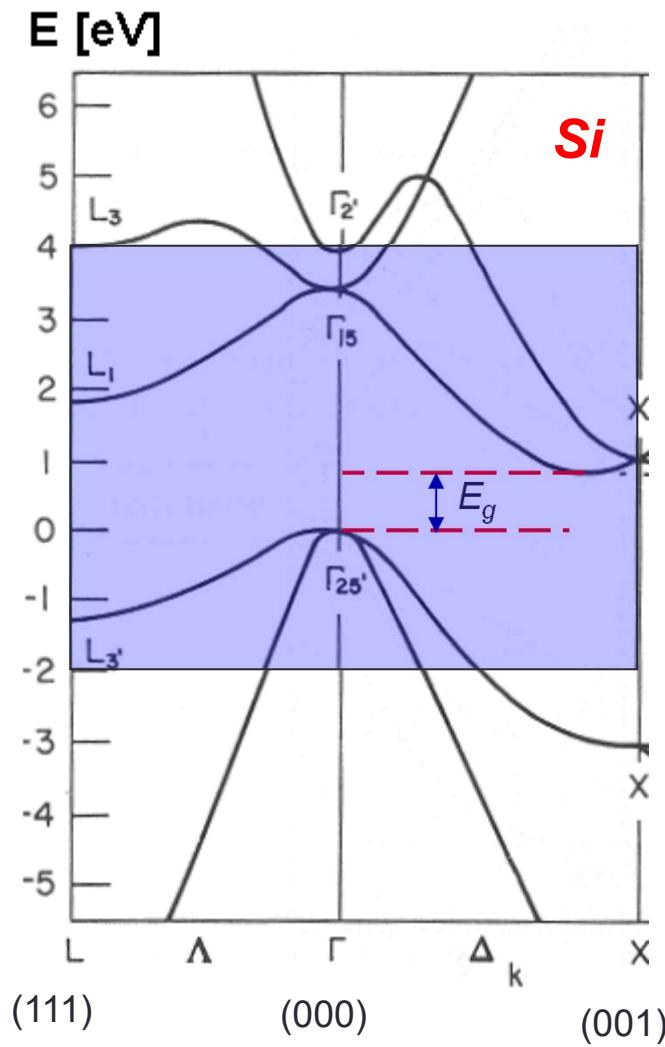
← bas de bande
← sommet de bande

Densité d'états 3D

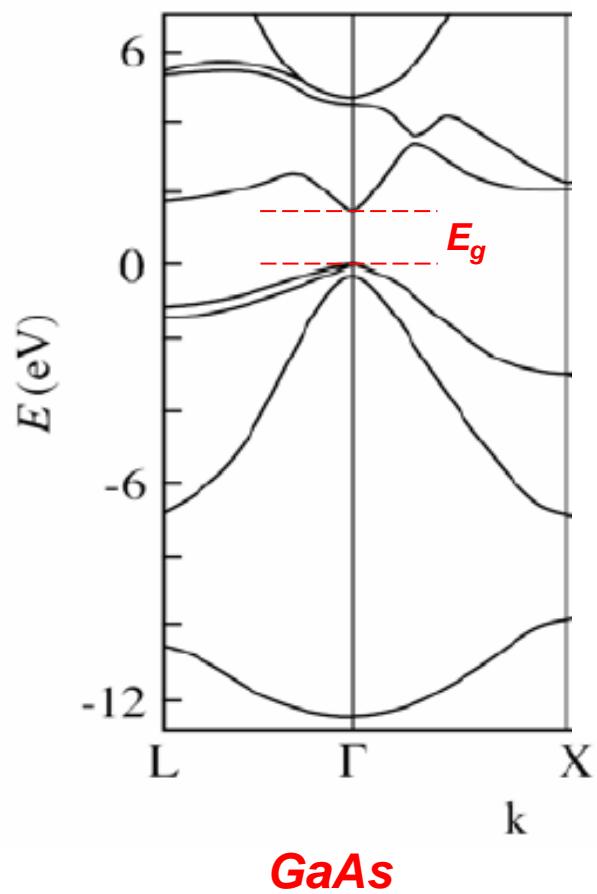


*Les masses effectives ne sont pas les mêmes et
l'approximation de la m^* n'est valable qu'en bord de bande !*

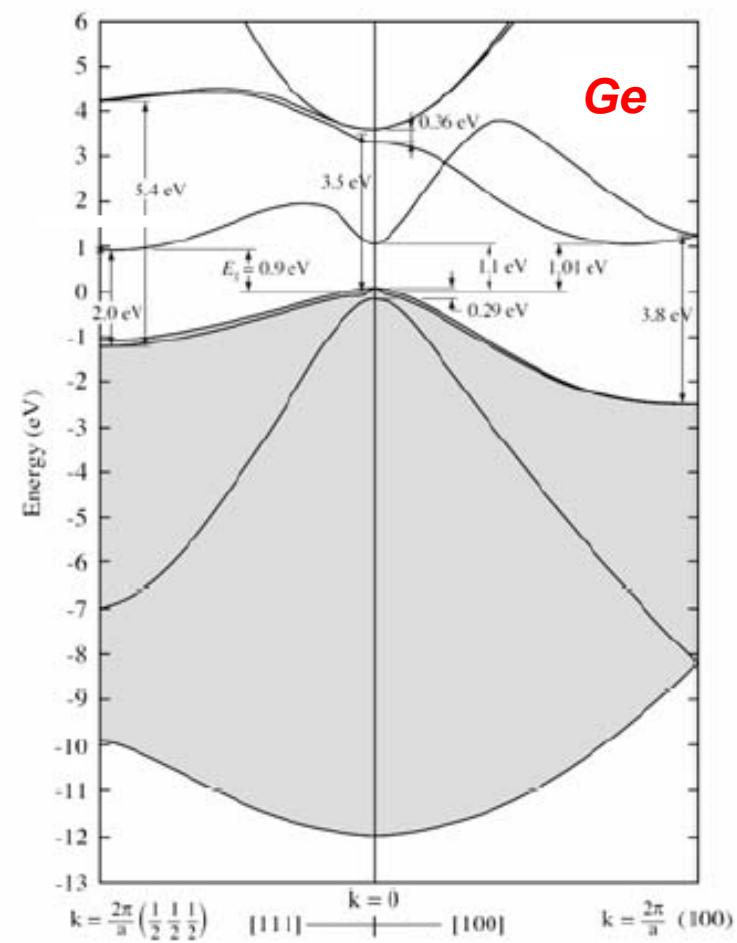
Structure de bande réelle!



Structure de bande réelle!



GaAs



synthèse

- Cristal \Leftrightarrow potentiel périodique
 - Apparition de structure en bande d'énergie
 - Notion de bande interdite



*Cela suffit-il à expliquer la différence entre métal et isolant (ou semiconducteur) ?
Suite au prochain chapitre*

CHAPITRE 7

Courant dans les solides :
cas particulier des semiconducteurs

Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin

- Vecteur densité de courant:
 - C'est quoi la densité de courant: c'est un déplacement de charges électriques par unité de temps et de surface

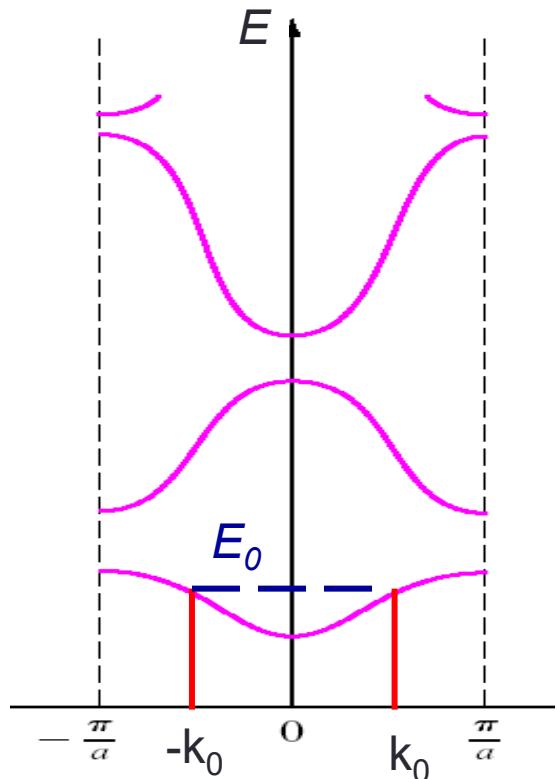
$$\vec{j} = -q \sum_i n_i \vec{v}_i = -q \sum_i \vec{v}_i$$

- À 1 dim:
avec n_i le nombre (densité linéique) d'électrons de vitesse \vec{v}_i

$$\bar{j} = -q \sum_i \bar{v}_i$$

Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin

- Contribution des diverses bandes au courant électrique
 - Bandé pleine



- Sur chacune des valeurs permises de k_0 on peut former un paquet d'ondes
- La bande est dite pleine si toute les valeurs de k_0 sont utilisées (niveau d'énergie occupé).
- $E(k)$ est paire en $k \Leftrightarrow E(-k_0) = E(+k_0) \Leftrightarrow$ la probabilité de trouver un électron en k_0 ou en $-k_0$ est identique (démontré chapitre suivant)
- Vitesse de la particule $v_g = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k_0}$ impaire en $k \Leftrightarrow v_g(k) = -v_g(-k)$

$$\bar{j} = -q \sum_i \bar{v}_i = 0 \quad (\text{la bande est pleine})$$

Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin

- Règle 1: la contribution au courant électrique d'une bande pleine est toujours égale à zéro.
- Règle 2: la contribution au courant électrique d'une bande vide est égale à zéro.
- Corollaire: le courant électrique est dû aux bandes incomplètement remplies

R1. 满带对电流贡献为 0.

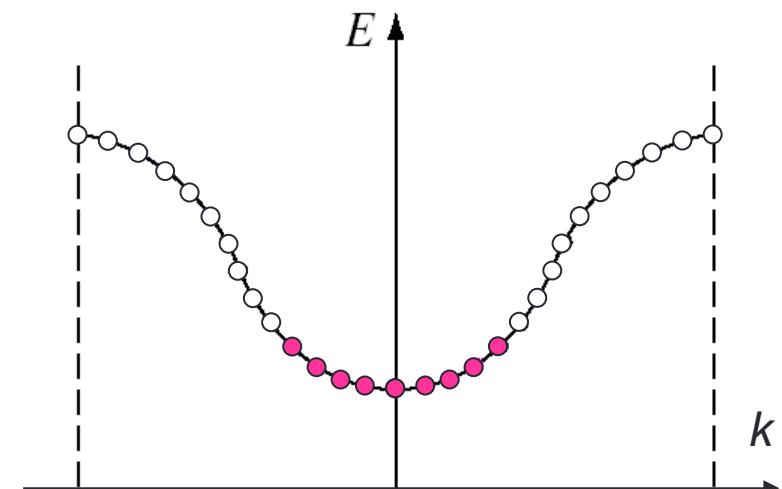
R2. 空带对电流贡献为 0.

Cor. 电流是由于带填充不完全造成的.

Contribution à J d'une bande incomplètement remplie

- Cristal parfait, $\mathcal{E}_{elec} = 0$ et T uniforme.
 - On est à l'équilibre thermodynamique
 - Les probabilités d'occupation des états d'énergie k et $-k$ sont identiques

$$\bar{j} = -q \sum_i \bar{v}_i = 0 \quad [v_g(k) = -v_g(-k)]$$



- Résultat non surprenant: pas de champ électrique \Leftrightarrow pas de courant de conduction!

Contribution à J d'une bande incomplètement remplie

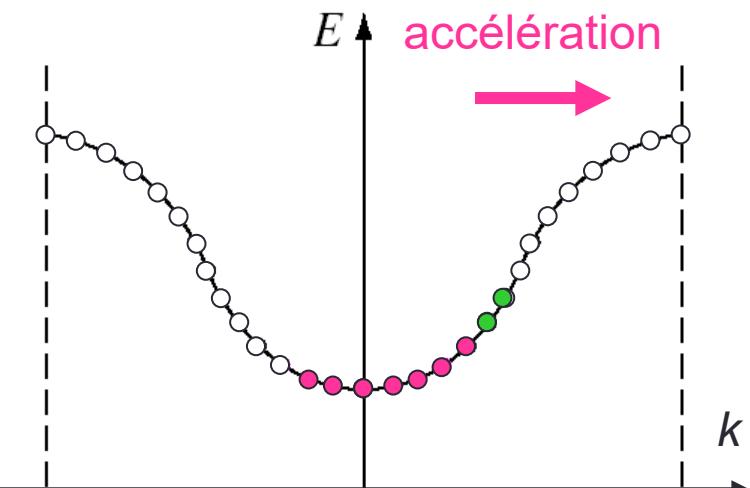
- Cristal parfait, $\mathcal{E}_{elec} \neq 0$ et T uniforme.
 - À t=0, on applique \mathcal{E}_{elec}
 - Un paquet d'ondes qui « avait » auparavant k_0 subit une accélération

- À t>0,
$$\hbar \frac{dk_0}{dt} = -q \frac{\mathcal{E}_{elec}}{\hbar}$$

$$k'_0(t) = k_0 - q \frac{\mathcal{E}}{\hbar} t$$

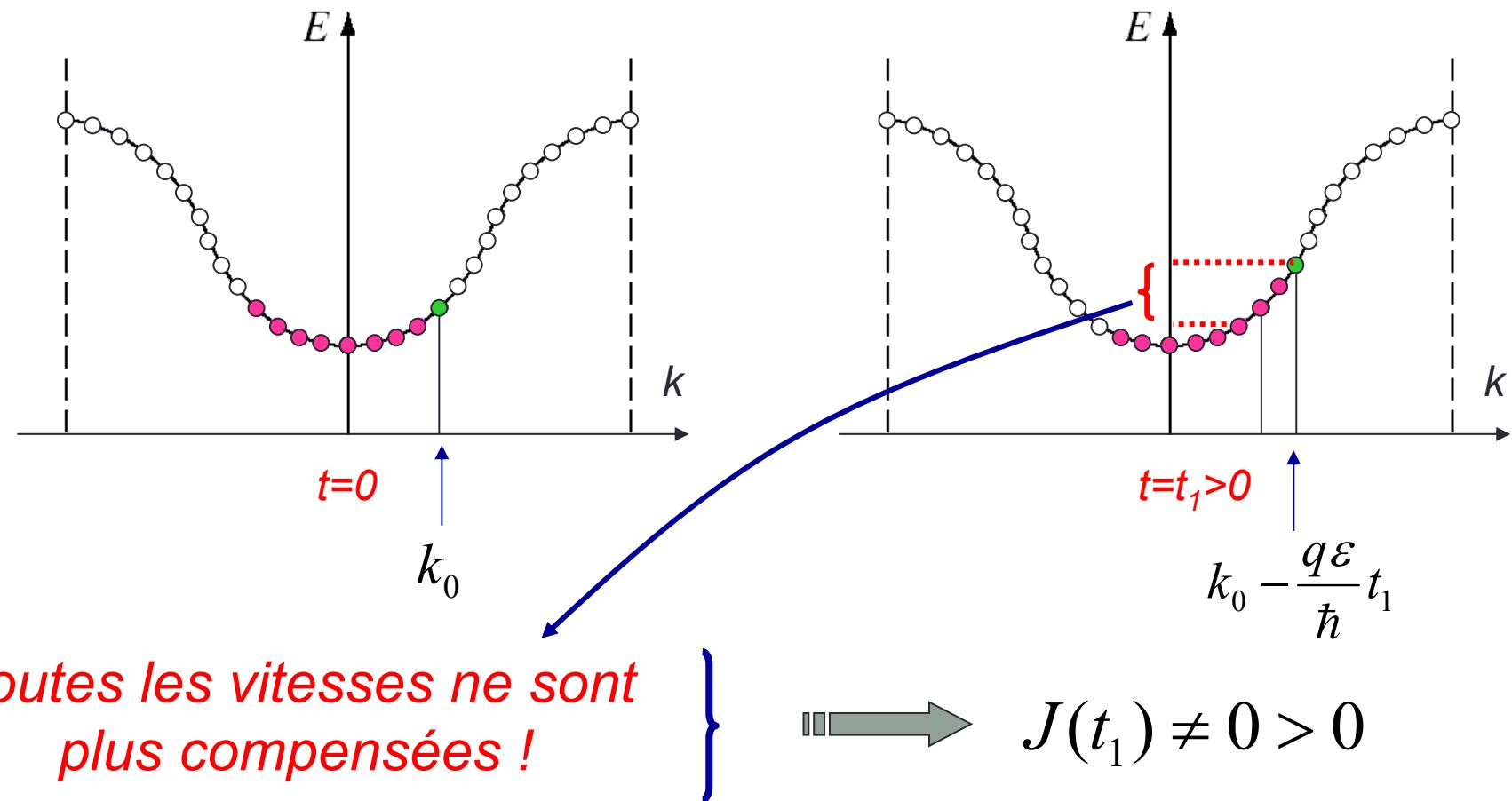
- Tous les électrons subissent la même variation Δk

$$\Delta \overline{k}_0 = -q \times \frac{\mathcal{E}}{\hbar} \times t \quad \forall \overline{k}_0$$



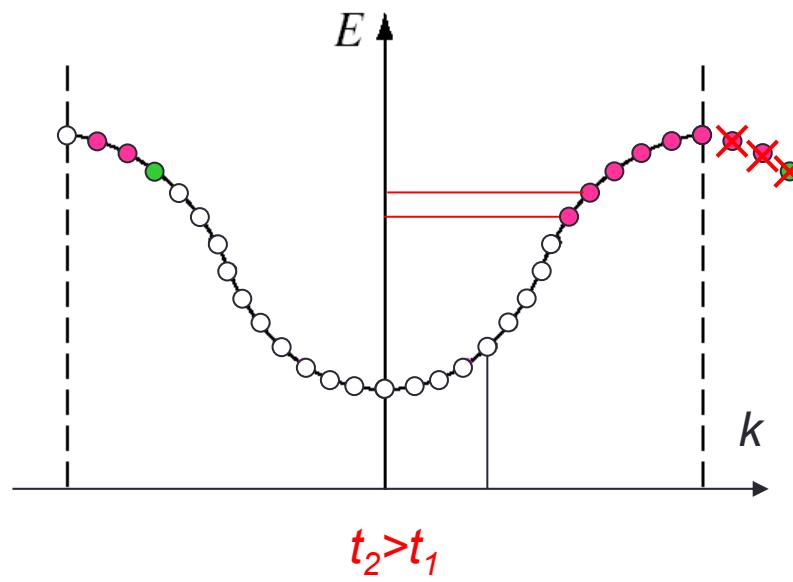
Contribution à J d'une bande incomplètement remplie

- Cristal parfait, $\mathcal{E}_{elec} \neq 0$ et T uniforme.

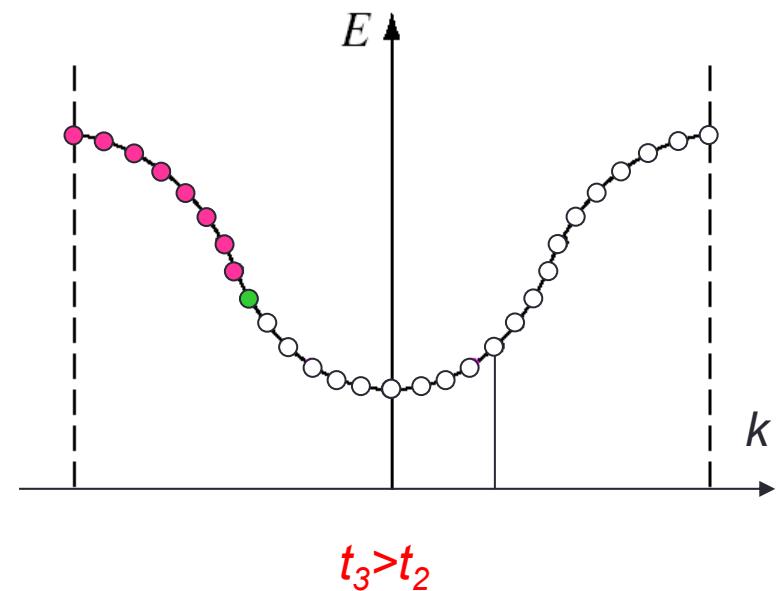


Contribution à J d'une bande incomplètement remplie

- Cristal parfait, $\mathcal{E}_{elec} \neq 0$ et T uniforme.



$$J(t_2) \neq 0 > 0$$



$$J(t_3) \neq 0 < 0 \quad !!!$$

Bizarre ! Champ électrique constant et courant qui change alternativement de signe en fonction du temps !!

Contribution à J d'une bande incomplètement remplie

- Dans le cristal de Bloch-Brillouin, on prévoit que l'application d'un champ électrique continu $\mathcal{E}_{\text{elec}}$ doit engendrer un courant électrique alternatif.
- La période de ce courant serait:

$$\hbar \frac{dk}{dt} = -q\varepsilon \quad \Rightarrow \quad \hbar \frac{2\pi}{a} \frac{1}{T} = -q\varepsilon$$

$$T = \frac{\hbar 2\pi / a}{q\varepsilon}$$

- Ce résultat n'est pas en cohérence avec les résultats expérimentaux !!!!
- Le cristal n'est pas aussi parfait que cela!!

Le cristal réel de Bloch-Brillouin

- Cristal réel, $\varepsilon_{elec} \neq 0$ et T uniforme.
 - Le cristal présente un certain nombre d'imperfections
↔ grandes catégories:
 - Impuretés chimiques
 - Défauts ponctuels intrinsèques:
 - Lacunes
 - Interstitiels
 - Anti-sites
 - Défauts étendus
 - Macles
 - Dislocations
 - Clusters (groupe d'impuretés)
 - Vibration de la chaîne atomique autour de l'équilibre (phonons)

Le cristal réel de Bloch-Brillouin

- Cristal réel: conséquence sur les porteurs de charge:
 - Le potentiel de B-B n'est plus exactement périodique:
 - B-B $v_1(x) = v_1(x+a)$
 - Réel $v(x) = v_1(x) + \Delta v(x)$
Aléatoire!
 - L'électron dans ce potentiel \Leftrightarrow soumis à une force ($-\text{grad}v(x)$)

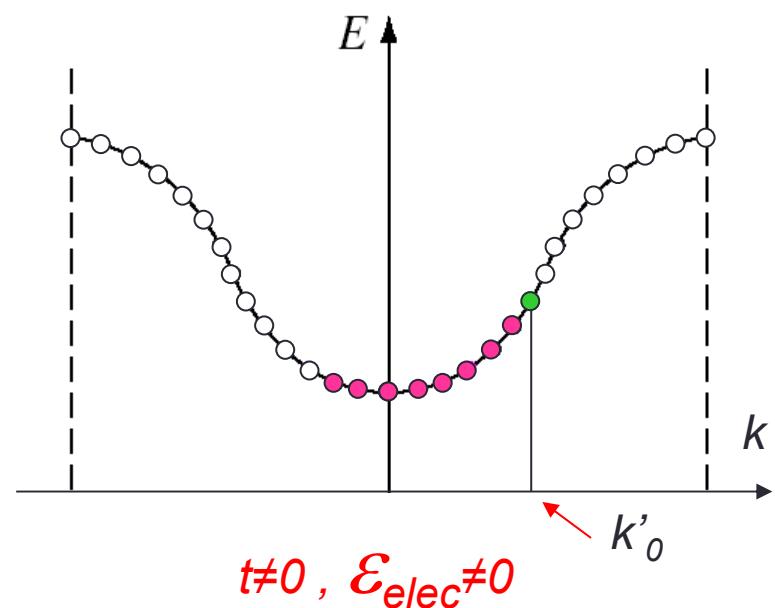
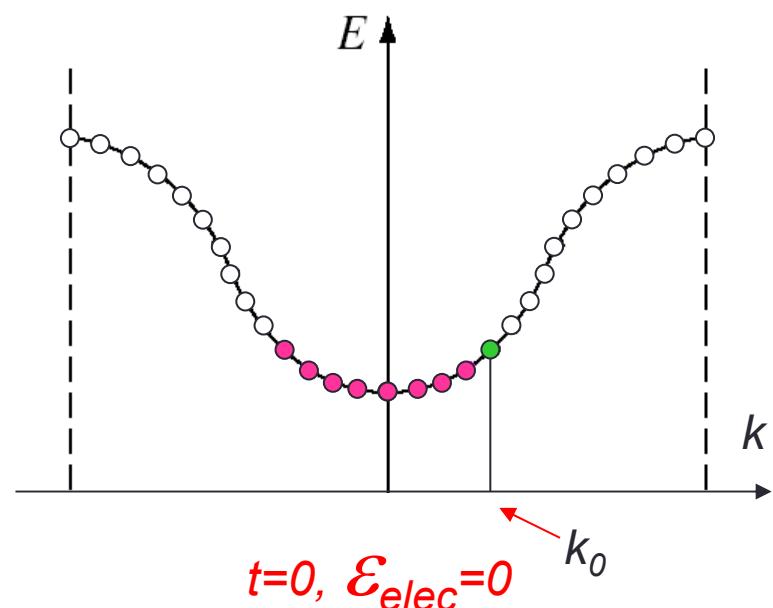
$$\hbar \frac{dk_0}{dt} = -q\varepsilon - \text{grad}(\Delta V(x)) = -q\varepsilon + \text{Force aléatoire}$$

- Cette force imprime des impulsions aléatoires (= à des forces lors des chocs avec les « impuretés »)
- En moyenne, tout les τ (temps moyen entre deux chocs), l'électron change de direction et surtout perd son énergie cinétique \Leftrightarrow il acquiert donc en moyenne un « excédent » de vecteur d'onde:

$$\dot{k}_0 = k_0 - q \frac{\varepsilon}{\hbar} \tau \quad \forall t$$

Le cristal réel de Bloch-Brillouin

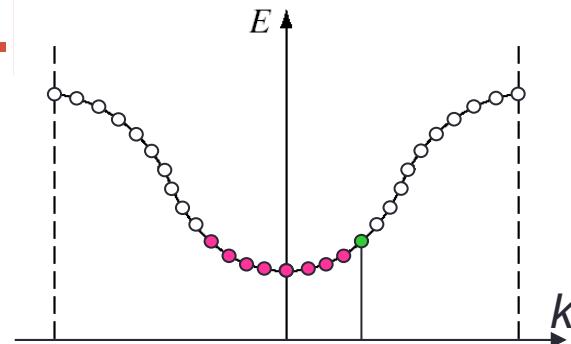
- Cristal réel, $\mathcal{E}_{elec} \neq 0$ et T uniforme.



$$\dot{k}_0 = k_0 - q \frac{\mathcal{E}}{\hbar} \tau \quad \underline{\forall t}$$

Le cristal réel de Bloch-

- *Bandes presque vides:*
 - Énergie et vitesse de groupe:



- $\mathcal{E}=0$: $E_{k_0} = E_c + \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m_1^*}$ $v_g = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k_0} = \frac{\hbar}{m_1^*} k_0$ $k'_0 = k_0 - q \frac{\epsilon}{\hbar} \tau$

$$\bar{j} = -q \sum_i \overline{v_{g_i}} = -q \frac{\hbar}{m_1^*} \sum_i k_i = 0$$

- $\mathcal{E} \neq 0$:

$$\bar{j} = -q \sum_i \overline{v_{g_i}} = -q \frac{\hbar}{m_1^*} \sum_i k'_i = -q \frac{\hbar}{m_1^*} \sum_i k_i + q^2 \frac{\hbar}{m_1^*} \frac{\epsilon_{elec} \tau}{\hbar} n$$

$$\bar{j} = q \mu_n n \epsilon_{elec}$$

avec $\mu_n = q \frac{\tau}{m_1^*} > 0$

$$\bar{j} = \sigma_n \epsilon_{elec}$$

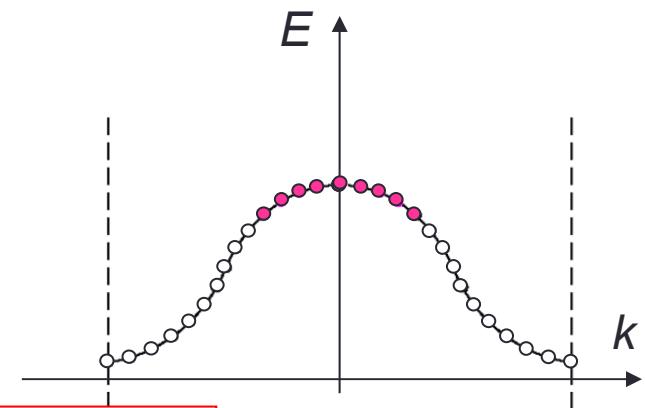
Mobilité (cm^2/Vs)

C'est la loi d'Ohm

Le cristal réel de Bloch-Brillouin

- Bandes presque pleines:

- Astuce: pour calculer la contribution au courant d'une bande presque pleine, on « ajoute » les électrons manquant puis on les « enlève », ce qui va nous permettre d'introduire la notion de trous.
- N : nb de places (\sim nb d'atomes)
- N-p: nb d'électrons dans la bande
- p: nb de places vides (de « trous »)



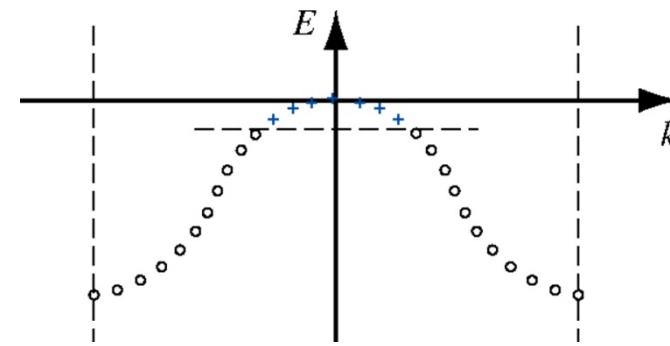
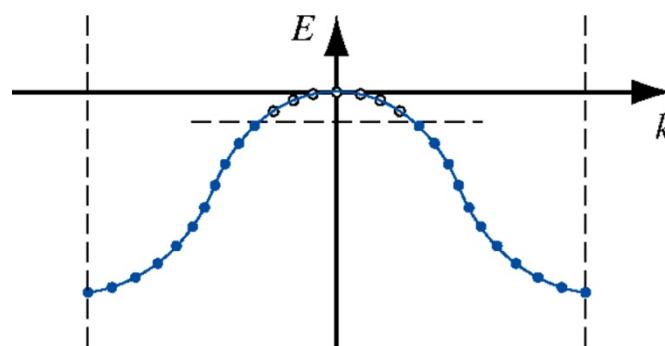
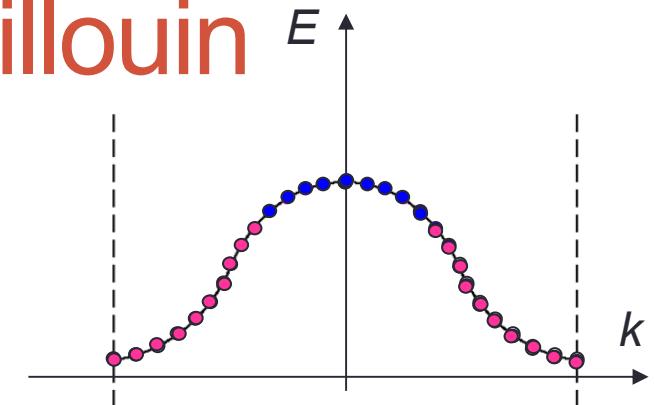
$$\begin{aligned}
 \bar{j} &= -q \sum_{i=1}^{N-p} v_{g_i} = -q \sum_{i=1}^N v_{g_i} - (-q \sum_{i=1}^p v_{g_i}) \\
 &= \underbrace{0}_{\text{bande pleine}} + q \sum_{i=1}^p v_{g_i}
 \end{aligned}$$

Charge positive!

Le cristal réel de Bloch-Brillouin

- Bandes presque pleines:

- Règle: la contribution au courant d'une bande presque pleine est obtenue en supposant que les états vides sont effectivement occupés par des porteurs de charges positives $+q$: des trous. Il suffit de sommer sur le nombre total de trous
- Trous: paquet d'ondes de charges positives



Notion de trous

- Expression de J :
- Nota: pour « arracher » 1 e^- en (a) il faut plus d'énergie qu'en (b) \Leftrightarrow un trou en (a) est plus énergétique qu'en (b).

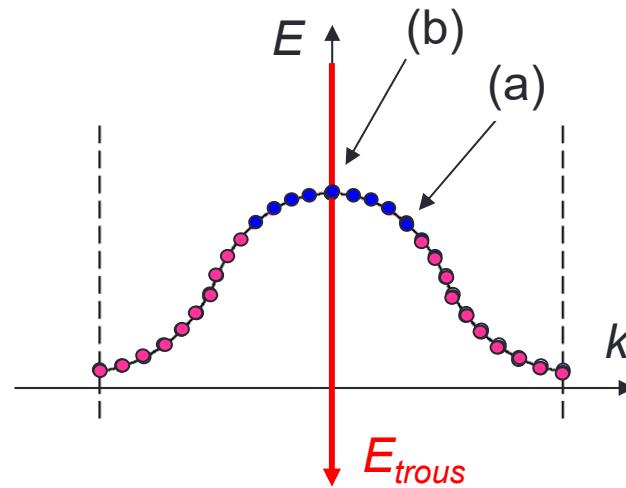
$$\bullet E(e^-) = -E(h^+) \Leftrightarrow E_{trous} = -E_V + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} \Rightarrow v_g^{trous} = \frac{\hbar k_0}{m^*}$$

$$\bullet \varepsilon_{elec} = 0 \Leftrightarrow J = q \left[\frac{\hbar}{m^*} \sum \overline{k_0} \right] = 0$$

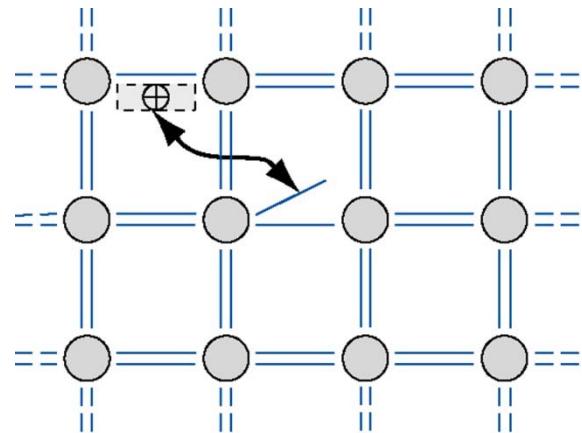
$$\bullet \varepsilon_{elec} \neq 0 \Leftrightarrow J = q \left[\frac{\hbar}{m_2^*} \sum_{i=1}^p \left(\overline{k_0} + q \frac{\varepsilon_{elec} \tau}{\hbar} \right) \right] = \frac{q^2 \hbar}{m_2^*} \frac{\varepsilon_{elec}}{\hbar} \tau \times p$$



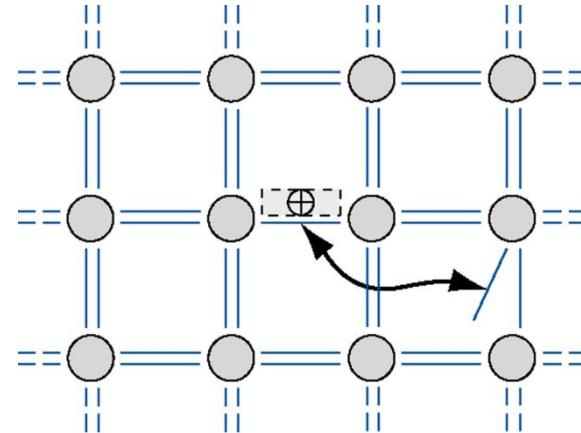
$$J = q \times p \times \mu_p \times \varepsilon_{elec} \quad \text{avec} \quad \mu_p = \frac{q \tau}{m_2^*}$$



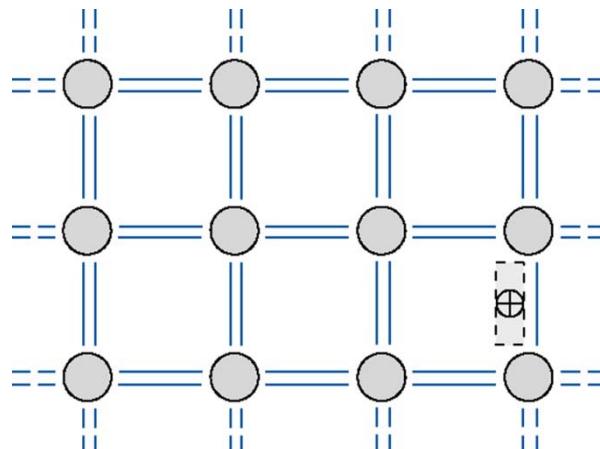
Notion de trous: conduction



(a)



(b)



(c)

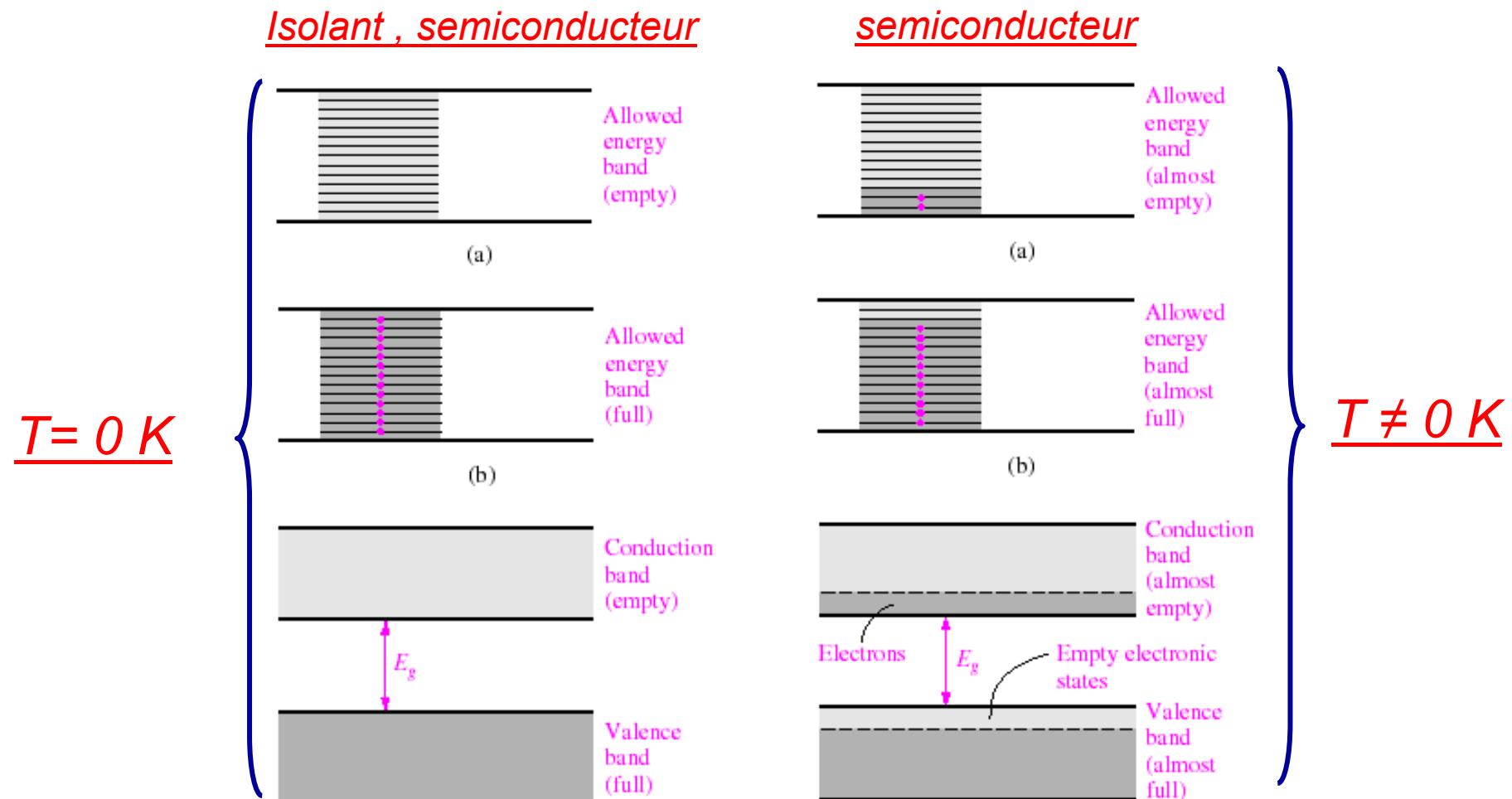
Conduction par électrons et trous

- Cas fréquent dans les semiconducteurs:
 - En pratique, dans les semiconducteurs, il existe une bande presque vide que l'on appelle bande de conduction (**BC**) au dessus d'une bande presque pleine que l'on appelle bande de valence (**BV**). Elles sont séparées par une bande interdite (« bandgap ou gap »).

$$\overline{J} = \underbrace{qn\mu_n\varepsilon}_{BC} + \underbrace{qp\mu_p\varepsilon}_{BV} = \sigma\varepsilon$$

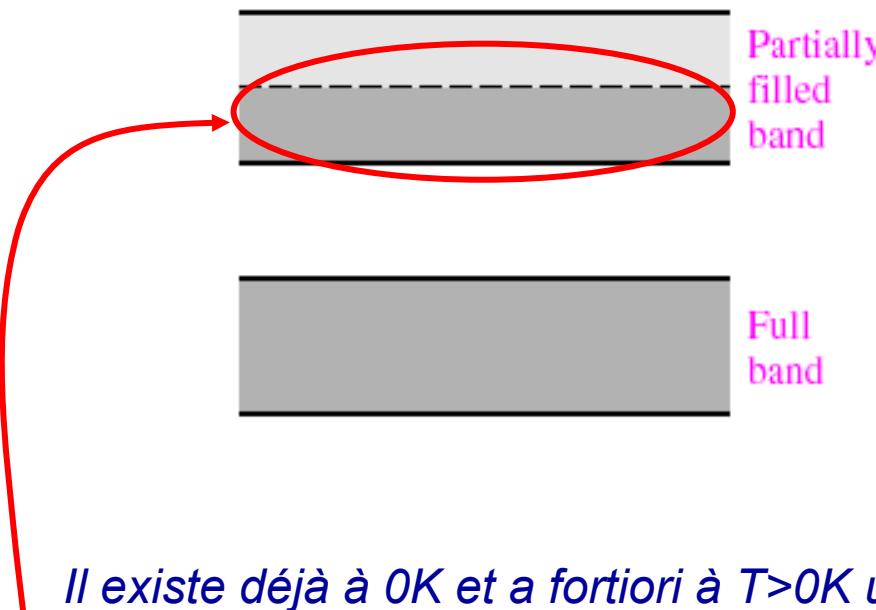
Semiconducteur ou isolant ?

- Comment les différentie on?



Métal ?

- T=0K ou T \neq 0K



Résumé:

- Métal:
 - Très faible résistivité
 - Conduit mieux le courant à basse température
- Isolant:
 - Ne conduit pas le courant même à haute température
 - « gap » supérieur à 3,5 eV (valeur généralement admise)
- Semiconducteur:
 - « gap » inférieur à 3,5 eV (la tendance est à l'augmentation de ce critère!)
 - Sa conductivité est une fonction **non monotone** de la température

CHAPITRE 8

Mécanique statistique : la fonction de
Fermi – Dirac et la fonction de
Maxwell – Boltzmann

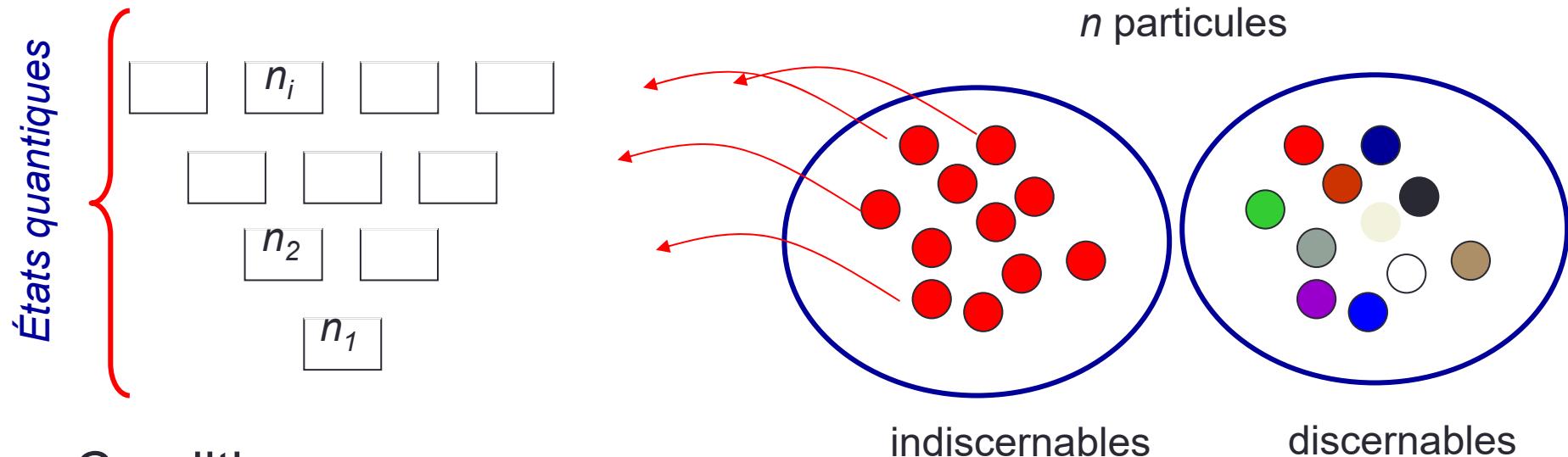
Les différentes statistiques

- Statistique de Maxwell – Boltzmann
 - Particule discernable
 - Molécules de gaz dans une enceinte basse pression
- Statistique de Bose – Einstein
 - Particule indiscernable
 - Plusieurs particules sur un même état quantique
 - Photons, Phonons
- Statistique de Fermi – Dirac
 - Particule indiscernable
 - 1 seule particule sur un même état quantique (principe d'exclusion de Pauli)
 - Électrons dans les solides

Les particules n'interagissent pas entre elles

Les différentes statistiques

- Méthodes de résolution:



- Conditions :
 - Nb de particules est constant
 - Énergie interne constante
 - Discernables ou indiscernables?
 - 1 ou plusieurs par état quantique ?

$$\therefore \sum_i n_i = n$$

$$\therefore \sum_i n_i E_i = E$$

Maxwell – Boltzmann

- Discernables
 - Chaque état peut contenir grand nombre de particules
 - L'état d'équilibre est celui le plus probable
-

- Soit un état d'équilibre avec n_1 particules dans c_1 , n_2 dans c_2 , ..., n_i dans c_i .
- Quelle est la probabilité d'obtenir cette configuration?

$$P = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_i! \dots} = \frac{n!}{\prod_i n_i!}$$

- Cette configuration est celle d'équilibre si P ou $\ln(P)$ est maximum $\Leftrightarrow d(\ln P) = 0$
- On obtient (voir par ex. Mathieu)

Probabilité que
la particule soit
sur le niveau E_i

$$f(E_i) = \frac{n_i}{g_i} = e^{-(E_i - E_F)/kT}$$

n_i : nb de particules sur E_i
 g_i : nb de places (états) sur E_i

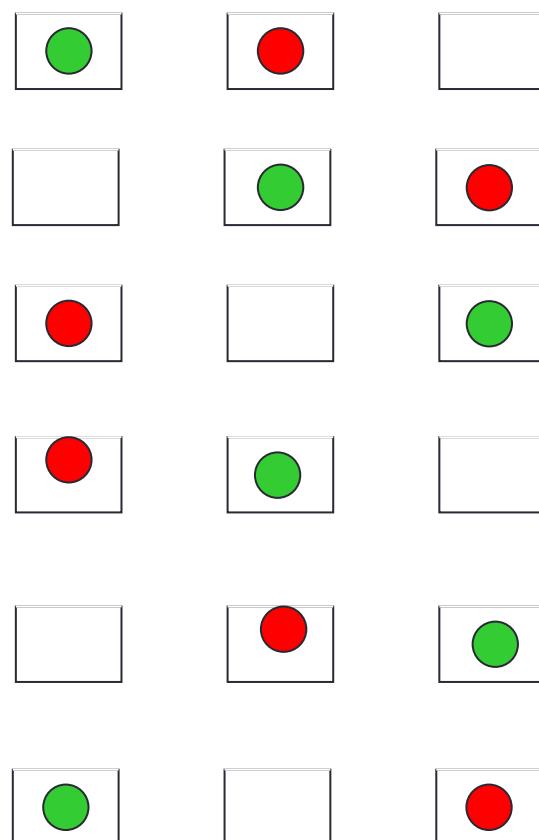
Statistique de Fermi – Dirac

- Niveau de Fermi: ce niveau E_F représente la variation de l'énergie libre du système en fonction du nombre de particules. On appelle également cette quantité le potentiel chimique
- l'énergie libre d'un système représente le travail maximal que ce système peut fournir à l'extérieur

Différence discernable ou non

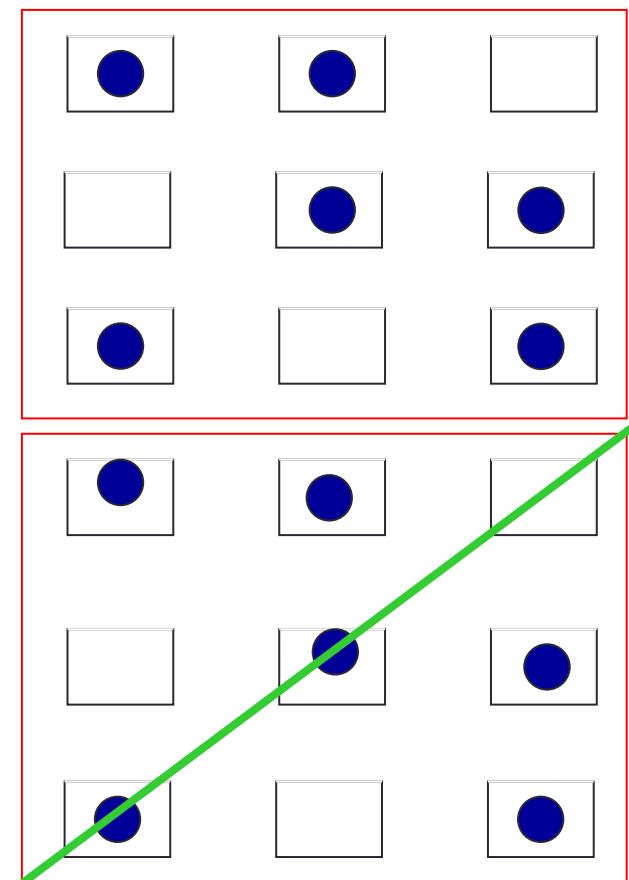
(1 « bille » par case \Leftrightarrow Pauli)

Discernable



$$\frac{g_i!}{(g_i - N_i)!}$$

Indiscernable

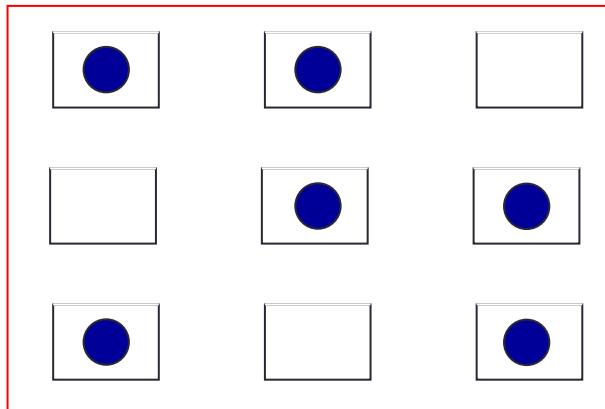


$$\frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

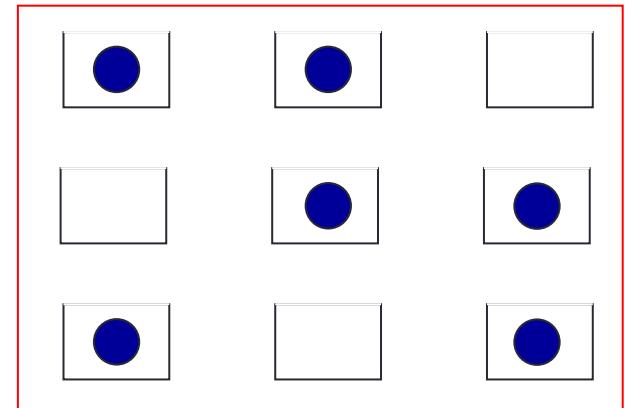
N_i : nb de particules sur E_i
 g_i : nb de places (états) sur E_i

indiscernables

« Bose »



« Pauli »



$$\frac{(N_i + g_i - 1)!}{(g_i - 1)! N_i!}$$

$$\frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

N_i : nb de particules sur E_i

g_i : nb de places (états) sur E_i

Statistique de Fermi – Dirac

- Même démarche que précédemment

$\xrightarrow{\hspace{1cm}} E_i \xleftarrow{\hspace{1cm}} \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$

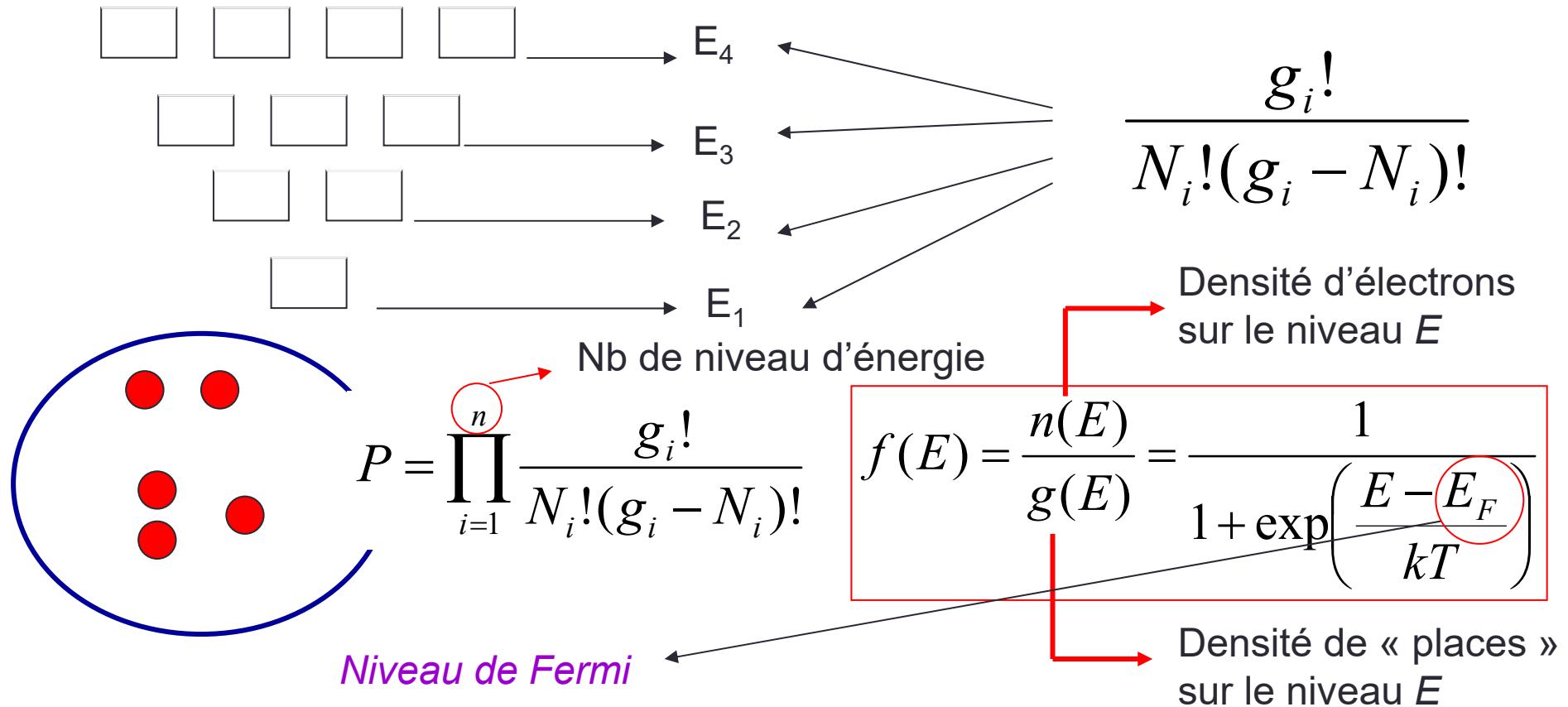
- Niveau d'énergie E_i , g_i fois dégénéré (g_i « boites » ou cellules état quantiques de même énergie E_i) et N_i particules à distribuer.
- Si maintenant , on a plusieurs (n) niveau d'énergie, le résultat est le produit de toutes les distributions

Nb de niveau d'énergie

$$P = \prod_{i=1}^n \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

Statistique de Fermi – Dirac

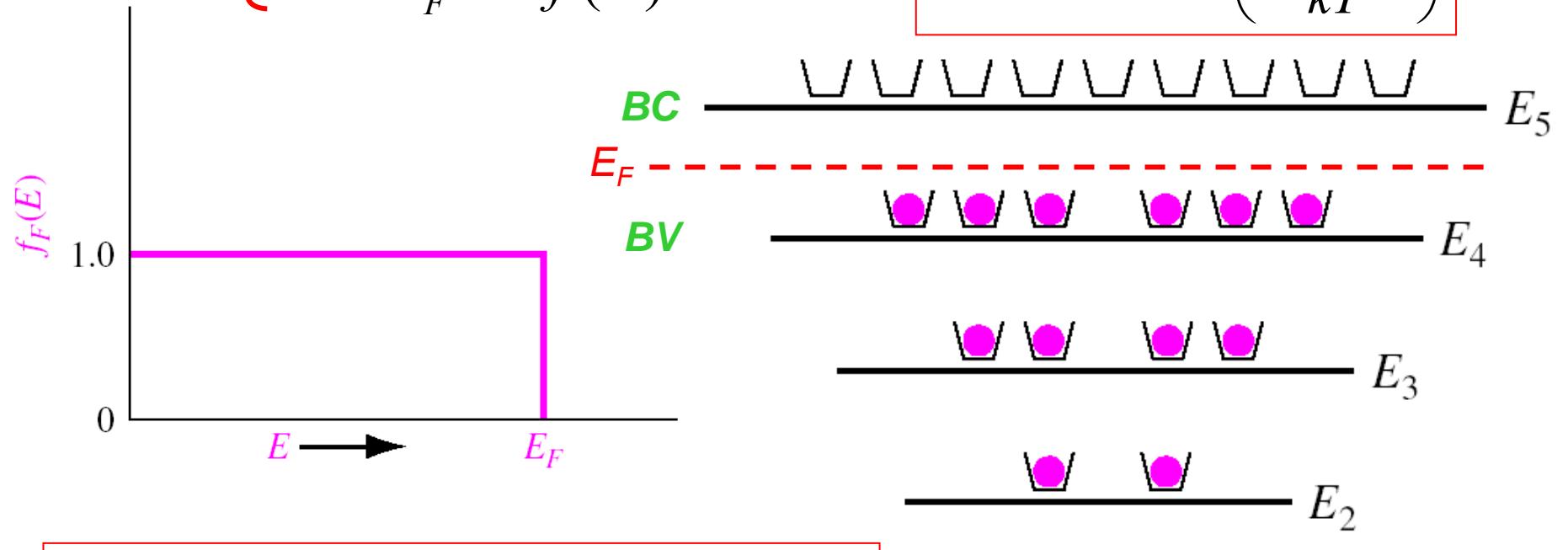
- Même démarche que précédemment



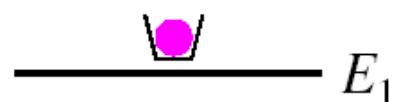
Fonction de Fermi – Dirac

À T=0K: $\begin{cases} E < E_F \Rightarrow f(E) = 1 \\ E > E_F \Rightarrow f(E) = 0 \end{cases}$

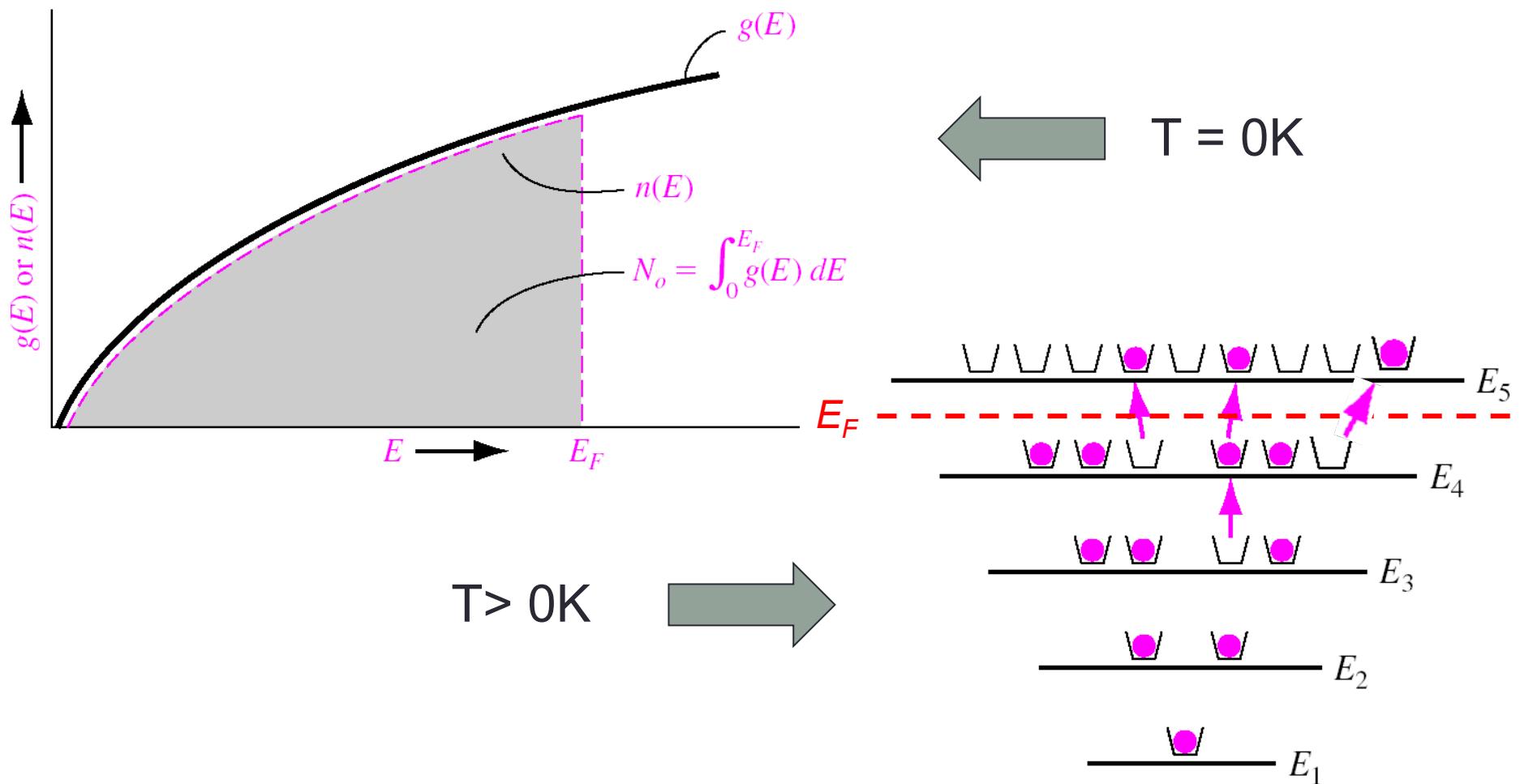
$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$



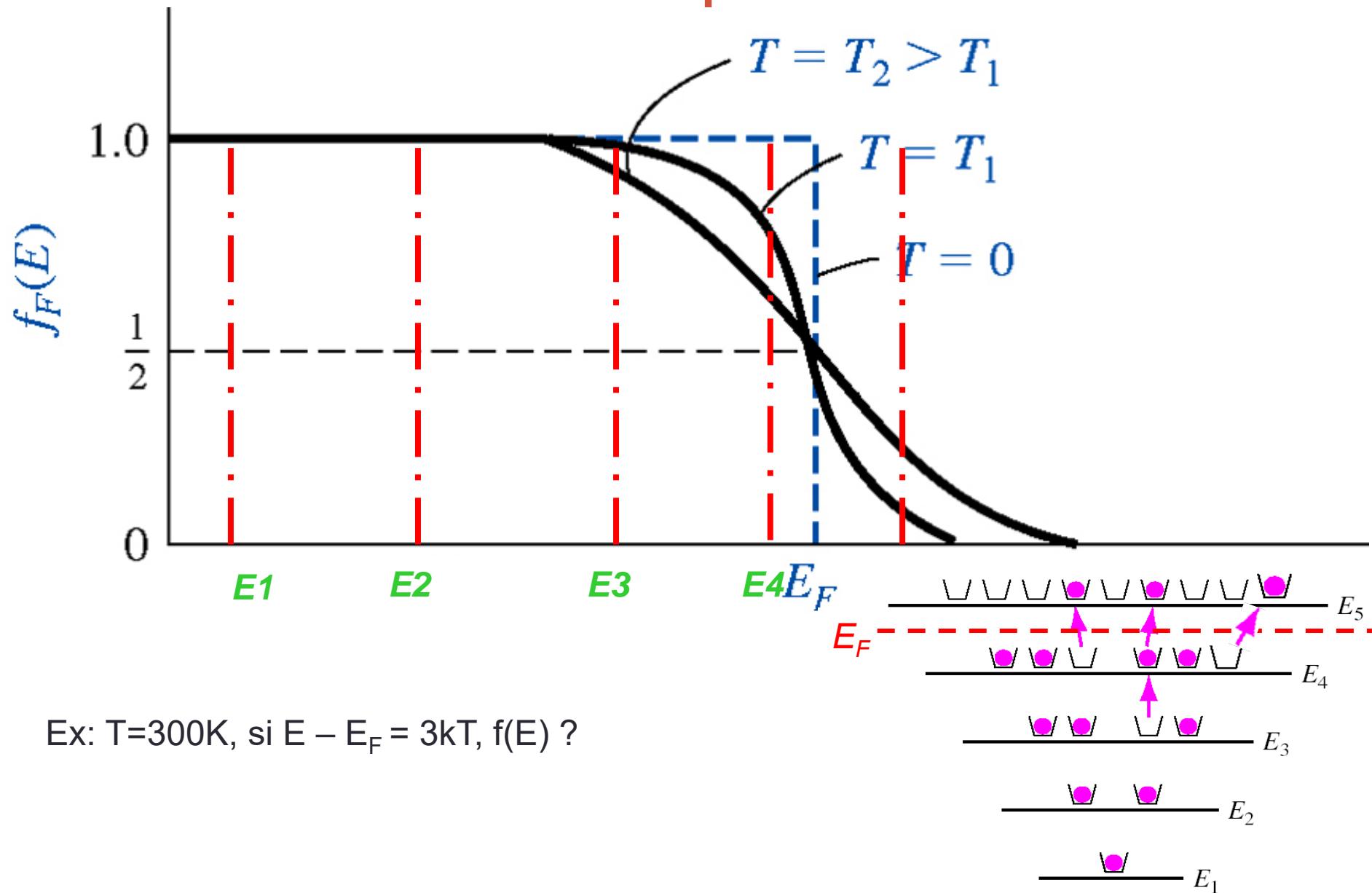
$$f_F(E = E_F) = \frac{1}{1 + \exp(0)} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$



Fonction de Fermi – Dirac

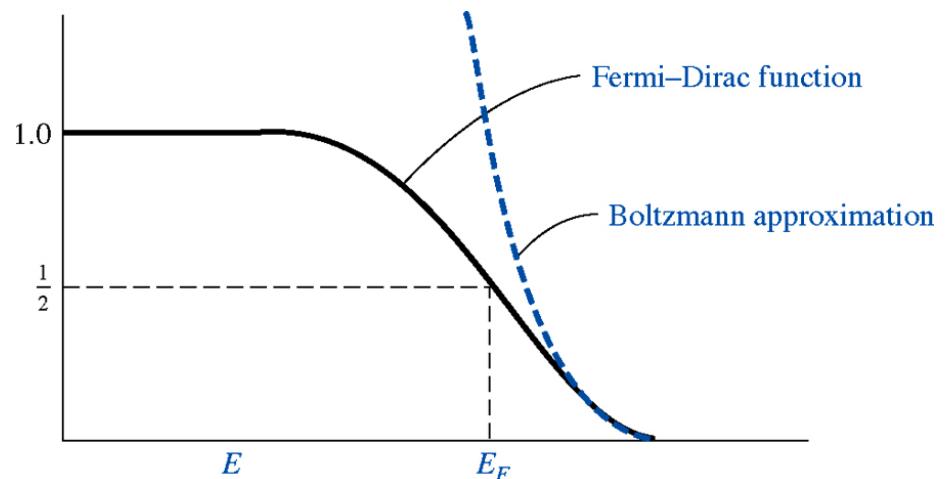


Influence de la température



Passage FD \leftrightarrow MB ?

- L'utilisation de FD pour les calculs n'est pas tjs aisée
- Dans quelle mesure MB est suffisant ?
 - Condition:

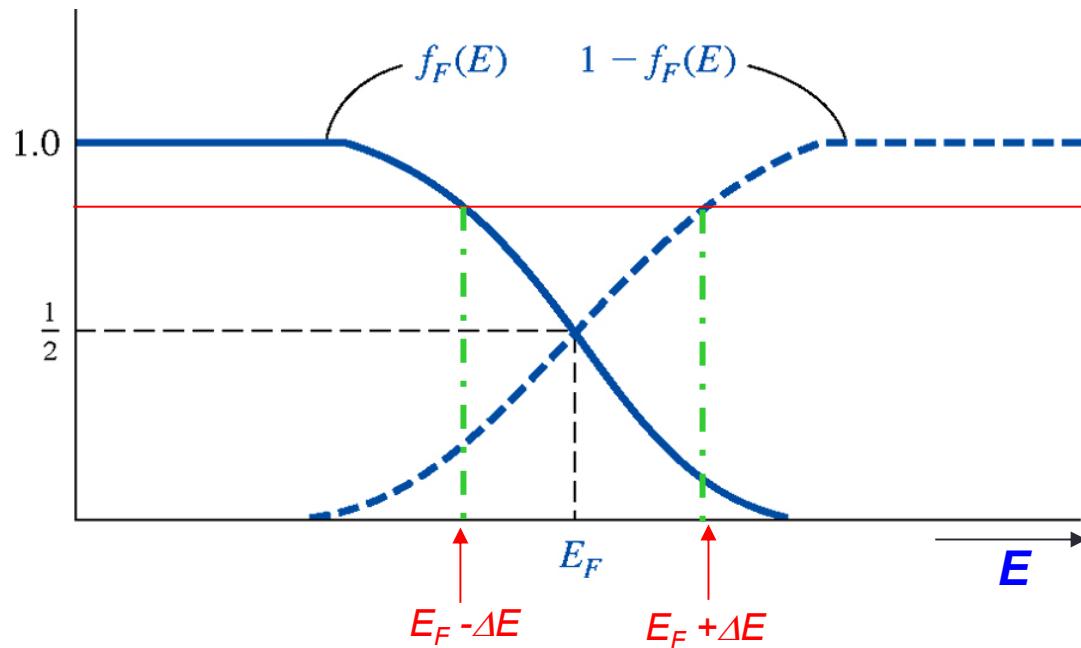


$$E - E_F \gg kT \quad \rightarrow \quad f_F(E) \approx \exp \left[\frac{-(E - E_F)}{kT} \right]$$

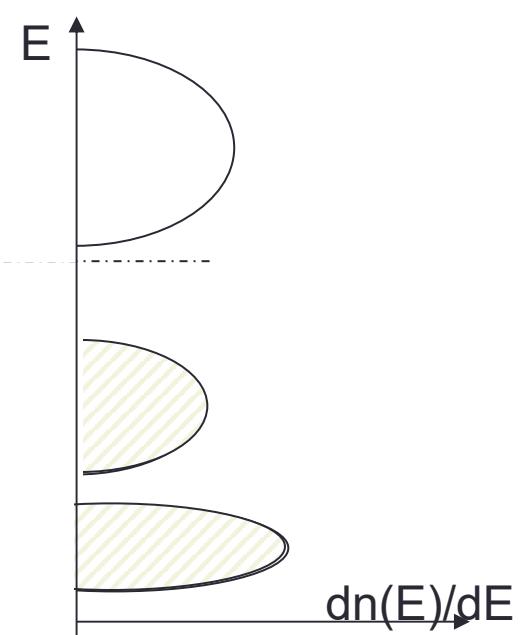
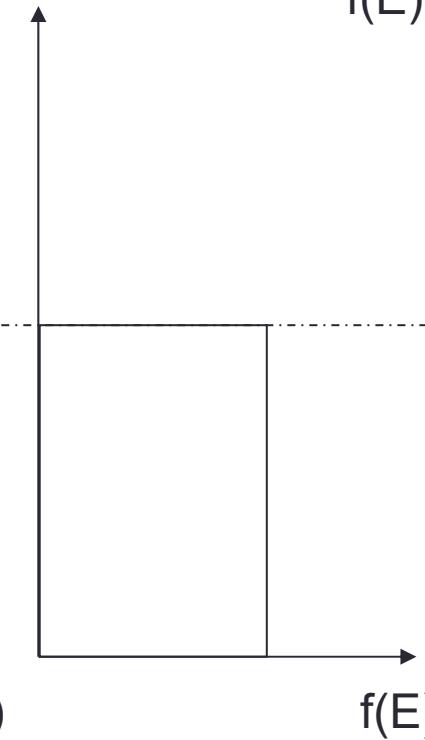
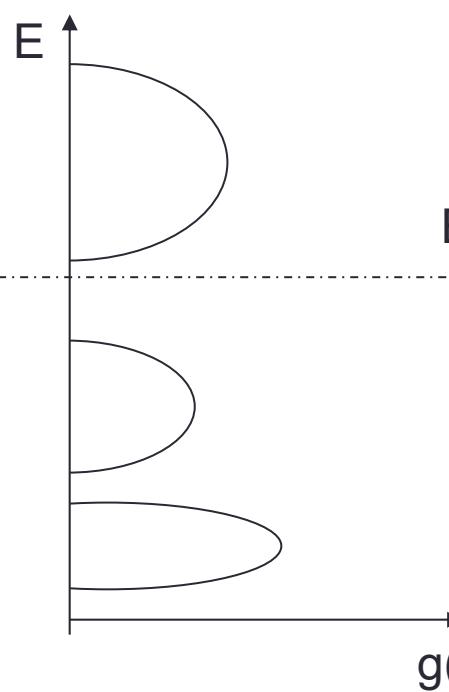
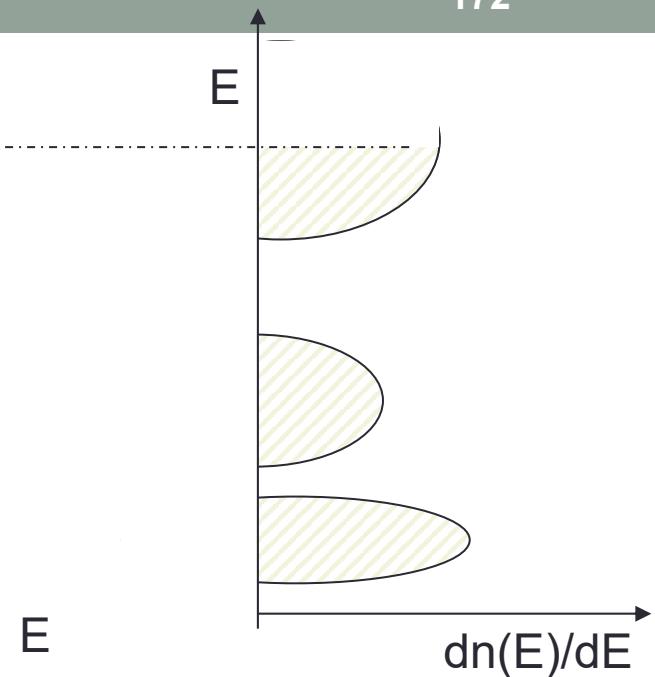
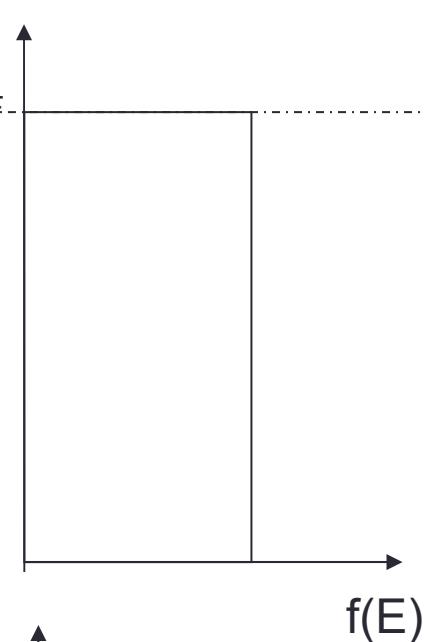
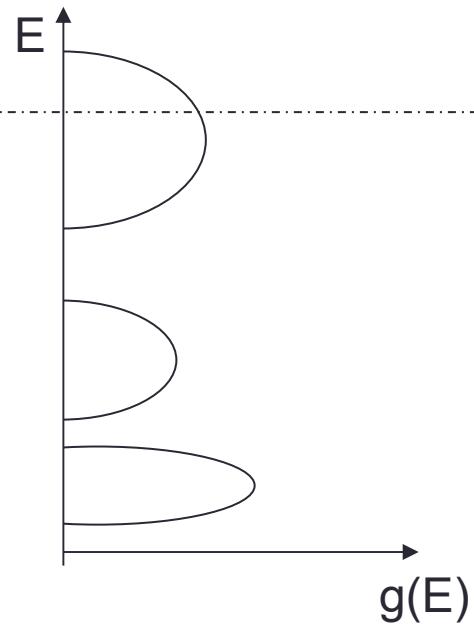
Si $E - E_F > 3 kT$, erreur est de 5%

- Règle: on confondra la statistique de Fermi – Dirac et la statistique de Maxwell – Boltzmann pour tous les niveaux d'énergie E tels que $|E - E_F| > 3kT$. À T ambiante, $kT=25$ meV $\Leftrightarrow |E - E_F| > 75$ meV.

Passage FD \leftrightarrow MB



Pour $E < E_F$, il est facile de montrer que la probabilité de non occupation $1-f(E)$ est la même à $E_F - \Delta E$ que la probabilité d'occupation $f(E)$ à $E_F + \Delta E$. Le point $f(E) = 0.5$ est le centre de symétrie pour la courbe.



CHAPITRE 10

Le semiconducteur à l'équilibre
thermodynamique

Le semiconducteur à l'équilibre

- C'est quoi l'équilibre?
 - Pas de forces extérieures:
 - Pas de tension appliquée
 - Pas de champ magnétique
 - Pas de gradient de température

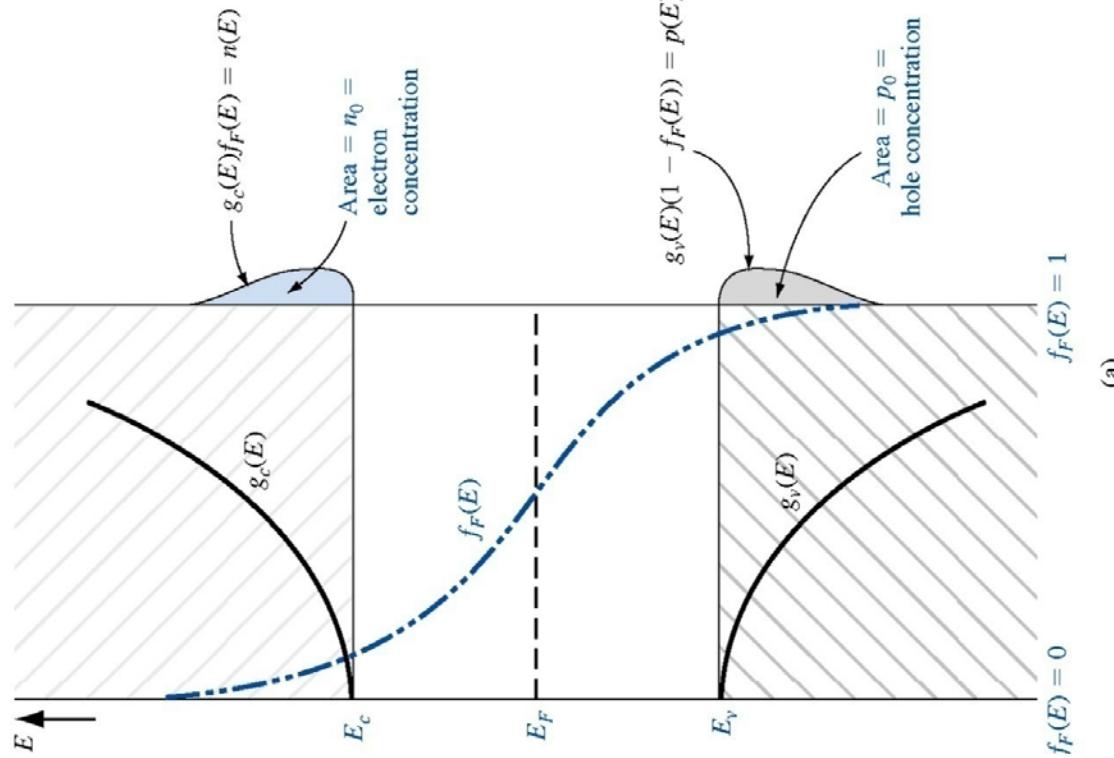
Densité de porteurs de charges dans les SC.

- Question: combien y a t il d'électrons dans la BC et de trous dans la BV dans un semiconducteur à une température T?
- Réponse : (voir chap 9!)
 - À une énergie E: $n(E) = g_c(E)f(E)$
 - $p(E) = g_v(E)(1 - f(E))$
 - Dans la bande de largeur ΔE

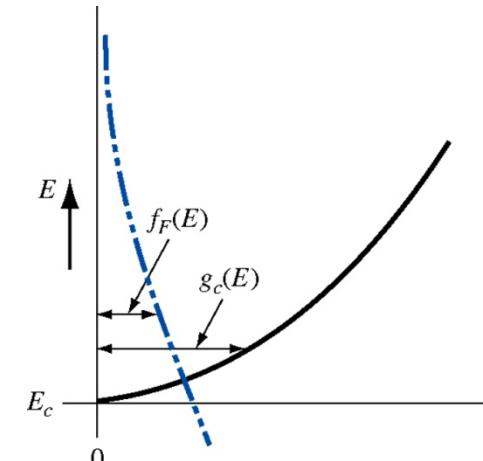
$$n_0 = \int_{E_c \text{ min}}^{E_c \text{ max}} g_c(E)f(E)dE$$

$$p_0 = \int_{E_v \text{ min}}^{E_v \text{ max}} g_v(E)(1 - f(E))dE$$

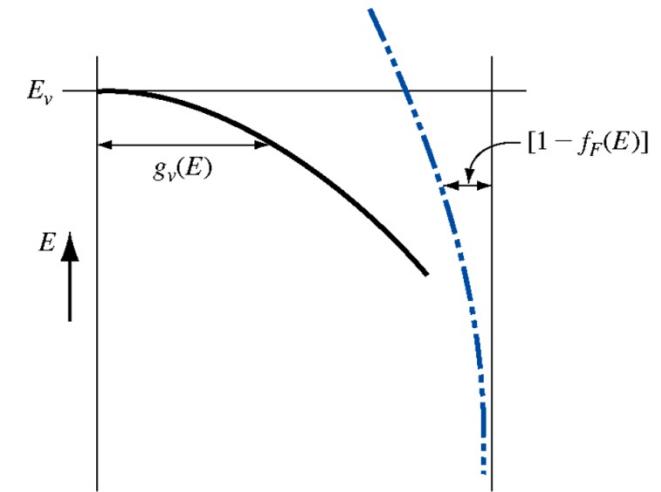
Densité de porteurs de charges dans les SC.



(a)



(b)



(c)

Calcul de n_0 et p_0

- hypothèse: E_F est à plus de $3kT$ sous la BC ou à plus de $3kT$ au dessus de BV \Leftrightarrow on peut utiliser l'approximation de MB.
- *Expression de n_0 :*

$$n_0 = \int_{E_c \min}^{E_c \max} g_c(E) f(E) dE = \int_{E_c \min}^{+\infty} \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \times e^{-\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} dE$$

équilibre $n_0 = N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right]$ avec $N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^* k T}{h^2}\right)^{3/2}$

fonction de Boltzmann $f(E)$

$$n_0 = N_C f(E_c)$$

Calcul de n_0 et p_0

$$n_0 = N_C \exp\left[-\frac{(E_c - E_F)}{kT}\right] \text{ avec } N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$p_0 = N_V \exp\left[-\frac{(E_F - E_v)}{kT}\right] \text{ avec } N_V = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

N_c et N_v sont les **densité d'états effectives** (\sim le nombre de places) dans la bande de conduction et la bande de valence respectivement. L'ordre de grandeur est $N_c \sim N_v \sim 2.5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

La loi d'action de masse

$\text{FD} \rightarrow \text{MB}$

- Règle pratique: le produit du nombre d'électrons dans la BC par le nombre de trous dans la BV est donné par:

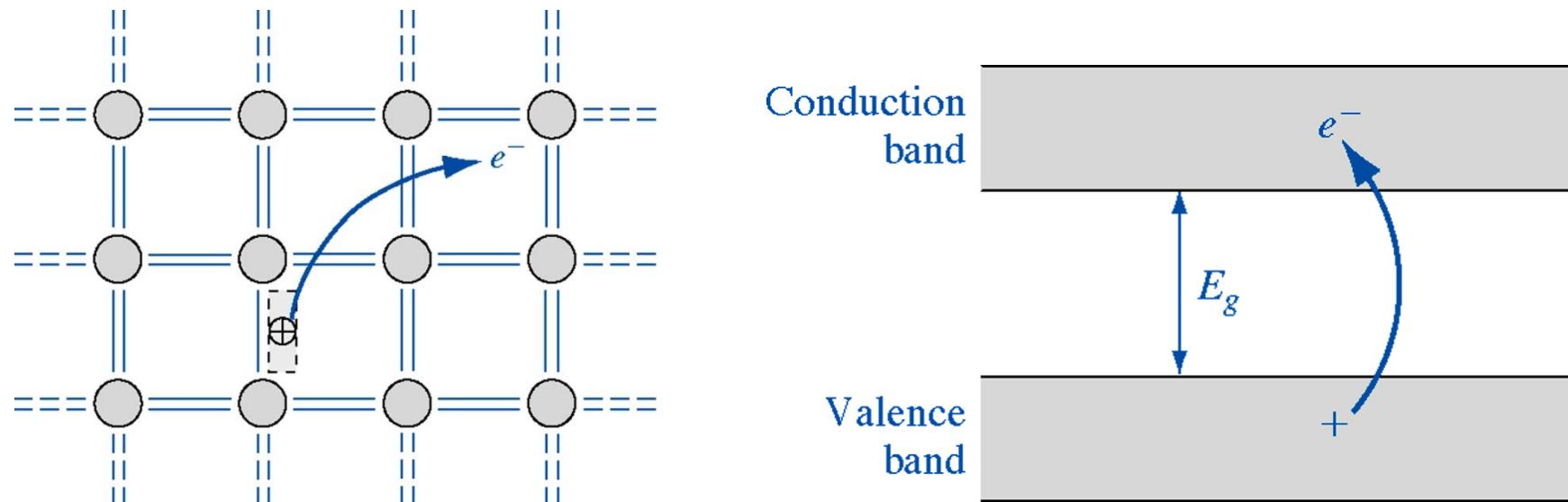
$$n_o \times p_o = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{kT}\right) = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) = n_i^2$$

- Remarque importante: les expressions que nous venons d'établir pour n et p l'ont été en supposant que E_F distant d'au moins $3kT$ d'une ou l'autre bande. Ce calcul ne suppose pas que $n = p \Leftrightarrow$ la règle $n \times p = n_i^2$ restera vraie lorsque l'on dopera le SC, à condition de respecter la condition sur E_F . C'est le cas usuel. Dans le cas contraire (exception) on dit que le SC est dégénéré.

Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque

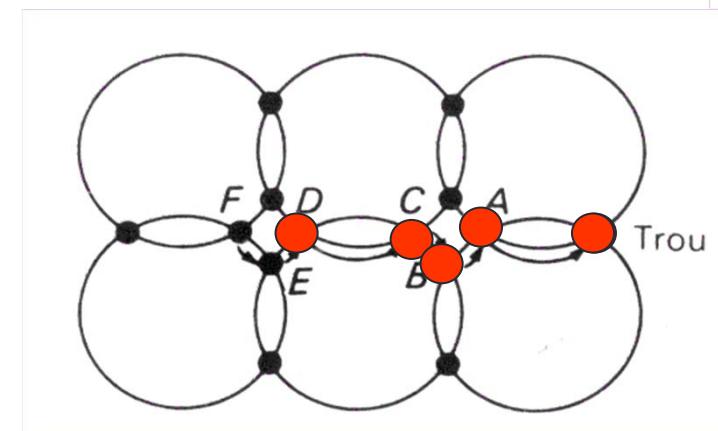
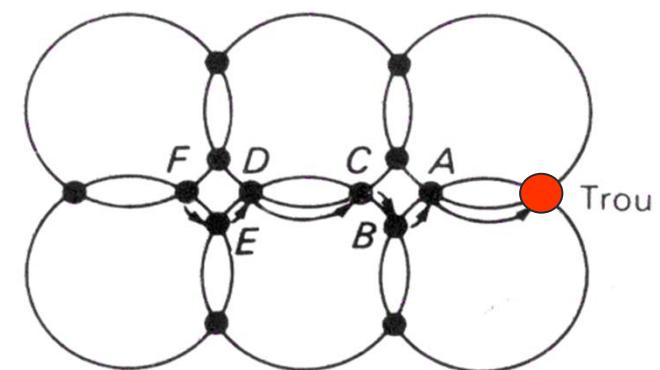
- Semiconducteur intrinsèque : semiconducteur sans impuretés , *i.e* que les niveaux d'énergie permis sont seulement ceux des bandes.
- Les électrons n dans la BC proviennent de la BV; ils laissent des trous p dans la BV

$$\Rightarrow n = p = n_i \quad \forall T$$



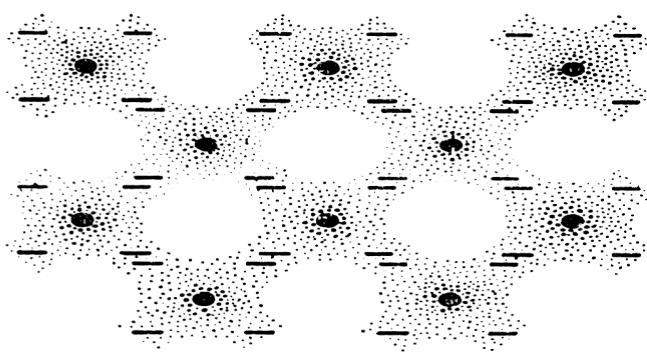
Conduction bipolaire

- La présence d'électrons et trous entraîne une conduction bipolaire dans les SC
- On peut privilégier une des deux conductions par le dopage du semi-conducteur, *ie* l'introduction d'impuretés

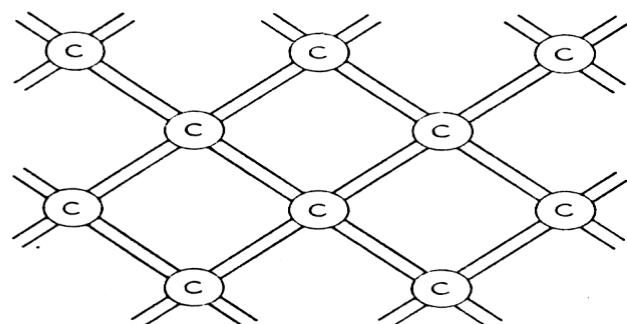


E_{externe}

Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)



(a) ELECTRON PAIR BONDS



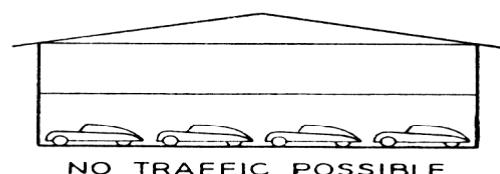
(c) PLANE DIAGRAM OF DIAMOND LATTICE WITH BONDS REPRESENTED BY LINES



POSITIVE CHARGE
+4 IN CORE OF
CARBON ATOM

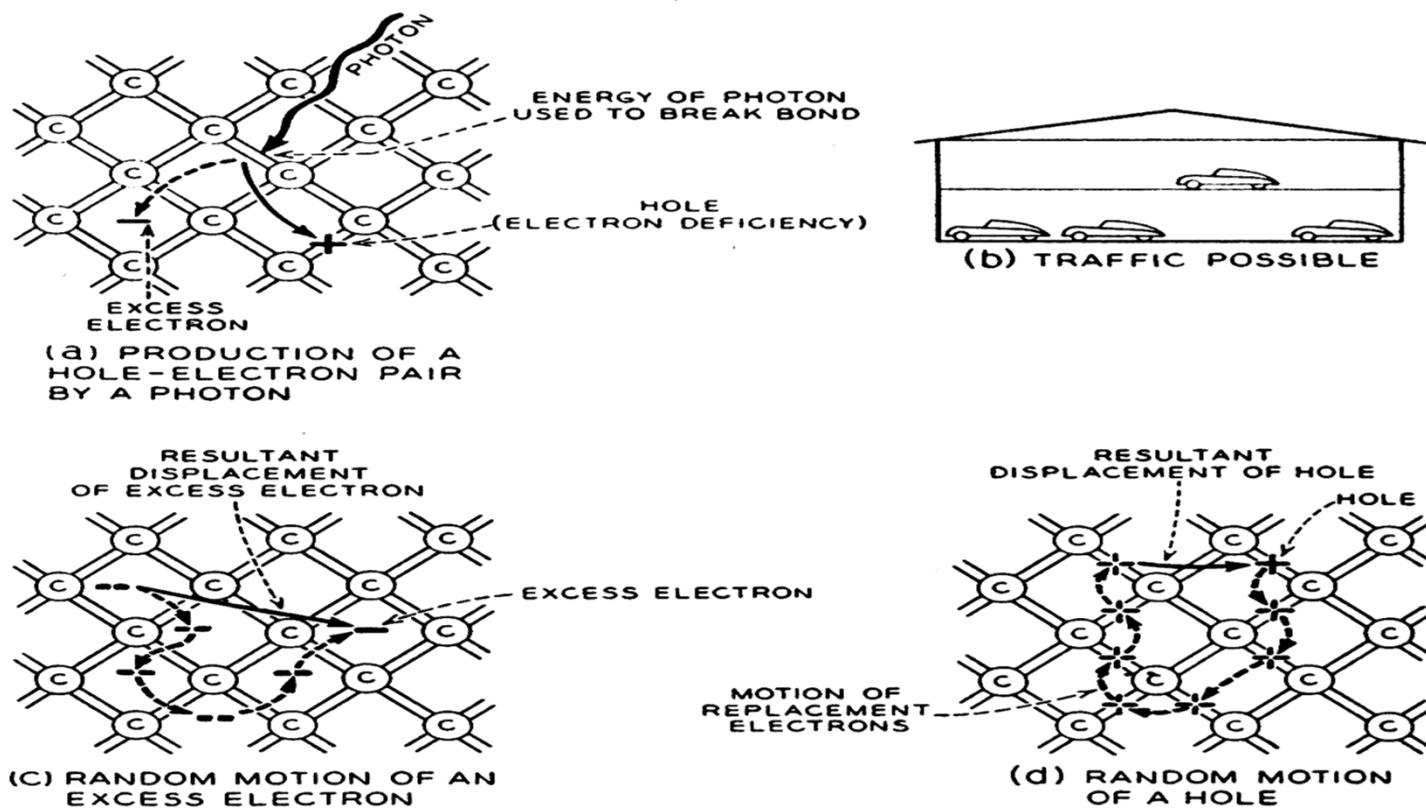
VALENCE
ELECTRONS

(b)



FOUR
VALENCE BONDS

Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)



Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque

- Postulat: $n = p$

$$n_0 = N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_{F_i})}{kT}\right] = p_0 = N_V \exp\left[\frac{-(E_{F_i} - E_v)}{kT}\right]$$



$$\exp\left[\frac{2E_{F_i}}{kT}\right] = \frac{N_C}{N_V} \exp\left[\frac{(E_c + E_v)}{kT}\right]$$



$$E_{F_i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} kT \ln \frac{N_V}{N_C} = \frac{E_c + E_v}{2} + \underbrace{\frac{3}{4} kT \ln \frac{m_v^*}{m_c^*}}_{\sim 10 \text{ meV}} \approx \frac{E_c + E_v}{2} = E_{F_i}$$

$\sim 10 \text{ meV}$

Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque

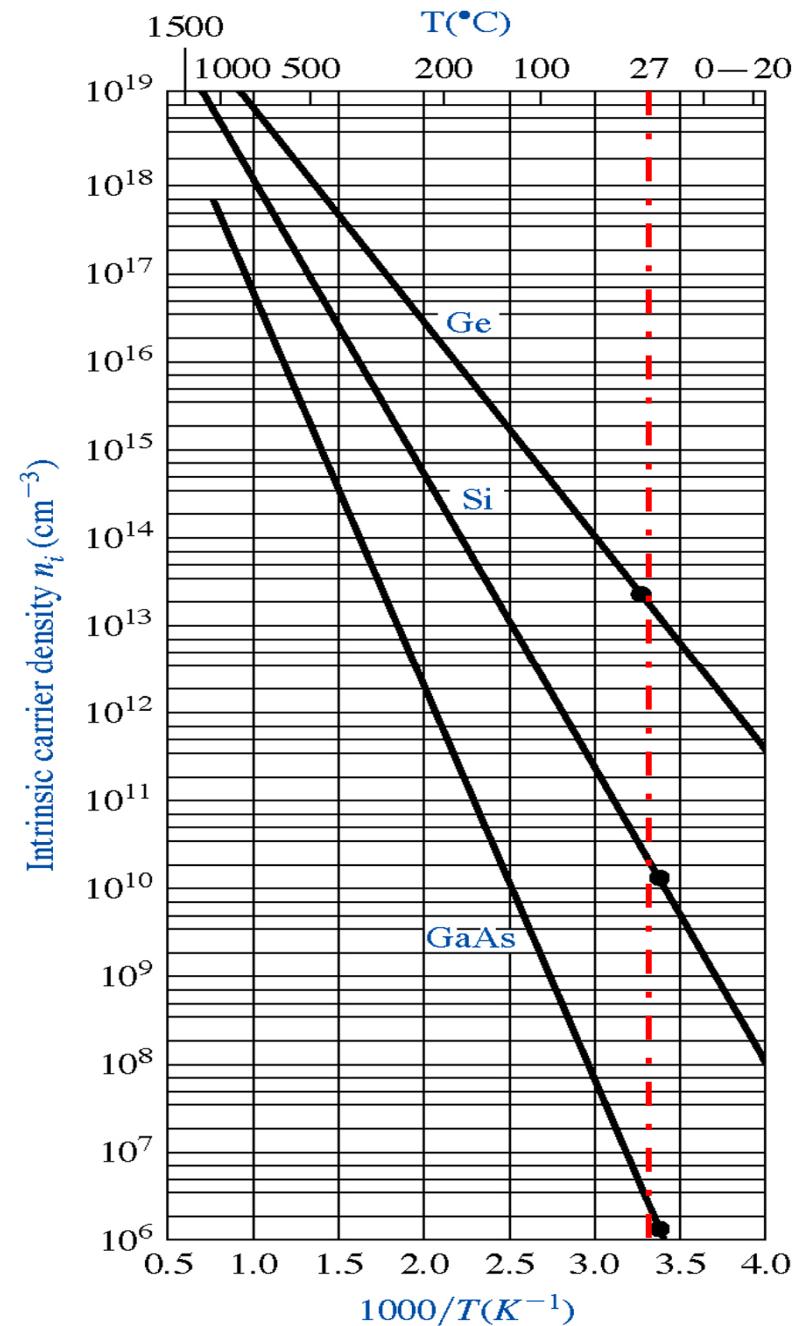
- Quelques valeurs numériques

	m_c^*/m_0	m_v^*/m_0	N_C (10^{19} cm^{-3})	N_V (10^{19} cm^{-3})	Eg (eV)	n_i (cm^{-3}) à 300K
Si	1,06	0,59	2,7	1,1	1,12	$1,5 \times 10^{10}$
Ge	0,55	0,36	1	0,5	0,66	$2,4 \times 10^{13}$
GaAs	0,067	0,64	0,04	1,3	1,43	$\sim 1 \times 10^6$
GaN	0,2	1,4	0,223	4,6	3,39	$\sim 10^{-11}$
4H-SiC			1,69	2,49	2,86	
InP	0,073	0,87	0,05	2	1,27	

Variation $n_i(T)$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

- Dans un SC intrinsèque:
 - n_i n'est pas constant
 - n_i est d'autant plus grand que:
 - E_g est petit
 - Température élevée



掺杂

Dopage du semiconducteur

- Va permettre de changer et surtout contrôler les propriétés électriques du SC
- Introduction d'impuretés (dopants) qui vont modifier la relation $n = p$:
 - Impuretés de type donneur $\Leftrightarrow n > p \Leftrightarrow$ type n
 - Impuretés de type accepteur $\Leftrightarrow p > n \Leftrightarrow$ type p

La position des espèces chimiques dopantes dans le tableau de Mendeleïev et la position des atomes constitutants le réseau cristallin hôte définissent le rôle des impuretés

Semi-conducteur intrinsèque

- Variation exponentielle de la densité de porteurs
- Si $n_i > 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, le matériau inadapté pour des dispositifs électroniques.

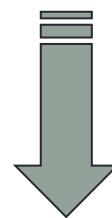
■ Remarque:

- Le produit np est indépendant du niveau de Fermi

Expression valable même si semi-conducteur dopé



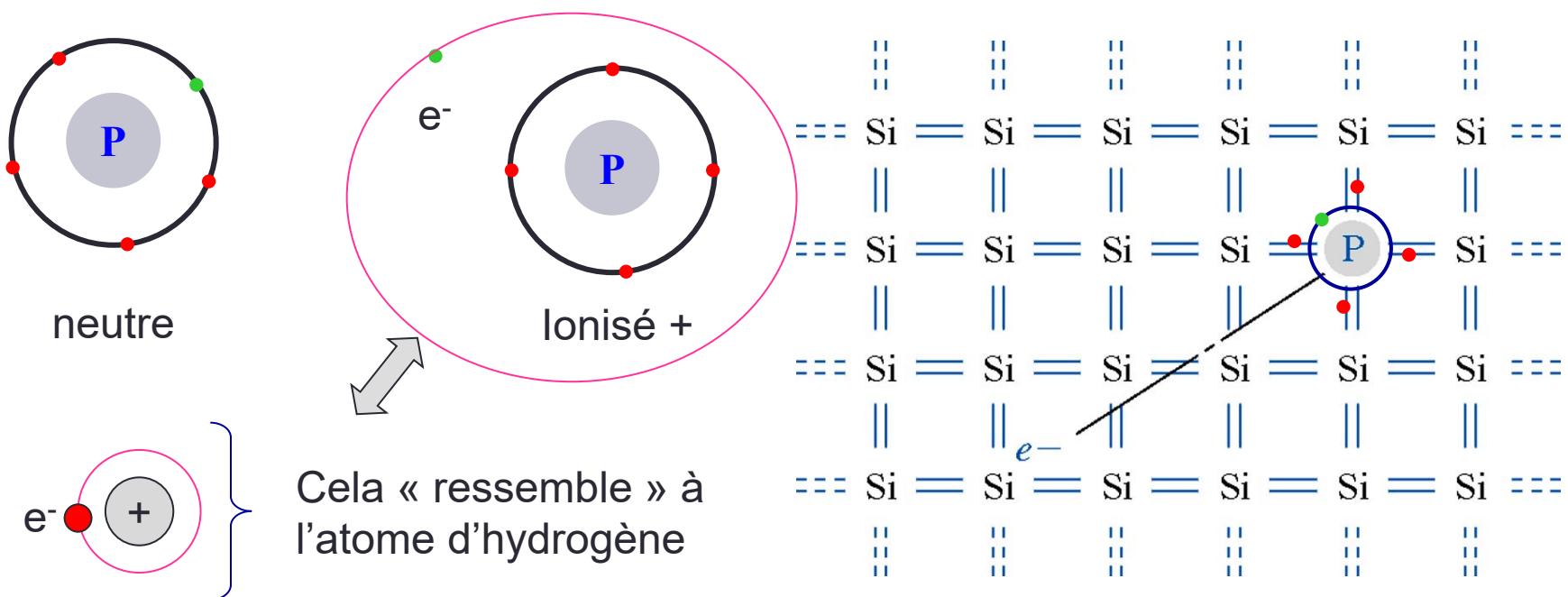
➡ *SC à grands « gap »*
Type SiC, GaN, Diamant



Introduction du dopage

Dopage du semiconducteur

- Considérons le cas du SC Silicium (col IV)
 - Introduisons des atomes dopants de la colonne V:
 - Par ex N, As ou P \Leftrightarrow 5 électrons périphériques *ie* un de « trop » / au Si.



Dopage du semiconducteur

- Atome colonne V : analogie avec l'atome d'hydrogène
 - Le « cinquième » électron n'appartient pas à la BV !
 - Le « cinquième » électron n'appartient pas à la BC !
 - Où est il énergétiquement ?
- Modèle de l'hydrogène « modifié »:
 - L'électron ne se déplace pas dans le vide
 - L'électron est affecté d'une masse « effective »

Niveau d'énergie dus aux impuretés.

- Force

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{vide}} \frac{q^2}{r^2}$$

- Potentiel

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{vide}} \frac{q^2}{r}$$

- Énergie

$$E_n = -\frac{mq^4}{2n^2(4\pi\epsilon_0\epsilon_{vide}\hbar)^2}$$

- Rydberg

$$R = \frac{mq^4}{2(4\pi\epsilon_0\epsilon_{vide}\hbar)^2} = 13,6eV$$

On doit remplacer:

- ϵ_{vide} par ϵ_{sc}
- m par m^* .



$$R_y^* = R_y \frac{1}{\epsilon_{sc}^2} \frac{m^*}{m_0}$$

Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.

- Application pour le Silicium ($\epsilon_{\text{Si}}=12$)
 - Dans notre cas E est l'énergie qu'il faut apporter à l'électron pour l'amener dans la bande de conduction
 - $E = E_C - E_D = R_y^*/n^2 = R_y^*$

$$R_y^* = 13,6 \frac{1}{(12)^2} \frac{0,5 \times m_0}{m_0} \approx 40 \text{ meV}$$

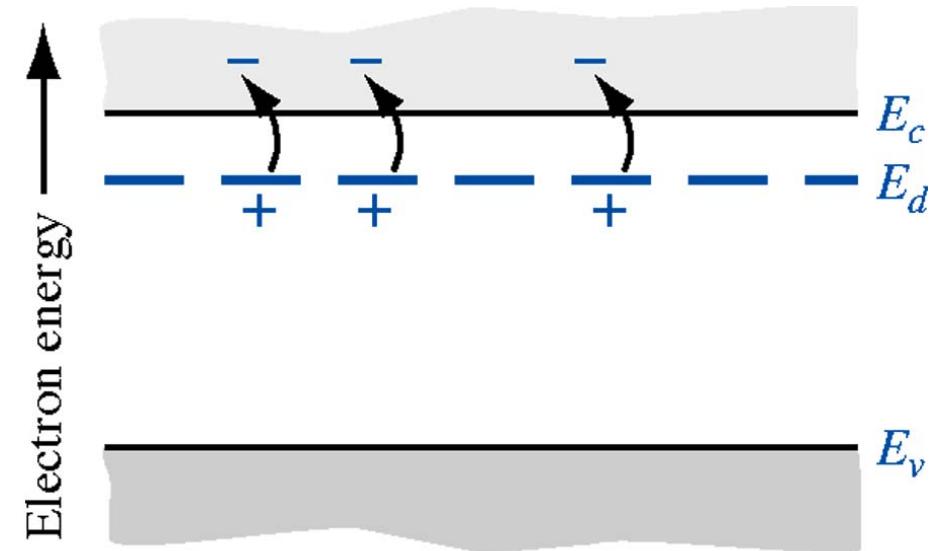
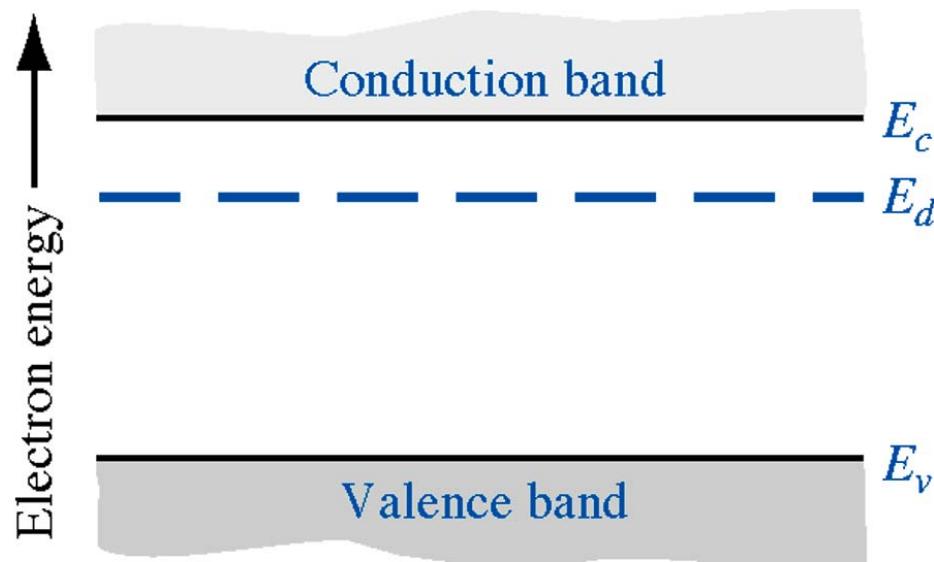
- Expérimentalement on trouve:
 - P => 44 meV
 - As => 49 meV
 - Sb => 39 meV
 - Bi => 67 meV

Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.

- Résumé:

- Tant que le « 5ème » électron lié à P (basse température) \Leftrightarrow état d'énergie E_D et son « orbite » est localisée près de l'atome
- Lorsque on « l'amène » sur E_C \Leftrightarrow changement de son état quantique (lié => état quantique décrit par l'onde de Bloch) \Leftrightarrow il peut se propager dans tout le cristal \Leftrightarrow il participe à la conduction
- SC composés (« compounds SC)
 - GaAs ou InP (III-V)
 - VI à la place de As => Se, Te
 - IV à la place de Ga => Si, C, Sn
 - $m^* = 0,05 m_0 \Leftrightarrow E_C - E_D = 5 \text{ meV} !!$

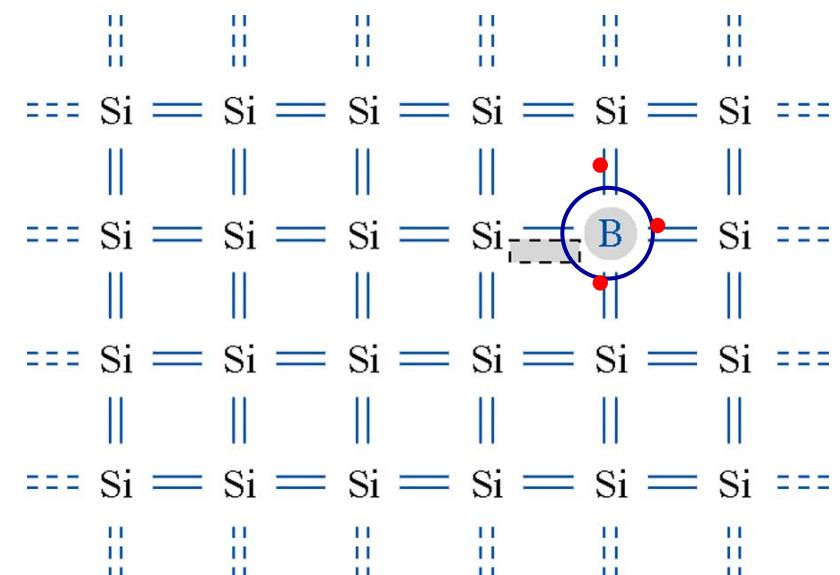
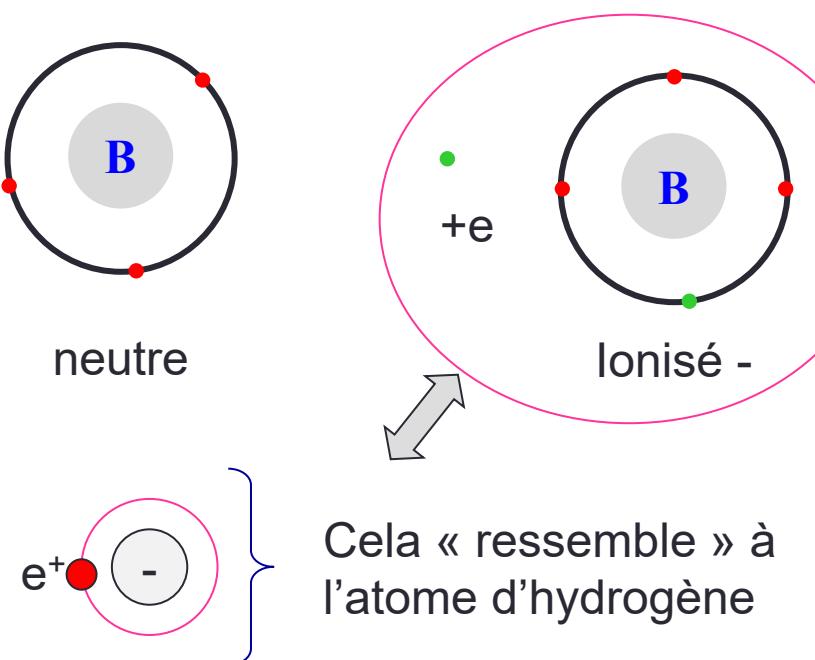
Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.



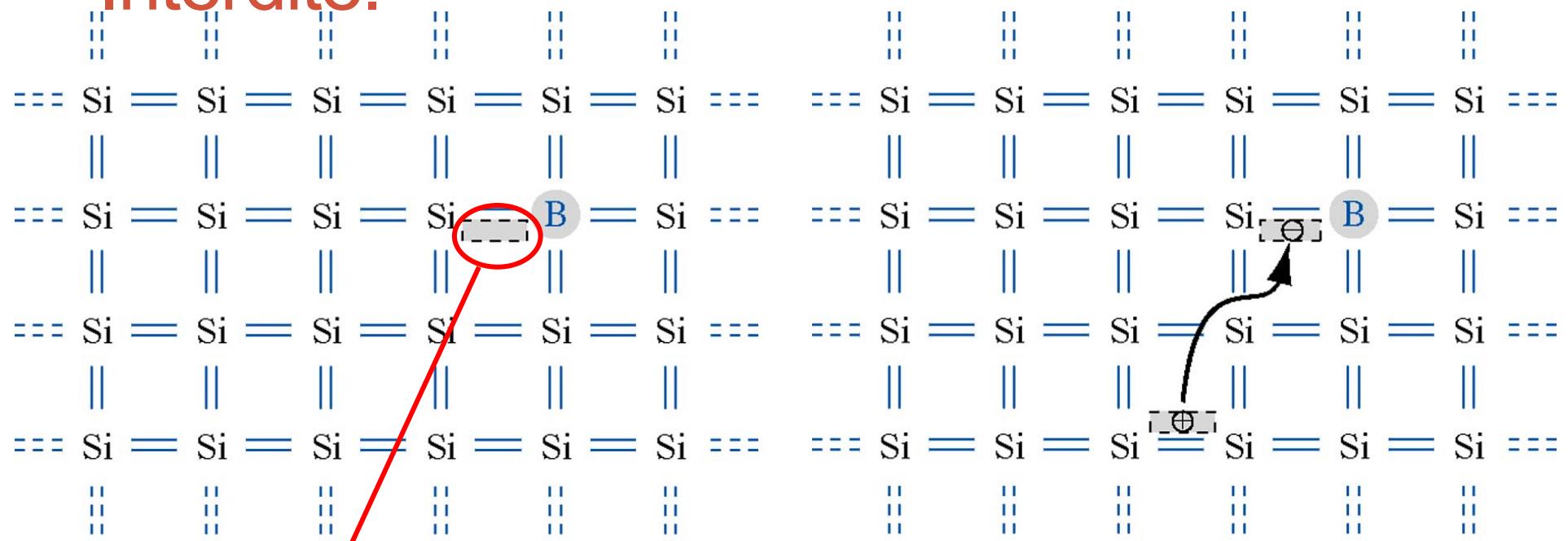
- On remarque que l'on a créé des électrons dans la bande de conduction sans la présence de trous dans la bande de valence $\Leftrightarrow n >> p$.
- La BV est pleine \Leftrightarrow ne conduit pas!

Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.

- Considérons le cas du SC Silicium (col IV)
 - Introduisons des atomes dopants de la colonne III:
 - Par ex B, Al ou Ga \Leftrightarrow 3 électrons périphériques *i.e* un de « moins » / au Si.



Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.



Etat quantique libre : le niveau de cet état quantique est très proche de la bande de valence. Même calcul que pour le « donneur »

Calcul de la position du niveau énergétique E_d ou E_a

- Le problème « ressemble » au modèle de l'atome d'hydrogène:

$$E_n = \frac{m_0 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} = \frac{13.6}{n^2} eV$$

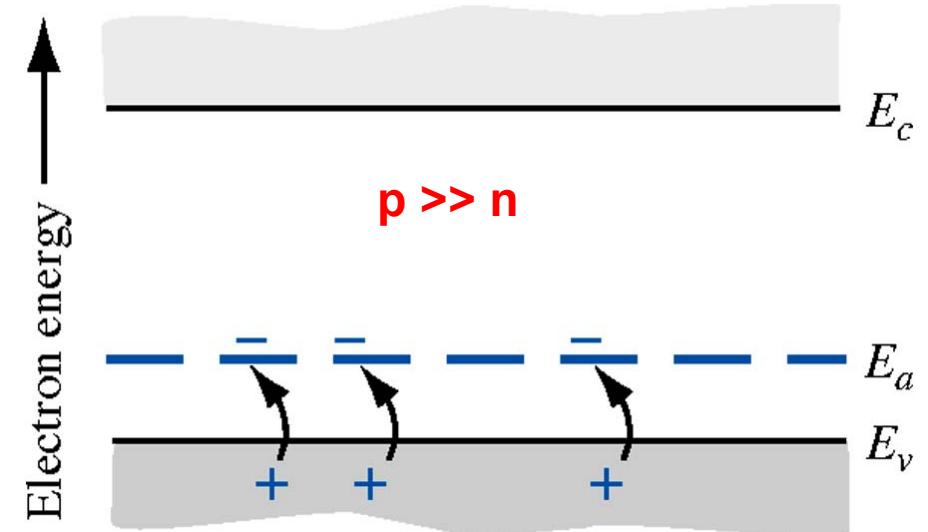
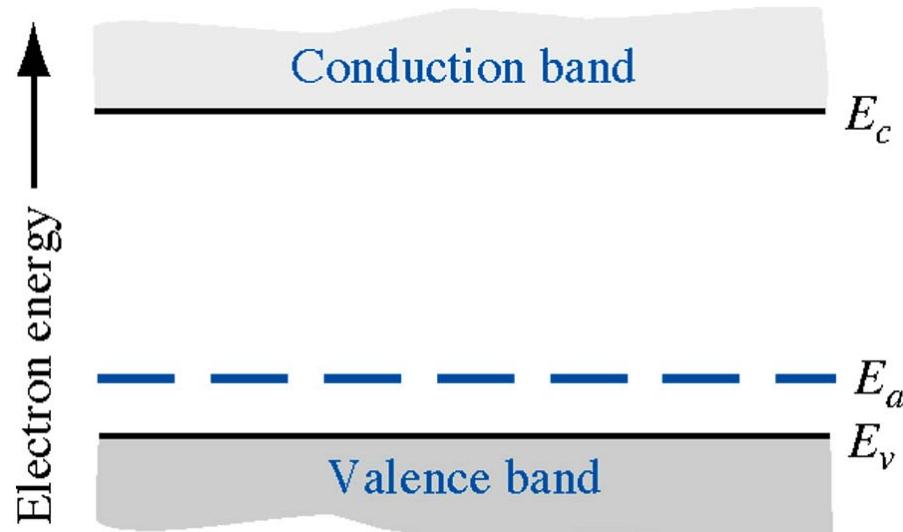
- Introduction du Rydberg « modifié » :

$$E_d = E_C - 13.6 \left(\frac{m^*}{m_0} \right) \left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon} \right)^2$$

Semiconductor	Impurity (Donor)	Shallow Donor Energy (meV)	Impurity (Acceptor)	Shallow Acceptor Energy (meV)
GaAs	Si	5.8	C	26
	Ge	6.0	Be	28
	S	6.0	Mg	28
	Sn	6.0	Si	35
Si	Li	33	B	45
	Sb	39	Al	67
	P	45	Ga	72
	As	54	In	160
Ge	Li	9.3	B	10
	Sb	9.6	Al	10
	P	12.0	Ga	11
	As	13.0	In	11

Exemple de dopants et leurs énergies

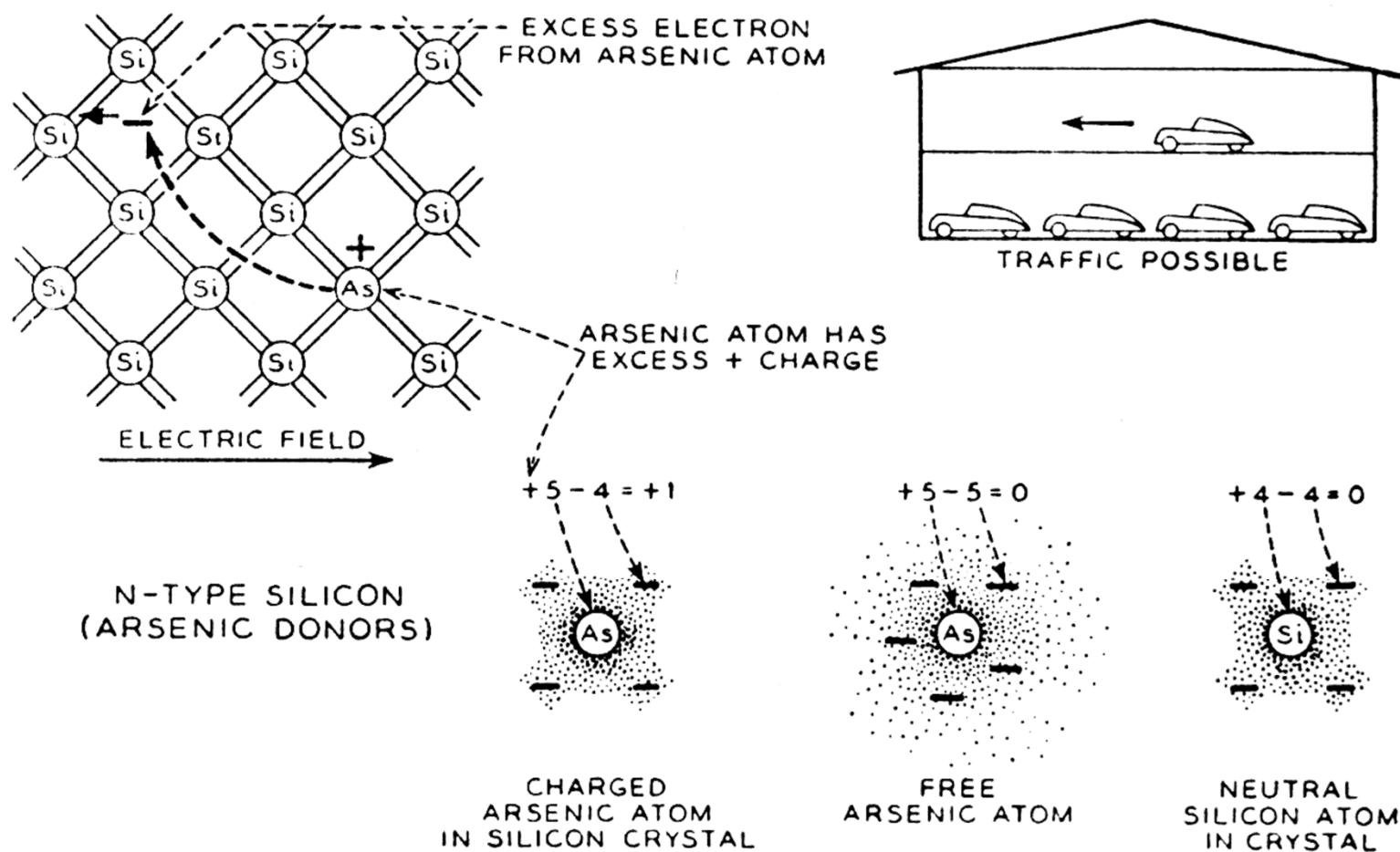
Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.



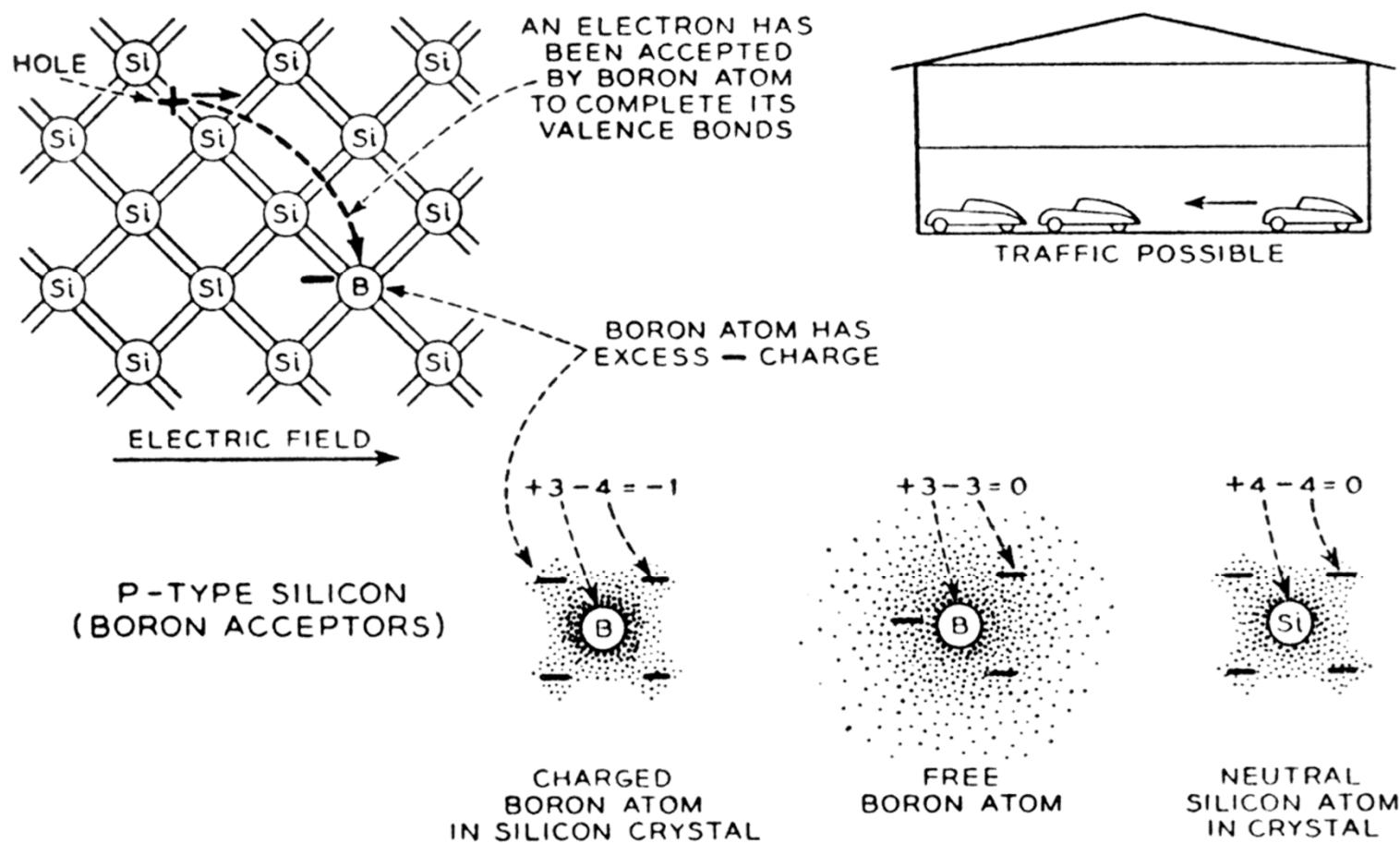
$$E_a - E_V = \frac{13,6}{\epsilon_{sc}^2} \frac{m_v^*}{m_0}$$

- Expérimentalement on trouve:
 - B => 45 meV
 - Al => 57 meV
 - Ga => 65 meV
 - In => 160 meV

Dopage d'un SC: type *n*



Dopage d'un SC: type *p*



Statistique des donneurs et des accepteurs

- États donneurs:

- Prob. d'occupation un peu différente:

$$f_D(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

- Le facteur $\frac{1}{2}$?

- P : $3s^23p^3 \Leftrightarrow$ 2 électrons s et 2 électrons p participent à la liaison \Rightarrow 1 électron p sur le niveau E_d (le 5°!). Cet électron possède 1 spin particulier (up ou down).
 - Une fois cet électron « parti », la case (le niveau) vide peut capturer un spin up **ou** down \Leftrightarrow le mécanisme de capture est augmenté / à l'émission

$$f_D(E) > f(E)$$

Statistique des donneurs et des accepteurs

- États donneurs:
 - Densité d'électrons sur E_D ?

$$n_D = N_D \times f_D(E_D) = \frac{N_D}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_D - E_F}{kT}\right)}$$

- Soit encore:

$$n_d = N_d - N_d^+$$

Statistique des donneurs et des accepteurs

- États accepteurs:
 - On ne peut capturer que l'électron qui a le bon « spin » mais on peut libérer n'importe lequel \Leftrightarrow

$$f_A(E) = \frac{1}{1 + 2 \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$



$$f(E) = \frac{1}{1 + g \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

g : facteur de dégénérescence
 1 : intrinsèque
 2 ou 4: accepteur
 $\frac{1}{2}$: donneur

Statistique des donneurs et des accepteurs

- États accepteurs:
 - Densité d'électrons sur E_A ?

$$n_A = N_A \times f_A(E_A) = \frac{N_A}{1 + 4 \exp\left(\frac{E_A - E_F}{kT}\right)}$$

- Soit encore:

$$p_A = N_A - n_A = N_A - N_A^- = \frac{N_A}{1 + \frac{1}{4} \exp\left(\frac{E_F - E_A}{kT}\right)}$$

Ionisation complète et gel des porteurs

- Équation de neutralité:

- Charges positives = charges négatives

$$e[p + N_D^+] = e[n + N_A^-]$$

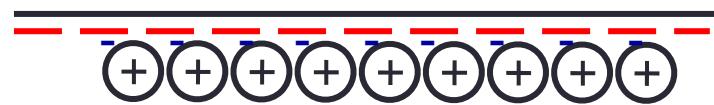
- Simplifions le problème: $N_A = 0$ (type n)

$$n - p = N_D^+$$

$$N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] - N_V \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right] = \frac{N_D}{1 + 2 \exp(-\frac{E_D - E_F}{kT})}$$

la densité de porteurs en Fct de T?

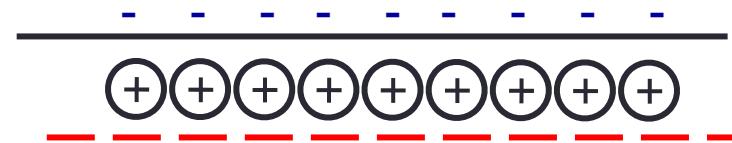
- BT



Freeze out (« gel des porteurs »)

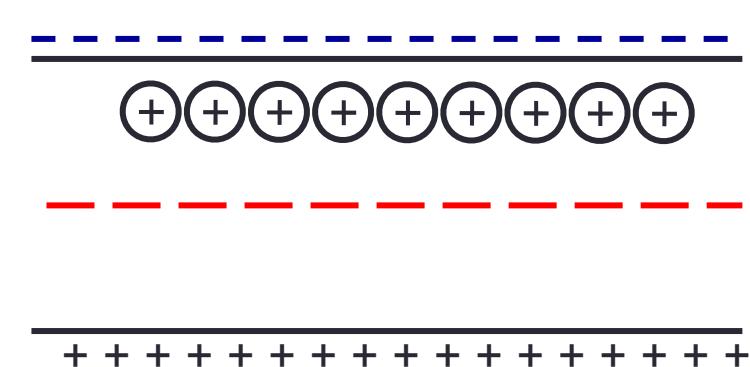
- T « intermédiaire »

Épuisement des donneurs

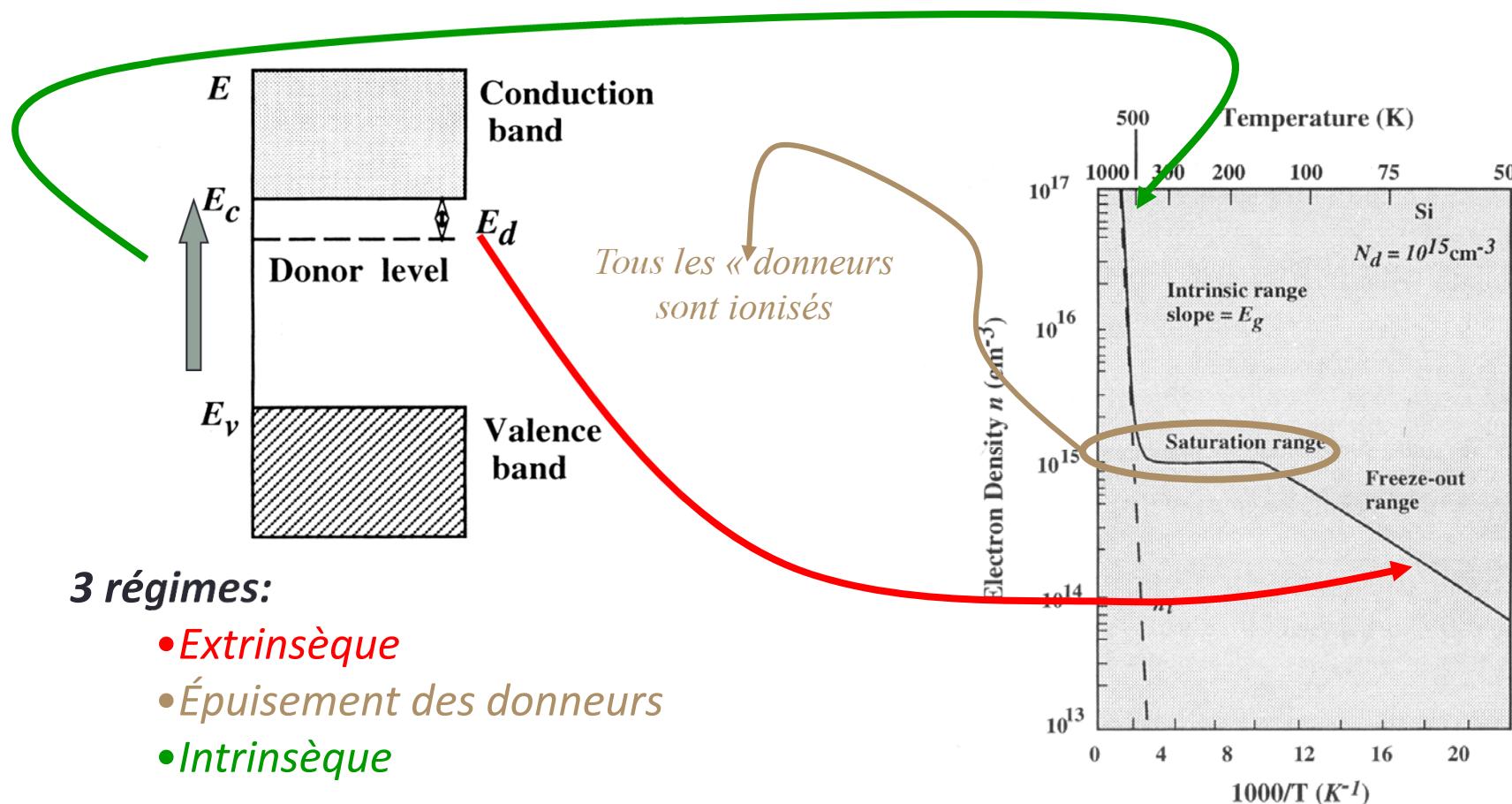


- « Haute » Température

intrinsèque



Variation de la conduction d'un semi-conducteur dopé en fonction de la température



3 régimes:

- **Extrinsèque**
- **Épuisement des donneurs**
- **Intrinsèque**

Niveau de Fermi $E_F(T)$

- « découpage » du pb en domaine de température:
 - TBT: on néglige la densité de trous ($p=ni^2/N_d$) , oui mais jusqu'à quelle température ?

$$n_i \ll N_D \quad \Leftrightarrow \quad kT \ll \frac{E_g}{2 \ln[(NcNv)^{1/2} / N_D]}$$

Ordre de grandeur : kT autour de $Eg/10$ (pour N_d de l'ordre de 10^{17} cm^{-3})



$$N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] - \frac{N_D}{1 + 2 \exp(\frac{E_D - E_F}{kT})} = 0$$

Niveau de Fermi $E_F(T)$

$$\rightarrow E_F = E_D + kT \ln \left\{ \frac{1}{4} \left[-1 + \left(1 + 8 \frac{N_d}{N_c} e^{(E_c - E_d)/kT} \right)^{1/2} \right] \right\}$$

- $kT \ll E_c - E_d$

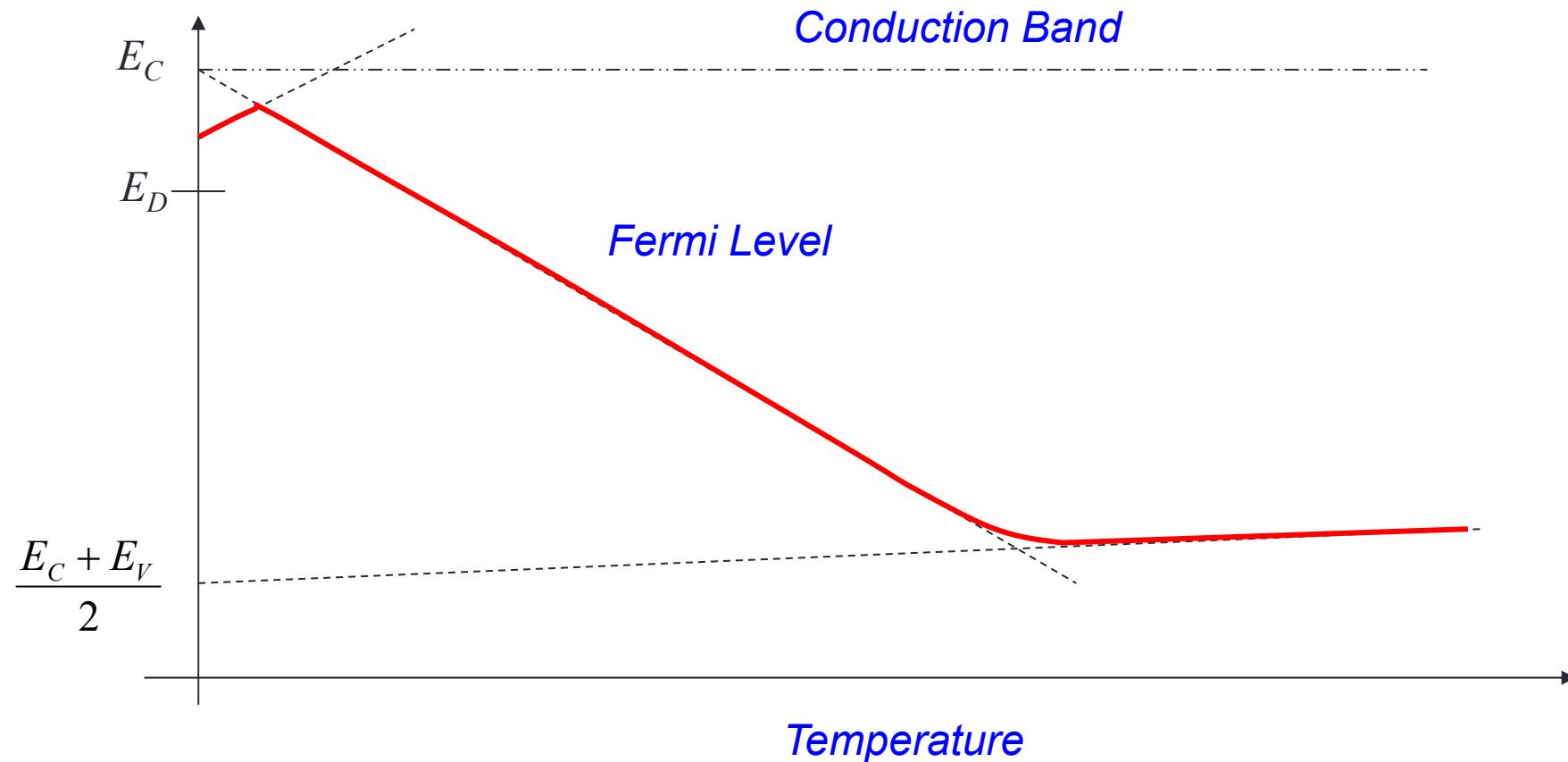
$$E_F = \frac{E_c + E_d}{2} + kT \ln \frac{2N_d}{N_c} , \quad E_F(T=0) = \frac{E_c + E_d}{2} \quad E_F^{\max} \Rightarrow N_c = N_d$$

- $E_c - E_d < kT < E_g$

\rightarrow (DL de la racine)

$$E_F = E_c - kT \ln \frac{N_c}{N_d}$$

E_F fonction de la Température



Distribution à l'équilibre des porteurs

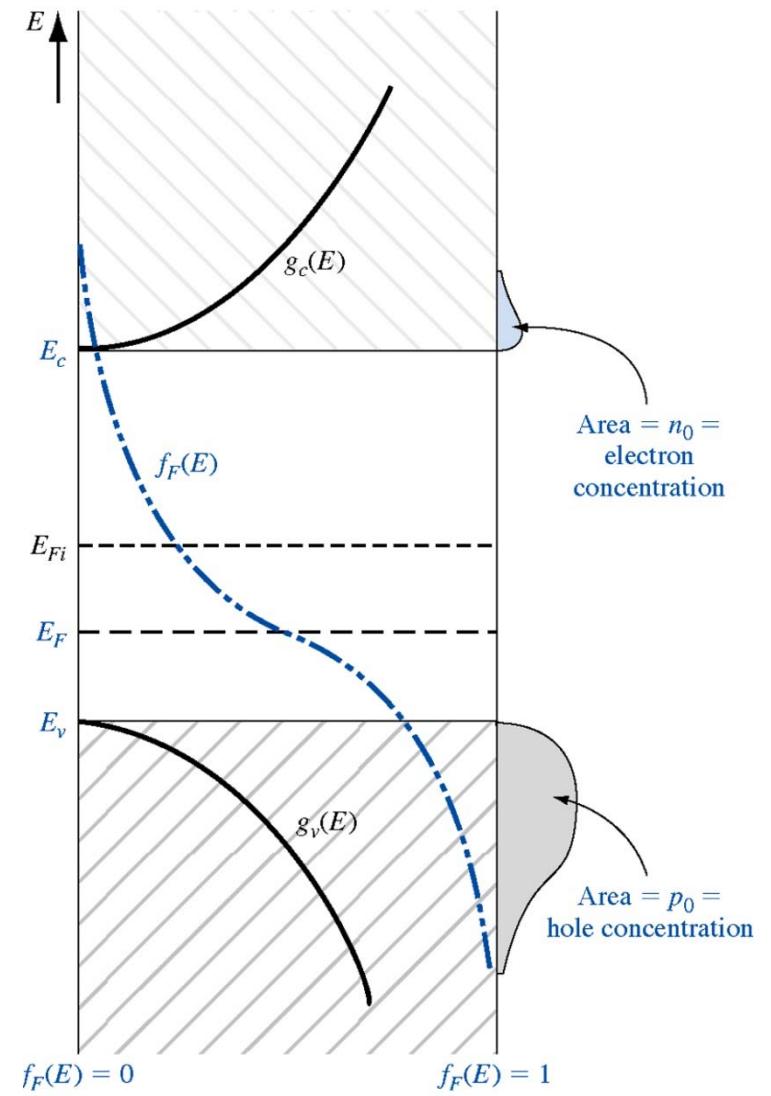
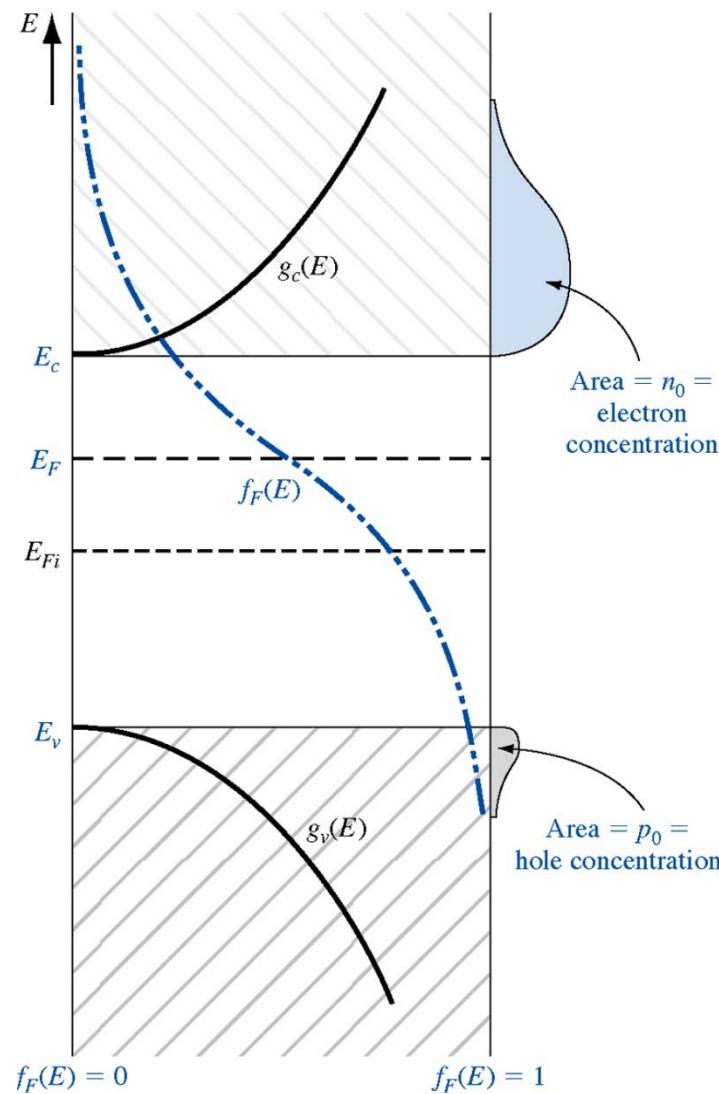
$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_f)}{kT}\right] = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_{fi}) - (E_f - E_{fi})}{kT}\right]$$

$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_{fi})}{kT}\right] \exp\left[-\frac{(E_{fi} - E_f)}{kT}\right]$$

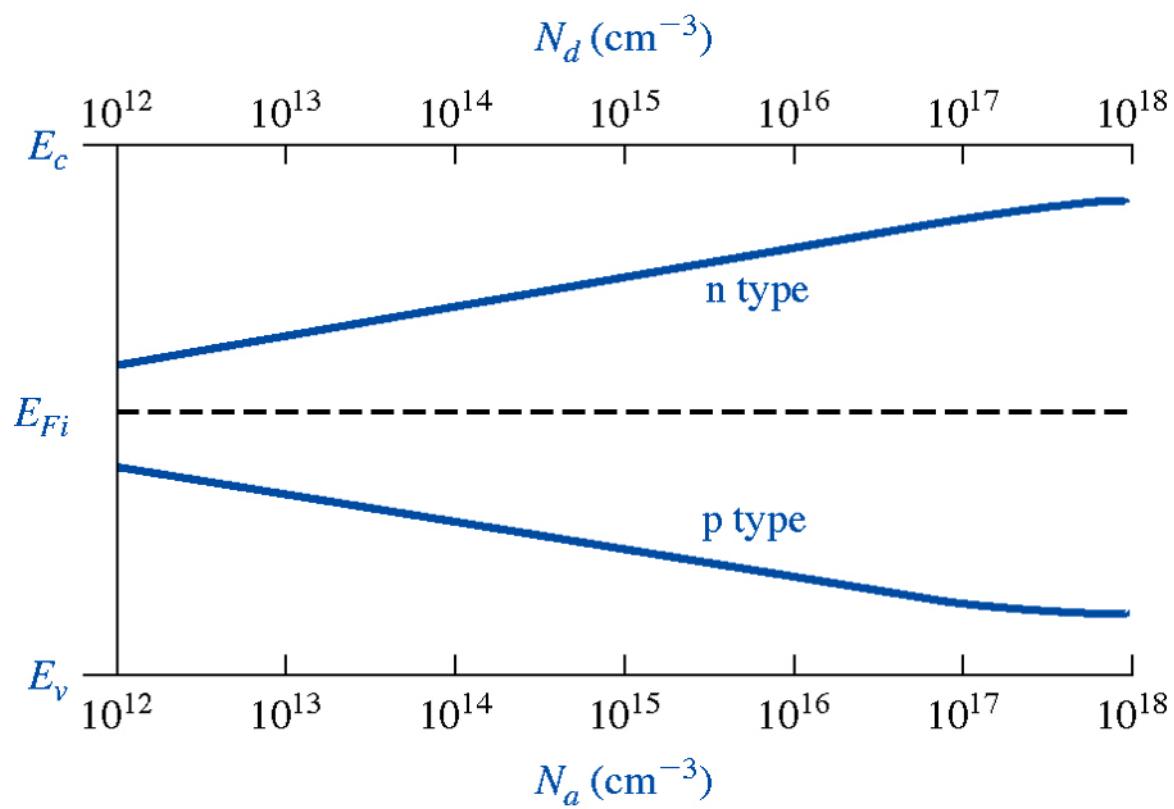
$$n_0 = n_i \exp\left[-\frac{(E_{fi} - E_f)}{kT}\right]$$

$$p_0 = n_i \exp\left[-\frac{(E_f - E_{fi})}{kT}\right]$$

Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque

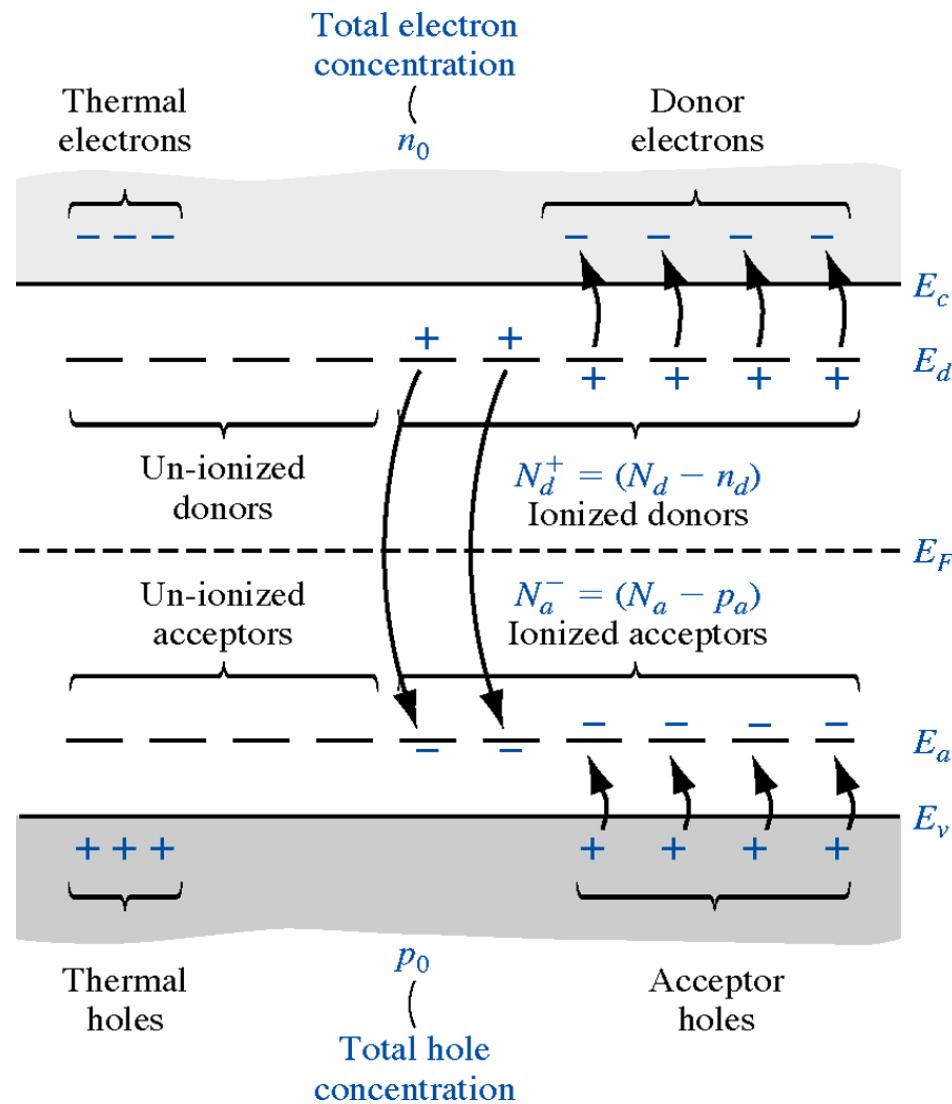


Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque



Concentration de h^+ et d' e^- à l'équilibre

Si il existe des donneurs, un peu plus compliqué!



Concentration de h^+ et d' e^- à l'équilibre

- *Neutralité électrique:*

$$n_0 + N_A^- = p_0 + N_D^+$$

- *Ionisation totale:*

$$n_0 + N_A = p_0 + N_D \quad \text{avec} \quad p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}$$

- *Soit:*

$$n_0^2 - (N_D - N_A)n_0 - n_i^2 = 0$$

- *On obtient:*

$$n_0 = \frac{(N_D - N_A)}{2} + \sqrt{\frac{(N_D - N_A)^2}{4} + n_i^2}$$

Différence $E_f - E_{fi}$

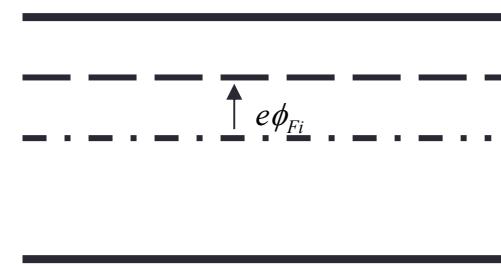
- Au lieu d'exprimer E_f en fonction de N_c et N_v , on peut écrire:

$$E_f - E_i = kT \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right)$$

type n

type p

$$E_i - E_f = kT \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right)$$



Différence $E_f - E_{fi}$

- On peut alors exprimer les densité d'électrons et de trous à *l'équilibre* par:

$$n = n_i e^{(E_F - E_{Fi})/kT} = n_i e^{e\phi_{Fi}/kT}$$

$$p = n_i e^{-(E_F - E_{Fi})/kT} = n_i e^{-e\phi_{Fi}/kT}$$

Équations de Boltzmann

avec:

$$e\phi_{Fi} = E_F - E_{Fi} > 0$$

type n

$$e\phi_{Fi} = E_F - E_{Fi} < 0$$

type p

CHAPITRE 11

Le semiconducteur hors équilibre

Plan:

- Recombinaison et génération
- Courants dans les SC
- Équation de densité de courants
- Équations de continuité
- Longueur de Debye
- Équation de Poisson
- Temps de relaxation diélectrique

Phénomènes de Génération - Recombinaison

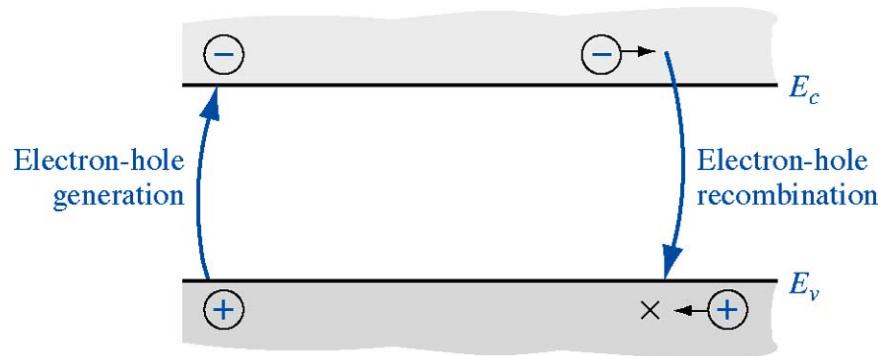
- Loi d'action de masse:
 - À l'équilibre thermodynamique: $np = n_i^2$
 - Hors équilibre: apparition de phénomènes de Génération - Recombinaison en excès
 - création ou recombinaison de porteurs : *rate*
Unité $[g]=[r]=\text{s}^{-1}\text{cm}^{-3}$
 - Taux net de recombinaison:

$$g' - r' = g + g_{th} - r' = g - r \quad \text{avec} \quad r = r' - g_{th}$$

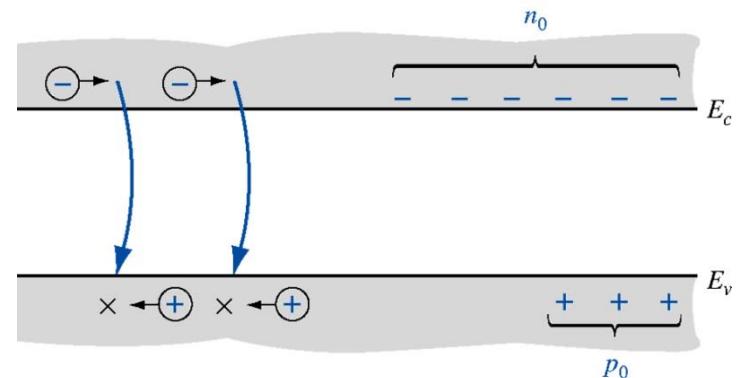
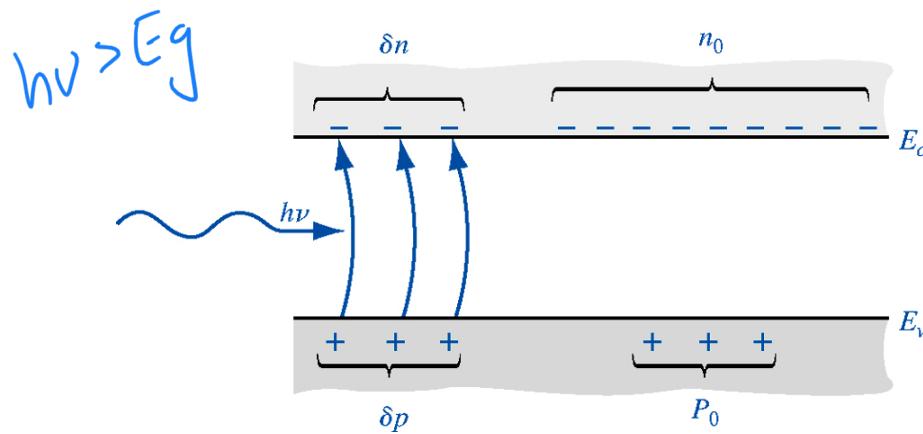
externe interne

The diagram illustrates the decomposition of the net generation rate r' into external g and internal g_{th} components. It also shows that the net generation rate r is equal to the difference between total generation g and internal recombination r' . Two purple arrows point from the terms g and g_{th} in the first equation to the terms g and r' in the second equation, indicating their equivalence.

Phénomènes de Génération - Recombinaison



À l'équilibre le taux de génération g est égal au taux de recombinaison r
Si $T=0K$, $g = r = 0$.



Recombinaison: 2 « chemins » possibles (1)

type n: $N_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3} = n$ $n_i = 10^{10} (\text{Zok})$

$$p = \frac{n_i^2}{\tau_h} = 10^2 \text{ cm}^{-3} \quad \Delta n = \Delta p = 10^{11}$$

- Recombinaison directe électron-trou
 - Processus fonction du nombre d'électron et de trous

τ_p : life time, durée de vie

$$r_p = \frac{\Delta p}{\tau_p} \qquad r_n = \frac{\Delta n}{\tau_n}$$

- Exemple: type n +excitation lumineuse en faible injection (
ie $\Delta n = \Delta p \ll n_0$)

$$p = p_0 + \underline{\Delta p}$$

$$n = \underline{n_0} + \Delta n \approx n_0$$

- *En régime de faible injection le nombre de porteurs majoritaires n'est pas affecté.*

$$p = 10^2 + 10^{11} = 10^{11} = \Delta p. \quad n = 10^{18} + 10^{11} = 10^{18} = n_0.$$

Recombinaison: 2 « chemins » possibles (2)

- Recombinaison par centres de recombinaison:
 - En général ces centres se trouvent en milieu de bande interdite
 - Le taux de recombinaison s'écrit:

$$r = \frac{1}{\tau_m} \frac{np - n_i^2}{2n_i + p + n}$$

Équation de Shockley-Read

où τ_m est caractéristique du centre recombinant

- Si les 2 processus s'appliquent:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_m} + \frac{1}{\tau_{n(p)}}$$

Recombinaison: 2 « chemins » possibles (3)

- Si semi-conducteur peu dopé: on applique SR
- Si semi-conducteur dopé n:

$$r_p = \frac{\Delta p}{\tau} \quad \text{Avec} \quad \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_m} + \frac{1}{\tau_p}$$

- Si région « vide » de porteurs (ex: ZCE)

$$r = \frac{1}{\tau_m} \frac{\cancel{n}_p - n_i^2}{2n_i + \cancel{n} + \cancel{n}}$$

$$r = -\frac{n_i}{2\tau_m} < 0$$

Taux net de génération.
Création de porteurs

Type P

Excitation lumineuse

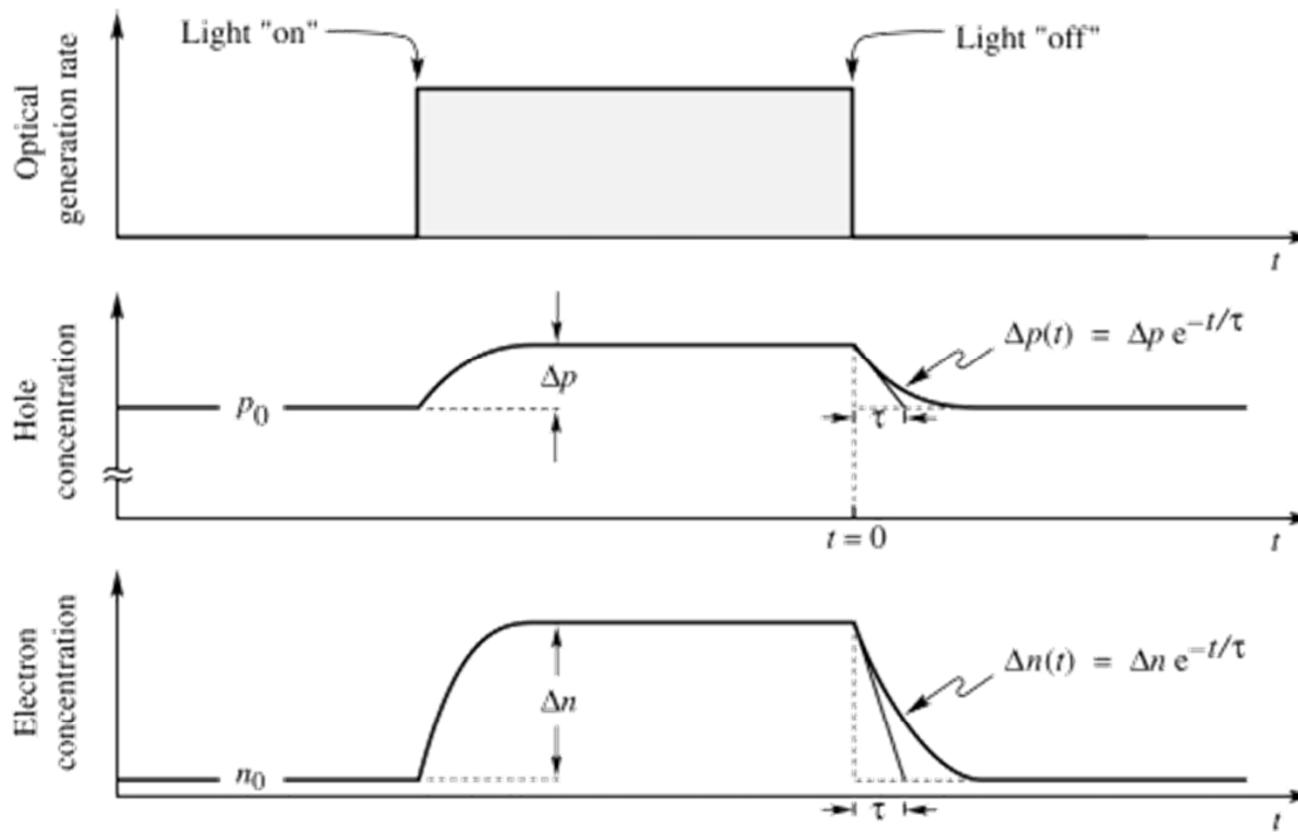


Fig. 1.2. Carrier concentration as a function of time before, during, and after an optical excitation pulse. The semiconductor is assumed to be p-type and thus it is $p_0 \gg n_0$. Electrons and holes are generated in pairs, thus $\Delta p = \Delta n$. Under low-level excitation shown here, it is $\Delta n \ll p_0$. In most practical cases the equilibrium minority carrier concentration is extremely small so that $n_0 \ll \Delta n$.

Recombinaison radiative et non radiative

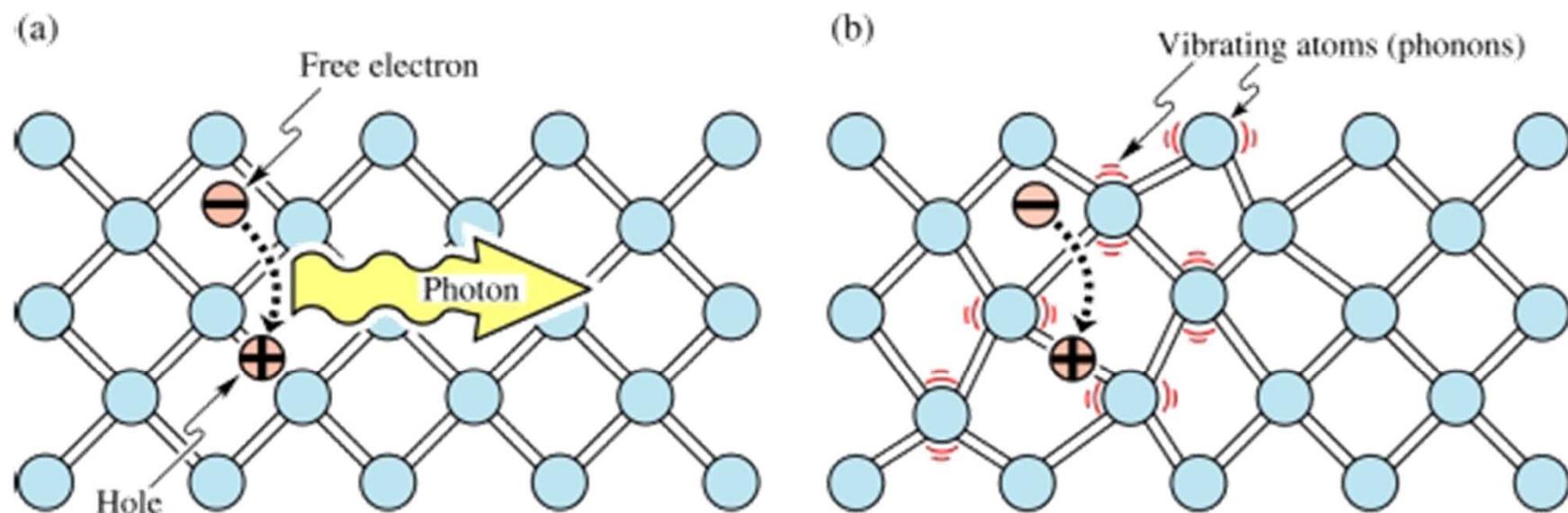


Fig. 1.5. (a) Radiative recombination of an electron-hole pair accompanied by the emission of a photon with energy $h\nu \approx E_g$. (b) In non-radiative recombination events, the energy released during the electron-hole recombination is converted to phonons (adopted from Shockley, 1950).

Recombinaisons de surface

Nonradiative recombination at surfaces

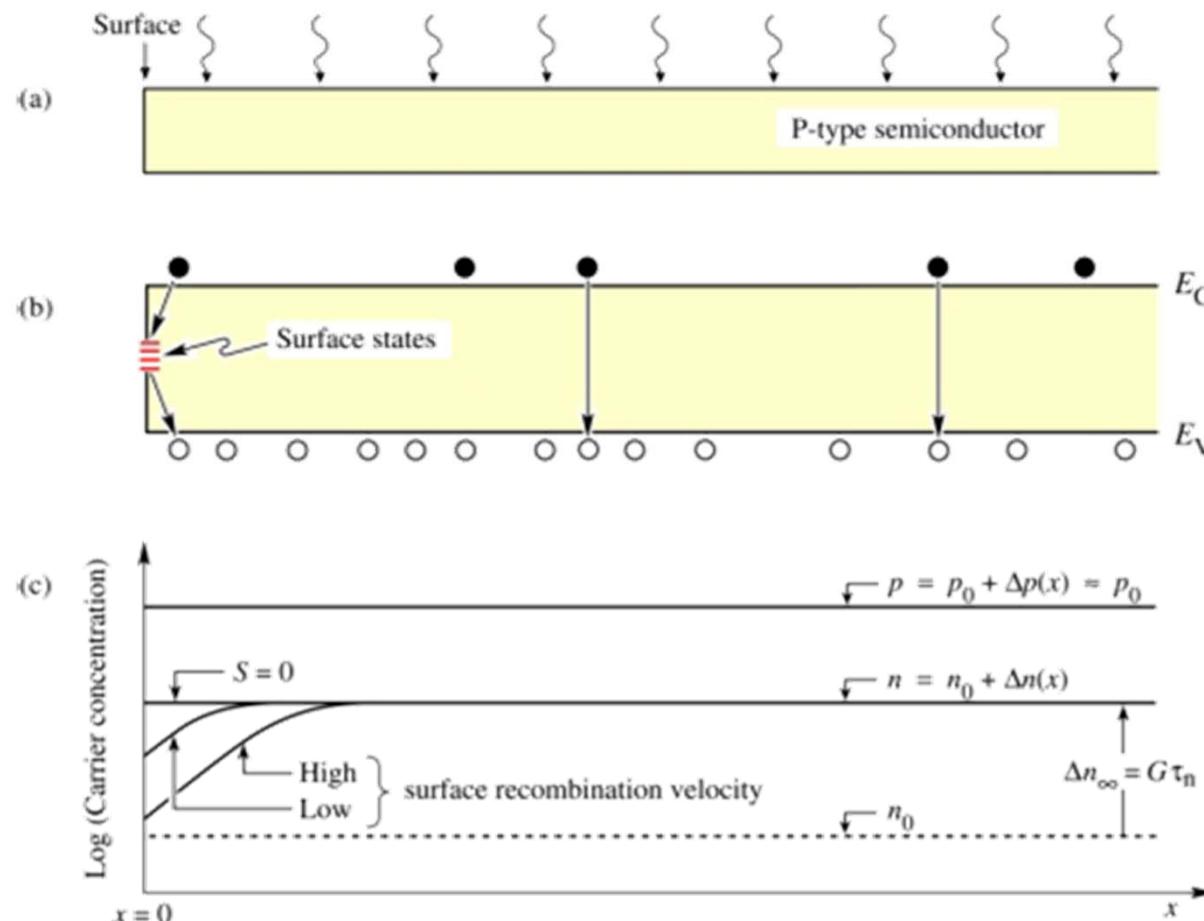


Fig. 1.9. (a) Illuminated p-type semiconductor, (b) band diagram, and (c) minority and majority carrier concentration near the surface assuming uniform carrier generation due to illumination. The excess carrier concentrations are Δn and Δp .

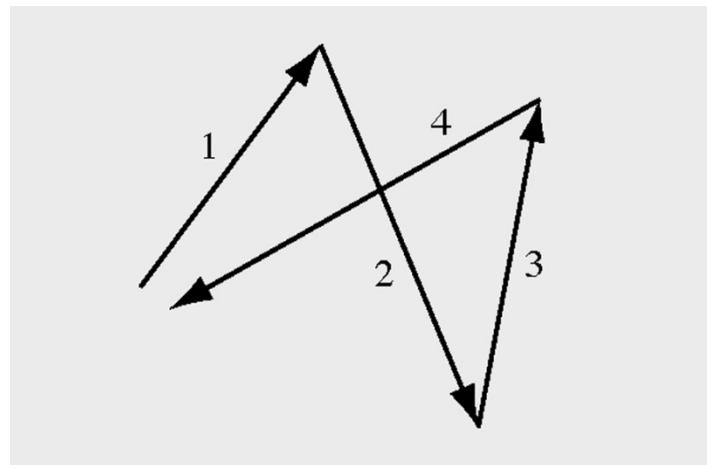
Courants dans les SC

- Courant de conduction: présence de champ électrique
 - Si $E=0$, vitesse des électrons=vitesse thermique (10^7 cm/s) mais => vitesse **moyenne** nulle car chocs (« scattering ») avec le réseau + impuretés.
 - Libre parcours moyen (« mean free path »):

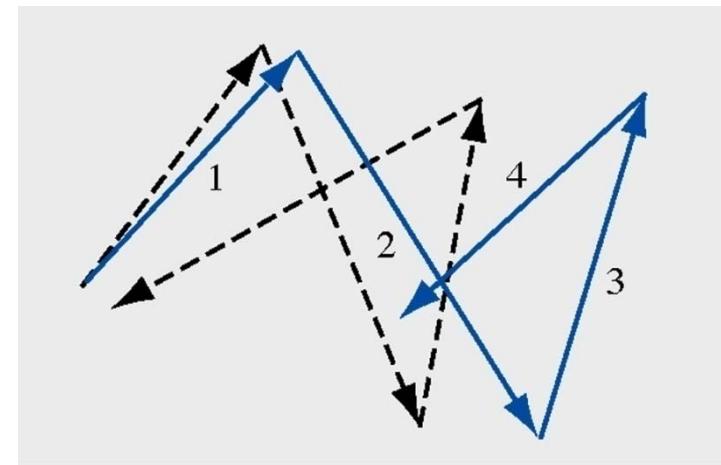
$$l = v_{th} \cdot \tau \approx 100 \text{ \AA}^\circ$$

$$\tau \approx 0.1 \text{ ps}$$

Vitesse de dérive (« drift velocity »)



(a)



(b)

Courants dans les SC

- Courant de conduction: présence de champ électrique
 - Entre deux chocs, les électrons sont accélérés uniformément suivant
 - Accélération:

$$\gamma = -qE / m^*$$

- Vitesse:

$$v = -qE\tau / m^* = \pm \mu E$$

- Mobilité:

$$\mu = |q\tau / m^*|$$

Si : $1500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
GaAs: $8500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
 $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$: $11000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Courants dans les SC

- La densité de courant de conduction s'écrit:

- Pour les électrons:

$$\vec{J}_{cn} = -ne\vec{v}_n = ne\mu_n \vec{E}$$

- Pour les trous:

$$\vec{J}_{cp} = +pe\vec{v}_p = pe\mu_p \vec{E}$$

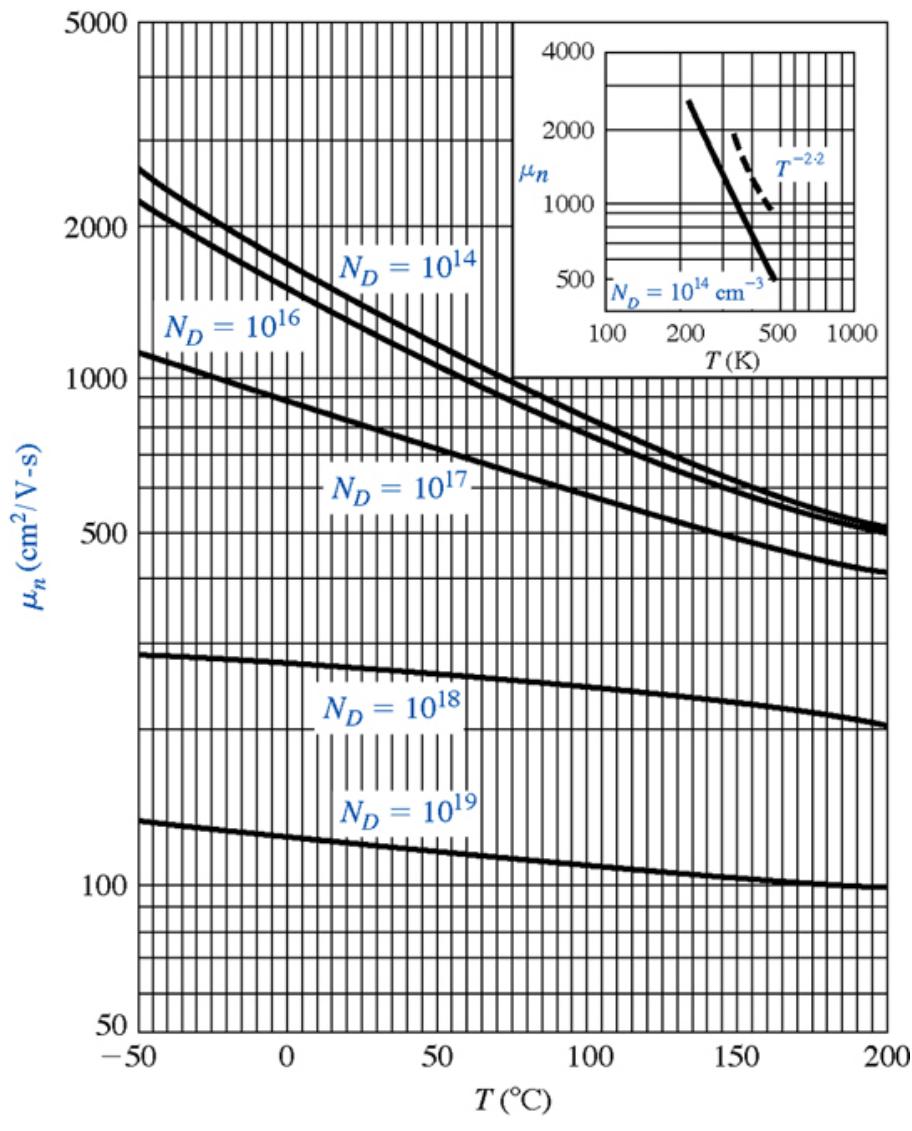
- Pour l'ensemble:

$$\vec{J}_{ctotal} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = (ne\mu_n + pe\mu_p) \vec{E}$$

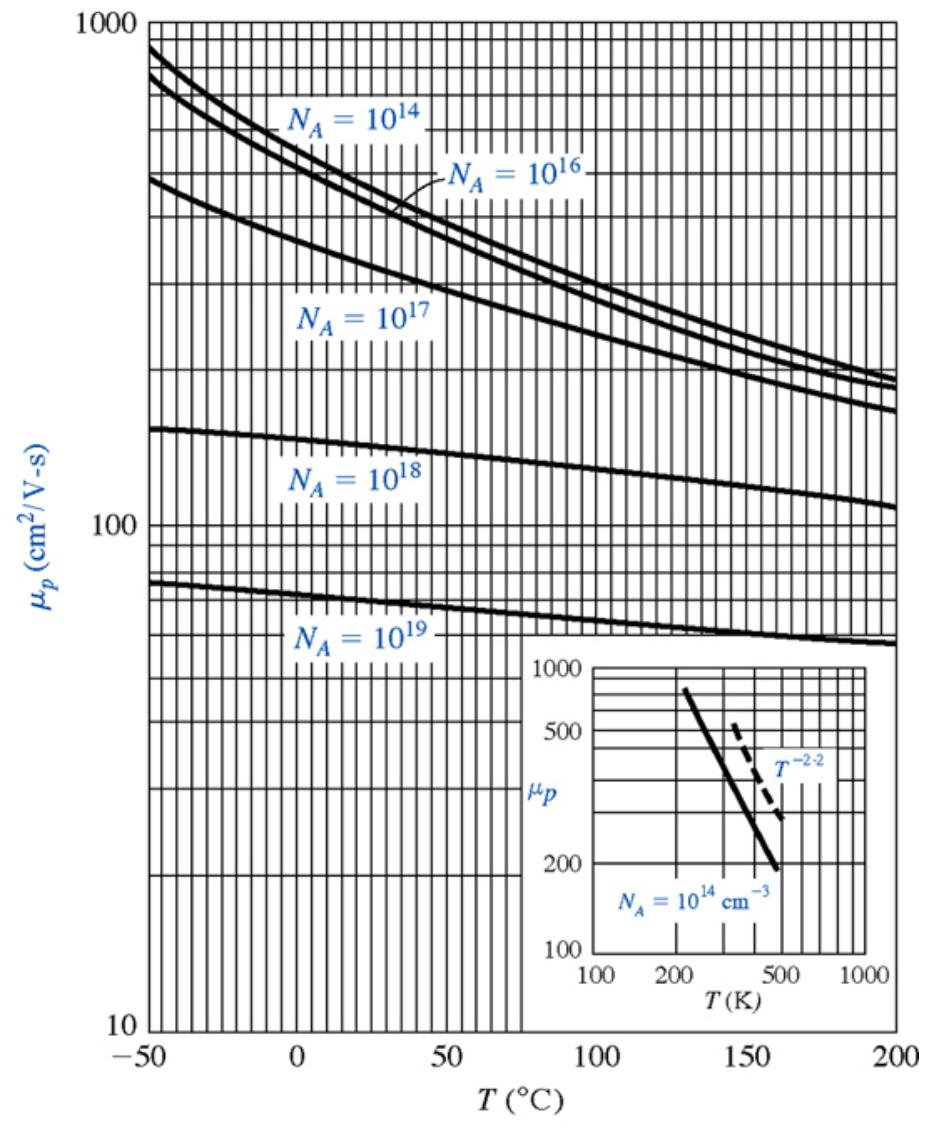
Courants dans les SC

- Importance de la mobilité sur les composants
 - Mobilité la plus élevée possible
 - => vitesse plus grande pour un même E
 - Facteurs limitants:
 - Dopage
 - Défauts (cristallins, structuraux, ...)
 - Température
 - Champ électrique de saturation + géométrie

Variation mobilité en fonction de la température

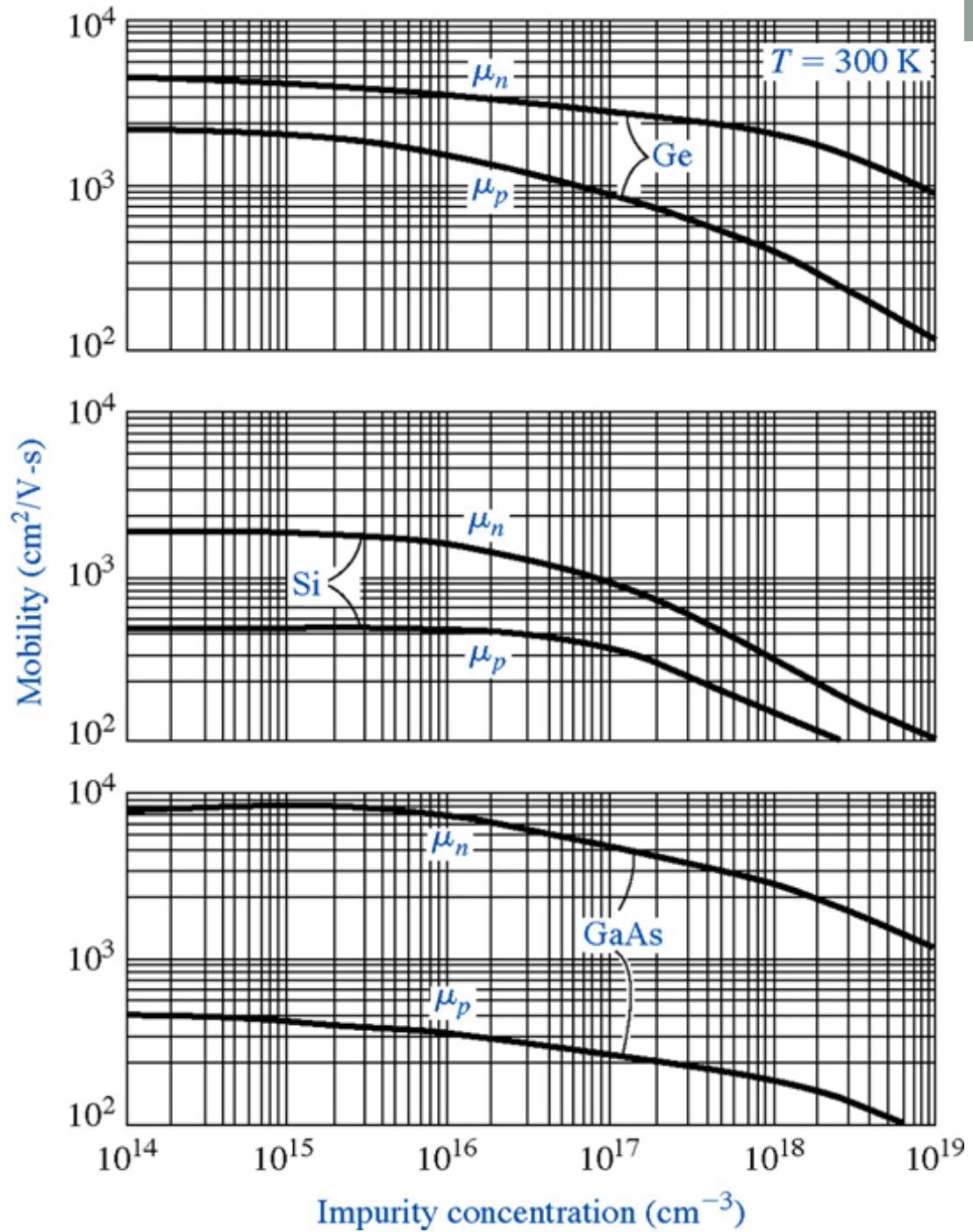


(a)



(b)

Variation de la mobilité en fonction de la concentration en dopants



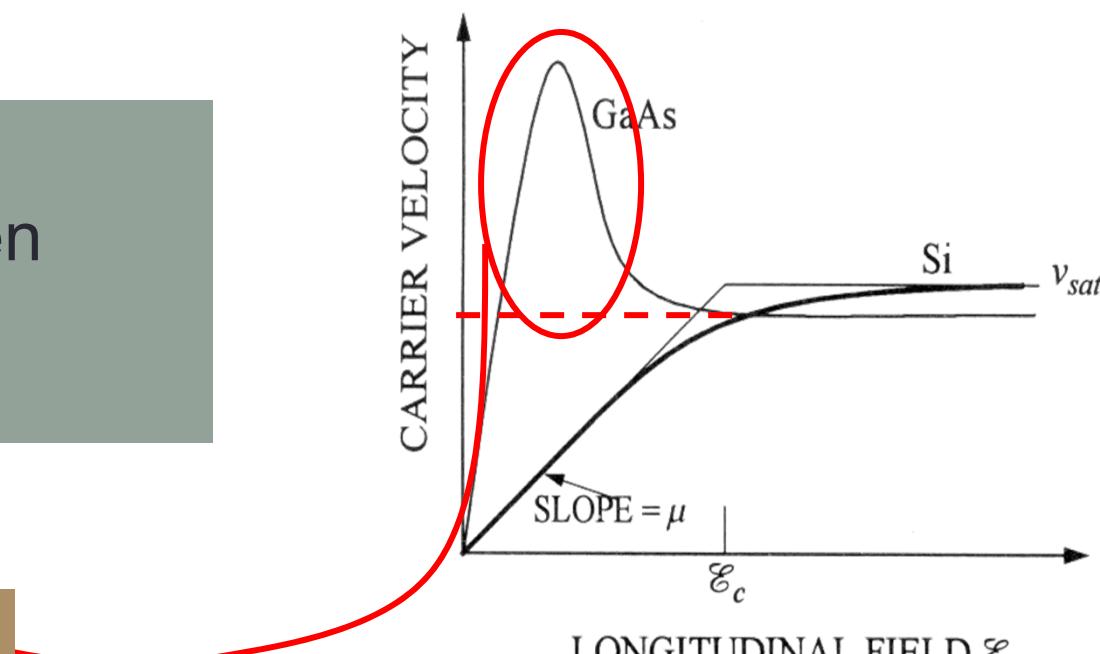
Courants dans les SC

- Vitesse de saturation des électrons
- La relation linéaire vitesse – champ valide uniquement pour:
 - Champ électrique pas trop élevé
 - Porteurs en équilibre thermique avec le réseau
- Sinon:
 - Au-delà d'un champ critique, saturation de la vitesse
 - Apparition d'un autre phénomène: « velocity overshoot » pour des semiconducteurs multivallée.
 - Régime balistique: pour des dispositifs de dimensions inférieures au libre parcours moyen ($0.01\mu\text{m}$)

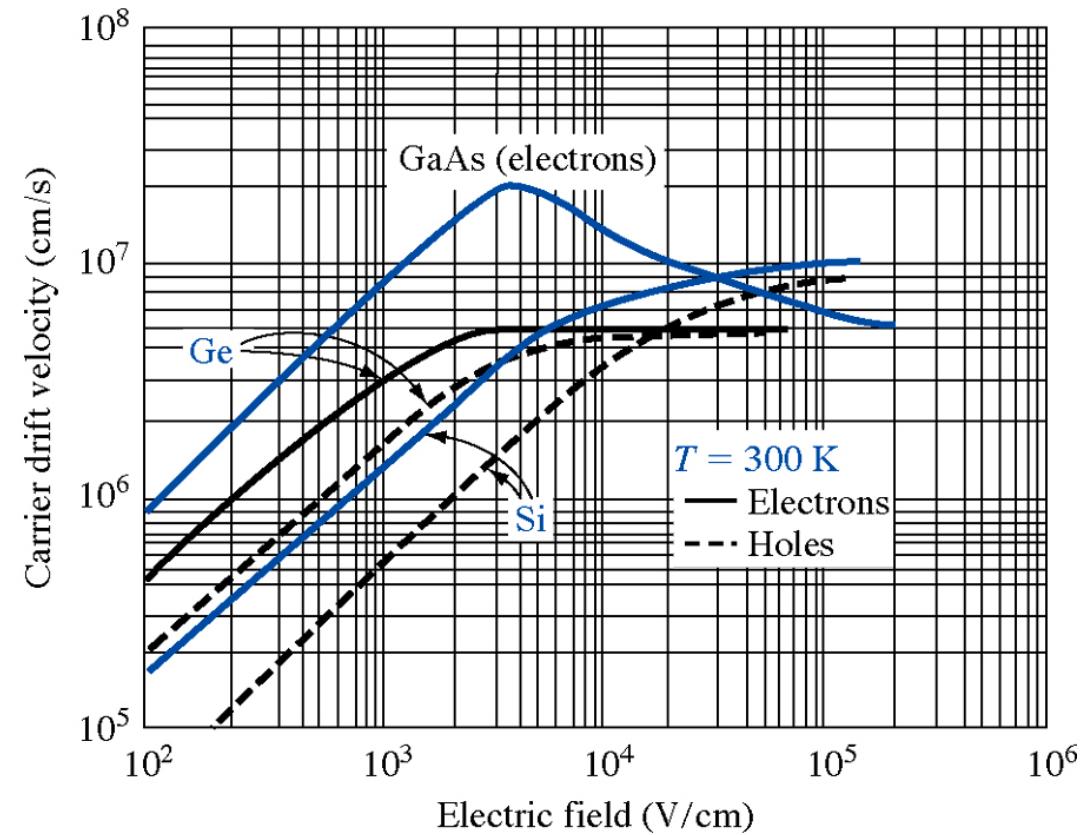
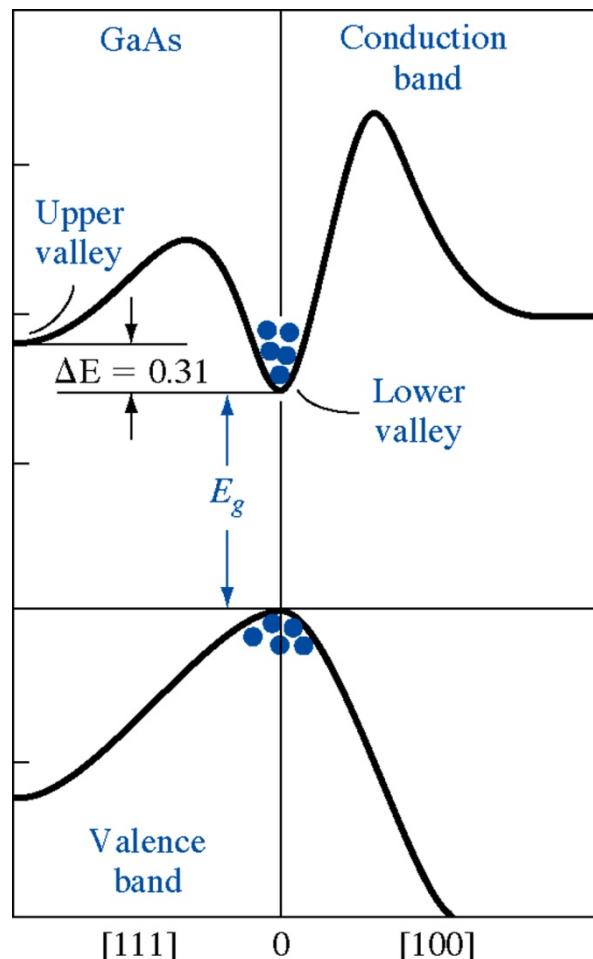
Vitesse de saturation

Différents comportement en fonction du SC

Survitesse
(*« overshoot »*)



Survitesse dans le cas de SC multi vallées



Courants dans les SC

- Courant de diffusion:
 - Origine: gradient de concentration
 - Diffusion depuis la région de forte concentration vers la région de moindre [].
 - 1° loi de Fick:

$$n_D^x = -D_n \frac{dn}{dx}$$

nb d'e⁻ qui diffusent par unité de temps et de volume (flux)

$$p_D^x = -D_p \frac{dp}{dx}$$

nb de h⁺ qui diffusent par unité de temps et de volume (flux)

Courants dans les SC

- Courant de diffusion: somme des deux contributions (électrons et trous):

$$J_{diff} = e(-n_D^x + p_D^x) = eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

- Constante ou coefficient de diffusion

$$[D_{n,p}] = \text{cm}^2/\text{s.}$$

Courants dans les SC

- Courant total: somme des deux contributions (si elles existent) de conduction et diffusion:

$$J_T = J_{cond} + J_{diff} = J_n + J_p$$
$$J_T = (ne\mu_n + pe\mu_p)E + e(D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx})$$

- D et μ expriment la faculté des porteurs à se déplacer. Il existe une relation entre eux: *relation d'Einstein*:

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e}$$

Équations de continuité – longueur de diffusion

- G et R altèrent la distribution des porteurs donc du courant

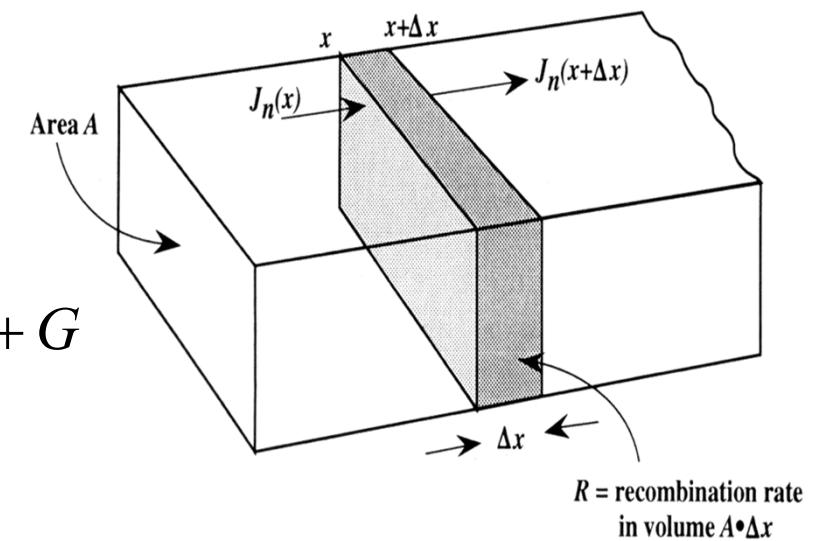
$$A\Delta x \frac{dn(x,t)}{dt} = A \left[\frac{J_n(x + \Delta x)}{e} - \frac{J_n(x)}{e} \right] - R + G$$

$$A\Delta x \frac{dn(x,t)}{dt} \cong A \frac{dJ_n(x)}{dx} \frac{\Delta x}{e} - R + G$$

- On obtient alors les **équations de continuité** pour les électrons et les trous:

$$\frac{dn(x,t)}{dt} = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} - r_n + g_n$$

$$\frac{dp(x,t)}{dt} = -\frac{1}{e} \frac{dJ_p}{dx} - r_p + g_p$$



Équations de continuité – longueur de diffusion

- *Exemple:* cas où le courant est ***exclusivement du à de la diffusion:***

$$J_n(\text{diff}) = eD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p(\text{diff}) = -eD_p \frac{dp}{dx}$$



$$\frac{dn}{dt} = D_n \frac{d^2n}{dx^2} - \frac{n - n_0}{\tau_n}$$

$$\frac{dp}{dt} = D_p \frac{d^2p}{dx^2} - \frac{p - p_0}{\tau_p}$$

Équations de continuité – longueur de diffusion

- En régime stationnaire, les dérivées par rapport au temps s'annulent:

$$\frac{d^2(n - n_0)}{dx^2} = \frac{n - n_0}{D_n \tau_n} = \frac{n - n_0}{L_n^2}$$

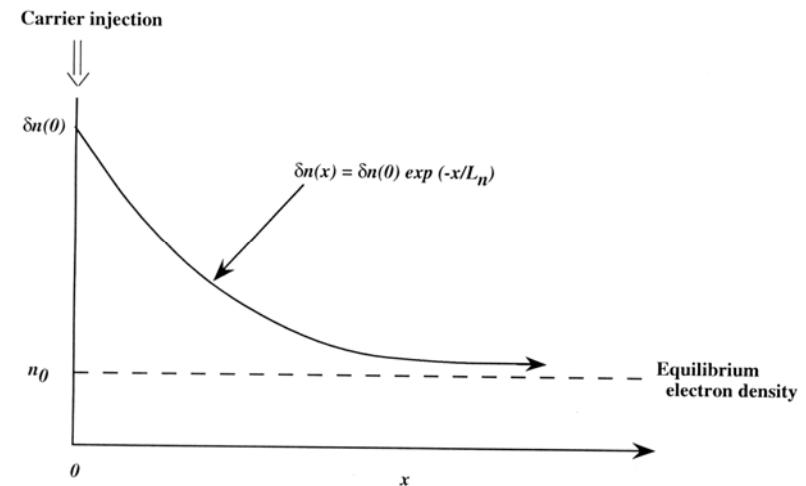
$$\frac{d^2(p - p_0)}{dx^2} = \frac{p - p_0}{D_p \tau_p} = \frac{p - p_0}{L_p^2}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

- Solutions:

$$\Delta n(x) = (n(x) - n_0) = \Delta n(0) e^{-x/L_n}$$



- Longueur de diffusion:** représente la distance moyenne parcourue avant que l'électron ne se recombine avec un trou (qq microns voire qq mm)
- L_n ou $L_p \gg$ aux dispos VLSI
- R et G jouent un petit rôle sauf dans qq cas précis* (Taur et al)

Équation de Poisson

- Elle est dérivée de la première équation de Maxwell. Elle relie le potentiel électrique et la densité de charge:

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_{sc}}$$

- Dans les SC, deux types de charges (fixes et mobiles):

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{e}{\epsilon_{sc}} \left[p(x) - n(x) + N_D^+(x) - N_A^-(x) \right]$$



*Charge mobiles
(électrons et trous)*

*Charges fixes
(dopants ionisés)*

Longueur de Debye

- Si on écrit l'équation de Poisson dans un type n en exprimant n en fonction de ϕ_{Fi} :

$$\frac{d^2\Phi_{Fi}}{dx^2} = -\frac{e}{\epsilon_{sc}} \left[N_d(x) - n_i e^{e\Phi_{Fi}/kT} \right]$$

- Si $N_d(x) \Rightarrow N_d + \Delta N_d(x)$, alors Φ_{Fi} est modifié de $\Delta\Phi_{Fi}$

en remarquant que: $V(x) = \Phi_{Fi} + cte$

$$\frac{d^2\Delta\phi_{Fi}}{dx^2} - \frac{e^2 N_d}{\epsilon_{sc} kT} \Delta\phi_{Fi} = -\frac{e}{\epsilon_{sc}} \Delta N_d(x)$$

Longueur de Debye

- Signification physique?
 - Solution de l'équation différentielle du 2° degré:

$$\Delta\phi_{Fi} = A \exp - \frac{x}{L_D} \quad \text{avec} \quad L_D = \sqrt{\frac{\epsilon_{sc} kT}{e^2 N_D}}$$

- La « réponse » des bandes n'est pas *abrupte* mais « prend » quelques L_D (si $N_d=10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $L_D=0.04\mu\text{m}$). Dans cette région, *présence d'un champ électrique* (neutralité électrique non réalisée)

Temps de relaxation diélectrique

- Comment évolue dans le temps la densité de *porteurs majoritaires* ?
 - Équation de continuité (R et G négligés):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n}{\partial x} \quad \text{or} \quad J_n = \sigma E = E / \rho_n \quad \text{et} \quad \frac{\partial E}{\partial x} = -en / \epsilon_{sc}$$

d'où

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\rho_n \epsilon_{sc}}$$

Solution: $n(t) \propto \exp(-t / \rho_n \epsilon_{sc})$

$$\tau = \rho_n \epsilon_{sc}$$

Temps de relaxation diélectrique (10^{-12} s)

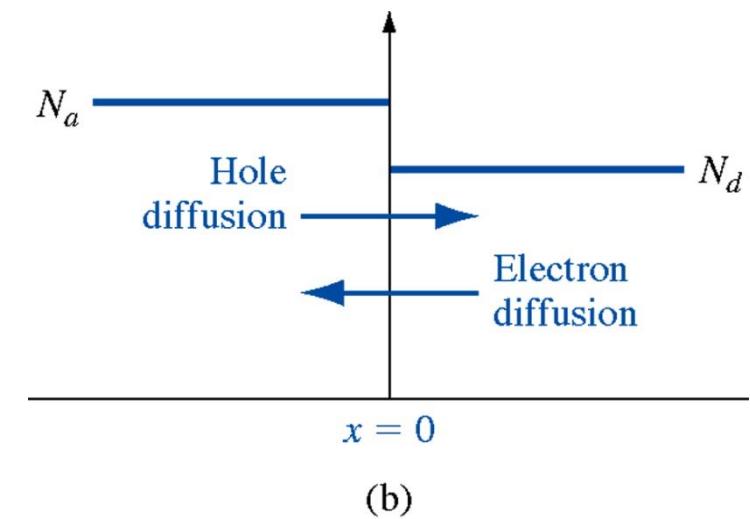
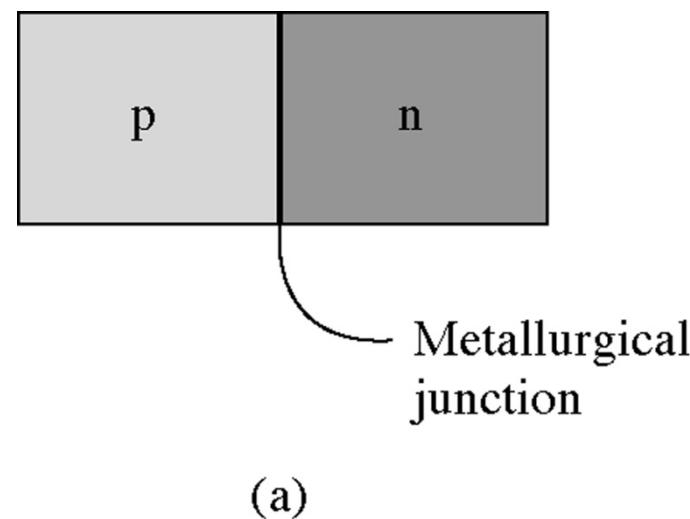
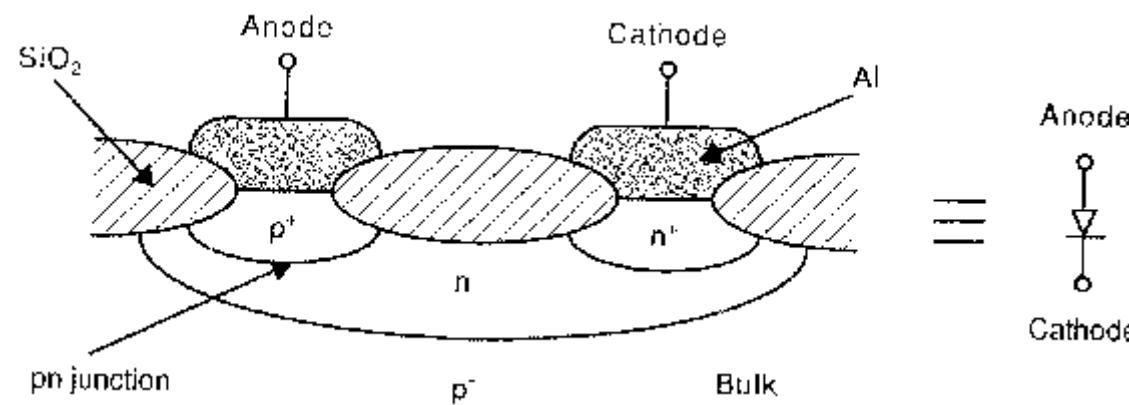
CHAP 12

Homo-jonction à semi-conducteur

Homojonction PN

- Composant à réponse non linéaire
- Dispositifs redresseur ou « rectifier devices »
- 2 types pour arriver au « même » résultat:
 - Jonction PN (notre propos)
 - Jonction à contact Schottky (chapitre suivant)

Mécanisme de formation de la jonction PN



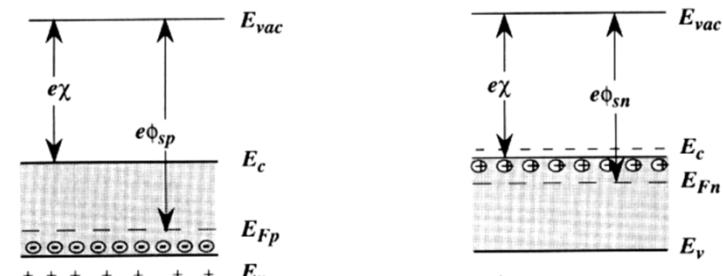
Mécanisme de formation de la jonction PN

• *Processus de mise à l'équilibre*

1^o phase : processus de diffusion

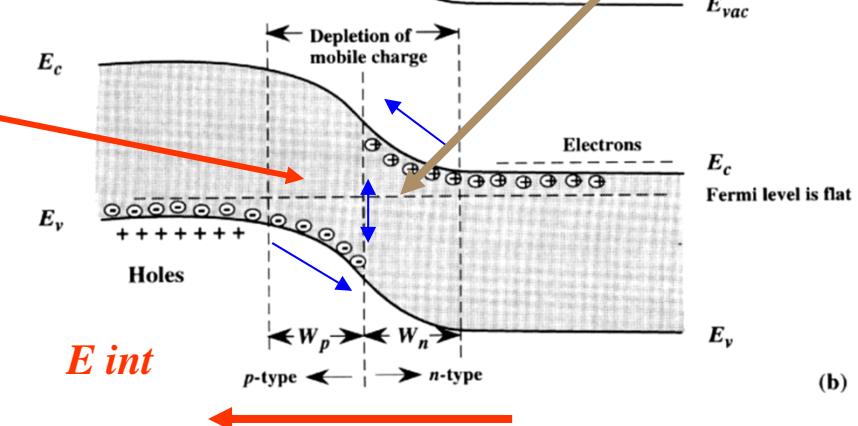
*2^o phase : Apparition d'un E interne:
équilibre la diffusion*

*Niveau de Fermi aligné:
équilibre thermodynamique*



(a)

*Recombinaison de
paires e-h*



(b)

- *Tension de diffusion V_D ou « built in potential V_{bi} »*

- Définition : différence de potentiel entre la région N et la région P

$$V_D = V_{bi} = V_N - V_P$$

Equation du courant de trous: $J_p(x) = e \left[\mu_p p(x) E(x) - D_p \frac{dp(x)}{dx} \right] = 0$

Soit encore $\frac{\mu_p}{D_p} E(x) = \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx}$ ou $\frac{-e}{kT} \frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx}$

En intégrant de la région P à la région N: $V_D = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{p_p}{p_n}\right)$

Soit finalement: $V_D = V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$

• Champ, potentiel et largeur de zone d'espace (1)

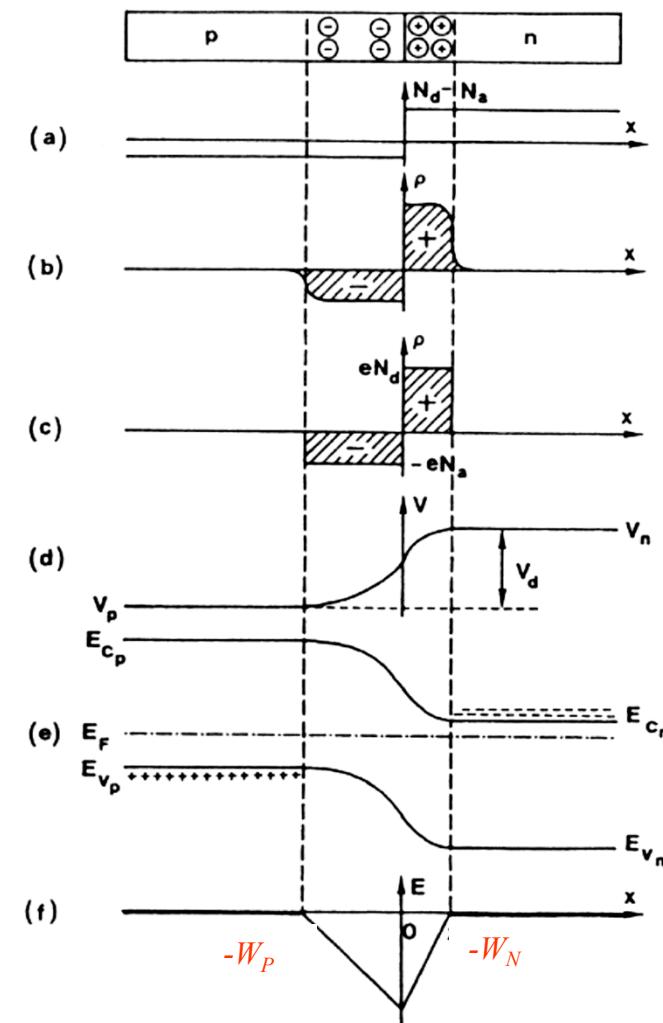
• *Equation de Poisson:*

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_{sc}}$$

■ *Dans la région N et P:*

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{e}{\epsilon_{sc}} N_D \quad 0 < x < W_N$$

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = +\frac{e}{\epsilon_{sc}} N_A \quad -W_P < x < 0$$



•Champ, potentiel et largeur de zone d'espace (2)

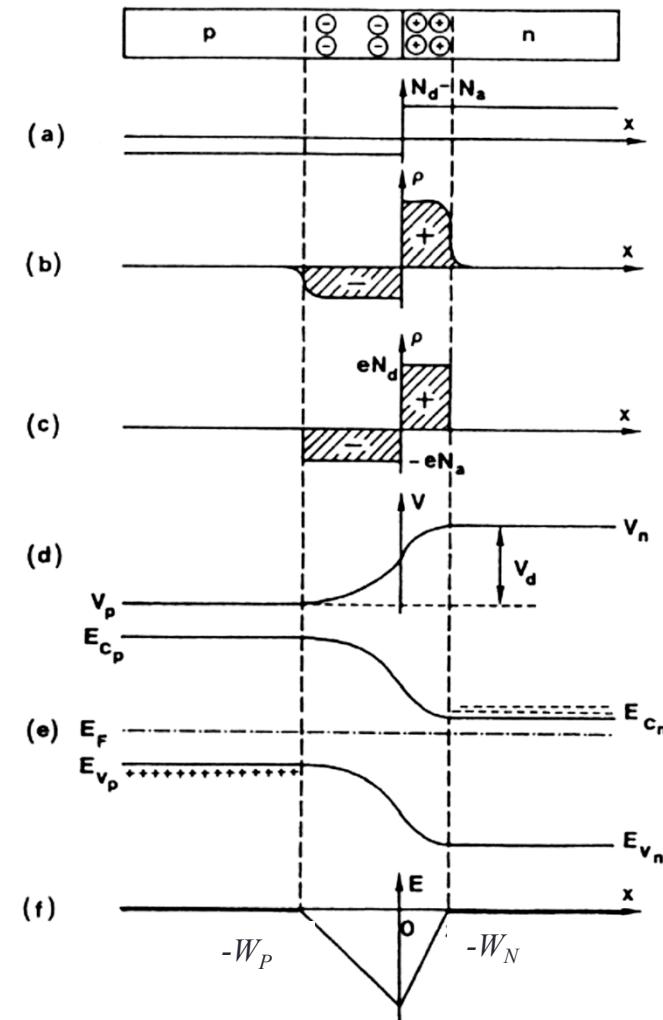
- Champ électrique $E(x)$

$$E_n(x) = +\frac{eN_D}{\epsilon_{sc}}(x - W_N) \quad E_P(x) = -\frac{eN_A}{\epsilon_{sc}}(x + W_P)$$

- Continuité du champ en $x=0$:

$$N_D W_N = N_A W_P$$

$$E_M = -\frac{eN_D W_N}{\epsilon_{sc}} = -\frac{eN_A W_P}{\epsilon_{sc}}$$



•Champ, potentiel et largeur de zone d'espace (3)

■ Potentiel électrique $E(x)$

$$V_n(x) = -\frac{eN_D}{2\varepsilon_{sc}}(x - W_N)^2 + V_n$$

$$V_p(x) = \frac{eN_A}{2\varepsilon_{sc}}(x + W_P)^2 + V_p$$

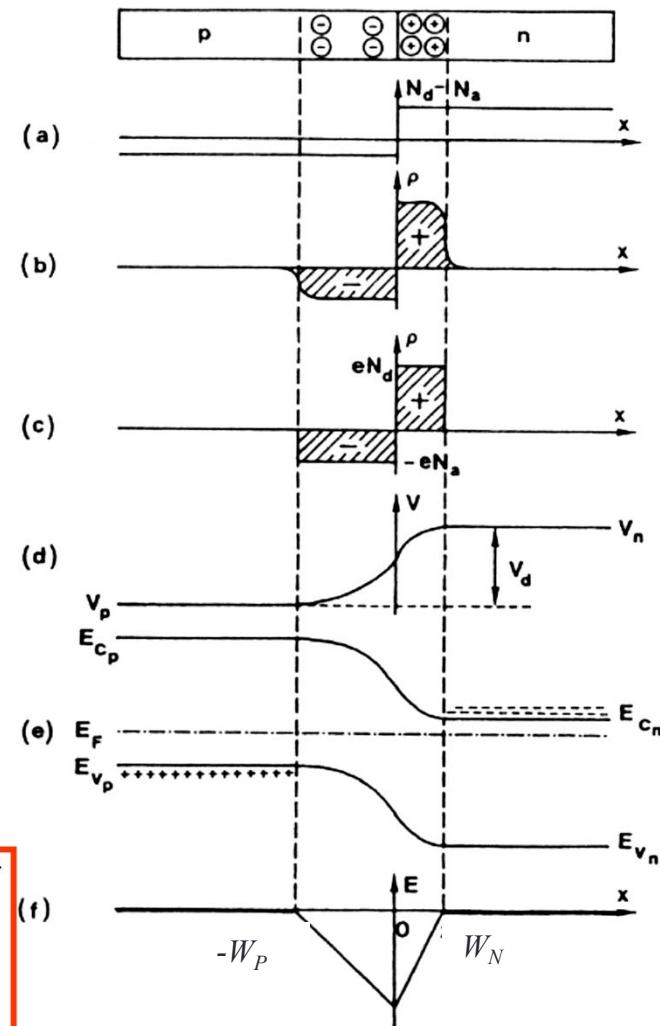
■ Zone de charge d'espace (ZCE)

$$V_n(0) = V_p(0) \Rightarrow -\frac{eN_D W_n^2}{2\varepsilon_{sc}} + V_n = \frac{eN_A W_p^2}{2\varepsilon_{sc}} + V_p$$

$$W_p(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)} V_{bi}}$$

$$W_n(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)} V_{bi}}$$

$$W(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e} \frac{N_D + N_A}{N_A N_D} V_{bi}}$$



Attention: tout ce que l'on vient de voir était pour $V=0$. Lorsque la diode est polarisée par une tension V sur P, V_{bi} doit être remplacée par $V_{bi} - V$

Jonction PN sous polarisation

- Cette polarisation va rompre l'équilibre entre les forces de diffusion et de conduction: => apparition d'un courant ?

- Hypothèses simplificatrices:
 - ZCE vide de porteurs
 - Faible injection
 - Approximation de Boltzmann
 - Toute la tension V_A appliquée sur la jonction
 - Pas de phénomènes de Génération - Recombinaison

Jonction PN sous polarisation

À l'équilibre, courant nul \Leftrightarrow deux composantes (diff et cond) s'opposent. Pris à part , l'ordre de grandeur de ces composantes 10^4 A/cm^2 (soit 1A pour diode typique) or en faible injection I est de l'ordre de qq mA à qq 10 mA

- **Approximation de Boltzmann:** L'approximation de Boltzmann consiste à dire que la résultante des courants étant *faible devant les composantes de ce courant*, on considère que l'on est encore en quasi-équilibre et donc que l'équation du courant est encore valide en remplaçant V_d par $V_d - V_a$:

$$\frac{-e}{kT} \frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx}$$

Densité de porteurs injectés à la frontière de la ZCE

- Si $V_A = 0$

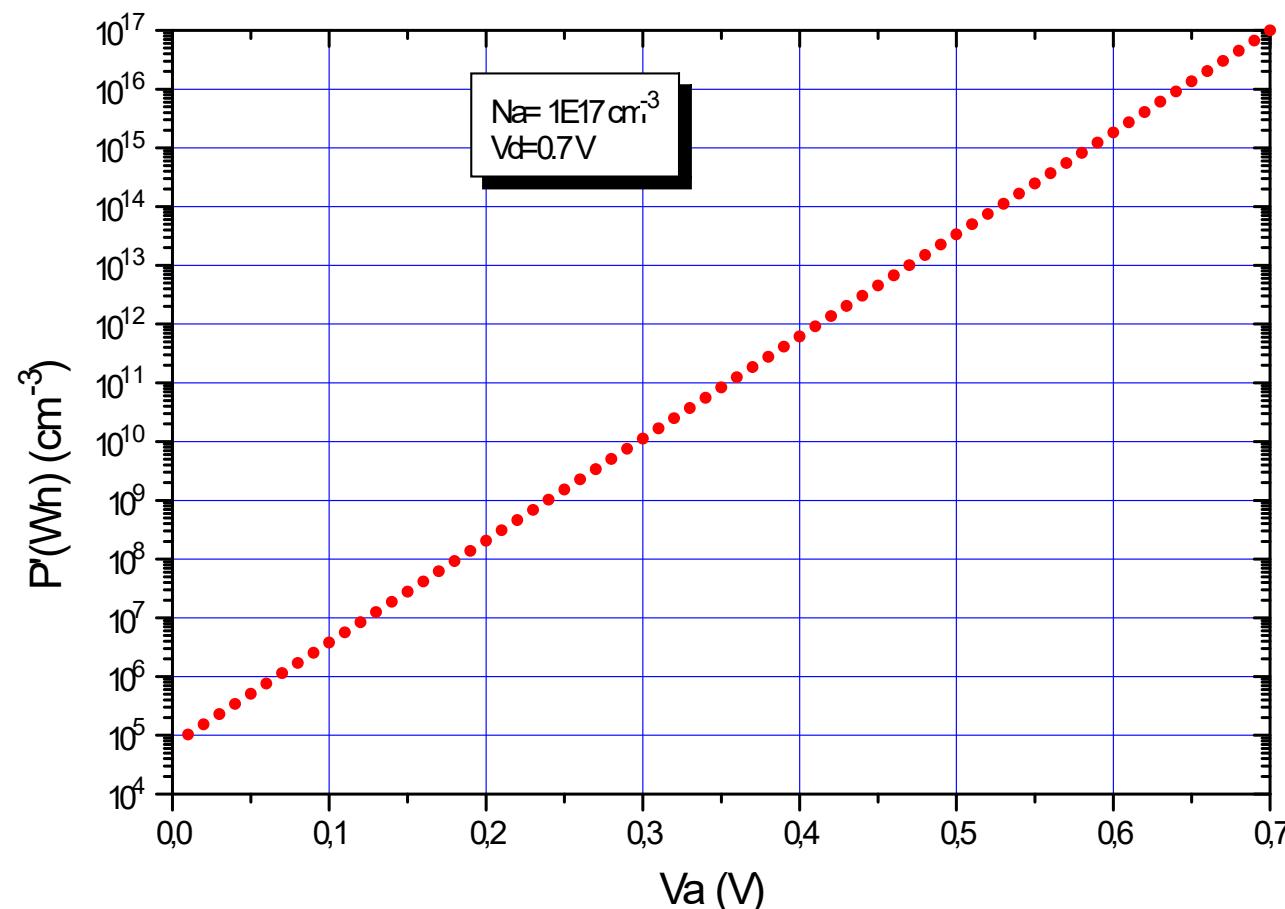
$$\frac{p(W_N)}{p_p} = \frac{p_n}{p_p} = \exp\left(-\frac{eV_{bi}}{kT}\right)$$

- Si $V_A \neq 0$ $\frac{p'(W_N)}{p_p} = \frac{p'_n}{p_p} = \exp\left(-\frac{e(V_{bi} - V_A)}{kT}\right) = \frac{p_n}{p_p} \exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right)$

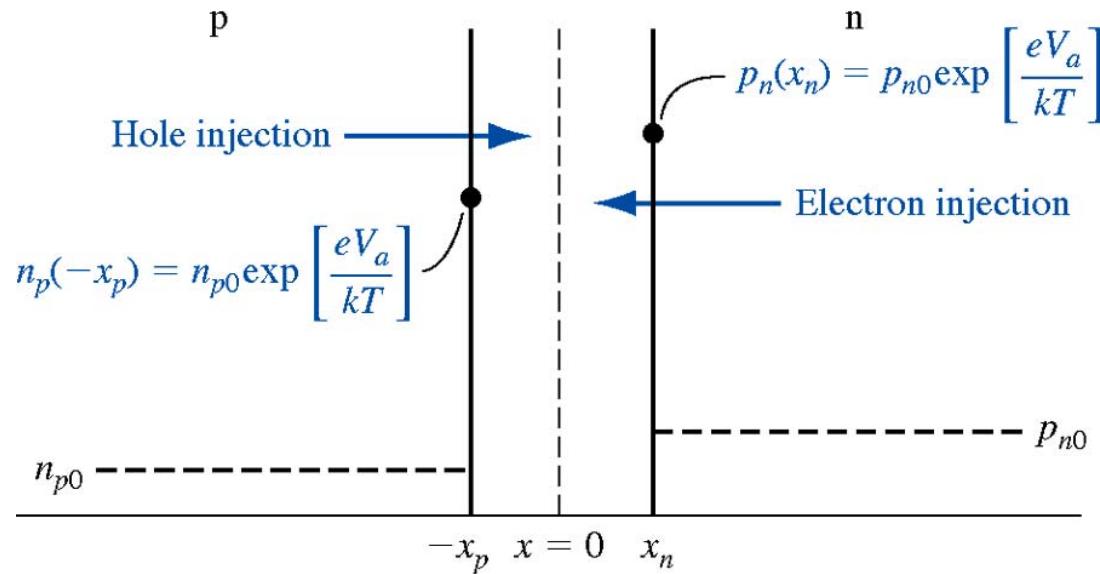
$$p'_n = p_n \exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) = \frac{n_i^2}{N_D} \exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) \quad n'_p = n_p \exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right)$$

$$n'_p * p_p = p'_n * n_n = n_i^2 \exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right)$$

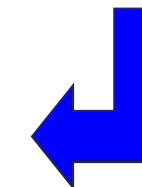
Variation de la densité de trous injectés en fonction de V_a



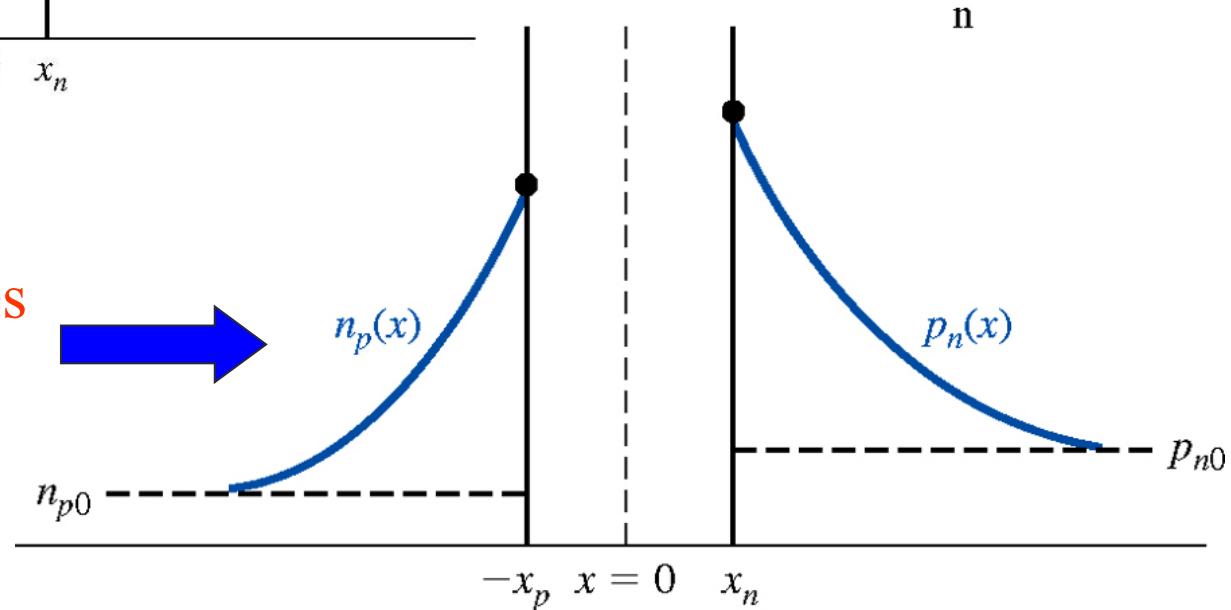
Injection de porteurs



En polarisation directe,
phénomènes de diffusion



Une fois injectés, les
porteurs diffusent



Distribution des porteurs dans les régions neutres

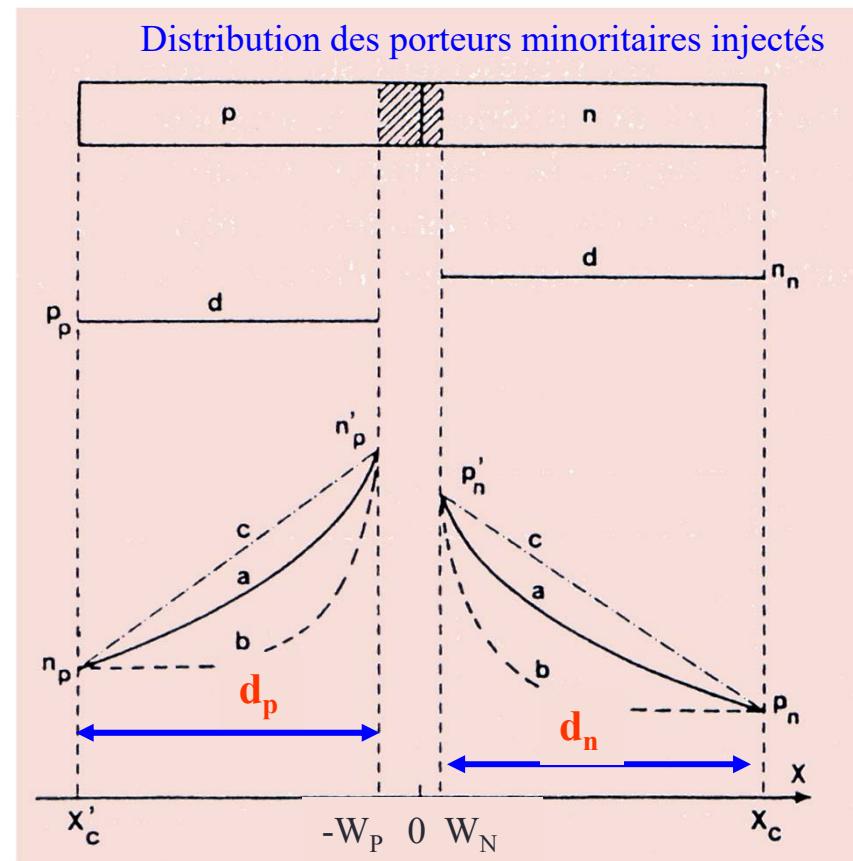
- Une fois les porteurs injectés, ils vont diffuser dans la région neutre et se recombiner avec les porteurs majoritaires

$$J_p(x) = -eD_p \frac{\partial p}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{p - p_n}{\tau_p}$$

- La distribution va être fonction de la géométrie de la région

$$p - p_n = A e^{-x/L_p} + B e^{+x/L_p}$$

- Les paramètres discriminatoires : la **longueur de diffusion** $L_{Dn,p}$ des électrons et des trous et la **largeur des régions neutres** $d_{n,p}$



a: région qcq, b: longue, c:courte,

Distribution des porteurs dans les régions neutres

- Régions longues ($d_{n,p} \gg L_{p,n}$)

$$p'(x) - p_n = p_n (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) e^{(W_N - x)/L_p}$$

$$n'(x) - n_p = n_p (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) e^{(x + Wp)/L_n}$$

- Régions courtes ($d_{n,p} \ll L_{p,n}$)

$$p'(x) - p_n = \frac{p_n}{d_n} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) (x_c - x)$$

$$n'(x) - n_p = \frac{n_p}{d_p} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) (x'_c + x)$$

- Régions qcq

$$p'(x) - p_n = \frac{p_n}{sh(\frac{d_n}{L_p})} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) sh\left[\frac{(x_c - x)}{L_p}\right]$$

$$n'(x) - n_p = \frac{n_p}{sh(\frac{d_p}{L_n})} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) sh\left[\frac{(x' + x'_c)}{L_n}\right]$$

Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres

- La distribution connue, on peut facilement calculer le courant qui est un **courant de diffusion**:

$$J_p(x) = -eD_p \frac{dp(x)}{dx} \quad J_n(x) = eD_n \frac{dn(x)}{dx}$$

- Hypothèse : **pas de Phénomènes de G-R dans la ZCE**

$$J(V) = J_p(-W_p) + J_n(W_p) = J_p(W_n) + J_n(-W_p)$$

- On obtient la formule classique:

$$J(V) = J_S(e^{eV/kT} - 1)$$

*J_S est le courant de saturation de la diode,
ou courant inverse théorique*

Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres

- Régions courtes

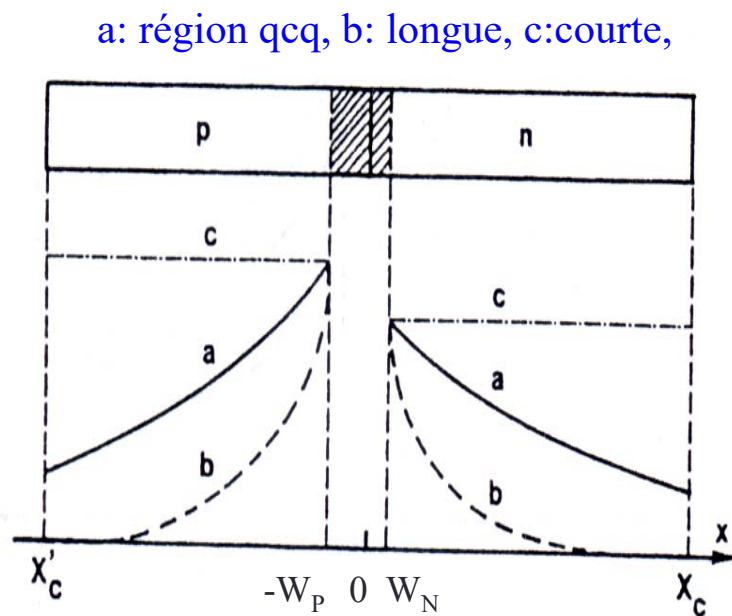
$$J_S = \frac{en_i^2 D_P}{N_D d_n} + \frac{en_i^2 D_n}{N_A d_p}$$

- Régions longues

$$J_S = \frac{en_i^2 D_P}{N_D L_P} + \frac{en_i^2 D_n}{N_A L_n}$$

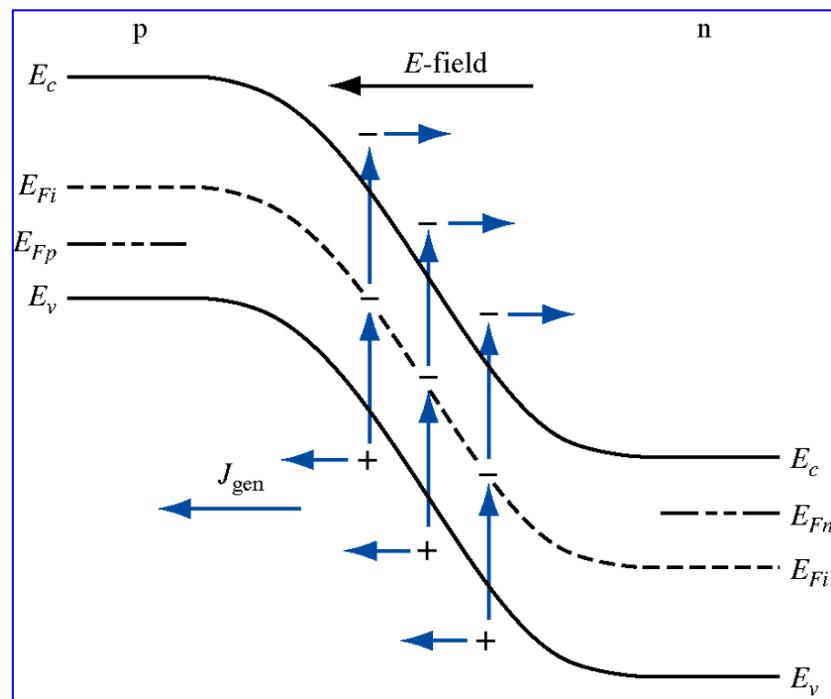
- Régions qcq

$$J_S = \frac{en_i^2 D_P}{N_D L_P \operatorname{th}\left(\frac{d_n}{L_P}\right)} + \frac{en_i^2 D_n}{N_A L_n \operatorname{th}\left(\frac{d_p}{L_n}\right)}$$

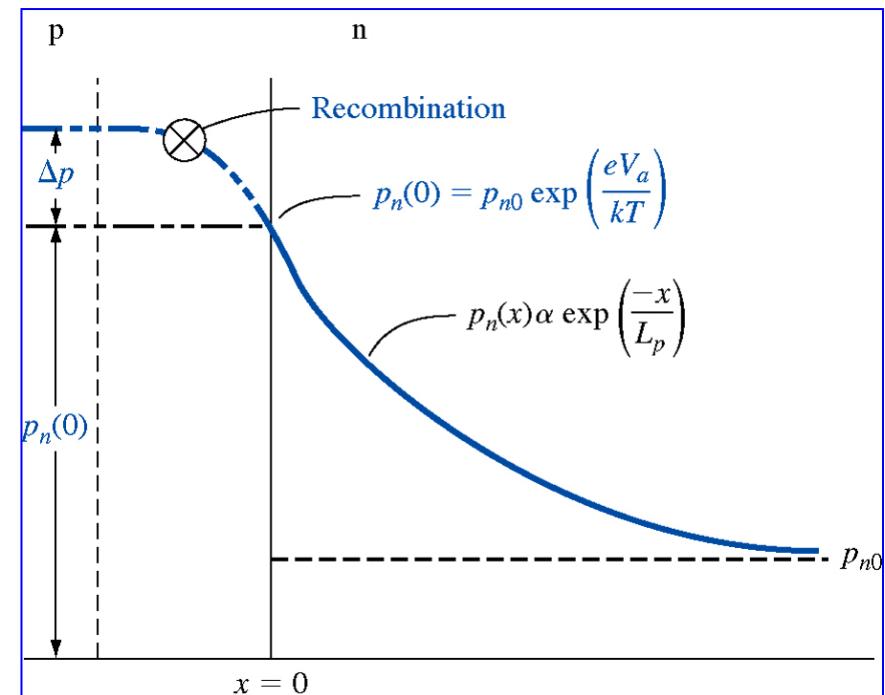


Courant de porteurs minoritaires

Génération –recombinaison dans la ZCE



Génération en inverse



Recombinaison en direct

La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE

- On affine le modèle \Leftrightarrow on tient compte de la G-R dans la ZCE
- Mécanisme connu (Shockley-Read)

$$r = \frac{1}{\tau} \frac{pn - n_i^2}{2n_i + p + n}$$

- On sait également que $p(W_N)n(W_N) = p(W_P)n(W_P) = n_i^2 \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$
- Si on suppose np constant dans la ZCE et $\gg n_i^2$ (en polarisation directe), le taux r est max pour $n=p$, soit encore

$$r_{\max} = \frac{n_i}{2\tau} \exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right)$$

La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE

- Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s'écrit alors:

$$\cancel{\frac{dn}{dt}} = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} + \cancel{g} - r \Leftrightarrow 0 = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} - r \Rightarrow dJ_n = erdx \quad J_{GR} = e \int_{W_P}^{W_N} r dx$$

- En polarisation inverse ($pn \ll n_i^2$), le taux est négatif ($r = -\frac{n_i}{2\tau} < 0$) et devient un taux net de génération
- En polarisation directe , le taux est $r_{max} = cte$ et le courant est un courant de recombinaisons.

La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE

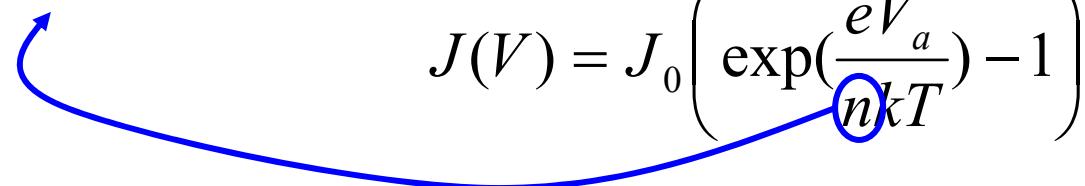
- Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s'écrit alors:

$$J_{GR} = J_{GR}^0 \left(\exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right) - 1 \right) \quad J_{GR}^0 = \frac{en_i}{2\tau} W_T$$

- Le courant global en intégrant cet effet s'écrit:

$$J(V_a) = J_S \left(\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right) + J_{GR}^0 \left(\exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right) - 1 \right)$$

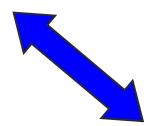
- Facteur d'idéalité:



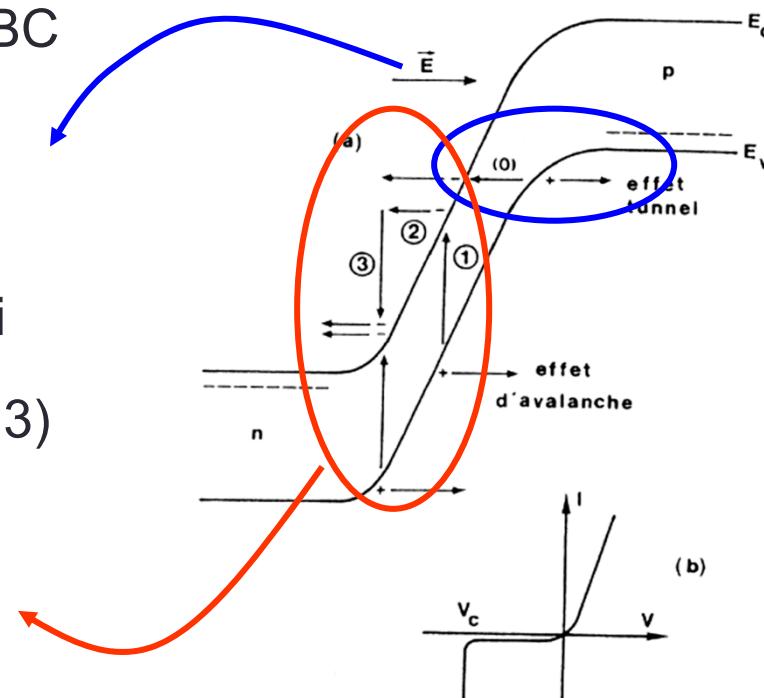
$$J(V) = J_0 \left(\exp\left(\frac{eV_a}{nkJ}\right) - 1 \right)$$

Diode en polarisation inverse: claquage de la jonction

- Effet thermique
- **Effet Zener:**
 - Passage direct de la BV à la BC par effet tunnel (0) si champ électrique supérieur à $E_{critique}$
- **Effet Avalanche:**
 - Avant le « tunneling », accélération des électrons qui excitent par impact des électrons de BV vers BC (1,2,3) etc....



$$V_{BD} = \frac{\epsilon E_C^2}{2eN_B}$$



- Perçage ou « punchthrough »

Jonction en régime dynamique: capacités de la jonction

- Capacité associée à charges
- 2 types de charges dans la jonction
 - Fixes (les dopants ionisés) dans la ZCE
 - Mobiles (les e^- et h^+) injectés en direct
- 2 types de capacités
 - Capacité de transition ou de la jonction
 - Capacité de diffusion ou stockage

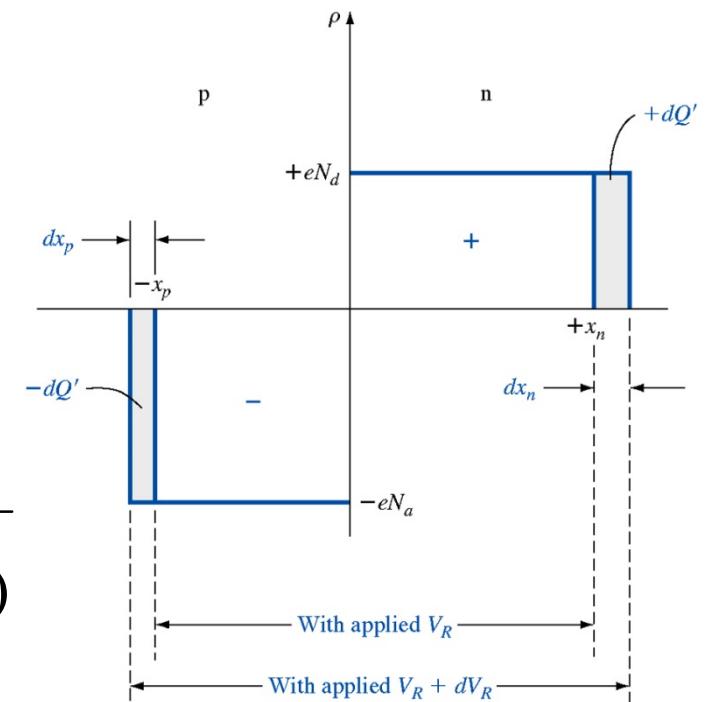
Capacité de transition ou de jonction

Elle est simplement associée à la charge Q contenue dans la ZCE

$$|Q| = eAN_AW_P = eAN_DW_N$$

$$C_T = \left| \frac{dQ'}{dV} \right|$$

$$W_p(V_d + V_A) = \sqrt{\frac{2\epsilon_{sc}}{e} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)} (V_d - V_A)}$$

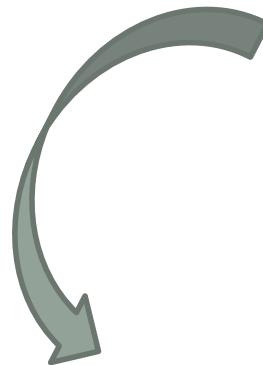


Soit:

$$C_T = \frac{A}{2} \sqrt{\frac{2e\epsilon}{(V_D - V_A)}} \frac{N_A N_D}{(N_A + N_D)} = \frac{A\epsilon}{W_T}$$

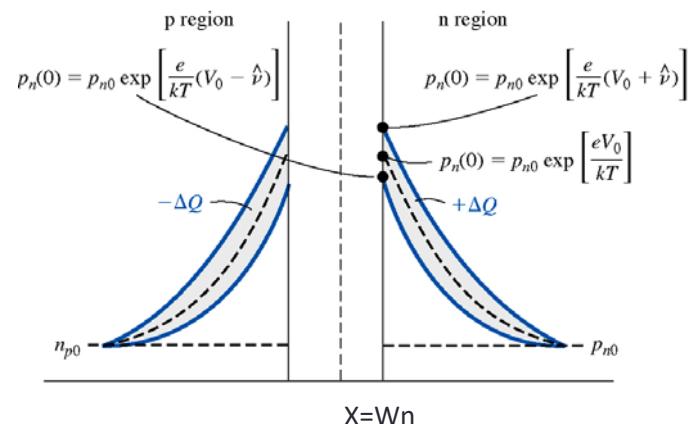
Capacité de diffusion ou de stockage

- Traduit le retard entre la tension et le courant
- Associée aux charges injectées dans les régions neutres:



$$Q_{Sp} = \tau_p J_p(Wn)$$

$$Q_{Sp} = e(p'(0) - p_n)L_P \left[\coth\left(\frac{d_n}{L_P}\right) - \frac{1}{\sinh\left(\frac{d_n}{L_P}\right)} \right]$$



$$Q_{Sp} = A \int_{W_N}^{X_C} e(p'(x) - p_n) dx$$

Densité de trous excédentaires
dans la région neutre N

Capacité de diffusion ou de stockage

- *L'expression précédente peut se mettre sous la forme:*

$$Q_{Sp} = \tau_{(p)} J_P(W_N) \quad \text{avec} \quad \tau_{(p)} = \tau_P \left(1 - \frac{1}{ch\left(\frac{d_n}{L_P}\right)} \right)$$

- L'expression du temps peut être simplifiée en fonction de la « géométrie » de la diode:

- *Diode courte:* $\tau_{(p)} = \tau_t = \frac{d_n^2}{2D_P}$ \leftrightarrow temps de transit
- *Diode longue :* $\tau_{(p)} = \tau_P$ \leftrightarrow durée de vie

Capacité de diffusion ou de stockage

- Cette étude dans la région N est valable dans la région P, et en final on obtient:

$$Q_S = Q_{Sn} + Q_{Sp} = \tau_{(n)} J_n(-W_P) + \tau_{(p)} J_p(W_N)$$

Soit à partir de : $C_S = \frac{dQ_S}{dV}$

$$C_S = C_{Sn} + C_{Sp} = \frac{e}{kT} K(\tau_{(n)} I_n + \tau_{(p)} I_p)$$

Facteur qui dépend de la géométrie

(2/3 \Leftrightarrow courte)

(1/2 \Leftrightarrow longue)

Capacité de diffusion ou de stockage

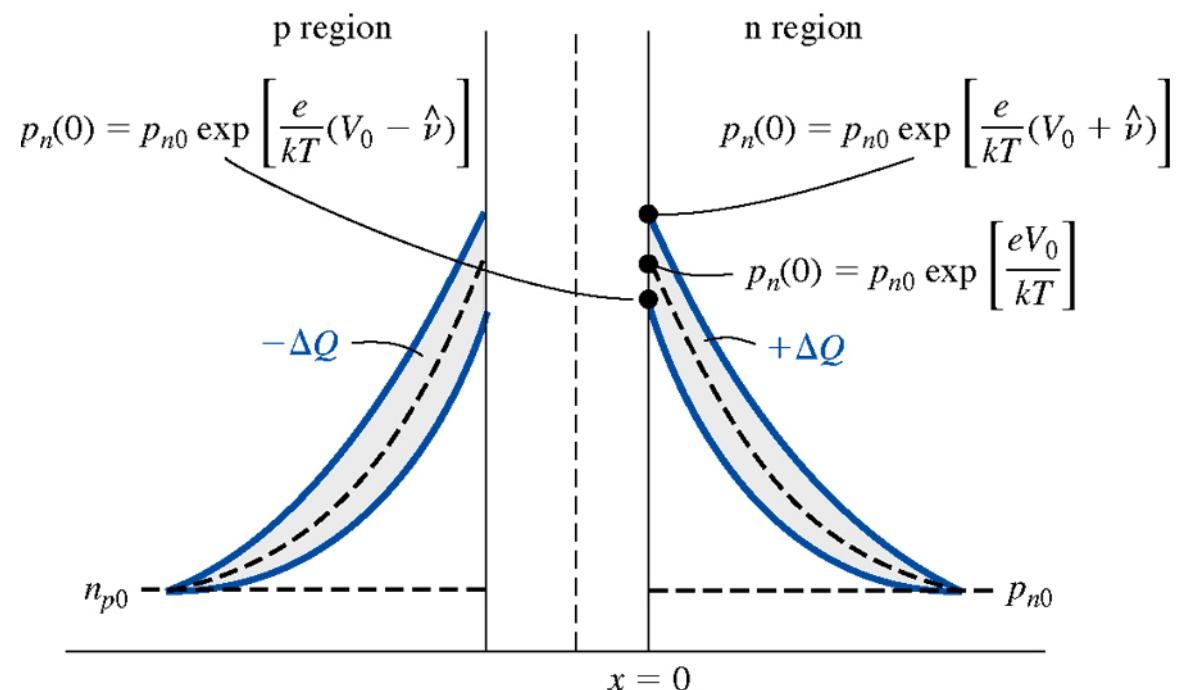
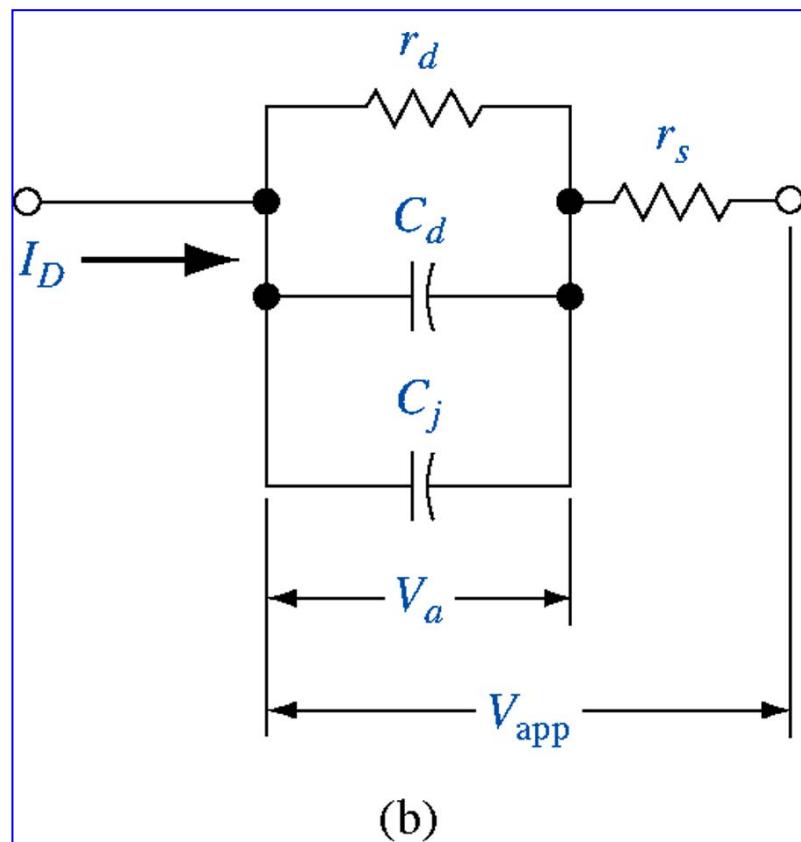


Schéma équivalent jonction pn



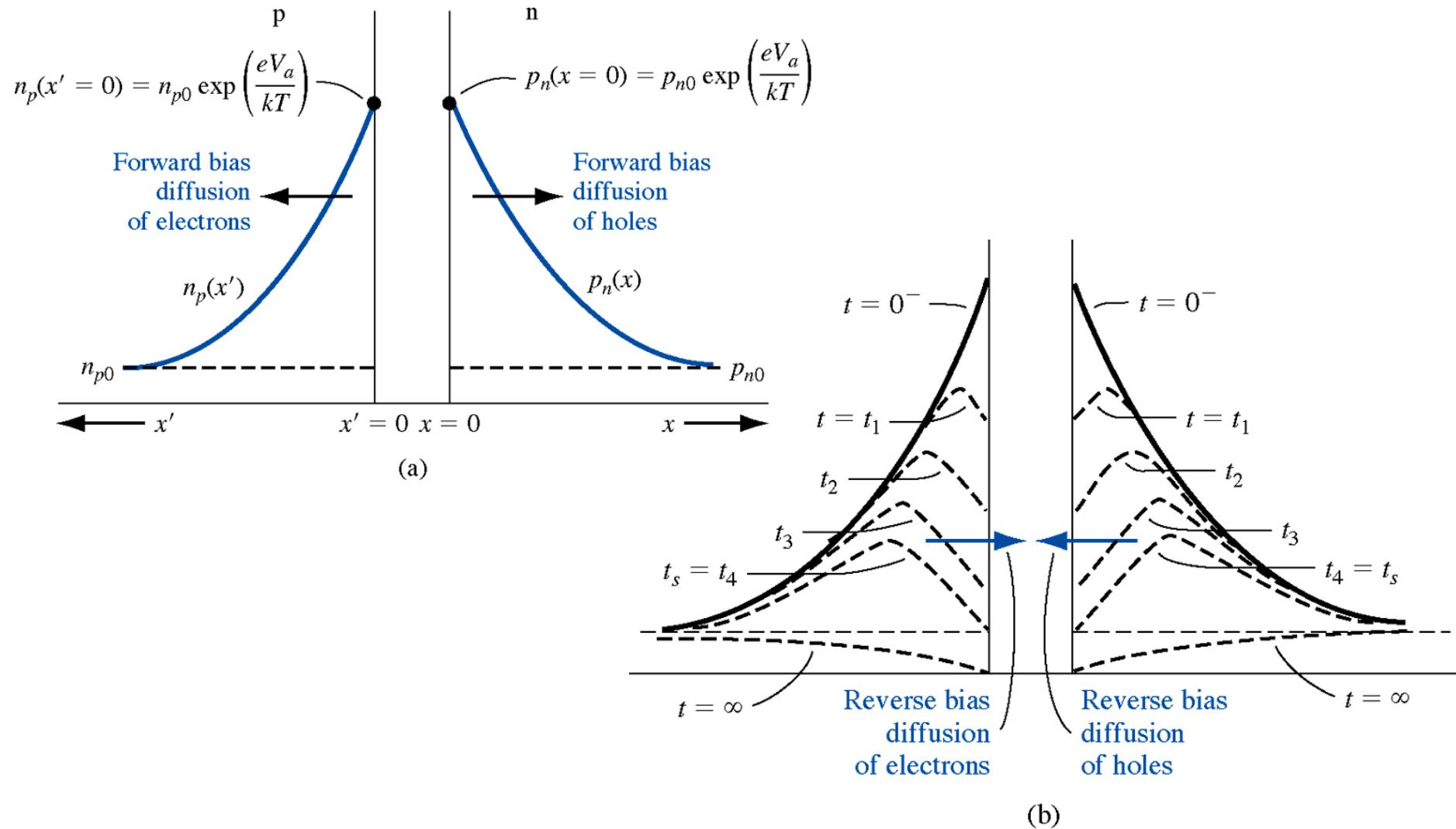
$$r_d = \frac{dV}{dI} = \frac{kT}{e} \frac{1}{I} \text{ résistance dynamique}$$

$$C_d = C_s = C_{Sn} + C_{Sp} = \frac{e}{kT} K(\tau_{(n)} I_n + \tau_{(p)} I_p) \text{ capa de diffusion}$$

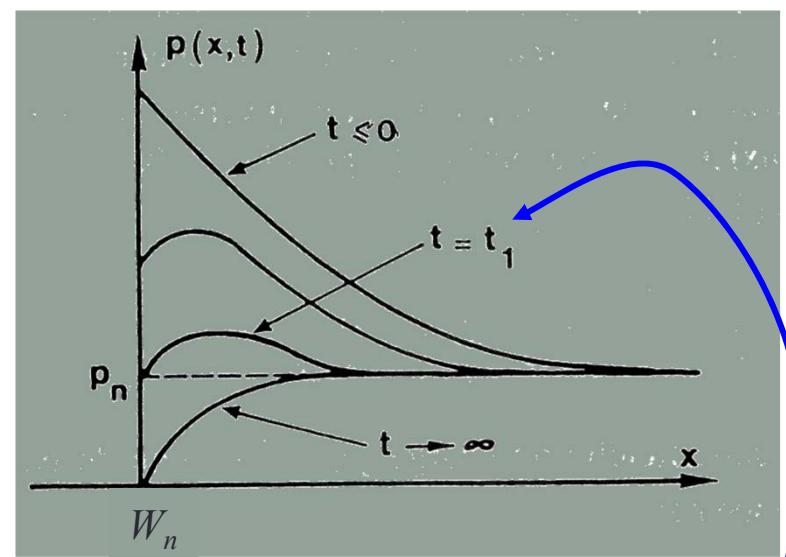
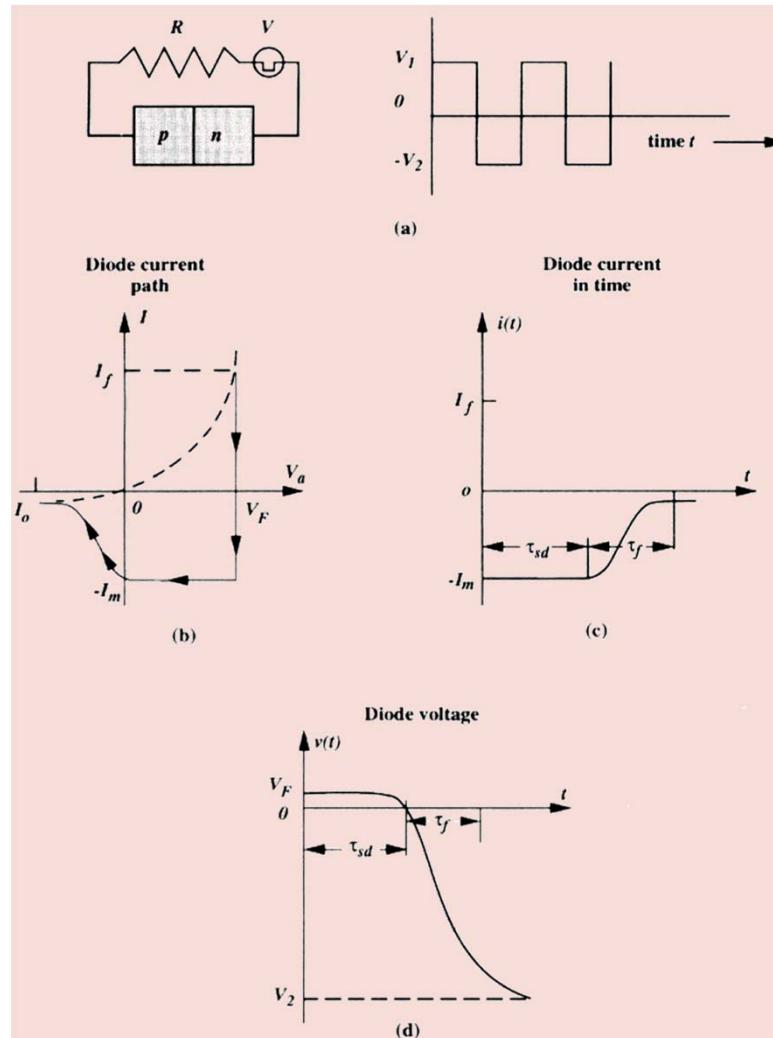
$$C_T = C_J = \frac{A}{2} \sqrt{\frac{2e\epsilon}{(V_D - V_A)}} \frac{N_A N_D}{(N_A + N_D)} = \frac{A\epsilon}{W_T} \text{ capa de jonction}$$

r_s résistance série

Jonction PN en commutation



Jonction PN en commutation



Tant que l'excédent de trous en W_n est positif

\Leftrightarrow Diode polarisée en direct

$$p'_n - p_n = p_n \left(e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1 \right)$$

$\tau_{sd} \Leftrightarrow$ Temps de stockage ie $p'(W_N) = p_n$

Jonction PN en commutation

- Problème majeur dans les composants à porteurs minoritaires:

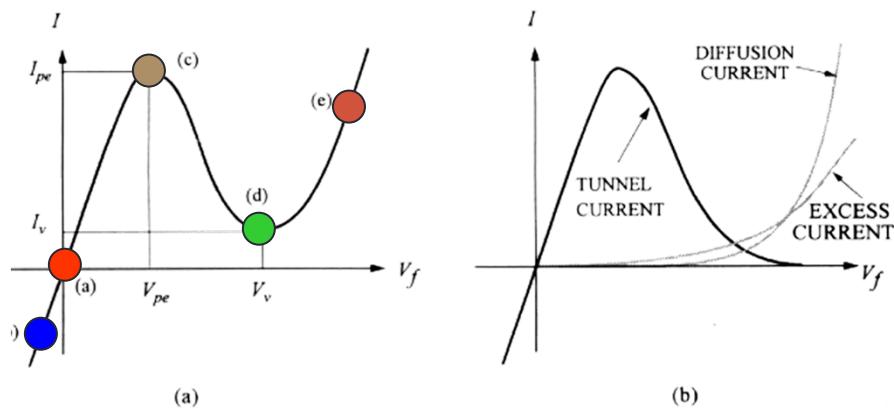
- Expression du temps de stockage:

$$\tau_{sd} \cong \tau_p \left[\ln\left(1 + \frac{I_f}{I_m}\right) - \ln\left(1 + \frac{I_f}{I_f + I_m}\right) \right]$$

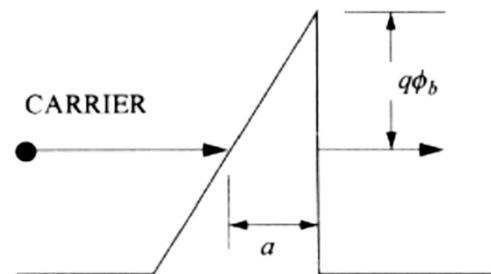
- Expression du temps de descente

$$\tau_f \cong 2.3 \left[\frac{\tau_F \delta + RC_j}{1 + \delta} \right] \text{ avec } \delta = \frac{I_f}{I_f + I_m}$$

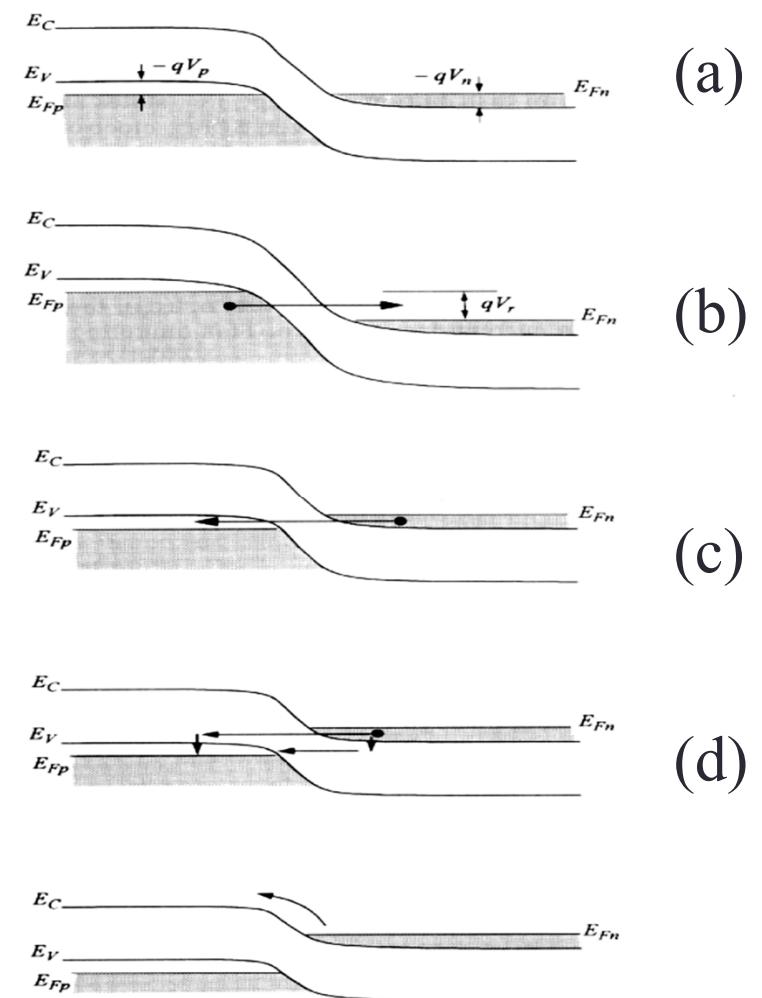
Diode Tunnel – diode Backward



$$I_t = I_{pe} \left(\frac{V_a}{V_{pe}} \right) \exp \left(1 - \frac{V_a}{V_{pe}} \right)$$

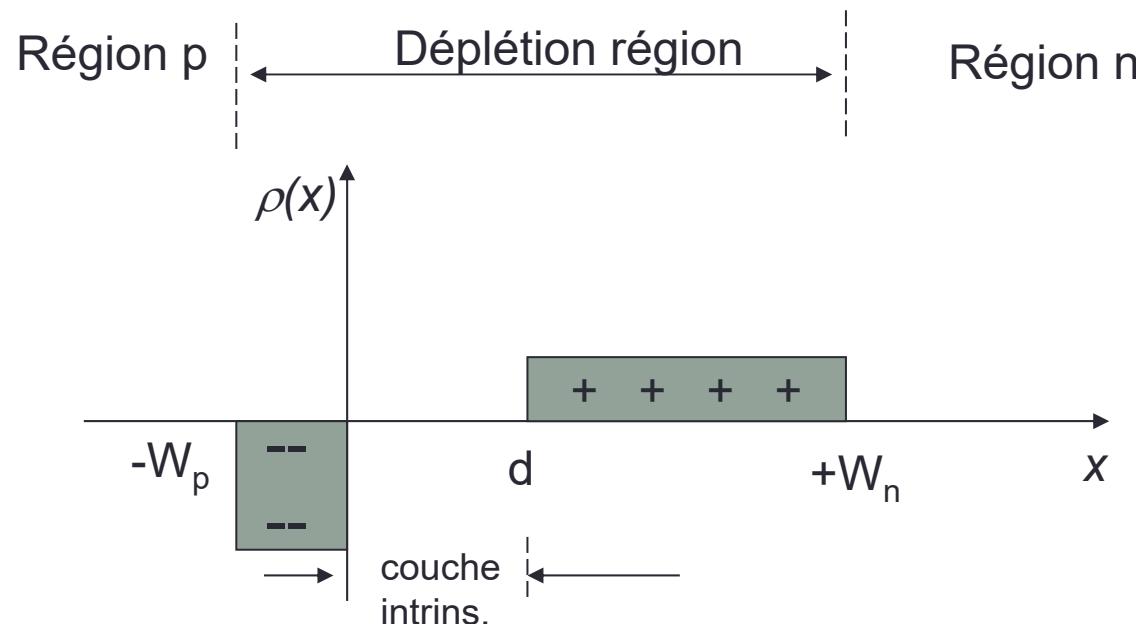


$$T_t \approx \exp \left(- \frac{4a\sqrt{2m^* e\phi_b}}{3\hbar} \right)$$



Diodes PIN

- Dispos VLSI modernes \Leftrightarrow très fort champ électrique
- Pb d'avalanche et effet de porteurs chauds
- Solutions:
 - Réduction du champ par augmentation de la ZCE
 - Incorporation d'une couche « non dopée » dite intrinsèque d'où le nom !



Diodes PIN

champ max (dans la zone intrinsèque)

$$E_m = -\frac{eN_A x_p}{\epsilon_{Si}} = -\frac{eN_D (x_n - d)}{\epsilon_{Si}}$$

Tension de diffusion ("built in potential")

$$V_{bi} = \frac{|E_m|}{2} (x_p + x_n + d) = \frac{|E_m|}{2} (W_d + d)$$

largeur de la ZCE

$$W_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}}{e} \frac{(N_A + N_D)}{N_A N_D} V_{bi} + d^2} = \sqrt{W_{d0}^2 + d^2}$$

capacité

champ électrique

$$\frac{C_T}{C_{T0}} = \frac{W_{d0}}{W_d} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{d^2}{W_{d0}^2}}} \quad \frac{E_m}{E_{m0}} = \frac{W_d}{W_d + W_{d0}} = \sqrt{1 + \frac{d^2}{W_{d0}^2}} - \frac{d}{W_{d0}}$$

